Synthese, Strukturchemie und physikalische Untersuchungen an Mangan-, Eisen- und Quecksilber-Chalkogenometallatverbindungen



Dissertation

zur Erlangung des Doktorgrades

der Naturwissenschaft (Dr. rer. nat.)

der Naturwissenschaftlichen Fakultät IV - Chemie und

Pharmazie der Universität Regensburg

vorgelegt von Alois Lecker aus Ränkam

November 2011



Diese Arbeit wurde von Herrn Prof. Dr. Arno Pfitzner angeleitet. Einreichung des Promotionsgesuchs: September 2011 Tag der mündlichen Prüfung: 20.12.2011

Prüfungsausschuss:

Vorsitzender: Herr Prof. Dr. H. Brunner 1. Gutachter: Herr Prof. Dr. A. Pfitzner 2. Gutachter: Herr Prof. Dr. N. Korber Weiterer Prüfer: Herr Prof. Dr. B. Dick Meinen Lieben gewidmet

Eidesstattliche Erklärung
Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit ohne unzulängliche Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe; die aus anderen Quellen direkt oder indirekt übernommenen Daten und Konzepte sind unter Angabe des Literaturzitats gekennzeichnet. Die Arbeit wurde bisher weder im In- noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer andern Prüfungsbehörde vorgelegt. Ich versichere an Eides statt, dass ich nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen habe.
Regensburg, 2011
Alois Lecker

"Der Mensch ist der Meister seines Schicksals." Johann Wolfgang von Goethe vi



Diese Arbeit wäre ohne die fachliche und persönliche Unterstützung zahlreicher Menschen nicht möglich gewesen. Ihnen allen möchte ich hiermit danken.

Besonderer Dank gebührt Herrn Prof. Dr. Arno Pfitzner für die Möglichkeit zur Durchführung der experimentellen Arbeit an seinem Arbeitskreis und die große wissenschaftliche Freiheit hinsichtlich der Auswahl der Themen.

Herrn Prof. Dr. Werner Kunz und seinem Mitarbeiter Herrn Björn Bartel für die rasterelektronenmikroskopische Analyse einiger Proben und die dabei entstandenen REM-Aufnahmen.

Herrn Prof. Dr. Rainer Winter und seinen Mitarbeitern Michael Linseis und Florian Pevny für ihre Hilfe bei der Aufnahme von UV/VIS-Spektren.

Herrn Dr. Michael Bräu, Herrn Dr. Daniel Kurowski und Herrn Anton Pointner für die im Rahmen ihrer Promotions- bzw. Zulassungsarbeit durchgeführten Synthesen und Analysen einiger Mangan- und Eisenverbindung, deren Ergebnisse auch in diese Arbeit mit einflossen.

Herrn Franz Rau sowie Herrn Florian Truksa, die mich bei der Präparation einiger Verbindungen tatkräftig unterstützten.

Frau Dr. Martina Andratschke für die zuverlässige Betreuung des Pulverdiffraktometers mit dem diverse Pulverdiffraktogramme aufgezeichnet wurden, von denen auch einige in diese Arbeit enthalten sind

Herrn Dr. Manfred Zabel und Frau Sabine Stempfhuber, die mir den eigenständigen Umgang mit einem STOE IPDS I ermöglichten und mir stets genügend Messzeit einräumten.

Frau Ulrike Schießl, Frau Daniela Garcia und Herrn Manuele Avola für die gute und schnelle Bearbeitung meiner DTA-Proben.

Frau Daniela Garcia sowie Herrn Tomas Rödl, welche die in dieser Arbeit enthaltenen Raman-Spekten aufzeichneten.

Herrn PD Dr. Richard Weihrich und Herrn Florian Pielnhofer, denen ich die Berechnung der elektronischen Bandstruktur sowie der DOS und TDOS einer Verbindung verdanke.

Herrn Dr. Hans Zwicknagl für seine langjährige Freundschaft und das erste Korrekturlesen dieser Arbeit

Unserer Sekretärin Frau Katharina Kaschura für ihre unerschöpflichen Papierreserven und ihrer Hilfe bei vielen organisatorischen Problemen.

Meinen ehemaligen Kommilitonen und Arbeitskollegen Herrn Dr. Stefan Lange, Herrn Dr. Michael Leitl und Herrn Dr. Stefan Seidlmayer mit denen mich gemeinsame Erinnerungen an eine schöne Studienzeit verbindet.

Des weiteren danke ich allen gegenwärtigen und ehemaligen Arbeitskollegen am Lehrstuhl von Herrn Prof. Dr. Arno Pfitzner für das gute Arbeitsklima und ihre Freundschaft:

Frau Dr. Irina Anuscă, Frau Sharareh Arab Bagheri, Herr Frederik Bachhuber, Herr Sven Bauernfeind, Herr Dr. Thomas Bernert, Herr Johannes Bucher, Herr Stephan Dankesreiter, Herr Stephan Eckl, Herr Anatoli Esch, Herr Dominik Frank, Herr Sebastian Greil, Herr Wilhelm Haas, Frau Heike Hack, Herr Dr. Jung Hoon Hong, Frau Dr. Diana Hoppe, Herr Sebastian Huber, Frau Freya von Krziwanek, Herrn Kurt G. Lange, Frau Iris Luber, Herr Sebastian Maderlehner, Herr Prof. Dr. Tom Nilges, Herr Dr. Patrick Pohla, Herr Philipp Peter, Herr Dr. Christian Preitschaft, Herr Jan Rothballer, Herr Dr. Andreas Roduch, Frau Nadia Rück, Herr Alexander Spengler, Herr Roland Stadler, Frau Marta Walczak, Frau Dr. Karolina Warzycha und Herr Matthias Übler.

Herausheben möchte ich hier auch die sehr große kameradschaftliche Verbundenheit innerhalb des Lehrstuhls, welche durch diverse gemeinsame Aktivitäten wie Tagungsbesuche, Lehrstuhlausflüge, Fußballturniere, gemeinsame Kaffeepausen, Grillabende und Kinobesuche entstand, während denen oft sehr interessante und lustige Diskussionen stattfanden.

Allen Mitgliedern des JungChemikerForums Regensburg für die kreative Zusammenarbeit bei gemeinsamen Aktionen wie dem alljährlichen "Schülerpraktikum" und der Veranstaltung "Chemie in der Grundschule".



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1
II Experimenteller und Methodischer Teil
2.1 Experimenteller Teil
2.1.1 Verwendete Chemikalien
2.1.2 Präparation der Verbindungen
2.2 Methodischer Teil
2.2.1 Röntgenpulverdiffraktometrie
2.2.2 Einkristalldiffraktometrie
2.2.3 Rasterelektronenmikroskopie
2.2.4 Thermische Analyse
2.2.5 UV/VIS-Spektroskopie
2.2.6 Raman-Spektroskopie
2.2.7 Bandstruktur- und DOS-Rechnungen
2.2.8 Gruppe-Untergruppe-Beziehung
III Untersuchungen zu den Mischkristallreihen 9
MnSb _{2-x} Bi _x S ₄ und MnSb _{2-x} Bi _x Se ₄
3.1 Motivation
3.2 Synthese und Charakterisierung der Edukte MnS,
MnSe, Sb ₂ S ₃ , Sb ₂ Se ₃ , Bi ₂ S ₃ und Bi ₂ Se ₃
3.3 Synthese und Charakterisierung der Mischkristallreihe
$\mathbf{MnSb_{2-x}Bi_xS_4}$
$3.3.1\ Synthese\ und\ Charakterisierung\ der\ tern\"{a}ren\ Randphase\ MnSb_2S_4\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\$
$3.3.2$ Synthese und Charakterisierung der ternären Randphase $MnBi_2S_4$
3.3.3 Synthese der Mischkristallreihe $MnSb_{2-x}Bi_xS_4$
3.3.4 Charakterisierung der MnSb _{2-x} Bi _x S ₄ Mischkristallreihe mittels

4.1 Motivation	54
IV Untersuchungen zur Mischkristallreihe FeSb _{1-x} Bi _x S ₂ Br	54
3.5 Zusammenfassung	49
3.3.6.4 Die Bindungsverhältnisse in den Bi/SbSe ₆ -Oktaedern und Bi/SbSe ₇ -Polyec	dern 46
3.4.6.3 Die Bindungsverhältnisse und Volumina in den MeS ₆ -Oktaedern	45
3.4.6.2 Die Besetzung der Manganlagen	
$Mn_{0,94}Sb_{1,64}Bi_{0,4}Se_4 \ und \ Mn_{0,73}Bi_{2,18}Se_4$	
$3.4.6.1$ Die strukturchemische Verwandtschaft zwischen $Mn_{0,88}Sb_{2,08}Se_4,\ldots$	43
3.4.6 Ein strukturchemischer Vergleich der untersuchten Verbindungen	43
3.4.5.3 Die Verbindung Mn _{0,73} Bi _{2,18} Se ₄	41
3.4.5.2 Die Verbindung Mn _{0,94} Sb _{1,64} Bi _{0,4} Se ₄	40
3.4.5.1 Die Verbindung Mn _{0,88} Sb _{2,08} Se ₄	40
durch Einkristallstrukturanalyse	
3.4.5 Charakterisierung einzelner Verbindungen der Mischkristallreihe MnSb _{2-x} Bi	$_{x}Se_{4}$ 40
Pulverdiffraktometrie	
3.4.4 Charakterisierung der Mischkristallreihe MnSb _{2-x} Bi _x Se ₄ mittels	36
3.4.3 Synthese der Mischkristallreihe MnSb _{2-x} Bi _x Se ₄	36
3.4.2 Synthese und Charakterisierung der ternären Randphase MnBi ₂ Se ₄	34
3.4.1 Synthese und Charakterisierung der ternären Randphase MnSb ₂ Se ₄	32
$MnSb_{2-x}Bi_xSe_4$	
3.4 Synthese und Charakterisierung der Mischkristallreihe	32
3.3.6.4 Die Bindungsverhältnisse in den Bi/SbS ₆ -Oktaedern und Bi/SbS ₇ -Polyeder	m 29
3.3.6.3 Die Bindungsverhältnisse und Volumina in den MeS ₆ -Oktaedern	
3.3.6.2 Die Besetzung der Manganlagen	
und $Mn_{0,94}Bi_{2,04}S_4$	
3.3.6.1 Die strukturchemische Verwandtschaft zwischen MnSb ₂ S ₄ , Mn _{0,97} Sb _{0,92} Bi ₁	$_{1,10}S_4$ 26
3.3.6 Ein strukturchemischer Vergleich der untersuchten Verbindungen	
$3.3.5.3$ Die Verbindung $Mn_{0,94}Bi_{2,04}S_4$	
$3.3.5.2$ Die Verbindung $Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S_4$	
3.3.5.1 Die Verbindung MnSb ₂ S ₄	23
durch Einkristallstrukturanalyse	
5.5.5 Charakteristerung einzemer Verbindungen der Mischkristamerne Misso _{2-x} Bi	_x S ₄ 23

4.2 Die Gruppe-Untergruppe-Beziehung zwischen FeUS ₃ und	58
4.3 Synthese und Charakterisierung der Edukte FeS, SbSBr und BiSBr	. 61
4.4 Synthese und Charakterisierung der Mischkristallreihe	. 62
$\mathrm{FeSb}_{1\text{-x}}\mathrm{Bi}_{\mathrm{x}}\mathrm{S}_{2}\mathrm{Br}$	
4.4.1 Synthese der Mischkristallreihe $FeSb_{1-x}Bi_xS_2Br$. 62
4.4.2 Charakterisierung der Mischkristallreihe FeSb _{1-x} Bi _x S ₂ Br mittels	. 62
Pulverdiffraktometrie	
4.4.3 Charakterisierung einzelner Verbindungen der Mischkristallreihe FeSb _{1-x} BiS ₂ Br	. 66
durch Einkristallstrukturanalyse	
4.4.3.1 Die Verbindung FeSbS ₂ Br	. 66
4.4.4 Ein strukturchemischer Vergleich der untersuchten Verbindungen	. 67
4.4.4.1 Die strukturchemische Verwandtschaft zwischen FeSbS ₂ Br,	. 67
FeSb _{0,51} Bi _{0,49} S ₂ Br und FeBiS ₂ Br	
$4.4.4.2$ Die Bindungsverhältnisse und Volumina in den FeS $_6$ - und FeS $_2$ Br $_4$ -Oktaedern	. 68
4.4.4.3 Die Bindungslängen in den Bi/SbS ₅ -Pyramiden	. 69
4.5 Zusammenfassung	. 71
V Quecksilber-Chalkogenometallate und Quecksilber-	72
Chalkogenidhalogenide	
5.1 Motivation	. 72
5.2 Charakterisierung der Edukte HgS, HgSe, HgTe, HgCl ₂ und Hg ₂ Cl ₂	. 78
5.3 Synthese und Charakterisierung von HgBi ₂ S ₄	. 79
5.3.1 Synthese von $HgBi_2S_4$. 79
5.3.2 Charakterisierung mittels Pulverdiffraktometrie	. 79
$5.3.3$ Die Kristallstruktur von $HgBi_2S_4$	80
5.3.4 Bestimmung der optischen Bandlücke durch UV/VIS-Spektroskopie	83
5.3.5 Charakterisierung durch Raman-Spektroskopie	. 83

5.4 Synthese und Charakterisierung von Hg _{0,5} Bi ₂ S ₃ Cl	85
5.4.1 Synthese von $Hg_{0,5}Bi_2S_3Cl$	85
5.4.2 Charakterisierung mittels Pulverdiffraktometrie	85
$5.4.3~Die~Kristallstruktur~von~Hg_{0,5}Bi_2S_3Cl\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$	86
$5.4.3.1 \ Beschreibung \ der \ Kristallstruktur \ von \ Hg_{0,5}Bi_2S_3Cl \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	86
$5.4.3.2\ Vergleich \ der\ Kristallstruktur\ von\ Hg_{0,5}Bi_2S_3Cl\ mit\ den\ Kristallstrukturen\ der$	89
beiden isotypen Verbindungen AgBi ₂ S ₃ Cl und AgBi ₂ Se ₃ Cl	
5.4.4 Charakterisierung durch Rasterelektronenmikroskopie	93
5.5 Synthese und Charakterisierung von Hg ₄ BiS ₂ Cl ₅	95
5.5.1 Synthese von $Hg_4BiS_2Cl_5$	95
5.5.2 Charakterisierung mittels Pulverdiffraktometrie	95
$5.5.3$ Die Kristallstruktur von $Hg_4BiS_2Cl_5$	96
5.5.3.1 Die $_{\infty}^{2}$ [Hg ₄ S ₂] ²⁺ -Teilstruktur	96
5.5.3.2 Die $_{\infty}^{-1}$ [BiCl ₅] ²⁻ -Teilstruktur	96
5.5.4 Bestimmung der Optischen Bandlücke durch UV/VIS-Spektroskopie	98
5.5.5 Charakterisierung durch Raman-Spektroskopie	99
$5.5.6\ Bandstruktur-\ und\ DOS-\ Rechnungen\ zu\ Hg_4BiS_2Cl_5\ .\ .\ .\ .\ .$	100
$5.5.6.1\ Die\ Bandstruktur\ von\ Hg_4BiS_2Cl_5\ .\ .\ .\ .\ .$. 100
5.5.6.2 Die verschiedenen DOS und die TDOS von $Hg_4BiS_2Cl_5$	101
5.6 Synthese und Charakterisierung von Hg ₄ BiSe ₂ Cl ₅	. 103
5.6.1 Synthese von $Hg_4BiSe_2Cl_5$	103
5.6.2 Charakterisierung mittels Pulverdiffraktometrie	103
$5.6.3 \ Die \ Kristallstruktur \ von \ Hg_4BiSe_2Cl_5 \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	104
5.6.3.1 Die $_{\infty}^{-1}$ [Hg ₄ Se ₂] ²⁺ -Teilstruktur Spektroskopie	104
5.6.3.2 Die $_{\infty}^{-1}$ [BiCl ₅] ²⁻ -Teilstruktur	104
5.6.4 Bestimmung der optischen Bandlücke durch UV/VIS-Spektroskopie	107
5.6.5 Charakterisierung durch Raman-Spektroskopie	107
5.7 Synthese und Charakterisierung von $Hg_3Bi_2Te_2Cl_8\ldots\ldots\ldots$	109
5.7.1 Synthese von $Hg_3Bi_2Te_2Cl_8$	109
5.7.2 Charakterisierung durch Pulverdiffraktometrie	109
5.7.3 Die Kristallstruktur von Hg ₃ Bi ₂ Te ₂ Cl ₈	110
5.7.3.1 Die ${}_{0}^{2}$ [Hg ₃ Te ₂] ²⁺ -Schichten	110

5.7.3.2 Die $_{\infty}^{2}$ [Bi ₂ Cl ₈] ²⁻ -Schichten	111
5.7.4 Bestimmung der Optischen Bandlücke durch UV/VIS-Spektroskopie	112
5.7.5 Charakterisierung durch Raman-Spektroskopie	113
5.8 Zusammenfassung	115
VI Zusammenfassung	117
VII Literaturverzeichnis	121
A Anhang	134
A.1 Übersicht der Publikationen und Posterbeiträge	134
A.2 Definitionen	135
A.2.1 Definitionen zur Einkristallstrukturanalyse	135
A.2.2 Definitionen zur Pulverdiffraktometrie	135
A.3 Die kristallographischen Daten von Kapitel 3	136
A.3.1 Die kristallographischen Daten von $Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S_4\ldots\ldots\ldots$	136
A.3.2 Die kristallographischen Daten von $Mn_{0,94}Bi_{2,04}S_4$	137
A.3.3 Die kristallographischen Daten von Mn _{0,88} Sb _{2,08} Se ₄	139
A.3.4 Die kristallokraphischen Daten von $Mn_{0,94}Sb_{1,64}Bi_{0,4}Se_4$	140
A.3.5 Die kristallokraphischen Daten von Mn _{0,73} Bi _{2,18} Se ₄	142
A.4 Die kristallographischen Daten von Kapitel 4	144
A.4.1 Die kristallokraphischen Daten von FeSb _{0,51} Bi _{0,49} S ₂ Br	144
A.4.2 Die kristallographischen Daten von FeBiS ₂ Br	145
A.5 Die kristallographischen Daten von Kapitel 5	147
A.5.1 Die kristallographischen Daten von HgBi ₂ S ₄	147
A.5.2 Die kristallographischen Daten von Hg _{0,5} Bi ₂ S ₃ Cl	148
A.5.3 Die kristallographischen Daten von Hg ₄ BiS ₂ Cl ₅	150
A.5.4 Die kristallographischen Daten von Hg ₄ BiSe ₂ Cl ₅	151
A 5 5 Die kristallographischen Daten von Hg ₃ Bi ₂ Te ₂ Cl ₈	153

A.6 Auswertung der Pulverdiffraktogramme von Kapitel 3	155
A.6.1 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnS	155
A.6.2 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSe	155
$A.6.3 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ von \ Sb_2S_3 \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $.156
$A.6.4 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ von \ Sb_2Se_3 \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	156
$A.6.5 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ von \ Bi_2S_3 \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	157
$A.6.6 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ von \ Bi_2Se_3 \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	157
$A.6.7 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ von \ MnSb_2S_4 \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	158
$A.6.8 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ der \ DTA \ Probe \ von \ MnSb_2S_4 \ . \ . \ . \ . \ . \ .$	159
$A.6.9 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ von \ MnBi_2S_4 \ldots \ldots \ldots \ldots$	159
$A.6.10$ Auswertung des Pulverdiffraktogramms der DTA Probe von $MnBi_2S_4$	160
$A.6.11 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ von \ MnSb_{1,8}Bi_{0,2}S_4 \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	161
$A.6.12 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ von \ MnSb_{1,6}Bi_{0,4}S_4 \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	161
$A.6.13 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ von \ MnSb_{1,4}Bi_{0,6}S_4 \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	162
$A.6.14 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ von \ MnSb_{1,2}Bi_{0,8}S_4 \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	163
A.6.15 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSbBiS ₄	164
$A.6.16 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ von \ MnSb_{0,8}Bi_{1,2}S_4 \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	165
$A.6.17 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ von \ MnSb_{0,6}Bi_{1,4}S_4 \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	165
$A.6.18 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ von \ MnSb_{0,4}Bi_{1,6}S_4 \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	166
$A.6.19 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ von \ MnSb_{0,2}Bi_{1,8}S_4 \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	167
$A.6.20 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ von \ MnSb_2Se_4 \ldots \ldots \ldots$	167
$A.6.21 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ der \ DTA \ Probe \ von \ MnSb_2Se_4 \ . \ . \ . \ . \ .$	168
A.6.22 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnBi ₂ Se ₄	.169
$A.6.23 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ der \ DTA \ Probe \ von \ MnBi_2Se_4 \ . \ . \ . \ . \ .$	169
$A.6.24 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ von \ MnSb_{1,8}Bi_{0,2}Se_4 \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ .$	170
$A.6.25 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ von \ MnSb_{1,6}Bi_{0,4}Se_4 \ . \ . \ . \ . \ . \ .$	171
$A.6.26 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ von \ MnSb_{1,4}Bi_{0,6}Se_4 \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ .$	171
$A.6.27 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ von \ MnSb_{1,2}Bi_{0,8}Se_4 \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ .$	172
A.6.28 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSbBiSe ₄	172
$A.6.29 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ von \ MnSb_{0,8}Bi_{1,2}Se_4 \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ .$	173
A.6.30 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb _{0,6} Bi _{1,4} Se ₄	174
A.6.31 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb _{0,4} Bi _{1,6} Se ₄	174
A.6.32 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb _{0,2} Bi _{1,8} Se ₄	175

A.7 Auswertung der Pulverdiffraktogramme von Kapitel 4 176
A.7.1 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von FeS
A.7.2 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von SbSBr
A.7.3 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von BiSBr
$A.7.4$ Auswertung des Pulverdiffraktogramms von $FeSbS_2Br$
$A.7.5 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ von \ FeSb_{0,7}Bi_{0,3}S_2Br \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $
$A.7.6 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ von \ FeSb_{0,51}Bi_{0,49}S_2Br \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $
A.7.7 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von $FeSb_{0,3}Bi_{0,7}S_2Br$
A.7.8 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von FeBiS ₂ Br
A.8 Auswertung der Pulverdiffraktogramme von Kapitel 5
A.8.1 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von HgS
A.8.2 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von HgSe
A.8.3 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von HgTe
A.8.4 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von HgCl ₂
$A.8.5 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ von \ Hg_2Cl_2 \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $
$A.8.6 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ von \ HgBi_2S_4 \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $
$A.8.7 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ von \ Hg_{0,5}Bi_2S_3Cl \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $
$A.8.8 \ Auswertung \ des \ Pulverdiffraktogramms \ von \ Hg_4BiS_2Cl_5 \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $
A.8.9 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von Hg ₄ BiSe ₂ Cl ₅
A.8.10 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von Hg ₃ Bi ₂ Te ₂ Cl ₈

I Einleitung

Die röntgenographische Charakterisierung von Feststoffen an Kristallen und Pulverproben dient heute als Ausgangspunkt, um ein tieferes Verständnis für deren Strukturchemie und physikalischen Eigenschaften zu gewinnen. Somit ist die experimentelle Kristallographie zu einem wichtigen Bindeglied zwischen der Physik, Chemie und den anderen Naturwissenschaften geworden, die nach einem tieferen Verständnis der Natur und der in ihr ablaufenden Prozesse trachtet.

Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse dürfen nicht nur dazu genutzt werden schnellere Computerchips oder kleinere Handys zu entwickeln, sondern sollten auch zum Ziel haben, durch die Weiterentwicklung bekannter und Etablierung neuer Technologien die auf der Erde vorkommenden Rohstoffquellen zu schonen. Denn nur durch einen sorgsamen Umgang mit unseren Ressourcen ermöglichen wir es den nachfolgenden Generationen diese ebenfalls zu ihrem Wohl zu nutzen.

Dabei dienen vor allem die in der Grundlagenforschung gewonnenen Einblicke in die Strukturchemie und physikalischen Eigenschaften von Verbindungen als Basis für deren Nutzung in der angewandten Forschung.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit ternären und quaternären Verbindungen der Übergangsmetalle Mangan, Eisen und Quecksilber, der Pniktogene Antimon und Bismut, der Chalkogene Schwefel, Selen und Tellur sowie der Halogene Chlor und Brom.

Im Anschluss an diese Einleitung I wird im folgenden Kapitel II das Experimentelle Vorgehen und die zur Charakterisierung angewandten Methoden beschrieben. Der Hauptteil dieser Arbeit gliedert sich in drei verschieden große Bereiche.

In Abschnitt III dienen die beiden Mischkristallreihen MnSb_{2-x}Bi_xS₄ und MnSb_{2-x}Bi_xSe₄ einer strukturchemischen Betrachtung der durch *D. Kurowski* synthetisierten Verbindungen MnSb₂S₄, MnBi₂S₄, MnSb₂Se₄ und MnBi₂Se₄ [1, 2], bei der vor allem die von ihm postulierte "Quasi-Isotypie-Beziehung" zwischen MnSb₂S₄ und den anderen drei Verbindungen im Blickpunkt steht.

Die FeSb_{1-x}Bi_xS₂Br-Mischkristallreihe in Kapitel IV wurde von *A. Pointner* [3], *M. F. Bräu* [4] und im Rahmen dieser Arbeit hergestellt, um ausgehend von FeSbS₂Br eine schrittweise

Substitution des Antimons durch Bismut durchzuführen und deren Auswirkung auf die Zellkonstanten und Bindungsverhältnisse genauer zu betrachteten.

Die neuen Quecksilberverbindungen $Hg_{0,5}Bi_2S_3Cl$, $Hg_4BiS_2Cl_5$, $Hg_4BiSe_2Cl_5$, und $Hg_3Bi_2Te_2Cl_8$ bilden zusammen mit dem schon länger bekannten $HgBi_2S_4$ [5, 6] den inhaltlichen Schwerpunkt in Abschnitt V.

In der Zusammenfassung VI wird auf die wesentlichen Inhalte dieser Arbeit noch einmal eingegangen und diese näher diskutiert.

Abgeschlossen wird diese Arbeit durch das Literaturverzeichnis VII und den Anhang A, welcher die kristallographischen Daten der untersuchten Verbindungen und die Auswertung aller wichtiger Pulverdiffraktogramme entsprechend ihrer Reihenfolge in dieser Arbeit enthält.

II Experimenteller und Methodischer Teil

2.1 Experimenteller Teil

2.1.1 Verwendete Chemikalien

Für die Präparation aller in dieser Arbeit diskutierten Verbindungen wurden die in der folgenden Tabelle 2.1 angegebenen Substanzen eingesetzt.

Tab.2.1: Übersicht über die verwendeten Substanzen und deren Reinheit.

Edukt		Form	Hersteller	Reinheit
Antimon	Sb	Granalien	Chempur	99,999%
Antimon(III)-bromid	SbBr ₃	Pulver	Alfa Aesar	> 99,5%
Bismut	Bi	Stücke	Johnson Matthey	m5N+
Bismut(III)-bromid	BiBr ₃	Pulver	Alfa Aesar	> 98 %
Bismut(III)-oxid	Bi_2O_3	Pulver	Chempur	99,8%
Eisen	Fe	Pulver	Riedel-de Haën	> 99 %
Mangan	Mn	Pulver	Alfa Aesar	99,95%
Quecksilber(I)-chlorid	Hg ₂ Cl ₂	Pulver	Merck	> 99,5 %
Quecksilber(II)-chlorid	HgCl ₂	Pulver	Merck	> 99,5 %
Quecksilber(II)-selenid	HgSe	Pulver	ABCR	99,99%
Quecksilber(II)-sulfid	HgS	Pulver	Fluka	> 99 %
Quecksilber(II)-tellurid	НgТе	Pulver	Alfa Aesar	> 99 %
Schwefel	S	Plättchen	Chempur	99,999%
Selen	Se	Kügelchen	Chempur	99,999%

Zur Präparation des verwendeten Bismut(III)-chlorids diente Bismut(III)-oxid als Ausgangsmaterial. Dabei wurde das Bismut(III)-oxid zunächst in Salzsäure aufgelöst und anschließend

bis zur Trockne eingedampft. Der erhaltene Rückstand wurde dann im N₂-Strom destilliert, wobei sich Kristalle von reinem Bismut(III)-chlorid abschieden [7]. Die Synthese der weiteren binären und ternären Edukte wird in den jeweiligen Kapiteln kurz beschrieben.

2.1.2 Präparation der Verbindungen

Für alle im Folgenden beschriebenen Verbindungen kam die klassische fest-fest Synthese zum Einsatz. Dafür wurden die verwendeten Edukte entsprechend dem molaren Verhältnis auf einer Analysenwaage der Firma Kern (Genauigkeit 0,1 mg) in Quarzampullen eingewogen. Diese heizte man zuvor in einem Trockenschrank bei etwa 140 °C aus. Nach dem Befüllen der Ampullen wurden diese an einer Vakuumapparatur mehrfach evakuiert und mit Argon gespült, um den enthaltenen Luftsauerstoff möglichst vollständig zu entfernen. Das Abschmelzen dieser Ampullen mit einem Knallgasbrenner erfolgte nach einem letzten Evakuierungsvorgang. Für das Aufschmelzen und Tempern der so präparierten Versuchsproben dienten Röhrenöfen, die mit NiCr/Ni-Thermoelementen und programmierbaren Reglern der Firma EUROTherm ausgestattet sind. Dabei wurden Heizraten von 1 K/min verwendet. Die Präparation von Hg₃Bi₂Te₂Cl₈ erfolgte in einer Handschuhbox der Firma Braun, in der Argon als Schutzgas diente, da hierbei auch das vorher synthetisierte sehr hygroskopische BiCl₃ verwendet wurde.

2.2 Methodischer Teil

2.2.1 Röntgenpulverdiffraktometrie

Zur standardmäßigen Charakterisierung der synthetisierten Proben und anschließenden Verfeinerung der Gitterkonstanten kam die Röntgenpulverdiffraktometrie zur Anwendung. Die dafür vorgesehenen Substanzen wurden zunächst in einem Achatmörser fein vermahlen und dann mit Hilfe einer Baysilone Paste der Bayer AG zwischen zwei Mylar-Folien fixiert. Die damit versehenen Flachbettträger wurden auf einem STOE Stadi P Diffraktometer mit Cu K α_1 Strahlung ($\lambda=1,54051$ Å) in Transmissionsstellung vermessen. Zur Monochromatisierung der verwendeten Strahlung diente ein Germaniumeinkristall. Die präparierten Proben wurden innerhalb von 160 Minuten in einem Winkelbereich von 8 ° < 2 θ < 90 ° gemessen, wobei für manche Pulverdiffraktogramme auch deutlich längere Messzeiten verwendet wurden. Die Erfassung der Beugungsintensitäten erfolgte durch einen ortsempfindlichen Detektor (PSD), und für deren Auswertung kam das Softwarepaket WinX^{Pow} [8] von STOE zum Einsatz.

2.2.2 Einkristalldiffraktometrie

Für die Einkristallstrukturanalyse vorgesehenen Kristalle wurden unter einem Lichtmikroskop mit Hilfe von Aceton oder Toluol von eventuell anhaftenden Verunreinigungen befreit und mit einem Zweikomponentenklebstoff auf dünne Glasfäden fixiert. Voruntersuchungen zur Qualitätsüberprüfung der ausgewählten Kristalle erfolgten an Weissenbergkameras der Firma Huber Diffraktionstechnik.

Geeignete Kristalle wurden auf einem STOE IPDS I der Firma Stoe & Cie mit MoK α -Strahlung (λ = 0,71073 Å) vermessen, wobei ein Graphitmonochromator zum Einsatz kam. Für die Sammlung und Reduktion der erhaltenen Messdaten sowie deren Lorenz- und Polarisationsfaktorkorrektur diente das Programmpaket XArea [9]. Die Bestimmung der Raumgruppensymmetrie aufgrund ihrer systematischen Reflexionsbedingungen erfolgte mit dem Programm XPREP [10]. Für die numerische Absorptionskorrektur der Datensätze anhand der Kristallgestalt und Summenformel kamen die beiden Programme X-RED [11] und X-SHAPE [12] zum Einsatz, welche im Programmpaket XArea [9] implementiert sind.

Die Lösung der Kristallstruktur mit direkten Methoden wurde mit dem Programm SHELXS-97 [13] und ihre anschließende Verfeinerung mit dem Programm SHELXL-97 [13] durchgeführt, welche Teil des Programmpakets WinGX [14] sind. Dabei erfolgte die Strukturverfeinerung nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate gegen F². Alle Strukturen wurden mit dem Programmpaket PLATON [15] analysiert, wobei vor allem die Programme TwinRotMat [16] zur Auffindung meroedrischer Verzwilligungen und Structure Tidy [17] zur Überführung in die Standardaufstellung genutzt wurden. Die Volumenberechnung der in manchen Strukturen enthaltenen Oktaeder erfolgte mit dem Programm IVTON [18]. Zur Visualisierung der Kristallstrukturen und die in ihnen enthaltenen Baueinheiten diente das Programm Endeavour [19].

2.2.3 Rasterelektronenmikroskopie

Zur Morphologiebetrachtung anhand von REM-Aufnahmen (<u>Rasterelektronenmikroskopie/englisch: SEM scanning elektron microscope</u>) und zur qualitativen Analyse einiger Proben mittels EDX (<u>energy-dispersive X-ray analysis</u>) wurden einige Kristalle der entsprechenden Verbindungen auf eine Graphitfolie aufgebracht und mit einem QUANTA 400F Rasterelektronenmikroskop der Firma FEI vermessen. Die anschließende Auswertung der Messdaten erfolgte mit dem Programm GENESIS Version 4.52 [20].

2.2.4 Thermische Analyse

Für die thermische Analyse mittels DTA (<u>D</u>ifferenz-<u>T</u>hermo-<u>A</u>nalyse) wurden die Proben in Quarzampullen mit einem Durchmesser von 2 mm und einer Länge von 50 mm eingewogen, welche dann evakuiert und bei einer Länge von etwa 10 mm abgeschmolzen wurden. Anschließend erfolgte deren Vermessung an einer Setaram TMA 92 16.18, wobei für die Auswertung der erhaltenen Daten das Programm Setsoft 2000 Version 1.5 [21] Verwendung fand

2.2.5 UV/VIS-Spektroskopie

Um die UV/VIS-Spektren einiger Verbindungen zu bestimmen wurden Remissionsspektren unter Verwendung einer Ulbricht-Kugel und mit BaSO₄ als Referenzsubstanz aufgenommen. Dafür diente ein OMEGA 20 Zweistrahlphotometer von Bruins Instruments. Für das Sammeln und Analysieren der erhaltenen Messdaten diente das Programm OMEGA software Version 3.3 [22]. Nach deren Umwandlung entsprechend der Kubelka-Munk-Theorie [23] in ein Absorptionsspektrum konnte durch eine lineare Interpolation auf die Basislinie ähnlich dem Tauc-Plot [24] die optische Bandlücke ermittelt werden.

2.2.6 Raman-Spektroskopie

Eine ausreichende Menge der geeigneten polykristallinen Proben wurde für die Aufnahme von Schwingungsspektren in Duranglaskapillaren mit einem Durchmesser von 1,5 mm gefüllt. Die Vermessung dieser Proben erfolgte mit einem FT-Raman-Modul der Firma Varian unter Verwendung eines FTS 7000e Spektrometers der gleichen Firma. Als Strahlenquelle diente ein Nd:YAG-Laser (λ = 1064 nm). Die Erfassung der Messdaten erfolgte mit einem stickstoffgekühlten Germaniumdetektor in Reflexionsstellung, wobei die Anzahl der Scans variiert wurde, um ein möglichst gutes Signal-Rausch-Verhältnis zu erzielen. Für die Auswertung der erhaltenen Spektren kam die Varian Resolution Pro Software Version 4.1.0.101 [25] zum Einsatz.

2.2.7 Bandstruktur- und DOS-Rechnungen

Von Hg₄BiS₂Cl₅ wurde die elektronische Bandstruktur mit Hilfe von LCAO (<u>L</u>inear <u>C</u>ombination of <u>A</u>tomic <u>O</u>rbitals) ab initio Rechnungen, sowie die DOS (<u>D</u>ensity <u>o</u>f <u>s</u>tate) im Rahmen der Dichtefunktionaltheorie (DFT) mit dem Programm CRYSTAL06 [26] von Herrn PD Dr. Richard Weihrich und Herrn Florian Pielnhofer untersucht. Diese Berechnungen dienten der Interpretation der Bindungsverhältnisse, sowie zur Verifizierung der aus UV/VIS-Spektren erhaltenen optischen Bandlücke.

2.2.8 Gruppe-Untergruppe-Beziehung

Um strukturelle Verwandtschaften zwischen Verbindungen besser verstehen und beschreiben zu können, entwickelte *H. Bärnighausen* eine Art Flussdiagramm, welches man auch als Stammbaum bezeichnet [27]. Darin wird die, entsprechend den "International Tables for Crystallography" [28] bestehende, Gruppe-Untergruppe-Beziehung von Verbindungen anhand ihrer Raumgruppen, Symmetrieelemente und Atomlagen aufgezeigt. Ausgehend von einem höhersymmetrischen Aristotyp gelangt man durch die Reduktion der Symmetrieelemente, welche als Übergang bezeichnet wird, zum niedersymmetrischen Subtyp. Dabei unterscheidet man zwischen folgenden drei Übergängen:

1. Bei *translationengleichen (t) Übergängen* bleibt das Translationsgitter erhalten, aber durch den Symmetrieabbau gelangt man in eine niedrigere Kristallklasse.

- 2. Klassengleiche (k) Übergänge zeichnen sich dadurch aus, dass sich nicht die Kristallklasse, sondern das Translationsgitter verändert. Hier fällt entweder eine Zentrierung weg, oder mindestens eine Zellkonstante verdoppelt bzw. verdreifacht sich.
- 3. Die *isomorphen (i) Übergänge* sind ein Spezialfall der *klassengleichen Übergänge* bei denen sich der Raumgruppentyp <u>nicht</u> ändert. Durch eine Vergrößerung der Elementarzelle erfolgt jedoch eine Ausdünnung der Symmetrieelemente.

Bei all diesen Übergängen wird dem entsprechenden Symbol t, k oder i immer eine Zahl nachgestellt, die den Grad des Übergangs angibt.

Neben interessanten Erkenntnissen über Symmetrieverwandtschaften von Verbindungen ermöglicht das Verständnis von Gruppe-Untergruppe-Beziehungen auch Aussagen über mögliche Verzwilligungen und Phasenübergänge 2. Ordnung.

III Untersuchungen zu den Mischkristallreihen MnSb_{2-x}Bi_xS₄ und MnSb_{2-x}Bi_xSe₄

3.1 Motivation

Die vier Mangan-Chalkogenometallat-Verbindungen MnSb₂S₄, MnBi₂S₄, MnSb₂Se₄ und MnBi₂Se₄ mit der allgemeinen Summenformel Mn_{1-x}Pn_{2+y}Q₄ (Pn: Sb, Bi; Q: S, Se); (x = 0-0,3; y = 0,667x) wurden im Rahmen der Dissertation von *D. Kurowski* [1] sowie durch *S. Lee* et al. [29] hergestellt. Dabei gelang ihre Synthese aus den binären Edukten MnQ, Sb₂Q₃ und Bi₂Q₃ durch eine Festphasenreaktion bei 490 °C bis 700 °C, wobei MnSb₂S₄ nur in einem sehr schmalen Temperaturbereich von 490 °C bis 540 °C zugänglich war. Bei der anschließenden Untersuchung ihrer Struktur anhand von Pulverproben und Einkristallen konnte festgestellt werden, dass diese vier Verbindungen zwar im gleichen monoklinen Raumgruppentyp *C2/m* (Nr. 12) kristallisieren aber nicht isotyp zueinander sind [1, 2], da nur MnSb₂S₄ isotyp zu HgBi₂S₄ kristallisiert [5, 6], wohingegen die Kristallstrukturen der anderen drei Verbindungen isotyp zu der des FeSb₂Se₄ [3, 30] sind.

Am deutlichsten ist dies an den Manganlagen zu erkennen. So befindet sich das Mangan von MnSb₂S₄ auf den Wyckoff-Positionen Mn1: 2*a* (0 0 0) und Mn2: 2*c* (0 0 ½), analog zu den Quecksilberlagen von HgBi₂S₄ [6], wohingegen das Mangan von MnBi₂S₄, MnSb₂Se₄ und MnBi₂Se₄ die Wyckoff-Positionen Mn1: 2*a* (0 0 0) und Mn2: 2*d* (0 ½½½) entsprechend den Eisenlagen von FeSb₂Se₄ [3, 30] besetzt.

Ermöglicht wird diese Strukturvariation, die von *D. Kurowski* als "Quasi-Isotypie-Beziehung" bezeichnet wurde, durch den schichtartigen Aufbau dieser Verbindungen. Ihre Kristallstrukturen bestehen nämlich aus Strängen von kantenverknüpften MnQ6-Oktaedern, die entlang *b* verlaufen und durch nahezu quadratische SbQ5- und BiQ5-Pyramiden zu Schichten in der *ab*-Ebene miteinander verbunden sind. Da diese Schichten nur durch schwache Vander-Waals-Kräfte zusammengehalten werden können sie leicht gegeneinander verschoben werden, was zum Beispiel auf thermischem Wege erfolgen kann, wie durch *P. F. P. Poudeu* et al. [30] gezeigt wurde.

Anhand einer derartigen Verschiebung um a/2 lässt sich auch die Überführbarkeit der Mn2-Lage von MnSb₂S₄ auf der Wyckoff-Position 2c (0 0 ½) in die Mn2-Lage auf der Wyckoff-

Position 2*d* (0 ½ ½) von MnSb₂Se₄, MnBi₂S₄ und MnBi₂Se₄ wie in Abbildung 3.1 veranschaulichen

Neben dieser strukturellen Verwandtschaft enthalten diese Verbindungen auch noch einen zweiten strukturchemisch interessanten Aspekt, nämlich die Möglichkeit zur Ausbildung von Mn/Sb- bzw. Mn/Bi-Mischbesetzungen, wie sie bereits von *D. Kurowski* [1] und *S. Lee* et al. [29] beobachtet wurden. Diese Mischbesetzungen kommen dadurch zustande, dass nicht nur Mangan eine oktaedrische Koordinationssphäre einnehmen kann [31-33], sondern auch Antimon [34-38] und Bismut [34, 38-42].

Zur Untersuchung der strukturchemischen Verwandtschaft, welche in Abbildung 3.1 erläutert wird, und der möglichen Mn/Sb- und Mn/Bi-Mischbesetzungen wurden im Rahmen dieser Arbeit die beiden Mischkristallreihen MnSb_{2-x}Bi_xS₄ und MnSb_{2-x}Bi_xSe₄ angefertigt und mittels Pulverdiffraktometrie und Einkristallstrukturananlyse untersucht. Dabei dienten die aufgezeichneten Pulverdiffraktogramme zur Phasenanalyse der synthetisierten Proben und zur Bestimmung der Zellkonstanten der enthaltenen Verbindungen, wodurch auch die in manchen Proben enthaltenen Nebenprodukte identifiziert wurden. Die aus den Einkristallstrukturananlysen erhaltenen Daten wurden mit dem Programmpaket PLATON [15] geprüft und dann zur Entwicklung eines Strukturmodells genutzt, wobei die Volumina der in diesen Verbindungen enthaltenen MnQ₆-Oktaeder mit dem Programm IVTON [18] berechnet wurden, um daran den Einfluss der Mischbesetzung zu verifizieren.

Im Folgenden wird die Synthese und Charakterisierung der verwendeten binären Edukte kurz erläutert. Im Anschluss daran befassen sich die Kapitel 3.3 und 3.4 ausführlich mit den beiden angefertigten Mischkristallreihen MnSb_{2-x}Bi_xS₄ und MnSb_{2-x}Bi_xSe₄. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse werden in Kapitel 3.5 noch einmal zusammengefasst und auch zur Entwicklung des quasi ternären MnS - Sb₂S₃ - Bi₂S₃-Phasendiagramms genutzt.

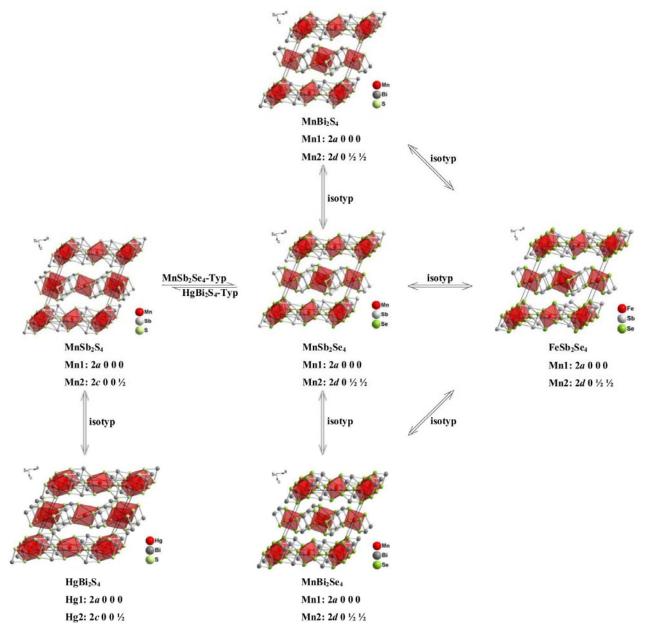


Abb. 3.1: Veranschaulichende Darstellung der strukturchemischen Verwandtschaft zwischen den genannten Verbindungen entsprechend ihrer Mn-, Hg- und Fe-Lagen.

3.2 Synthese und Charakterisierung der Edukte MnS, MnSe, Sb₂S₃, Sb₂Se₃, Bi₂S₃ und Bi₂Se₃

Die für die beiden Mischkristallreihen MnSb_{2-x}Bi_xS₄ und MnSb_{2-x}Bi_xSe₄ verwendeten binären Edukte MnS, MnSe, Sb₂S₃, Sb₂Se₃ Bi₂S₃ und Bi₂Se₃ wurden durch Reaktionen von stöchiometrischen Verhältnissen der entsprechenden Elemente in evakuierten Quarzampullen erhalten. Dabei erfolgte das Aufschmelzen bei Temperaturen zwischen 600 °C und 800 °C und das anschließende Tempern bei Temperaturen zwischen 500 °C und 700 °C. Die dabei erhaltenen Proben wurden mit Hilfe der Pulverdiffraktogramme Nr. A.6.1 bis A.6.6 auf ihre Phasenreinheit überprüft und indiziert.

Tab. 3.1: Vergleich der erhaltenen Zellkonstanten und Zellvolumina der synthetisierten Edukte mit den jeweiligen Literaturangaben.

Verbindung	Raumgruppe	a/ Å	b/ Å	c/ Å	$V/$ $Å^3$	Literatur
MnS	$Fm\overline{3}m$	5,24(1)			143,88(1)	[31]
	$Fm\overline{3}m$	5,221(1)			142,32(1)	[32]
	$Fm\overline{3}m$	5,226(2)			142,728(8)	d. Arb.
MnSe	$Fm\overline{3}m$	5,450(1)			161,88(1)	[32]
	$Fm\overline{3}m$	5,464(4)			163,13(2)	[33]
	$Fm\bar{3}m$	5,4600(3)			162,771(3)	d. Arb.
Sb_2S_3	Pnma	11,28(1)	3,83(1)	11,20(1)	483,87(1)	[34]
	Pnma	11,302(1)	3,8341(6)	11,222(2)	486,28(1)	[35]
	Pnma	11,313(1)	3,8383(6)	11,231(1)	487,68(6)	d. Arb.
Sb ₂ Se ₃	Pnma	11,68(1)	3,98(1)	11,58(1)	538,31(1)	[36]
	Pnma	11,7938(9)	3,9858(6)	11,6478(7)	547,54(4)	[37]
	Pnma	11,794(1)	3,986(1)	11,648(1)	547,583(1)	[38]
	Pnma	11,782(2)	3,9785(4)	11,635(1)	545,39(8)	d. Arb.
Bi ₂ S ₃	Pnma	11,29(1)	3,978(1)	11,15(1)	500,76(1)	[34]
	Pnma	11,305(2)	3,981(1)	11,147(3)	501,67(2)	[38]
	Pnma	11,279(2)	3,981(1)	11,137(2)	500,87(2)	[39]
	Pnma	11,307(2)	3,9831(5)	11,156(1)	502,43(2)	d. Arb.
Bi ₂ Se ₃	$R\bar{3}m$	4,143(5)		28,64(2)	425,7(5)	[42]
	$R\bar{3}m$	4,1397(5)		28,642(3)	425,07(1)	d. Arb.

3.3 Synthese und Charakterisierung der Mischkristallreihe MnSb_{2-x}Bi_xS₄

3.3.1 Synthese und Charakterisierung der ternären Randphase MnSb₂S₄

Für die Synthese von MnSb₂S₄ wurde MnS und Sb₂S₃ im stöchiometrischen Verhältnis abgewogen, in einem Achatmörser innig verrieben und zu Presslingen (~ 1 g) verarbeitet. Durch das anschließende vierwöchige Tempern in evakuierten Quarzampullen bei 500 °C entstand das Reaktionsprodukt, welches sich zu einem feinkörnigen, leuchtendroten Pulver verreiben lässt. Während des Tempervorgangs wurden die Proben einmal im Achatmörser homogenisiert, um eine möglichst vollständige Reaktion zu gewährleisten.

Um das erhaltene Reaktionsprodukt zu analysieren wurde ein Pulverdiffraktogramm angefertigt und mit einem aus Einkristalldaten [2] berechneten Pulverdiffraktogramm verglichen. Dabei sind sechs schwache Reflexe des Edukts Sb₂S₃ bei der synthetisierten Probe zu erkennen, bei ansonst sehr guter Übereinstimmung der beiden Kurven, wie anhand von Abb. 3.2 zu sehen ist.

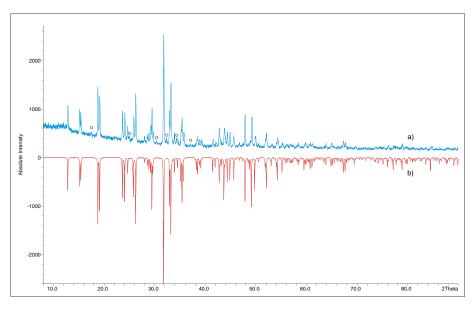


Abb. 3.2: Vergleich eines gemessenen Pulverdiffraktogramms von MnSb₂S₄ a) mit einem aus Einkristalldaten [2] berechneten b). Die mit einem ° gekennzeichneten Reflexe stammen von verbliebenem Sb₂S₃.

Bei der Indizierung des aufgenommenen Pulverdiffraktogramms ergibt sich eine monokline Elementarzelle mit den in der folgenden Tabelle aufgeführten Zellkonstanten. Diese stimmen gut mit den Literaturangaben [2] überein.

Tab. 3.2: Vergleich der Zellkonstanten und Zellvolumina von MnSb₂S₄ aus [2] mit den in dieser Arbeit ermittelten.

a/ Å	b/ Å	c/ Å	β/ °	V/ Å ³	Literatur
12,747(3)	3,799(1)	15,106(3)	113,91(3)	668,7(3)	[2]
12,7196(2)	3,7942(1)	15,0457(3)	113,858(2)	664,08(2)	d. Arb.

Von dieser Verbindung wurde eine thermische Analyse mittels DTA durchgeführt. Wie der Abbildung 3.3 zu entnehmen ist zersetzt sich MnSb₂S₄ bei 680 °C in die binären Edukte MnS und Sb₂S₃, weshalb beim zweiten Aufheizen ein zusätzlicher Peak für das entstandene Sb₂S₃ bei 594 °C auftritt. Für das ebenfalls entstandene MnS ist bei dieser Aufnahme kein zusätzliches Signal zu finden, da dessen Schmelzpunkt von 1655 °C außerhalb des Messbereichs liegt. Das nach der DTA-Messung von dieser Probe aufgenommene Pulverdiffraktogramm Nr. A.6.8 enthält sowohl Reflexe von MnSb₂S₄, als auch von Sb₂S₃ und MnS.

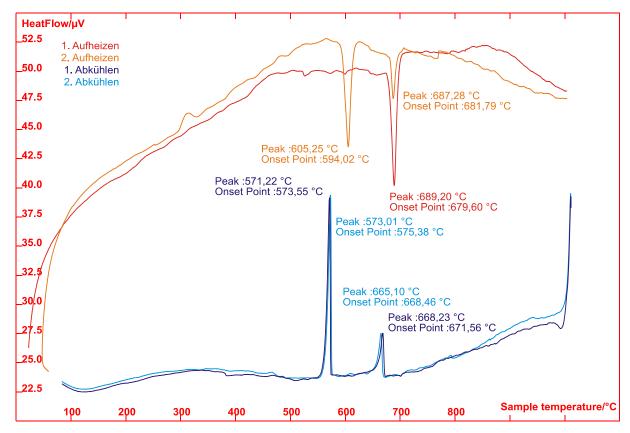


Abb. 3.3: Die DTA-Kurve von MnSb₂S₄. Deutlich zu erkennen ist die Zersetzung der Verbindung bei 680 °C. Das hierbei entstandene Sb₂S₃ hat entsprechend dem zweiten Heizzyklus einen Schmelzpunkt von 594 °C.

3.3.2 Synthese und Charakterisierung der ternären Randphase MnBi₂S₄

Die Synthese von $MnBi_2S_4$ erfolgte aus den binären Verbindungen MnS und Bi_2S_3 , die im stöchiometrischen Verhältnis abgewogen wurden. Nach innigem Verreiben der Edukte in einem Achatmörser wurden daraus Presslinge ($\sim 1\,g$) geformt und vier Wochen in evakuierten Quarzampullen bei $600\,^{\circ}C$ getempert. Das Reaktionsprodukt ließ sich zu einem feinkörnigen grauen Pulver verreiben. Um eine möglichst vollständige Reaktion zu gewährleisten wurden auch diese Proben während des Tempervorgangs einmal im Achatmörser homogenisiert.

Von der erhaltenen Substanz wurde anschließend ein Pulverdiffraktogramm aufgenommen und mit einem aus Neutronenbeugungsdaten [1] berechneten Pulverdiffraktogramm anhand der folgende Abbildung 3.4 verglichen.

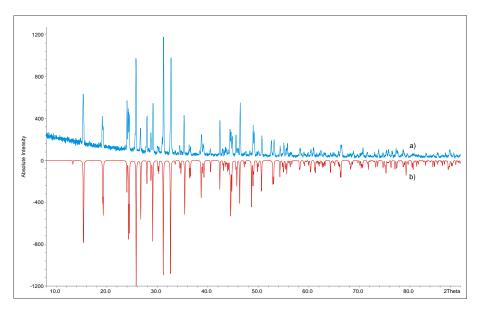


Abb. 3.4: Vergleich eines gemessenen Pulverdiffraktogramms von MnBi₂S₄ a) mit einem aus Neutronenbeugungsdaten [1] berechneten b).

Die Indizierung des aufgenommenen Pulverdiffraktogramms ergibt eine monokline Elementarzelle mit den in der folgenden Tabelle aufgeführten Zellkonstanten. Diese stimmen sehr gut mit den Literaturangaben [1] überein.

Tab. 3.3: Vergleich der Zellkonstanten und Zellvolumina von MnBi₂S₄ aus [1] mit den in dieser Arbeit ermittelten.

a/ Å	b/ Å	c/ Å	β/ °	V / $Å^3$	Literatur
12,7636(4)	3,9161(1)	14,7482(5)	115,26(1)	666,66(4)	[1]
12,7681(2)	3,9179(1)	14,7544(3)	115,295(2)	667,31(2)	d. Arb.

Von dieser Verbindung wurde ebenfalls eine DTA-Messung zur thermischen Analyse durchgeführt. Wie anhand der Abbildung 3.5 zu erkennen ist zersetzt sich MnBi₂S₄ bei 815 °C in die binären Edukte MnS und Bi₂S₃, weshalb bei der ersten Abkühlkurve ein zusätzlicher Peak für das entstandene Bi₂S₃ bei 717 °C auftritt. Das ebenfalls entstandene MnS erzeugt bei dieser Aufnahme kein zusätzliches Signal, da dessen Schmelzpunkt von 1655 °C außerhalb des Messbereichs liegt. Das nach der DTA-Messung von dieser Probe aufgenommene Pulverdiffraktogramm Nr. A.6.10 enthält sowohl Reflexe von MnBi₂S₄, als auch von Bi₂S₃ und MnS.

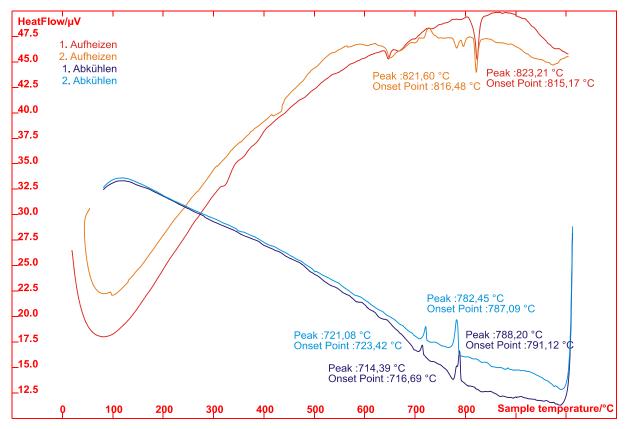


Abb. 3.5: Die DTA-Kurve von MnBi₂S₄. Deutlich zu erkennen ist die Zersetzung der Verbindung bei 815 °C, die auch zu Bi₂S₃ führt, dessen Erstarrungspunkt beim ersten Abkühlen bei 717 °C liegt.

3.3.3 Synthese der Mischkristallreihe MnSb_{2-x}Bi_xS₄

Da die beiden Verbindungen MnSb₂S₄ und MnBi₂S₄, wie in Kapitel 3.1 erläutert wird, nicht isotyp sind wurde die MnSb_{2-x}Bi_xS₄ Mischkristallreihe angefertigt um herauszufinden, ob und bei welchem Antimon- bzw. Bismut-Gehalt eine Mischungslücke auftritt. Dazu erfolgte die Reaktion der beiden Randphasen MnSb₂S₄ und MnBi₂S₄ in einem stöchiometrischen Mischungsverhältnis von 9:1 bis 1:9 in evakuierten Quarzampullen. Um eine bessere Reaktion zu ermöglichen wurden die erhaltenen Proben zu Presslingen (~ 1 g) weiterverarbeitet, die über einen Zeitraum von vier Wochen getempert wurden. Das Tempern erfolgte dabei nicht bei gleichen Temperaturen, um einer befürchteten Zersetzung entgegenzuwirken. Die Reaktionen wurden bei den Mischungsverhältnissen von 9:1 bis 7:3 bei 620 °C, bei den Mischungsverhältnissen von 6:4 bis 4:6 bei 660 °C und bei den Mischungsverhältnissen von 3:7 bis 1:9 bei 720 °C durchgeführt. Dabei wurden die Proben während des Tempervorgangs einmal im Achatmörser homogenisiert und wieder zu Presslingen verarbeitet, um eine möglichst vollständige Umsetzung zu gewährleisten.

3.3.4 Charakterisierung der $MnSb_{2-x}Bi_xS_4$ Mischkristallreihe mittels Pulverdiffraktometrie

Von den erhaltenen Proben wurden die Pulverdiffraktogramme Nr. A.6.7 und Nr. A.6.9 sowie Nr. A.6.11 bis Nr. A.6.19 angefertigt und verfeinert um zu überprüfen, ob und bei welchem Bismutgehalt im MnSb_{2-x}Bi_xS₄ System eine Mischungslücke auftritt. Die Abbildung 3.6 gibt alle gemessenen Pulverdiffraktogramme entsprechend ihrer Probenzusammensetzung gestaffelt wieder.

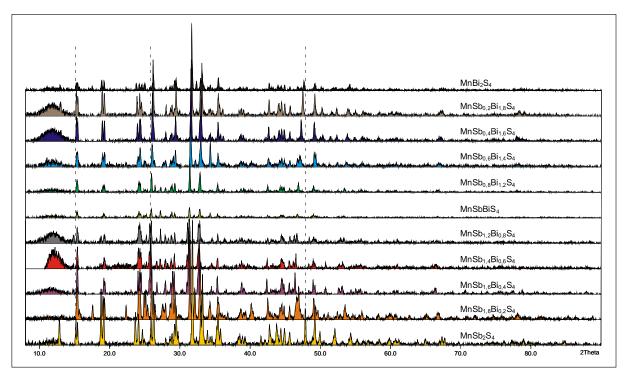


Abb. 3.6: Vergleich der gemessenen Pulverdiffraktogramme. Die gestrichelten Linien geben die Positionen der 200, 004 und 020 Reflexe von MnSb₂S₄ an.

Bei der Verfeinerung dieser Pulverdiffraktogramme kann festgestellt werden, dass es in einem Bereich von x=0,4 bis x=1,0 zu einer Entmischung der Proben kam, welche zu den beiden Verbindungen $MnSb_{1,6}Bi_{0,4}S_4$ und $MnSbBiS_4$ führte. Somit weicht die Zusammensetzung der hier erhaltenen quaternären Verbindungen von einem linearen Verlauf zwischen den Randphasen $MnSb_2S_4$ und $MnBi_2S_4$ erheblich ab, weshalb von einer Mischungslücke in diesem Bereich ausgegangen werden kann. Außerdem enthalten einige Proben dieser Mischkristallreihe die binären Zersetzungsprodukte MnS und Sb_2S_3 .

Tab. 3.4: Die Zellkonstanten und Zellvolumina der in der MnSb $_{2-x}$ Bi $_x$ S $_4$ Mischkristallreihe enthaltenen Verbindungen. Der grau hinterlegte Abschnitt kennzeichnet die Mischungslücke in einem Bereich von x = 0,4 bis x = 1,0 mit den beiden Verbindungen MnSb $_{1,6}$ Bi $_{0,4}$ S $_4$ und MnSbBiS $_4$.

Einwaagen/	a/Å	b/ Å	c/Å	β/°	$V/Å^3$
enthaltene					
Verbindungen					
MnSb ₂ S ₄	12,7196(2)	3,7942(1)	15,0457(3)	113,858(2)	664,08(2)
$MnSb_{1,8}Bi_{0,2}S_4$	12,7245(4)	3,8066(1)	15,0163(5)	114,007(2)	664,44(3)
$MnSb_{1,6}Bi_{0,4}S_4$	12,7285(4)	3,8185(1)	14,9863(5)	114,136(3)	664,72(3)
MnSb _{1,4} Bi _{0,6} S ₄ /					
$MnSb_{1,6}Bi_{0,4}S_4/$	12,7296(4)	3,8187(2)	14,9865(5)	114,136(4)	664,82(3)
MnSbBiS ₄	12,7440(4)	3,8541(1)	14,9017(5)	114,574(3)	665,64(3)
MnSb _{1,2} Bi _{0,8} S ₄ /					
$MnSb_{1,6}Bi_{0,4}S_4/$	12,7296(4)	3,8182(2)	14,9870(5)	114,148(3)	664,69(3)
MnSbBiS ₄	12,7430(3)	3,8544(1)	14,9012(4)	114,561(3)	665,67(2)
MnSbBiS ₄	12,7422(2)	3,8545(7)	14,9028(2)	114,564(1)	665,70(1)
$MnSb_{0,8}Bi_{1,2}S_4$	12,7473(4)	3,8670(1)	14,8706(7)	114,698(3)	665,97(3)
$MnSb_{0,6}Bi_{1,4}S_4$	12,7538(6)	3,8796(1)	14,8405(7)	114,856(4)	666,28(4)
$MnSb_{0,4}Bi_{1,6}S_4$	12,7588(4)	3,8925(1)	14,8138(6)	115,005(3)	666,75(3)
$MnSb_{0,2}Bi_{1,8}S_4$	12,7612(4)	3,9050(1)	14,7854(7)	115,137(3)	667,01(3)
$MnBi_2S_4$	12,7681(2)	3,9179(1)	14,7544(3)	115,295(2)	667,31(2)

Trägt man die in dieser Tabelle enthaltenen Zellkonstanten und Zellvolumina mit ihren Fehlern gegen den Bismutgehalt (x) auf, dann erhält man die in folgender Abbildung 3.7 dargestellten Verläufe. Deutlich erkennbar ist hierbei die Mischungslücke in einem Bereich von x = 0.4 bis x = 1.0.

Zur besseren Veranschaulichung werden im Bereich der Mischungslücke von x = 0,4 bis x = 1,0 die Verläufe der Zellkonstanten und Zellvolumina durch gestrichelte Linien verdeutlicht, da hier von einem linearen Verlauf der Zellvolumina entsprechend der Regel von *L. Vegard* [43] abgewichen wird.

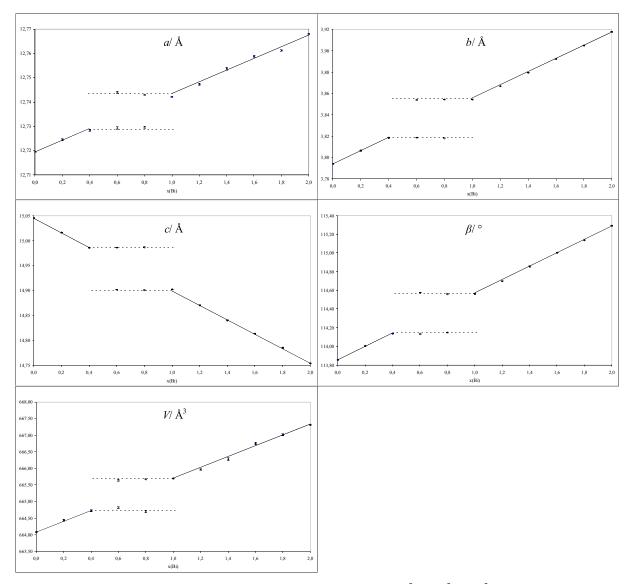


Abb. 3.7: Auftragung der verfeinerten Gitterkonstanten a/ Å, b/ Å, c/ Å und $\beta/$ ° sowie der Zellvolumina V/ Å³ der Mischkristallreihe MnSb_{2-x}Bi_xS₄ in Abhängigkeit vom Bismutgehalt (x). Die eingezeichneten Geraden dienen zur Veranschaulichung ihrer Verläufe, wobei die gestrichelten Linien den Bereich der Mischungslücke verdeutlichen.

Wie anhand der Tabelle 3.4 und der Abbildung 3.7 zu erkennen ist nehmen im Verlauf dieser Mischkristallreihe die a- und b-Achse sowie der monokline Winkel zu, nur die c-Achse verkürzt sich recht deutlich, sodass insgesamt eine geringe Volumenzunahme resultiert. Außerdem erfolgt in einem Bereich von x = 0.4 bis x = 1.0 eine Entmischung der Proben, welche in einer Mischungslücke mit den beiden Verbindungen MnSb $_{1.6}$ Bi $_{0.4}$ S $_4$ und MnSbBiS $_4$ resultiert.

Als Ursache für diese Mischungslücke ist der hier stattfindende Übergang von der $HgBi_2S_4$ -Struktur (für $MnSb_2S_4$ bis $MnSb_{1,6}Bi_{0,4}S_4$) zur $MnSb_2Se_4$ -Struktur (für $MnSbBiS_4$ bis $MnBi_2S_4$) zu sehen.

Dieser Übergang erfolgt, da mit der Abnahme der *c*-Achse eine Annäherung der Schichten einhergeht und in den Verbindungen des HgBi₂S₄-Typs die enthaltenen MeS₆-Oktaeder (Me: Hg, Mn, Bi) direkt übereinander gestapelt sind, wohingegen sie in den Verbindungen des MnSb₂Se₄- Typs quasi auf Lücke sitzen.

Die direkte Übereinanderlagerung der MeS₆-Oktaeder wie im HgBi₂S₄ ist in den Verbindungen MnSb₂S₄ bis MnSb_{1,6}Bi_{0,4}S₄ noch möglich, da hier die Schichten mit einem Abstand von 2,35(1) Å (Schichtabstand im MnSb₂S₄) noch recht weit voneinander entfernt sind.

Im Gegensatz dazu ist aber in den Verbindungen MnSbBiS₄ bis MnBi₂S₄ der Abstand zwischen den Schichten mit etwa 1,97(1) Å (Schichtabstand im Mn_{0,94}Bi_{2,04}S₄) schon deutlich geringer, weshalb hier eine gegeneinander versetzte Anordnung der MeS₆-Oktaeder wie im MnSb₂Se₄ bevorzugt wird, was in der folgenden Abbildungen 3.8 veranschaulicht wird.

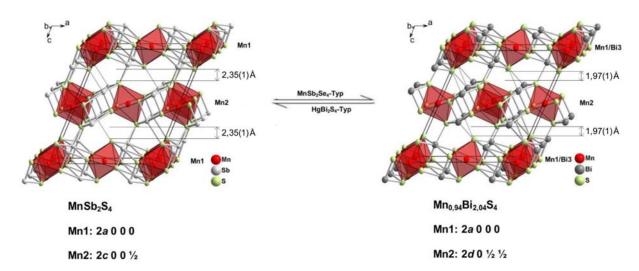


Abb. 3.8: Der strukturelle Übergang von MnSb₂S₄ (isotyp zu HgBi₂S₄) zu Mn_{0,94}Bi_{2,04}S₄ (isotyp zu MnSb₂Se₄) aufgrund des abnehmenden Schichtabstandes und der Stapelung der MeS₆-Oktaeder.

Als Abschluss dieser Auswertungen erfolgt in der folgenden Abbildung 3.9 ein Vergleich der Pulverdiffraktogramme von MnSb₂S₄, MnSb_{1,2}Bi_{0,8}S₄ und MnBi₂S₄ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

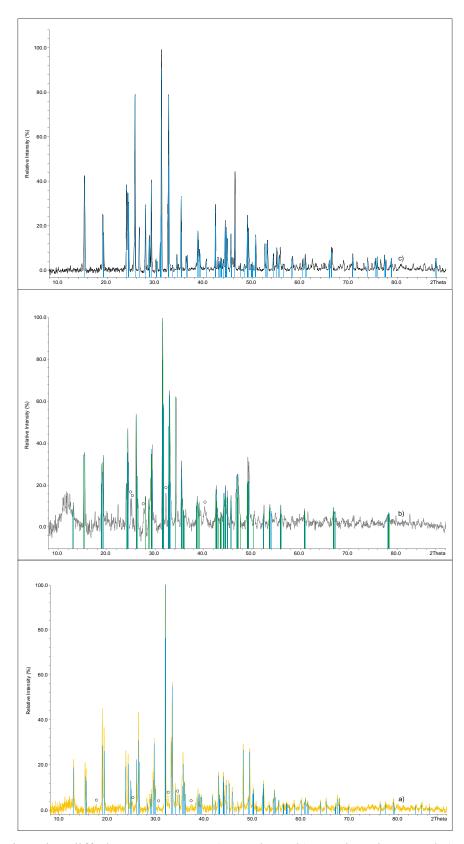


Abb. 3.9: Die Pulverdiffraktogramme von a) $MnSb_2S_4$, b) $MnSb_{1,2}Bi_{0,8}S_4$ und c) $MnBi_2S_4$ im Vergleich. Die zur Indizierung verwendeten Reflexe sind farbig dargestellt. Dabei sind die im Pulverdiffraktogramm von $MnSb_{1,2}Bi_{0,8}S_4$ enthaltenen Reflexe des $MnSb_{1,6}Bi_{0,4}S_4$ grün und die Reflexe des $MnSbBiS_4$ blau gefärbt. Das ebenfalls enthaltene Zersetzungsprodukt ist Sb_2S_3 (o).

${\bf 3.3.5~Charakterisierung~einzelner~Verbindungen~der~MnSb_{2-x}Bi_xS_4~Serie~durch} \\ {\bf Einkristallstrukturanalyse}$

Um die Strukturchemie der MnSb_{2-x}Bi_xS₄ Mischkristallreihe genauer untersuchen zu können wurden aus den synthetisierten Proben Einkristalle präpariert und auf einem entsprechenden Diffraktometer vermessen. Die Resultate der auf diesen Messungen beruhenden Strukturrechnungen werden in den folgenden Abschnitten dargestellt und zusammengefasst.

3.3.5.1 Die Verbindung MnSb₂S₄

Im MnSb₂S₄ [1, 2] besetzt Mangan genauso wie Antimon zwei und Schwefel vier unabhängige Lagen. Dabei nimmt Mn1 die Wyckoff-Position 2a (0 0 0) und Mn2 die Wyckoff-Position 2c (0 0 $\frac{1}{2}$) ein, wodurch sich eine Isotypie zu HgBi₂S₄ [5, 6] ergibt. Diese Atome bilden Schichten in einem Abstand von 2,35(1) Å aus, die parallel zur ab-Ebene liegen. Darin befindet sich Mangan im Zentrum von MnS₆-Oktaeder, welche entlang b über gemeinsame Kanten zu Strängen verknüpft sind. Antimon wird in einer 1+2+2 Koordination von Schwefel umgeben, sodass sich eine fast quadratische SbS5-Pyramide ergibt. In den MnS_6 -Oktaedern betragen die Bindungslängen d(Mn-S) = 2,546(4) Å und 2,643(1) Å in den Mn1S₆-Oktaedern sowie d(Mn-S) = 2,611(6) Å und 2,614(1) Å in den Mn2S₆-Oktaedern. Daraus resultiert ein mit IVTON [18] berechnetes Volumen von 23,56(2) Å³ für die Mn1S₆-Oktaeder sowie ein Volumen von 23,69(4) Å³ für die Mn2S₆-Oktaeder. Bei den SbS₅-Pyramiden variieren die Bindungslängen zwischen d(Sb-S) = 2,474(5) Å und 3,051(2) Å für die Sb1S₅-Pyramiden und zwischen d(Sb-S) = 2,474(6) Å und 3,035(3) Å in den Sb2S₅-Pyramiden. Wenn man die Koordinationssphäre von Antimon vergrößert und auch längere Abstände berücksichtigt erhält man für Sb1 eine 3+2+1 Umgebung in Form eines verzerrten und gestreckten SbS₆-Oktaeders mit einem maximalen Abstand von d(Sb-S) = 3,265(8) Å. Für Sb2 ergibt sich hierbei eine 3+2+2 Umgebung in Form eines verzerrten und überkappten Oktaeders mit einem maximalen Abstand von d(Sb-S) = 3,590(6) Å.

3.3.5.2 Die Verbindung Mn_{0.97}Sb_{0.92}Bi_{1,10}S₄

Entsprechend den kristallographischen Daten A.3.1 besetzt im Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S₄ Mangan genau wie Antimon bzw. Bismut zwei und Schwefel vier unabhängige Lagen. Mn1 nimmt hierbei die Wyckoff-Position 2*a* (0 0 0) und Mn2 die Wyckoff-Position 2*d* (0 ½ ½) ein, wodurch sich eine Isotypie zu MnSb₂Se₄ [1] ergibt. Somit ist bei dieser Verbindung der strukturelle Übergang vom HgBi₂S₄-Typ zum MnSb₂Se₄-Typ in der MnSb_{2-x}Bi_xS₄-

Mischkristallreihe bereits erfolgt, was auch die ausgewerteten Pulverdiffraktogramme nahegelegen. Die Mn1-Lage ist hierin zu 96 % mit Mangan und zu 4 % mit Bismut besetzt, wobei der dadurch auftretende Ladungsüberschuss dadurch kompensiert wird, dass die Mn2-Lage nur zu 98 % besetzt ist, wodurch die Elektroneutralität der Verbindung gewahrt bleibt. Auch die Bi/Sb-Positionen weisen eine Mischbesetzung auf, in denen Bismut mit einer 56 %igen Besetzung der Bi1-Lage und einer 52 %igen Besetzung der Bi2-Lage etwas überwiegt. Die Gesamtstruktur ist wie auch beim MnSb₂S₄ schichtartig mit zur ab-Ebene parallelen Schichten, die 2,02(1) Å voneinander entfernt sind. Darin sind MnS₆-Oktaeder und fast quadratische Bi/SbS₅-Pyramiden über gemeinsame Schwefelecken miteinander verbunden. In den kantenverknüpften MnS₆-Oktaedern, die Stränge entlang b ausbilden, betragen die Bindungslängen in den Mn1S₆-Oktaedern d(Mn-S) = 2,639(4) Å und 2,595(5) Å sowie d(Mn-S) = 2,639(4) Å und 2,595(6) Å sowie d(Mn-S) = 2,639(4) Å d(Mn-S) = 2,639(S) = 2,648(4) Å und 2,550(4) Å in den Mn2S₆-Oktaedern. Für diese MnS₆-Einheiten ergibt sich somit ein mit IVTON [18] berechnetes Volumen von 24,045(2) Å³ bei den Mn1S₆-Oktaedern und ein Volumen von 23,666(8) Å³ bei den Mn2S₆-Oktaedern. Somit führt die 4 %ige Mischbesetzung der Mn1-Lage zu einer Volumenvergrößerung um 0,379 Å³. Bei den Bi/SbS₅-Pyramiden variieren die Bindungslängen zwischen d(Bi/Sb-S) = 2,575(5) Å und 3,024(4) Å für die Bi1/Sb1S₅-Pyramiden und im Bereich von d(Bi/Sb-S) = 2,585(4) Å und 3,001(4) Å in den Bi2/Sb2S₅-Pyramiden. Bei einer Erweiterung dieser Koordinationssphären gelangt man auch hier zu einer 3+2+1 Umgebung in Form eines leicht verzerrten und gestreckten Bi/SbS₆-Oktaeders für Bi1, wobei hier der maximale Abstand d(Bi/Sb-S) =3,061(6) Å beträgt. Beim Bi2 tritt wiederum eine 3+2+2 Umgebung in Form eines verzerrten und überkappten Bi/SbS₇-Oktaeders auf, der einen maximalen Abstand von d(Bi/Sb-S) =3,503(4) Å aufweist.

3.3.5.3 Die Verbindung Mn_{0.94}Bi_{2.04}S₄

Das Mn_{0,94}Bi_{2,04}S₄ weist genauso wie die beiden vorher genannten Verbindungen zwei unabhängige Mangan- und Bismut-Lagen sowie vier unabhängige Schwefel-Lagen auf, was aus den kristallographischen Daten A.3.2 hervorgeht. Dabei ist auch diese Verbindung isotyp zu MnSb₂Se₄ [1], weshalb Mn1 die Wyckoff-Position 2*a* (0 0 0) und Mn2 die Wyckoff-Position 2*d* (0 ½ ½) einnimmt. Der Ladungsüberschuss der zu 8% mit Bismut besetzten Mn1-Lage wird in dieser Verbindung dadurch ausgeglichen, dass die Mn2-Position nur zu 96 % besetzt ist, womit die Elektroneutralität der Verbindung erhalten bleibt. Die Gesamtstruktur besteht aus Schichten, die parallel zur *ab*-Ebene angeordnet sind und zueinander einen Abstand von 1,97(1) Å einnehmen. Die hierin enthaltenen MnS₆-Oktaeder sind über

gemeinsame Kanten entlang b zu Strängen verknüpft, die in a Richtung durch fast quadratische BiS₅-Pyramiden miteinander verbunden sind. Die Bindungslängen in den Mn1S₆-Oktaedern betragen d(Mn-S) = 2,587(5) Å und 2,659(3) Å, und die Bindungen in den Mn2S₆-Oktaedern sind d(Mn-S) = 2,508(5) Å und 2,676(3) Å lang. Das mit IVTON [18] berechnete Volumen dieser MnS₆-Einheiten beträgt für die Mn1S₆-Oktaeder 24,29(1) ų und 23,818(9) ų für die Mn2S₆-Oktaeder. Somit führt die 8 %ige Mischbesetzung der Mn1-Lage durch Bismut zu einer Volumenvergrößerung um 0,472 ų. Die Bindungslängen in den BiS₅-Pyramiden bewegen sich in einem Bereich von d(Bi-S) = 2,633(5) Å bis 3,010(3) Å für die Bi1S₅-Pyramiden und variieren von d(Bi-S) = 2,591(5) Å bis 3,012(4) Å in den Bi2S₅-Pyramiden. Wenn man im Mn_{0.94}Bi_{2.04}S₄ eine Erweiterung dieser Koordinationssphären durchführt gelangt man auch hier zu einer 3+2+1 Umgebung in Form eines leicht verzerrten und gestreckten BiS₆-Oktaeders für Bi1, in dem das zusätzliche Schwefel einen Abstand von d(Bi-S) = 2,984(3) Å aufweist. Bi2 besitzt auch hier eine erweiterte 3+2+2 Umgebung in Form eines verzerrten und überkappten BiS₇-Oktaeders, der einen maximalen Abstand von d(Bi-S) = 3,443(4) Å aufweist.

3.3.6 Ein strukturchemischer Vergleich der untersuchten Verbindungen

3.3.6.1 Die strukturchemische Verwandtschaft zwischen MnSb₂S₄, Mn_{0.97}Sb_{0.92}Bi_{1,10}S₄ und Mn_{0.94}Bi_{2.04}S₄

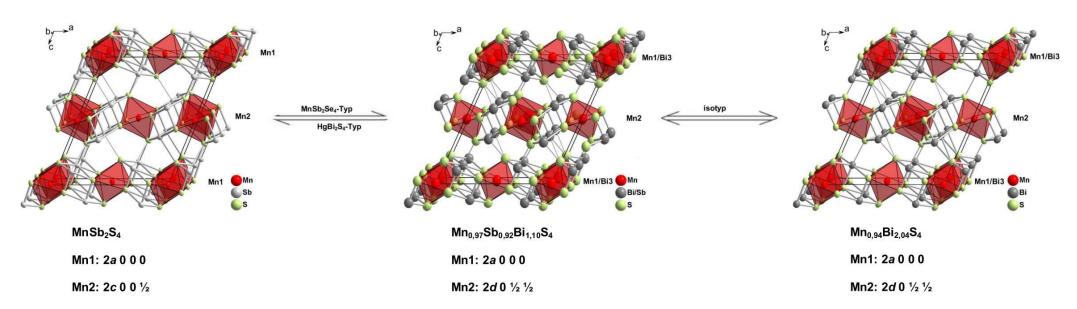


Abb. 3.10: Die Kristallstrukturen von MnSb₂S₄, Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S₄ und Mn_{0,94}Bi_{2,04}S₄ im Vergleich. Deutlich erkennbar ist hierbei der strukturelle Übergang von MnSb₂S₄, welches isotyp zu HgBi₂S₄ kristallisiert, zu Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S₄, welches isotyp zu MnSb₂Se₄ kristallisiert. Die dargestellten Ellipsoide repräsentieren eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von 90 %.

3.3.6.2 Die Besetzung der Manganlagen

Im MnSb₂S₄ [1, 2] sind beide Manganlagen vollbesetzt, wohingegen im Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S₄ und im Mn_{0,94}Bi_{2,04}S₄ eine Manganposition durch Bismut mischbesetzt ist. Der dadurch entstehende positive Ladungsüberschuss wird durch Leerstellen in der jeweils anderen Manganlage kompensiert, sodass die Elektroneutralität der Verbindungen erhalten bleibt.

Im Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S₄ ist die Mn1-Lage zu 4 % durch Bismuth mischbesetzt und die zweite Manganlage nur zu 98 % besetzt. Ein ähnliches Besetzungsverhältnis findet sich auch im Mn_{0,94}Bi_{2,04}S₄ wieder, worin die erste Manganlage zu 8 % mit Bismut mischbesetzt ist und die Mn2-Lage Lücken aufweist, die zu einer nur 96 %igen Besetzung führen.

In den synthetisierten Verbindungen liegen somit deutliche Mischbesetzungen einer Manganlage durch Bismut vor, wie sie auch schon von *D. Kurowski* [1] und *S. Lee* et al. [29] in äquivalenten Verbindungen beobachtet wurden.

Der Grund für diese Mischbesetzungen liegt in dem sehr ähnlichen Radius des zweiwertigen Manganions von 0,97 Å [44] mit dem Radius des dreiwertigen Bismutions mit 1,03 Å [44] und in der Bevorzugung einer oktaedrischen Koordinationssphäre für Mangan [31-33] und Bismut [34, 38-42].

Im MnSb₂S₄ findet sich keine Mischbesetzung, da der Radius des dreiwertigen Antimonions mit 0,76 Å womöglich zu klein ist, um eine Mischbesetzung mit Mangan in einer Schwefelverbindung zu ermöglichen.

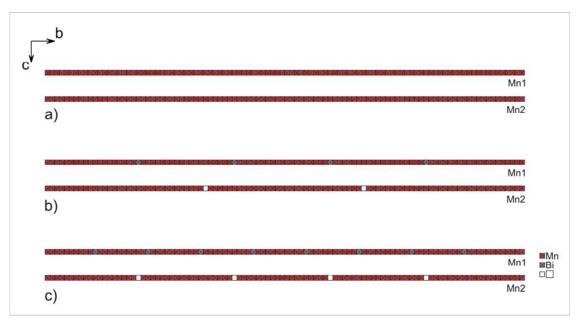


Abb. 3.11: Schematische Darstellung der statistischen Manganlagenbesetzung in den Verbindungen MnSb₂S₄, Mn_{0.97}Sb_{0.92}Bi_{1.10}S₄ und Mn_{0.94}Bi_{2.04}S₄.

3.3.6.3 Die Bindungsverhältnisse und Volumina in den MeS₆-Oktaedern

Aufgrund der teilweisen Besetzung der Manganlagen durch Bismut und der zum Ladungsausgleich enthaltenen Leerstellen in den anderen Manganpositionen haben die in den Verbindungen enthaltenen MeS₆-Oktaeder (Me: Mn, Sb, Bi) unterschiedlich lange Bindungen und verschieden große Volumina. Dabei sind die Unterschiede in den Bindungslängen der teilweise durch Bismut mischbesetzten MeS₆-Oktaeder geringer als in den reinen MnS₆-Oktaedern. Die daraus resultierenden Volumina sind im MnSb₂S₄ mit $V(\text{Mn1S}_6) = 23,56(2)$ Å³ und $V(\text{Mn2S}_6) = 23,69(4)$ Å³ fast gleich groß, was daran liegt, dass hier noch keine Mischbesetzung erfolgt. Die entsprechenden Oktaeder unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Volumina von $V(\text{Mn1S}_6) = 24,045(2)$ Å³ und $V(\text{Mn2S}_6) = 23,666(8)$ Å³ im Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S₄ durch die auftretende Mischbesetzung schon um 0,379 Å³, da durch die teilweise Substitution von Mangan durch Bismut eine Vergrößerung der substituierten Oktaeder erfolgt. Dieser Trend bleibt beim Mn_{0,94}Bi_{2,04}S₄ erhalten, worin sich die Größen der enthaltenen Oktaeder mit ihren Volumina von $V(\text{Mn1S}_6) = 24,29(1)$ Å³ und $V(\text{Mn2S}_6) = 23,818(9)$ Å³ mit 0,472 Å³ noch stärker unterscheiden.

Table 3.5: Die Bindungslängen, Volumina und Volumendifferenzen der in den Verbindungen MnSb₂S₄, Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S₄ und Mn_{0,94}Bi_{2,04}S₄ enthaltenen MeS₆-Oktaeder.

	$MnSb_2S_4$		$Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S_4$		$Mn_{0,94}Bi_{2,04}$	S_4
	Mn1	Mn2	Mn1/Bi3	Mn2	Mn1/Bi3	Mn2
d(Mn-S)/Å äquatorial	2,643(1)	2,614(1)	2,639(4)	2,648(4)	2,659(3)	2,676(3)
d(Mn-S)/Å axial	2,546(4)	2,611(6)	2,595(5)	2,550(4)	2,587(5)	2,508(5)
$V/\text{Å}^3$	23,56(2)	23,69(4)	24,045(2)	23,666(8)	24,29(1)	23,818(9)
$\Delta V/\text{Å}^3$	0,13		0,379		0,472	

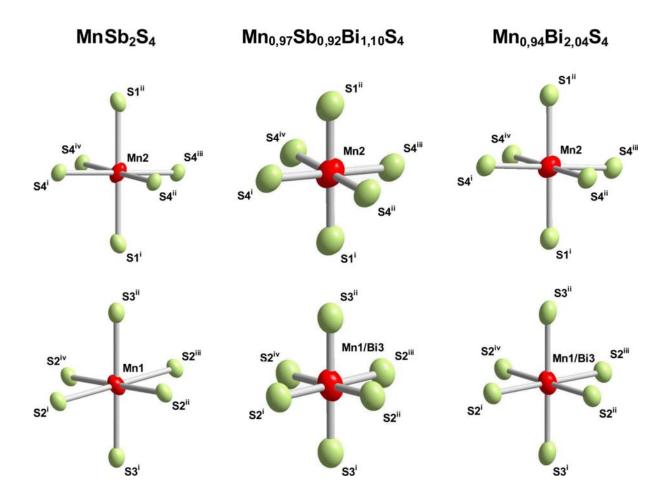


Abb. 3.12: Überblick über die in den Verbindungen MnSb₂S₄, Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S₄ und Mn_{0,94}Bi_{2,04}S₄ enthaltenen MeS₆-Oktaeder. Die dargestellten Ellipsoide repräsentieren eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von 90%.

3.3.6.4 Die Bindungsverhältnisse in den Bi/SbS₆-Oktaedern und Bi/SbS₇-Polyedern

Die Bismut- bzw. Antimon-Lagen der untersuchten Verbindungen verfügen in erster Näherung über eine nahezu quadratisch pyramidale 1+2+2 Koordination durch Schwefel. Erst wenn man auch etwas größere Abstände mit berücksichtigt gelangt man zu einer 3+2+1 Koordination durch Schwefel, wie sie für die Sb1 bzw. Bi1-Lagen aufzufinden ist, oder zu einer 3+2+2 Koordination durch Schwefel, welche die Sb2 bzw. Bi2-Lagen aufweist.

Die Länge der Abstände wird im Verlauf der MnSb_{2-x}Bi_xS₄ Mischkristallreihe in erster Hinsicht von zwei entgegengesetzten Tendenzen beeinflusst. Zum einen führt die zunehmende Mischbesetzung der Antimonlagen durch Bismut zu einer Verlängerung der Bindungen innerhalb einer Schicht, also in den Bi/SbS₅-Pyramiden. Zum anderen führt die Abnahme des Schichtabstandes zu einer Verkürzung der Abstände zwischen den Schichten.

Der erste Trend ist an den Bindungen zwischen den Schweratomen und den Pyramidenspitzen besonderst stark ausgeprägt. Die entsprechenden Bindungen sind mit d(Sb-S) = 2,474(6) Å im MnSb₂S₄ noch relativ kurz, nehmen aber in den Bi/SbS₅-Pyramiden des Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S₄ mit d(Bi/Sb-S) = 2,575(5) Å und 2,585(4) Å aufgrund der Bi/Sb-Mischbesetzung deutlich zu und sind im Mn_{0,94}Bi_{2,04}S₄ mit d(Bi-S) = 2,591(5) Å und 2,633(5) Å am längsten.

Der zweite Trend spiegelt sich an den längsten Abständen in den Sb2/Bi2S₇-Polyedern am besten wieder. Diese Abstände sind im MnSb₂S₄ mit d(Sb-S) = 3,590(6) Å noch relativ lang, betragen im Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S₄ nur noch d(Bi/Sb-S) = 3,503(4) Å und sind im Mn_{0,94}Bi_{2,04}S₄ mit d(Bi-S) = 3,439(5) Å am kürzesten.

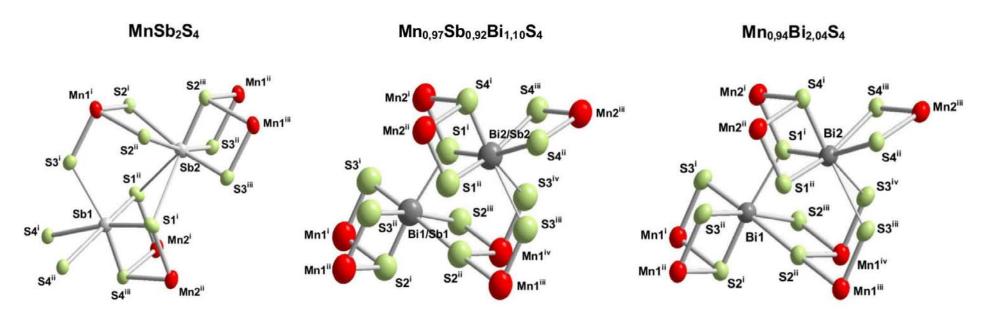


Abb. 3.13: Die Bi/SbS₆-Oktaeder und Bi/SbS₇-Polyeder der Verbindungen MnSb₂S₄, Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S₄ und Mn_{0,94}Bi_{2,04}S₄ mit den enthaltenen Bindungen und Abständen. Dabei sind die Bi/Sb-S-Abstände zwischen den Schichten dünner gezeichnet. Die dargestellten Ellipsoide repräsentieren eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von 90 %.

Die dargestellten Abstände des MnSb₂S₄ betragen in Å: $d(Sb1-S1^i) = 2,576(1)$, $d(Sb1-S1^{ii}) = 2,576(1)$, $d(Sb1-S3^i) = 3,265(8)$, $d(Sb1-S4^i) = 3,051(2)$, $d(Sb1-S4^{ii}) = 3,051(2)$, $d(Sb1-S4^{ii}) = 3,051(2)$, $d(Sb1-S4^{ii}) = 2,474(5)$, $d(Sb2-S1^i) = 3,590(6)$, $d(Sb2-S1^{ii}) = 3,590(6)$, $d(Sb2-S2^{ii}) = 3,035(3)$, $d(Sb2-S2^{iii}) = 2,474(6)$, $d(Sb2-S3^{iii}) = 2,578(1)$, $d(Sb2-S3^{iii}) = 2,578(1)$.

Die dargestellten Abstände des $Mn_{0.97}Sb_{0.92}Bi_{1,10}S_4$ betragen in Å: $d(Bi1/Sb1-S1^i) = 3,062(1)$, $d(Bi1/Sb1-S2^i) = 2,575(1)$, $d(Bi1/Sb1-S2^{ii}) = 3,024(1)$, $d(Bi1/Sb1-S2^{ii}) = 3,024(1)$, $d(Bi1/Sb1-S3^{ii}) = 2,647(1)$, $d(Bi1/Sb1-S3^{ii}) = 2,632(1)$, $d(Bi2/Sb2-S1^{ii}) = 2,632(1)$, $d(Bi2/Sb2-S1^{ii}) = 2,632(1)$, $d(Bi2/Sb2-S1^{ii}) = 3,502(2)$, $d(Bi2/Sb2-S3^{iii}) = 3,502(2)$, $d(Bi2/Sb2-S3^{iii}) = 3,502(2)$, $d(Bi2/Sb2-S4^{ii}) = 3,001(1)$, $d(Bi2/Sb2-S4^{iii}) = 3,001(1)$, $d(Bi2/Sb2-S4^{iii}) = 3,001(1)$.

Die dargestellten Abstände des $Mn_{0,94}Bi_{2,04}S_4$ betragen in Å: $d(Bi1-S1^i) = 2,984(5)$, $d(Bi1-S2^i) = 2,633(5)$, $d(Bi1-S2^{ii}) = 3,010(3)$, $d(Bi1-S2^{ii}) = 2,691(3)$, $d(Bi1-S3^{ii}) = 2,691(3)$, $d(Bi2-S1^{ii}) = 2,689(3)$, $d(Bi2-S1^{ii}) = 2,689(3)$, $d(Bi2-S3^{ii}) = 3,439(5)$, $d(Bi2-S3^{ii}) = 3,439(5)$, $d(Bi2-S4^{ii}) = 3,012(4)$, $d(Bi2-S4^{ii}) = 3,012(4)$.

$3.4 \ Synthese \ und \ Charakterisierung \ der \ Mischkristallreihe \\ MnSb_{2-x}Bi_xSe_4$

3.4.1 Synthese und Charakterisierung der ternären Randphase MnSb₂Se₄

Für die Synthese von MnSb₂Se₄ wurde MnSe und Sb₂Se₃ verwendet. Nach dem Verreiben der im stöchiometrischen Verhältnis abgewogenen Edukte in einem Achatmörser wurden Presslinge (~1 g) hergestellt. Nach dem Aufschmelzen bei 700 °C in evakuierten Quarzampullen folgte ein zweiwöchiges Tempern bei 590 °C, während dem die Proben einmal im Achatmörser homogenisiert wurden. Die Produktreguli ließen sich zu einem dunkelgrauen Pulver verreiben.

Zur Analyse des erhaltenen Produkts wurde ein Pulverdiffraktogramm angefertigt und mit einem aus Neutronenbeugungsdaten [1] berechneten Pulverdiffraktogramm verglichen.

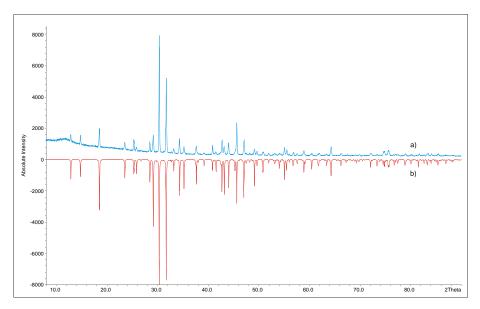


Abb. 3.14: Vergleich eines gemessenen Pulverdiffraktogramms von MnSb₂Se₄ a) mit einem aus Neutronendaten [1] berechneten b).

Bei der Indizierung des aufgenommenen Pulverdiffraktogramms erhält man eine monokline Elementarzelle mit den in der folgenden Tabelle aufgeführten Zellkonstanten. Diese stimmen gut mit den Literaturangaben [1] überein.

Tab. 3.6: Vergleich der Zellkonstanten und Zellvolumina von MnSb₂Se₄ aus [1] mit den in dieser Arbeit ermittelten.

a/ Å	b/ Å	c/ Å	β/ °	V/ Å ³	Literatur
13,330(2)	3,9681(5)	15,325(2)	115,291(7)	732,9(2)	[1]
13,3388(3)	3,9733(1)	15,3136(3)	115,775(2)	730,87(2)	d. Arb.

Im Anschluss daran erfolgte eine thermische Analyse mittels DTA. Wie der Abbildung 3.15 zu entnehmen ist zersetzt sich MnSb₂Se₄ bei 673 °C. Dabei bilden sich die Edukte MnSe und Sb₂Se₃, weshalb beim zweiten Aufheizen ein zusätzlicher Peak für das entstehende Sb₂Se₃ bei 593 °C auftritt. Für das ebenfalls entstehende MnSe ist bei dieser Aufnahme kein zusätzliches Signal zu finden, da dessen Schmelzpunkt von 1460 °C außerhalb des Messbereichs liegt. In dem nach der DTA-Messung dieser Probe aufgenommenen Pulverdiffraktogramm Nr. A.6.21 konnten sowohl Reflexe von MnSb₂Se₄ als auch von Sb₂Se₃ und MnSe gefunden werden.

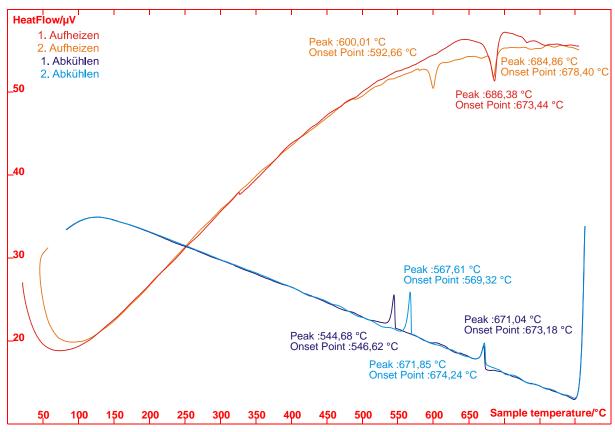


Abb. 3.15: Die DTA-Kurve von MnSb₂Se₄. Deutlich zu erkennen ist die Zersetzung der Verbindung bei 673 °C, wodurch Sb₂Se₃ entsteht, das einen Schmelzpunkt von 593 °C aufweist.

3.4.2 Synthese und Charakterisierung der ternären Randphase MnBi₂Se₄

Die Synthese von MnBi₂Se₄ erfolgte aus den binären Edukten MnSe und Bi₂Se₃, die im stöchiometrischen Verhältnis abgewogen wurden. Nach innigem Verreiben der Edukte in einem Achatmörser wurden daraus Presslinge (~1 g) geformt und zwei Wochen in evakuierten Quarzampullen bei 600 °C getempert. Dabei wurden die Proben einmal im Achatmörser homogenisiert, um eine vollständige Reaktion zu gewährleisten. Das Reaktionsprodukt ließ sich zu einem feinkörnigen grauen Pulver verreiben.

Von der erhaltenen Substanz wurde anschließend ein Pulverdiffraktogramm zur Identifizierung aufgenommen und mit einem aus Neutronenbeugungsdaten [1] berechneten Pulverdiffraktogramm verglichen.

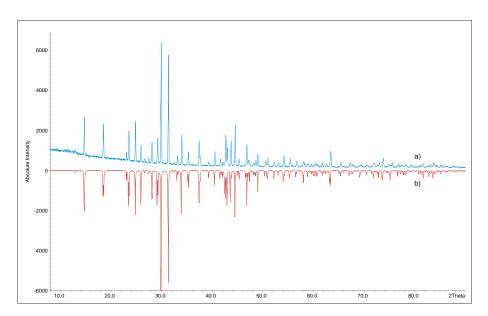


Abb. 3.16: Vergleich eines gemessenen Pulverdiffraktogramms von MnBi₂Se₄ a) mit einem aus Neutronenbeugungsdaten [1] berechneten b).

Die Indizierung des aufgenommenen Pulverdiffraktogramms ergibt eine monokline Elementarzelle mit den in der folgenden Tabelle aufgeführten Zellkonstanten. Diese stimmen gut mit den Literaturangaben [1] überein.

Tab. 3.7: Vergleich der Zellkonstanten und Zellvolumina von MnBi₂Se₄ aus [1] mit den in dieser Arbeit ermittelten.

a/ Å	b/ Å	c/ Å	β/ °	V / $Å^3$	Literatur
13,3681(1)	4,0872(1)	15,2993(1)	116,466(1)	748,33(1)	[1]
13,3841(3)	4,0712(1)	15,2517(3)	115,926(2)	747,42(2)	d. Arb.

Für die Untersuchung des Schmelzverhaltens dieser Verbindung diente eine thermische Analyse mittels DTA. Wie aus der Abbildung 3.17 zu erkennen ist zersetzt sich MnBi₂Se₄ bei 746 °C. Dabei bilden sich die Edukte MnSe und Bi₂Se₃, weshalb beim zweiten Aufheizen ein zusätzlicher Peak für das entstehende Bi₂Se₃ bei 668 °C auftritt. In dem von dieser Probe nach der DTA-Messung aufgenommenen Pulverdiffraktogramm Nr. A.6.23 konnten sowohl die Reflexe von MnBi₂Se₄ als auch von Bi₂Se₃ und MnSe gefunden werden.

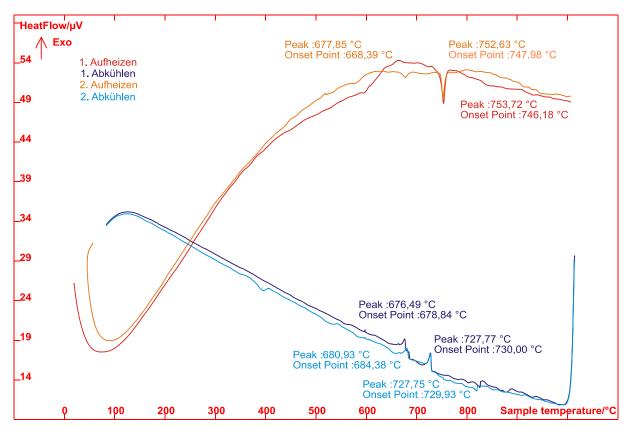


Abb. 3.17: Die DTA-Kurve von MnBi₂Se₄. Deutlich zu erkennen ist die Zersetzung der Verbindung bei 746°C, bei dem das bei 668°C schmelzende Bi₂Se₃ entsteht.

3.4.3 Synthese der Mischkristallreihe MnSb_{2-x}Bi_xSe₄

Die MnSb_{2-x}Bi_xSe₄ Mischkristallreihe wurde angefertigt, um die Substituierbarkeit des Antimons durch Bismut in der MnSb₂Se₄-Struktur zu untersuchen. Dazu erfolgte die stöchiometrische Einwaage der beiden Randphasen MnSb₂Se₄ und MnBi₂Se₄ in einem Mischungsverhältnis von 9:1 bis 1:9. Die so erhaltenen Proben wurden zu Presslingen (~1 g) weiterverarbeitet, um eine bessere Reaktion zu ermöglichen, und im Anschluss daran über einen Zeitraum von vier Wochen in evakuierten und abgeschmolzenen Quarzampullen zur Reaktion gebracht. Dabei erfolgte das Tempern nicht bei gleichen Temperaturen, um einer Zersetzung der Proben entgegenzuwirken. Die Reaktionen wurden bei den Mischungsverhältnissen von 9:1 bis 7:3 bei 620 °C, bei den Mischungsverhältnissen von 6:4 bis 4:6 bei 660 °C und bei den Mischungsverhältnissen von 3:7 bis 1:9 bei 700 °C durchgeführt. Um eine möglichst vollständige Umsetzung zu gewährleisten wurden die Proben nach zwei Wochen im Achatmörser homogenisiert und wieder zu Presslingen verarbeitet.

3.4.4 Charakterisierung der Mischkristallreihe MnSb_{2-x}Bi_xSe₄ mittels Pulverdiffraktometrie

Anhand der Pulverdiffraktogramme Nr. A.6.20 und Nr. A.6.22 sowie Nr. A.6.24 bis Nr. A.6.32 der erhaltenen Proben soll ermittelt werden, ob bei der Mischkristallreihe MnSb₂. _xBi_xSe₄ eine lineare Zunahme der Zellvolumina nach *L. Vegard* [43] vorliegt, und ob es bei den Tempervorgängen zu Zersetzungen kam. Dabei konnten beim Verfeinern dieser Pulverdiffraktogramme keine Nebenprodukte gefunden werden. Die Abbildung 3.18 gibt aller gemessener Pulverdiffraktogramme entsprechend ihrer Probenzusammensetzung gestaffelt wieder.

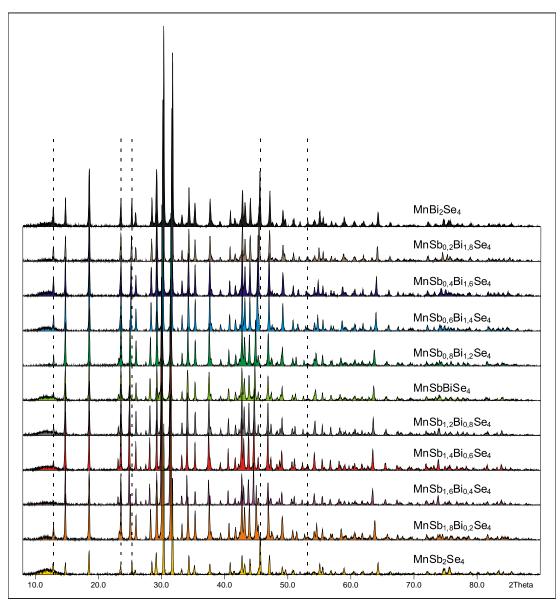


Abb. 3.18: Vergleich der gemessenen Pulverdiffraktogramme. Die gestrichelten Linien geben die Positionen der 002, 110, 111, 020 und 024 Reflexe von MnSb₂Se₄ an.

Tab. 3.8: Die Zellkonstanten und Zellvolumina der Mischkristallreihe MnSb_{2-x}Bi_xSe₄

Verbindung	a/ Å	b/ Å	c/Å	β/°	$V/Å^3$
MnSb ₂ Se ₄	13,3388(3)	3,9733(1)	15,3136(3)	115,775(2)	730,87(2)
$MnSb_{1,8}Bi_{0,2}Se_4$	13,3423(4)	3,9823(2)	15,3078(3)	115,796(2)	732,29(3)
$MnSb_{1,6}Bi_{0,4}Se_4$	13,3487(3)	3,9942(1)	15,3012(3)	115,810(1)	734,44(2)
$MnSb_{1,4}Bi_{0,6}Se_4$	13,3521(3)	4,0034(1)	15,2944(3)	115,824(2)	735,89(2)
$MnSb_{1,2}Bi_{0,8}Se_4$	13,3564(4)	4,0130(1)	15,2871(3)	115,836(2)	737,48(2)
MnSbBiSe ₄	13,3627(3)	4,0221(1)	15,2830(3)	115,857(1)	739,17(2)
$MnSb_{0,8}Bi_{1,2}Se_4$	13,3655(3)	4,0325(1)	15,2768(3)	115,870(2)	740,85(2)
$MnSb_{0,6}Bi_{1,4}Se_4$	13,3701(3)	4,0414(1)	15,2718(3)	115,888(2)	742,38(2)
$MnSb_{0,4}Bi_{1,6}Se_4$	13,3746(3)	4,0519(1)	15,2635(3)	115,900(1)	744,09(2)
$MnSb_{0,2}Bi_{1,8}Se_4$	13,3797(3)	4,0617(1)	15,2583(3)	115,915(2)	745,82(2)
MnBi ₂ Se ₄	13,3841(3)	4,0712(1)	15,2517(3)	115,926(2)	747,42(2)

Bei der Auftragung der in dieser Tabelle enthaltenen Zellkonstanten und Zellvolumina mit ihren Fehlern erhält man die in folgender Abbildung 3.19 dargestellten nahezu linearen Verläufe. Daran ist vor allem zu erkennen, dass außer der c-Achse alle Zellkonstanten und auch die Zellvolumina mit steigendem Bismutgehalt (x) kontinuierlich zunehmen.

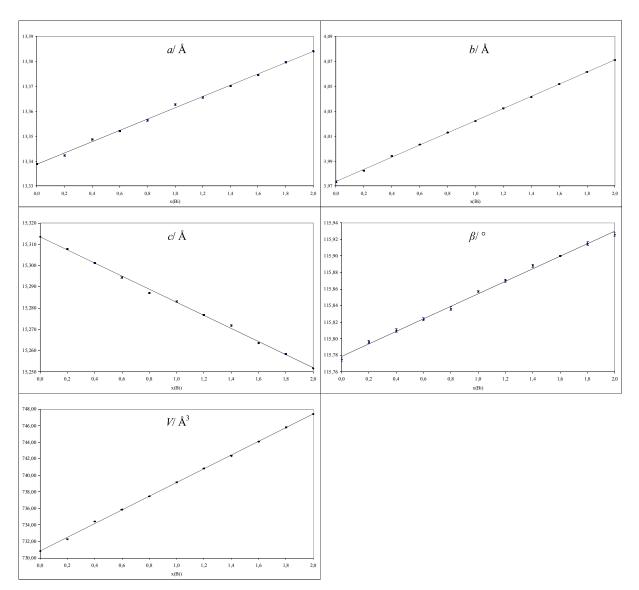


Abb. 3.19: Auftragung der verfeinerten Gitterkonstanten a/ Å, b/ Å, c/ Å und $\beta/$ ° sowie der Zellvolumina V/ Å³ der Mischkristallreihe MnSb_{2-x}Bi_xSe₄ in Abhängigkeit vom Bismutgehalt (x). Die Ausgleichsgeraden wurden durch lineare Regression bestimmt.

Wie man anhand der Tabelle 3.8 und der Abbildung 3.19 erkennen kann tritt in dieser Mischkristallreihe ein kontinuierlicher Verlauf der Zellkonstanten und Zellvolumina entsprechen der Regel von *L. Vegard* [43] auf. Dabei ist im Vergleich zur MnSb_{2-x}Bi_xS₄ Serie keine Mischungslücke zu erkennen, da alle hier enthaltenen Verbindungen in der Struktur des MnSb₂Se₄ kristallisieren. Die zu beobachtende Verkürzung der *c*-Achse ist dabei auf den

geringer werdenden Abstand zwischen den Schichten von 1,92(1) Å (Schichtabstand im $Mn_{0.88}Sb_{2.08}Se_4$) auf 1,86(1) Å (Schichtabstand im $Mn_{0.73}Bi_{2.18}Se_4$) zurückzuführen.

Zum Abschluss dieser Auswertungen erfolgt in der folgenden Abbildung 3.20 ein Vergleich der Pulverdiffraktogramme von MnSb₂Se₄, MnSbBiSe₄ und MnBi₂Se₄ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

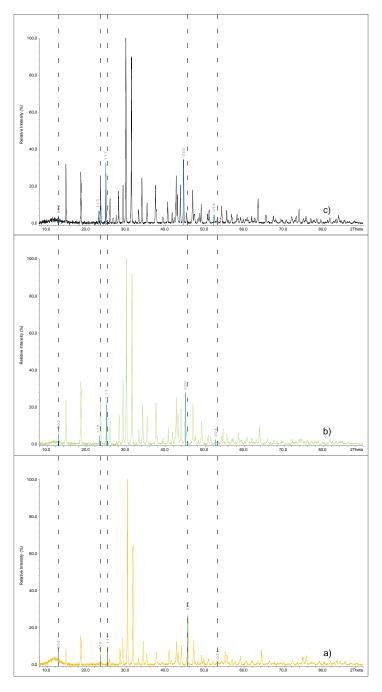


Abb. 3.20: Vergleich der Pulverdiffraktogramme von a) MnSb₂Se₄, b) MnSbBiSe₄ und c) MnBi₂Se₄. Die gestrichelten Linien sollen die Verschiebung der farbig hervorgehobenen Reflexe 002, 110, 111, 020 und 024 veranschaulichen.

3.4.5 Charakterisierung einzelner Verbindungen der MnSb_{2-x}Bi_xSe₄ Serie durch Einkristallstrukturanalyse

Um die Strukturchemie der MnSb_{2-x}Bi_xSe₄ Mischkristallreihe genauer untersuchen zu können wurden aus den synthetisierten Proben Einkristalle präpariert und auf einem entsprechenden Diffraktometer vermessen. Die Resultate der auf diesen Messungen beruhenden Strukturrechnungen werden in den folgenden Abschnitten dargestellt und zusammengefasst.

3.4.5.1 Die Verbindung Mn_{0.88}Sb_{2.08}Se₄

Wie den kristallographischen Daten A.3.3 zu entnehmen ist besetzt Mangan genau wie Antimon zwei und Selen vier unabhängige Lagen im Mn_{0.88}Sb_{2.08}Se₄. Dabei ist die Mn1-Position mit 16% durch Antimon mischbesetzt was hinsichtlich der Elektroneutralität dadurch ausgeglichen wird, dass die Mn2-Lage nur zu 92% besetzt ist. Die Gesamtstruktur besteht aus Schichten, die parallel zur ab-Ebene liegen und einen Abstand von 1,92(1) Å zueinander aufweisen. Hierin sind MnSe₆-Oktaeder entlang b zu kantenverknüpften Strängen miteinander verbunden, die wiederum über SbSe5-Pyramiden zu Schichten vernetzt sind. In den kantenverknüpften MnSe₆-Oktaedern betragen die Bindungslängen in den Mn1Se₆-Oktaedern d(Mn-Se) = 2,717(1) Å und 2,757(1) Å und in den $Mn2Se_6$ -Oktaedern d(Mn-Se) = 2,643(4) Å und 2,770(1) Å. Für diese MnSe₆-Einheiten ergibt sich ein mit IVTON [18] berechnetes Volumen von 27,52(1) Å³ bei den Mn1Se₆-Oktaedern und ein Volumen von 26,95(1) Å³ bei den Mn2Se₆-Oktaedern. Somit führt die 16 %ige Mischbesetzung der Mn2-Lage mit Antimon zu einer Volumenvergrößerung von 0,57 Å³. In den SbSe₅-Pyramiden liegen die Bindungslängen zwischen d(Sb-Se) = 2,635(1) Å und 3,106(2) Å für die Sb1Se₅-Pyramiden und zwischen d(Sb-Se) = 2,607(4) Å und 3,128(2) Å in den Sb2Se₅-Pyramiden. Wenn man diese Koordinationssphäre erweitert ergibt sich eine 3+2+1 Umgebung in Form eines leicht verzerrten und gestreckten SbSe6-Oktaeders für Sb1, in dem der Abstand zum Selen der benachbarten Schicht d(Sb-Se) = 3,170(2) Å beträgt. Sb2 besitzt dementsprechend eine 3+2+2 Umgebung in Form eines verzerrten und überkappten SbSe7-Oktaeders, worin der längste Abstand d(Sb-Se) = 3,622(4) Å zum Selen der benachbarten Schicht reicht.

3.4.5.2 Die Verbindung $Mn_{0.94}Sb_{1.64}Bi_{0.4}Se_4$

Im Mn_{0,94}Sb_{1,64}Bi_{0,4}Se₄ gibt es ebenfalls zwei unabhängige Mangan- und Antimon- bzw. Bismut-Lagen und vier unabhängige Selen-Lagen, wie den kristallographischen Daten A.3.4 zu entnehmen ist. Da die Mn1-Lage zu 8 % mit Antimon mischbesetzt ist enthält die Mn2-

Position Lücken, die zu einer 96 %igen Besetzung führen, sodass die Elektroneutralität erhalten bleibt. Auch die Bi/Sb-Positionen sind mischbesetzt, wobei auf beiden Lagen zu 80 % Antimon und zu 20 % Bismut sitzt. Die Gesamtstruktur besteht aus Schichten von kantenverknüpften MnSe₆-Oktaedern, die Stränge entlang b bilden und ihrerseits über Bi/SbSe₅-Pyramiden miteinander verbunden sind. Diese Schichten haben einen Abstand von 1,89(1) Å zueinander. In den MnSe₆-Oktaedern sind die auftretenden Bindungen in den $Mn1Se_6$ -Oktaedern d(Mn-Se) = 2,718(2) Å und 2,756(1) Å und in den $Mn2Se_6$ -Oktaedern d(Mn-Se) = 2,629(2) Å und 2,777(1) Å lang. Für diese MnSe₆-Einheiten erhält man ein mit IVTON [18] berechnetes Volumen von 27,50(1) Å³ für die Mn1Se₆-Oktaeder und ein Volumen von 26,94(1) Å³ bei den Mn2Se₆-Oktaedern. Demzufolge erfolgt durch die 8 %ige Mischbesetzung der Mn1-Lage mit Antimon eine Volumenvergrößerung um 0,56 Å³. In den Bi/SbSe₅-Pyramiden variieren die Bindungslängen zwischen d(Bi/Sb-Se) = 2,672(2) Å und 3,111(1) Å in den Bi1/Sb1Se₅-Pyramiden und zwischen d(Bi/Sb-Se) = 2,628(2) Å und 3,125(2) Å in den Bi2/Sb2Se₅-Pyramiden. Durch die Bi-Mischbesetzung werden die Bindungen zu den Pyramidenspitzen mit d(Bi/Sb-Se) = 2,628(2) Å und 2,672(2) Å im Vergleich zu denen des $Mn_{0.88}Sb_{2.08}Se_4$ mit d(Sb-Se) = 2,607(4) Å und 2,635(1) Å merklich länger. Wenn man die Koordinationssphäre dieser Bi/Sb-Positionen erweitert gelangt man für Bi1/Sb1 zu einer 3+2+1 Umgebung, welche die Form eines leicht verzerrten und gestreckten $Bi/SbSe_6$ -Oktaeders aufweist, wobei hierin der maximale Abstand d(Bi/Sb-Se) = 3,141(2) Å beträgt. Für Bi2/Sb2 erhält man so eine 3+2+2 Umgebung, welche die Gestallt eines verzerrten und überkappten Bi/SbSe7-Oktaeders aufweist, in dem der längste Abstand d(Bi/Sb-Se) = 3,604(2) Å ist.

3.4.5.3 Die Verbindung Mn_{0,73}Bi_{2,18}Se₄

Entsprechend den kristallographischen Daten A.3.5 besetzt Mangan im $Mn_{0,73}Bi_{2,18}Se_4$ genauso wie Bismut zwei und Selen vier unabhängige Lagen. Da die Mn2-Lage nur zu 82 % besetzt ist entsteht an dieser Position ein Elektronenmangel der dadurch kompensiert wird, dass die Mn1-Lage zu 36 % mit Bismut mischbesetzt ist, wodurch die Elektroneutralität insgesamt gewahrt bleibt. Die schichtartige Gesamtstruktur wird auch hier von Strängen aus kantenverknüpften MnSe₆-Oktaedern gebildet, die entlang b angeordnet und über BiSe₅-Pyramiden miteinander verbunden sind. Der Schichtabstand beträgt dabei 1,86(1) Å. Die Bindungslängen der hierin enthaltenen MnSe₆-Oktaeder liegen bei d(Mn-Se) = 2,794(2) Å und 2,808(2) Å in den Mn1Se₆-Oktaedern und bei d(Mn-Se) = 2,585(4) Å und 2,807(2) Å in den Mn2Se₆-Oktaedern. Für diese MnSe₆-Einheiten erhält man somit ein Volumen von

29,31(1) ų bei den Mn1Se₆-Oktaedern und ein Volumen von 27,09(1) ų bei den Mn2Se₆-Oktaedern, das mit IVTON [18] berechnet wurde. Daraus ergibt sich, dass durch die 36%ige Mischbesetzung der Mn1-Lage mit Bismut eine Volumenvergrößerung von 2,22 ų erfolgt. Die Bindungslängen in den BiSe₅-Pyramiden liegen zwischen d(Bi-Se) = 2,797(2) Å und 3,056(2) Å in den Bi1Se₅-Pyramiden und zwischen d(Bi-Se) = 2,708(1) Å und 3,134(3) Å in den Bi2Se₅-Pyramiden. Die Bindungen zu den Pyramidenspitzen sind hier d(Bi-Se) = 2,884(2) Å und 2,708(4) Å lang. Bei einer Erweiterung dieser Koordinationssphäre erhält man für Bi1 eine 3+2+1 Umgebung in Form eines leicht verzerrten und gestreckten BiSe₆-Oktaeders, wobei hier der Abstand zum Selen der benachbarten Schicht d(Bi-Se) = 3,004(3) Å beträgt. Die entsprechende Koordinationssphäre hat für Bi2 die Gestallt eines verzerrten und überkappten BiSe₇-Oktaeders, in dem ein maximaler Abstand von d(Bi-Se) = 3,548(4) Å auftritt.

3.4.6 Ein strukturchemischer Vergleich der untersuchten Verbindungen

 $3.4.6.1\ Die\ strukturchemische\ Verwandtschaft\ zwischen\ Mn_{0,88}Sb_{2,08}Se_4,\ Mn_{0,94}Sb_{1,64}Bi_{0,4}Se_4\ und\ Mn_{0,73}Bi_{2,18}Se_4$

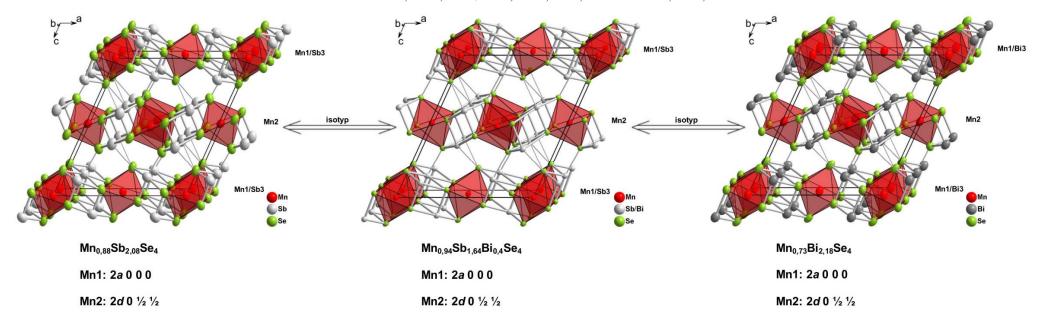


Abb. 3.21: Die Kristallstrukturen von $Mn_{0,88}Sb_{2,08}Se_4$, $Mn_{0,94}Sb_{1,64}Bi_{0,4}Se_4$ und $Mn_{0,73}Bi_{2,18}Se_4$ im Vergleich. Deutlich erkennbar ist hierbei die Isotypie dieser drei Verbindungen. Die dargestellten Ellipsoide repräsentieren eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von 90%.

3.4.6.2 Die Besetzung der Manganlagen

Alle in der MnSb_{2-x}Bi_xSe₄ Serie enthaltenen Verbindungen weisen eine Mischbesetzung einer Manganlage durch Antimon oder Bismut auf. Der dadurch entstehende positive Ladungsüberschuss wird durch Leerstellen in der jeweils anderen Manganlage kompensiert, sodass die Elektroneutralität der Verbindungen erhalten bleibt.

Beim $Mn_{0.88}Sb_{2.08}Se_4$ gleichen die Lücken der nur zu 92 % besetzten Mn1-Lage den positiven Ladungsüberschuss der zu 16 % mit Antimon besetzten Mn2-Position aus. Im $Mn_{0.94}Sb_{1.64}Bi_{0.4}Se_4$ ist die Mn1-Lage zu 8 % durch Antimon substituiert was dadurch kompensiert wird, dass die Mn2-Position nur zu 96 % besetzt ist. Am stärksten fällt die Mischbesetzung aber im $Mn_{0.73}Bi_{2.18}Se_4$ aus. Hier werden 36 % der Mn1-Lage von Bismut eingenommen, weshalb die Mn2-Position nur zu 82 % besetzt ist.

In diesen Verbindungen liegt somit eine deutliche Mischbesetzung einer Manganlage durch Antimon oder Bismut vor, welche schon von *D. Kurowski* [1] und *S. Lee* et al. [29] in vergleichbaren Verbindungen beschrieben wurde. Aufgrund der größeren Volumina der MeSe₆-Oktaeder (Me: Mn, Sb, Bi) im Vergleich zu den MeS₆-Oktaedern der Verbindungen aus der MnSb_{2-x}Bi_xS₄ Mischkristallreihe findet hier auch eine Mischbesetzung zwischen Mangan und Antimon statt.



Abb. 3.22: Schematische Darstellung der statistischen Besetzung der Manganlagen in den Verbindungen Mn_{0,88}Sb_{2,08}Se₄, Mn_{0,94}Sb_{1,64}Bi_{0,4}Se₄ und Mn_{0,73}Bi_{2,18}Se₄.

3.4.6.3 Die Bindungsverhältnisse und Volumina in den MeS₆-Oktaedern

Die teilweise Besetzung der Manganlagen durch Antimon bzw. Bismut und die zum Ladungsausgleich enthaltenen Leerstellen in den anderen Manganpositionen führen dazu, dass die in den Verbindungen enthaltenen MeSe₆-Oktaeder (Me: Mn, Bi, Sb) unterschiedlich groß sind. Dabei findet im Gegensatz zum MnSb₂S₄ schon beim Mn_{0,88}Sb_{2,08}Se₄ eine Mischbesetzung einer Manganposition durch Antimon statt, weshalb die hier enthaltenen MnSe₆-Oktaeder, deren Volumina $V(Mn1Se_6) = 27,52(1)$ Å³ und $V(Mn2Se_6) = 26,95(1)$ Å³ betragen, einen Volumenunterschied von 0,57 Å³ aufweisen.

Die Volumendifferenz bleibt im $Mn_{0,94}Sb_{1,64}Bi_{0,4}Se_4$ mit 0,56 ų nahezu konstant, wobei die hier enthaltenen $MeSe_6$ -Oktaeder $V(Mn1Se_6) = 27,50(7)$ ų und $V(Mn2Se_6) = 26,94(1)$ ų groß sind. Im $Mn_{0,73}Bi_{2,18}Se_4$ haben die Volumina der enthaltenen $MeSe_6$ -Oktaeder mit $V(Mn1Se_6) = 29,31(1)$ ų und $V(Mn2Se_6) = 27,09(1)$ ų den größten Unterschied von 2,22 ų. Somit nehmen die Volumina der mischbesetzten $MeSe_6$ -Oktaeder in diesen Verbindungen deutlich zu, was an den größeren Radien der eingebauten Bismutionen mit 1,03 Å im Vergleich zu den Radien der Manganionen mit 0,97 Å und Antimonionen mit 0,76 Å liegt [44]. Der Hauptgrund warum bereits in der reinen Mangan- und Antimonverbindung eine Mischbesetzung einer Manganlage auftritt ist darin zu sehen, dass die hier enthaltenen Oktaeder ein größeres Volumen als in den Schwefelverbindungen besitzen und so ein Austausch der Zentralionen leichter erfolgen kann.

Table 3.9: Die Bindungslängen, Volumina und Volumendifferenzen der in den Verbindungen Mn_{0.88}Sb_{2.08}Se₄, Mn_{0.94}Sb_{1.64}Bi_{0.4}Se₄ und Mn_{0.73}Bi_{2.18}Se₄ enthaltenen MeS₆-Oktaeder.

	$Mn_{0,88}Sb_{2,08}Se_4$		$Mn_{0,94}Sb_{1,64}Bi_{0,4}Se_4$		$Mn_{0,73}Bi_{2,18}$	Se ₄
	Mn1/Sb3	Mn2	Mn1/Sb3	Mn2	Mn1/Bi3	Mn2
d(Mn-Se)/Å äquatorial	2,717(1)	2,770(1)	2,756(1)	2,777(1)	2,808(2)	2,807(2)
d(Mn-Se)/Å axial	2,757(1)	2,643(4)	2,718(2)	2,629(2)	2,794(2)	2,585(4)
$V/\text{Å}^3$	27,52(1)	26,95(1)	27,50(7)	26,94(1)	29,31(1)	27,09(1)
$\Delta V/\text{Å}^3$	0,57		0,56		2,22	

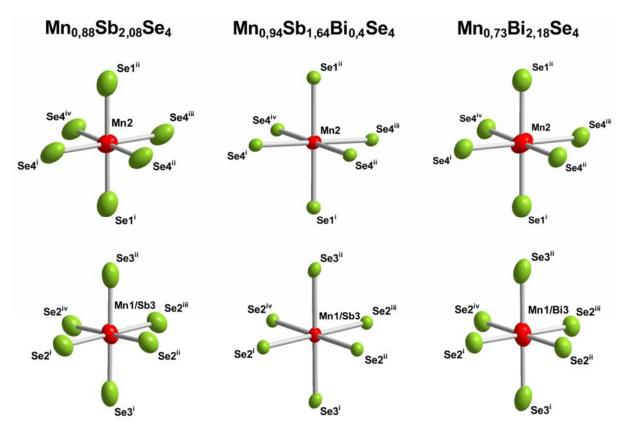


Abb. 3.23: Überblick über die in den Verbindungen Mn_{0,88}Sb_{2,08}Se₄, Mn_{0,94}Sb_{1,64}Bi_{0,4}Se₄ und Mn_{0,73}Bi_{2,18}Se₄ enthaltenen MnSe₆-Oktaeder. Die dargestellten Ellipsoide repräsentieren eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von 90%.

3.4.6.4 Die Bindungsverhältnisse in den Bi/SbSe₆-Oktaedern und Bi/SbSe₇-Polyedern

Die hier beschriebenen Verbindungen zeichnen sich dadurch aus, dass die enthaltenen Bismut bzw. Antimonlagen zunächst eine 1+2+2 Koordination durch Selen in Form einer nahezu quadratischen Pyramide aufweisen. Erst wenn man auch etwas größere Abstände mit berücksichtigt gelangt man zu einer 3+2+1 Koordination durch Selen wie bei den Sb1 bzw. Bi1-Lagen, oder zu einer 3+2+2 Koordination durch Selen wie für die Sb2 bzw. Bi2-Lagen.

Die Längen dieser Abstände werden von den gleichen entgegengesetzten Tendenzen beeinflusst die auch in der MnSb_{2-x}Bi_xS₄ Mischkristallreihe zu erkennen sind. Zum einen führt die zunehmende Mischbesetzung der Antimonlagen durch Bismut zu einer Verlängerung der Bindungen innerhalb einer Schicht was die Bi/SbSe₅-Pyramiden betrifft, und zum anderen führt die Abnahme des Schichtabstandes zu einer Verkürzung der Abstände zwischen den Schichten

Die erste Tendenz ist an den Bindungen zwischen den Schweratomen und den Pyramidenspitzen besonderst stark ausgeprägt. Diese Abstände sind im $Mn_{0,88}Sb_{2,08}Se_4$ mit d(Sb-Se) = 2,635(1) Å und 2,607(4) Å noch nahezu gleich lang und nehmen mit steigendem Bismutgehalt

im $Mn_{0,94}Sb_{1,64}Bi_{0,4}Se_4$ auf d(Sb-Se) = 2,672(2) Å und 2,628(2) Å zu. Am weitesten sind die Pyramidenspitzen von den Zentralatomen im $Mn_{0,73}Bi_{2,18}Se_4$ mit d(Bi-Se) = 2,884(2) Å und 2,708(4) Å entfernt.

Die zweite Tendenz ist am besten an den längsten Abständen der Sb2/Bi2Se₇-Polyeder zu erkennen. Diese Abstände sind im $Mn_{0,88}Sb_{2,08}Se_4$ mit d(Sb-Se) = 3,622(4) Å noch relativ lang, betragen im $Mn_{0,94}Sb_{1,64}Bi_{0,4}Se_4$ nur noch d(Bi/Sb-Se) = 3,604(2) Å und sind im $Mn_{0,73}Bi_{2,18}Se_4$ mit d(Bi/Sb-Se) = 3,548(4) Å am kürzesten.

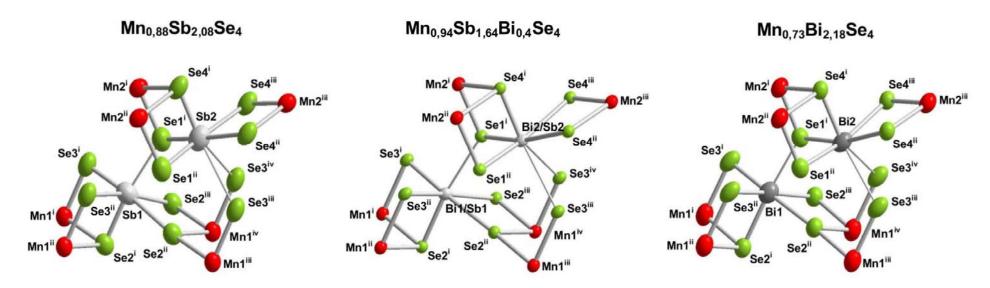


Abb. 3.24: Die Bi/SbSe₆-Oktaeder und Bi/SbSe₇-Polyeder der Verbindungen Mn_{0,88}Sb_{2,08}Se₄, Mn_{0,94}Sb_{1,64}Bi_{0,4}Se₄ und Mn_{0,73}Bi_{2,18}Se₄ mit den enthaltenen Bindungen und Abständen. Dabei sind die Bi/Sb-Se-Abstände zwischen den Schichten dünner gezeichnet. Die dargestellten Ellipsoide repräsentieren eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von 90 %.

Die dargestellten Abstände des $Mn_{0,88}Sb_{2,08}Se_4$ betragen in Å: $d(Sb1-Se1^i) = 3,170(2)$, $d(Sb1-Se2^i) = 2,635(1)$, $d(Sb1-Se2^{ii}) = 3,106(2)$, $d(Sb1-Se3^{ii}) = 2,713(1)$, $d(Sb1-Se3^{ii}) = 2,713(1)$, $d(Sb2-Se1^i) = 2,723(1)$, $d(Sb2-Se1^{ii}) = 2,723(1)$, $d(Sb2-Se3^{iii}) = 3,622(4)$, $d(Sb2-Se4^{ii}) = 2,607(4)$, $d(Sb2-Se4^{ii}) = 3,128(2)$, $d(Sb2-Se4^{iii}) = 3,128(2)$.

Die dargestellten Abstände des $Mn_{0,94}Sb_{1,64}Bi_{0,4}Se_4$ betragen in Å: $d(Bi1/Sb1-Se1^i) = 3,141(2)$, $d(Bi/Sb1-Se2^i) = 2,672(2)$, $d(Bi1/Sb1-Se2^{ii}) = 3,111(1)$, $d(Bi1/Sb1-Se2^{ii}) = 3,111(1)$, $d(Bi1/Sb1-Se3^{ii}) = 2,738(1)$, $d(Bi1/Sb1-Se3^{ii}) = 2,738(1)$, $d(Bi2/Sb2-Se1^{ii}) = 2,746(1)$, $d(Bi2/Sb2-Se1^{ii}) = 3,604(2)$, $d(Bi2/Sb2-Se3^{ii}) = 3,604(2)$, $d(Bi2/Sb2-Se3^{ii}) = 3,604(2)$, $d(Bi2/Sb2-Se3^{ii}) = 3,604(2)$, $d(Bi2/Sb2-Se3^{ii}) = 3,125(2)$, $d(Bi2/Sb2-Se3^{ii}) = 3,125(2)$.

Die dargestellten Abstände des $Mn_{0,73}Bi_{2,18}Se_4$ betragen in Å: $d(Bi1-Se1^i) = 3,004(3)$, $d(Bi1-Se2^i) = 2,884(2)$, $d(Bi1-Se2^{ii}) = 3,056(2)$, $d(Bi1-Se3^{ii}) = 2,797(2)$, $d(Bi1-Se3^{ii}) = 2,797(2)$, $d(Bi2-Se1^i) = 2,835(2)$, $d(Bi2-Se1^{ii}) = 2,835(2)$, $d(Bi2-Se3^{iii}) = 3,548(4)$, $d(Bi2-Se4^{ii}) = 2,708(4)$, $d(Bi2-Se4^{ii}) = 3,134(2)$.

3.5 Zusammenfassung

Da die beiden Randphasen $MnSb_2S_4$ und $MnBi_2S_4$ der $MnSb_{2-x}Bi_xS_4$ Mischkristallreihe nicht isotyp zueinander sind tritt im Bereich von x = 0.4 bis x = 1.0 eine Mischungslücke auf. Diese zeichnet sich durch eine Entmischung aus, welche zu den beiden Verbindungen $MnSb_{1,6}Bi_{0,4}S_4$ und $MnSbBiS_4$ führt. Außerdem erfolgt hier auch der strukturelle Übergang von Verbindungen des $HgBi_2S_4$ -Typs ($MnSb_2S_4$ bis $MnSb_{1,6}Bi_{0,4}S_4$) mit Mn2 auf der Wyckoff-Position 2c (0 0 ½) zu Verbindungen des $MnSb_2Se_4$ -Typs ($MnSbBiS_4$ bis $MnBi_2S_4$) mit Mn2 auf der Wyckoff-Position 2d (0 ½ ½). Allgemein betrachtet sind die Proben dieser Mischkristallreihe eher inhomogen, da man in einigen von ihnen die Zersetzungsprodukte MnS und Sb_2S_3 findet.

Anhand der drei kristallographisch untersuchten Verbindungen $MnSb_2S_4$, $Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S_4$ und $Mn_{0,94}Bi_{2,04}S_4$ kann man ebenfalls erkennen, dass bei einem x von 1,0 dieser strukturelle Übergang bereits erfolgt ist.

Bewirkt wird dieser Übergang dadurch, dass sich die c-Achse im Verlauf der Mischkristallreihe verkürzt und so eine Annäherung der Schichten erfolgt. Dabei kommt es in der HgBi₂S₄-Struktur des MnSb₂S₄ zu einer direkten Übereinanderlagerung der enthaltenen MeS₆-Oktaeder (Me: Hg, Mn, Bi), wie in der Abbildung 3.8 zu sehen ist. Dies ist in den Verbindungen mit x = 0 bis x = 0,4 noch möglich, da hier die Schichten mit einem Abstand von 2,35(1) Å (Schichtabstand im MnSb₂S₄) noch recht weit voneinander entfernt sind. Im Gegensatz dazu beträgt der Schichtabstand in den Verbindungen mit x = 1,0 bis x = 2,0 nur etwa 1,97(1) Å (Schichtabstand im Mn_{0,94}Bi_{2,04}S₄), weshalb hier eine gegeneinander versetzte Anordnung der MeS₆-Oktaeder, wie im MnSb₂Se₄, bevorzugt wird.

Im Gegensatz zu $MnSb_2S_4$ weisen die beiden Verbindungen $Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S_4$ und $Mn_{0,94}Bi_{2,04}S_4$ eine Mischbesetzung der Mn1-Lage durch Bismut auf, die durch Leerstellen in der Mn2-Lage kompensiert wird, sodass die Elektroneutralität insgesamt gewahrt bleibt. Aufgrund dieser Besetzungsunterschiede wächst auch die Volumendifferenz der enthaltenen MeS_6 -Oktaeder (Me: Mn, Sb und Bi) von 0,13 $Å^3$ im $MnSb_2S_4$ über 0,379 $Å^3$ im $Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S_4$ bis auf 0,472 $Å^3$ beim $Mn_{0,94}Bi_{2,04}S_4$. Dadurch kommt es auch zu einer Verringerung des Abstandes der in der ab-Ebene angeordneten Schichten von 2,35(1) Å im $MnSb_2S_4$ über 2,02(1) Å im $Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S_4$ bis zu 1,97(1) Å im $Mn_{0,94}Bi_{2,04}S_4$.

Die Bindungslängen in den enthaltenen Bi/SbS₆-Oktaedern und Bi/SbS₇-Polyedern nehmen durch die Substitution von Antimon durch Bismut innerhalb der Schichten zu, was vor allem an den Bindungen der Schweratome zu den Pyramidenspitzen von d(Sb-S) = 2,474(6) Å im

MnSb₂S₄ über d(Bi/Sb-S) = 2,575(5) Å und 2,585(4) Å im Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S₄ bis d(Bi-S) = 2,591(5) Å und 2,633(5) Å im Mn_{0,94}Bi_{2,04}S₄ zu erkennen ist.

Im Gegensatz dazu verkürzen sich die Bi/Sb-S-Abstände zwischen den Schichten, was man vor allem an den entsprechenden Abständen der Bi/SbS₇-Polyeder gut erkennen kann. Diese verkürzen sich ausgehend von d(Sb-S) = 3,590(6) Å im MnSb₂S₄ über d(Bi/Sb-S) = 3,503(4) Å im Mn_{0.97}Sb_{0.92}Bi_{1.10}S₄ bis zu d(Bi-S) = 3,439(5) Å im Mn_{0.94}Bi_{2.04}S₄.

Aufgrund dieser Erkenntnisse lässt sich ein isothermer Ausschnitt (bei 620 °C) aus dem quasi ternären MnS - Sb₂S₃ - Bi₂S₃-Phasendiagramm erstellen, der in Abbildung 3.25 dargestellt wird. Darin ist der Übergang von MnSb₂S₄ zu MnBi₂S₄ in der MnSb_{2-x}Bi_xS₄ Mischkristallreihe erkennbar, welcher durch die Substitution des Antimons durch Bismut erfolgt. Die hierbei betrachtete Konode wird etwas dicker und im Bereich der Mischungslücke gestrichelt dargestellt. Die synthetisierten Verbindungen werden durch rote Kreise gekennzeichnet.

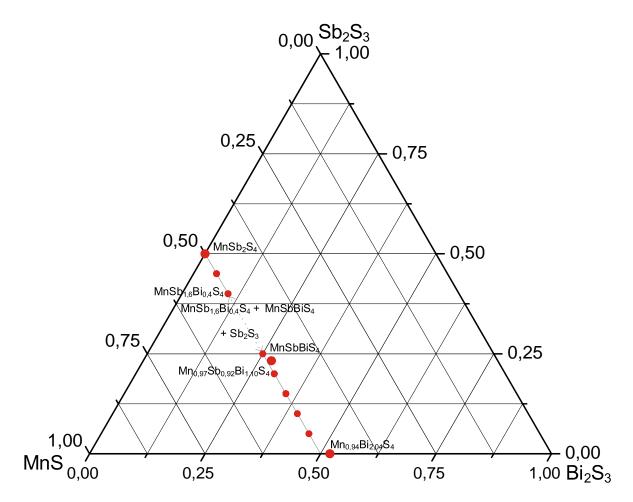


Abb. 3.25: Isothermer Ausschnitt (bei 620 °C) aus dem quasi ternären MnS - Sb_2S_3 - Bi_2S_3 -Phasendiagramm. Die Konode der $MnSb_{2-x}Bi_xS_4$ Serie ist etwas dicker und im Bereich der Mischungslücke gestrichelt dargestellt. In diesem Bereich treten $MnSb_{1,6}Bi_{0,4}S_4$ und $MnSbBiS_4$ als quaternäre Verbindungen sowie das Zersetzungsprodukt Sb_2S_3 auf. Die synthetisierten Verbindungen werden durch rote Kreise symbolisiert. Dabei sind die anhand von Einkristallen untersuchten Verbindungen $MnSb_2S_4$, $Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S_4$ und $Mn_{0,94}Bi_{2,04}S_4$ größer dargestellt.

Da die beiden Randphasen $MnSb_2Se_4$ und $MnBi_2Se_4$ der $MnSb_2xBi_xSe_4$ Serie zueinander isotyp sind erfolgt in dieser Mischkristallreihe eine kontinuierliche Veränderung der Zellkonstanten a, b, c und β , wodurch auch die Zellvolumina entsprechend der Regel von L. Vegard [43] sukzessive wachsen. Somit ist in dieser Mischkristallreihe im Gegensatz zur $MnSb_2xBi_xS_4$ Serie keine Mischungslücke enthalten.

Alle drei kristallographisch untersuchten Verbindungen Mn_{0,88}Sb_{2,08}Se₄, Mn_{0,94}Sb_{1,64}Bi_{0,4}Se₄ und Mn_{0,73}Bi_{2,18}Se₄ weisen eine Mischbesetzung der Mn1-Lage durch Antimon oder Bismut auf, die durch Leerstellen in der Mn2-Lage kompensiert wird.

Aufgrund dieser unterschiedlichen Besetzung wächst auch die Volumendifferenz der enthaltenen MeSe₆-Oktaeder (Me: Mn, Sb, Bi) von $0.57\,\text{Å}^3$ im $Mn_{0.88}Sb_{2.08}Se_4$ über $0.56\,\text{Å}^3$ im $Mn_{0.94}Sb_{1.64}Bi_{0.4}Se_4$ bis zu $2.22\,\text{Å}^3$ im $Mn_{0.73}Bi_{2.18}Se_4$ sehr stark. Dadurch kommt es auch zu einer Verringerung des Abstandes der in der *ab*-Ebene angeordneten Schichten von $1.92(1)\,\text{Å}$ im $Mn_{0.88}Sb_{2.08}Se_4$ über $1.89(1)\,\text{Å}$ im $Mn_{0.94}Sb_{1.64}Bi_{0.4}Se_4$ bis zu $1.86(1)\,\text{Å}$ im $Mn_{0.73}Bi_{2.18}Se_4$.

Die Abstände in den enthaltenen Bi/SbSe₆-Oktaedern und Bi/SbSe₇-Polyedern entwickeln sich entsprechend zweier entgegengesetzter Tendenzen. Wenn man die Bi/Sb-Se-Bindungen innerhalb einer Schicht betrachtet so werden diese durch die Substitution von Antimon durch Bismut länger, was vor allem an den Bindungen der Schweratome zu den Pyramidenspitzen von d(Sb-Se) = 2,635(1) Å und 2,607(4) Å im $Mn_{0,88}Sb_{2,08}Se_4$ über d(Bi/Sb-Se) = 2,672(2) Å und 2,628(2) Å im $Mn_{0,94}Sb_{1,6}Bi_{0,44}Se_4$ bis zu d(Bi-Se) = 2,884(2) Å und 2,708(4) Å im $Mn_{0,73}Bi_{2,18}$ Se₄ zu erkennen ist. Im Gegensatz dazu verkürzen sich die Abstände zwischen den Schichten, was sehr gut an den entsprechenden Abständen der Bi/SbSe₇-Polyeder zu sehen ist. Diese nehmen ausgehend von d(Sb-Se) = 3,622(4) Å im $Mn_{0,88}Sb_{2,08}Se_4$ über d(Bi/Sb-Se) = 3,604(2) Å im $Mn_{0,94}Sb_{1,64}Bi_{0,4}Se_4$ bis zu d(Bi-Se) = 3,548(4) Å im $Mn_{0,73}Bi_{2,18}Se_4$ schrittweise ab.

Tab. 3.10: Übersicht über die in diesem Kapitel betrachteten Verbindungen mit den Volumina der enthaltenen (Mn/Hg)/(S/Se)₆-Oktaedern.

Verbindung	Raumgruppe	Zellkonstanten/ Å	Λ, °	Formeleinheit pro Zelle Z; Zellvolumina V/ Å ³	Mn/HgQ ₆ -Volumina/ Å ³	Literatur
HgBi ₂ S ₄	C2/m	a = 14,17(1)	b = 4,06(1)	4; 708,85(4)	31,6(6); 33,0(7)	[6]
		c = 13,99(1)	$\beta = 118,27(1)$			
$Mn_{0,695}Bi_{2,2}S_{3,95}$	C2/m	a = 12,869(2)	b = 3,9546(6)	4; 671,63(3)	26,37(2); 24,58(7)	[29]
		c = 14,771(2)	$\beta = 116,690(9)$			
$MnSb_2S_4$	C2/m	a = 12,7196(2)	b = 3,7942(1)	4; 664,08(2)	23,56(2); 23,69(4)	[1, 2]
		c = 15,0457(3)	$\beta = 113,858(2)$			
$Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S_4$	C2/m	a = 12,7422(2)	b = 3,8545(7)	4; 665,70(1)	24,045(2); 23,666(8)	d. Arb.
		c = 14,9028(2)	$\beta = 114,564(1)$			
$Mn_{0,94}Bi_{2,04}S_4$	C2/m	a = 12,7681(2)	b = 3,9179(1)	4; 667,32(2)	24,29(1); 23,818(9)	d. Arb.
		c = 14,7543(3)	$\beta = 115,294(2)$			
$Mn_{0,88}Sb_{2,08}Se_4$	C2/m	a = 13,3388(3)	b = 3,9733(1)	4; 730,87(2)	27,52(1); 26,95(1)	d. Arb.
		c = 15,3136(3)	$\beta = 115,775(2)$			
$Mn_{0,94}Sb_{1,64}Bi_{0,4}Se_4$	C2/m	a = 13,3487(3)	b = 3,9942(1)	4; 734,44(2)	27,50(7); 26,94(1)	d. Arb.
		c = 15,3012(3)	β = 115,810(1)			
$Mn_{0,73}Bi_{2,18}Se_4$	C2/m	a = 13,3841(3)	b = 4,0712(1)	4; 747,42(2)	29,31(1); 27,09(1)	d. Arb.
		c = 15,2517(3)	$\beta = 115,926(2)$			

^{*} alle hier enthaltenen Oktaedervolumina wurden mit dem Programm IVTON [18] berechnet.

IV Untersuchungen zur Mischkristallreihe FeSb_{1-x}Bi_xS₂Br

4.1 Motivation

Alle bisher untersuchten Verbindung mit der allgemeinen Summenformel MPnQ₂X (M: Mn, Fe, Cd; Pn: Sb, Bi; Q: S, Se; X: Cl, Br, I) weisen entweder eine orthorombische Kristallstruktur in den beiden Raugruppen Pnma (Nr. 62) und Cmcm (Nr. 63) oder eine monokline Kristallstruktur in der Raumgruppe C2/m (Nr. 12) auf.

Die orthorhombischen Vertreter mit dieser Zusammensetzung, die in Tabelle 4.1 aufgelistet sind, leiten sich in ihrem schichtartigen Aufbau von FeUS₃ ab, dass von H. Noël und J. Padiou [45] synthetisiert und charakterisiert wurde. Dabei bestehen die zur ab-Ebene parallelen Schichten aus MQ_4X_2 -Oktaeder, die entlang a durch gemeinsame Q-Ecken und entlang b über gemeinsame Q-X-Kanten miteinander verknüpft sind. Diese Schichten sind durch PnQ_5 -Pyramiden in c-Richtung miteinander verbunden, sodass sich insgesamt eine dreidimensionale Netzwerkstruktur ergibt, wie in Abbildung 4.3 zu sehen ist.

Auch die monoklinen Varianten mit dieser Zusammensetzung lassen sich aufgrund ihrer aus Oktaedern aufgebauten Struktur auf das FeUS₃ zurückführen, wie ebenfalls durch die Abbildung 4.3 gezeigt wir. Im Gegensatz zu den orthorhombischen Verbindungen liegen in den monoklinen Vertretern, die in Tabelle 4.2 zusammengefasst sind, zwei verschiedene Sorten von M-zentrierten Oktaedern vor. Zum einen gibt es hier MQ₆-Oktaeder, an denen keine Halogenatome beteiligt sind, und zum anderen MQ₂X₄-Oktaeder, in denen vier Halogenatome auftreten. Diese Oktaeder bilden in *b*-Richtung über gemeinsame Q-Q- oder X-X-Kanten Stränge aus, die entlang *c* über gemeinsame Q-Atome miteinander eckenverknüpft sind. Bei dieser Eckenverknüpfung wechseln sich die beiden Oktaedertypen immer ab, sodass eine ABAB Stapelung auftritt. Dabei verbinden die enthaltenen PnQ₅-Pyramiden die MQ₆-Oktaeder zu Schichten parallel zur *ab*-Ebene.

Um zu erklären, warum einige dieser Substanzen orthorhombisch und andere monoklin kristallisieren entwickelte *L. Wang* et. al. [46] ein Klassifizierungskonzept. Demzufolge bestimmen ausschließlich die enthaltenen Chalkogenid- und Halogenidionen in welcher Kristallklasse die Struktur auftritt. Wenn die enthaltenen Chalkogen- und Halogenidionen der selben Periode entstammen, und daher einen sehr ähnlichen Ionenradius [44] besitzen, erfolgt

die Kristallisation in einer orthorhombisch Raumgruppe. Wenn die eingebauten Chalkogenund Halogenidionen allerdings aus unterschiedlichen Perioden sind, und deshalb deutlich unterschiedliche Ionenradien [44] aufweisen, erfolgt die Kristallisation in einer monoklinen Raumgruppe.

Dieser strukturchemische Zusammenhang wird im folgenden Kapitel 4.2 anhand der Gruppe-Untergruppe-Beziehung zwischen FeUS₃ und MnSbS₂Cl bzw. FeSbS₂Br näher erläutert.

Die in dieser Arbeit beschriebene FeSb_{1-x}Bi_xS₂Br Mischkristallreihe wurde in Zusammenarbeit mit *A. Pointner* [3] und *F. M. Bräu* [4] synthetisierte und mittels Pulverdiffraktometrie und Einkristallstrukturanalyse untersucht, um so die Strukturchemie dieser Verbindungsklasse genauer zu untersuchen. Dafür erfolgte ausgehend von FeSbS₂Br eine schrittweise Substitution des Antimons durch Bismut, deren Auswirkungen auf die Zellkonstanten, Zellvolumina und Bindungsverhältnisse betrachtet wurden.

In den nun folgenden Abschnitten dieses Themenbereichs wird zunächst in Kapitel 4.2 die Gruppe-Untergruppe-Beziehung zwischen FeUS₃ und MnSbS₂Cl bzw. FeSbS₂Br näher betrachtet. Kapitel 4.3 beschreibt dann kurz die Synthesen und Charakterisierung der verwendeten binären und ternären Edukte. Im Anschluss daran behandelt Kapitel 4.4 die Synthese und Charakterisierung der FeSb_{1-x}Bi_xS₂Br Mischkristallreihe, welche in Kapitel 4.5 noch einmal zusammengefasst wird.

Tab. 4.1: Systematischer Überblick über die orthorhombischen Verbindungen der allgemeinen Zusammensetzung MPnQ₂X des MnSbS₂Cl-Typs und FeUS₃ [46].

Verbindung	Raumgruppe	Zellkonstanten/	Å, °		Formeleinheit pro Zelle <i>Z</i> Zellvolumina <i>V</i> / Å ³	; Literatur
FeUS ₃	Стст	a = 3,795(3)	b = 11,626(5)	c = 8,717(4)	4; 384,60(6)	[45]
FeSbS ₂ Cl	Стст	a = 3,731(8)	b = 12,371(2)	c = 9.897(2)	4; 437,78(1)	[4, 47] *
FeSbSe ₂ Br	Стст	a = 3,903(7)	b = 12,960(2)	c = 9.897(2)	4; 500,57(2)	[4, 47] *
MnSbS ₂ Cl	Pnma	a = 9,535(2)	b = 3.816(8)	c = 12,245(2)	4; 445,53(3)	[48, 49]
$MnBiS_2Cl$	Pnma	a = 9,502(2)	b = 3,8802(8)	c = 12,305(3)	4; 453,7(2)	[49]
α -MnSbSe ₂ Br	Pnma	a = 10,005(2)	b = 3,9720(8)	c = 12,871(3)	4; 511,5(2)	[50] **
β -MnSbSe ₂ Br	Pbam	a = 10,046(2)	b = 25,994(5)	c = 3,9689(8)	4; 1036,4(4)	[50] **
$MnBiSe_2Br$	Pnma	a = 9,995(2)	b = 4.028(8)	c = 12,928(3)	4; 520,4(2)	[50]
CdSbS ₂ Cl	Pnma	a = 9,585(2)	b = 3,9910(8)	c = 12,443(3)	4; 475,9(2)	[46]
CdBiS ₂ Cl	Pnma	a = 9,541(2)	b = 3,9700(8)	c = 12,545(3)	4; 475,2(2)	[46]
CdBiSe ₂ Br	Pnma	a = 10,025(2)	b = 4,1190(8)	c = 13,143(3)	4; 542,7(2)	[46]

^{*} Von den beiden Verbindungen FeSbS₂Cl und FeSbSe₂Br [4, 47] wurden nur die Basisstrukturen in diese Tabelle aufgenommen um die kristallographische Betrachtung zu vereinfachen, da die realen Strukturen inkommensurabel moduliert sind und in der Superraumgruppe *Cmcm*(α00)0ss [4, 51] kristallisieren.

^{**} α-MnSbSe₂Br und β-MnSbSe₂Br sind zwei Modifikationen der gleichen Verbindung [50], wobei β-MnSbSe₂Br die Hochtemperaturvariante darstellt, die bei 600 °C unter Verwendung von Iod als Transportmittel zugänglich ist.

Tab. 4.2: Systematischer Überblick über die monoklinen Verbindungen der allgemeinen Zusammensetzung MPnQ₂X des MnSbSe₂I-Typs mit den Volumina der enthaltenen MQ₆- und MQ₂X₄-Oktaeder.

Verbindung	Raumgruppe	Zellkonstanten/ Å, °		Formeleinheit pro Zelle <i>Z</i> ; Zellvolumina <i>V</i> / Å ³	MQ ₆ -/ MQ ₂ X ₄ - Volumina/ Å ³	Literatur
MnSbS ₂ Br	C2/m	a = 12,669(3)	b = 3,8509(8)	4; 467,5(2)	23,52(2);	[50]
		c = 9,585(2)	$\beta = 91,00(3)$		24,82(2)	
$MnBiS_2Br$	C2/m	a = 12,767(2)	b = 3,9468(4)	4; 482,4(1)	24,189(9);	[52]
		c = 9,574(1)	$\beta = 90,87(2)$		25,32(1)	
$MnSbSe_2I$	C2/m	a = 13,319(3)	b = 4,0359(8)	4; 543,1(2)	27,48(4);	[53]
		c = 10,105(2)	$\beta = 91,27(3)$		29,73(1)	
$MnBiSe_2I$	C2/m	a = 13,428(2)	b = 4,112(1)	4; 559,3(1)	27,86(1);	[54]
		c = 10,130(2)	$\beta = 90,97(2)$		30,07(2)	
FeSbS ₂ Br	C2/m	a = 12,487(3)	b = 3,7868(7)	4; 445,5(2)	22,24(2);	[3, 4]
		c = 9,425(2)	$\beta = 91,48(2)$		23,37(1)	
$FeSb_{0,51}Bi_{0,49}S_2Br$	C2/m	a = 12,488(1)	b = 3,8319(4)	4; 449,6(1)	21,955(9);	d. Arb.
		c = 9,3982(7)	$\beta = 91,371(5)$		23,020(8)	
FeBiS ₂ Br	C2/m	a = 12,497(1)	b = 3,8807(3)	4; 454,4(1)	22,26(1);	[3, d. Arb.]
		c = 9.371(1)	$\beta = 91,253(8)$		23,18(1)	
$CdSbS_2Br$	C2/m	a = 12,938(3)	b = 3,9310(8)	4; 491,3(2)	25,79(5);	[46]
		c = 9,661(2)	$\beta = 91,11(3)$		27,11(5)	
$CdBiS_2Br$	C2/m	a = 12,977(3)	b = 4,0120(8)	4; 498,9(2)	26,1(1);	[46]
		c = 9,584(2)	$\beta = 91,07(3)$		27,3(1)	
CdBiSe ₂ I	C2/m	a = 13,659(3)	b = 4,1920(8)	4; 583,6(2)	30,25(6);	[46]
		c = 10,193(2)	$\beta = 90,88(3)$		32,66(6)	

^{*} alle hier enthaltenen Oktaedervolumina wurden mit dem Programm IVTON [18] berechnet.

4.2 Die Gruppe-Untergruppe-Beziehung zwischen FeUS₃ und MnSbS₂Cl bzw. FeSbS₂Br

Wie bereits von *O. Tougait* [53] erkannt wurde, stellen die Verbindungen mit der allgemeinen Zusammensetzung MPnQ₂X (M: Mn, Fe, Cd; Pn: Sb, Bi; Q: S, Se; X: Cl, Br, I) eine verzerrte und substituierte Variante des FeUS₃ dar [45]. Allerdings bezieht er sich hierbei nur auf die von ihm synthetisierte Verbindung MnSbSe₂I und gibt keine Gruppe-Untergruppe-Beziehung entsprechend des nach *H. Bärnighausen* [27] benannten Stammbaums an. Ein derartiger Symmetrie-Stammbaum ergibt sich, wenn man entsprechend den "International Tables for Crystallography" [28] einen Symmetrieabbau von der Aristotypverbindung ausgehend durchführt, bis man bei der Struktur der niedersymmetrischen Zielverbindung angelangt ist. Hier wird nun ein derartiger Stammbaum zur Verbindung MnSbS₂Cl als Vertreter der orthorhombischen Varianten der MPnQ₂X-Strukturen (1. Fall) und zur Verbindung FeSbS₂Br als Vertreter der monoklinen Varianten der MPnQ₂X-Strukturen (2. Fall) durchgeführt, wobei FeUS₃ als Aristotyp für beide Gruppe-Untergruppe-Beziehungen verwendet wird.

Im ersten Fall findet ein Übergang von der Ausgangsverbindung FeUS₃ in der orthorhombischen Raumgruppe Cmcm ($C2/m2/c2_1/m$, Nr. 63) zur Endverbindung MnSbS₂Cl in der orthorhombischen Raumgruppe Pnma ($P2_1/n2_1/m2_1/a$, Nr. 62) statt. Hierbei erfolgt ein klassengleicher Übergang vom Index 2, bei dem eine Transformation der Zellachsen entsprechend $a, b, c \rightarrow c, a, b$ auftritt. Da dadurch ebenfalls die Symmetrie abnimmt spaltet die durch Schwefel besetzte 8f-Lage in zwei 4c-Lagen im MnSbS₂Cl auf.

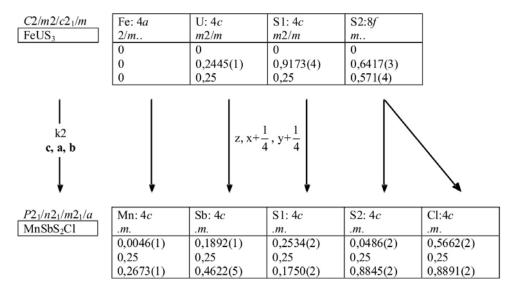


Abb. 4.1: Symmetrie-Stammbaum für die Gruppe-Untergruppe-Beziehung von FeUS₃ zu MnSbS₂Cl nach *H. Bärnighausen* [27]. Die auftretenden Lagen im MnSbS₂Cl wurden der Publikation von *C. Doussier* et al. [48] entnommen.

Im zweiten Fall kristallisiert die Ausgangsverbindung FeUS₃ in der orthorhombischen Raumgruppe Cmcm ($C2/m2/c2_1/m$, Nr. 63) und die Endverbindung FeSbS₂Br in der monoklinen Raumgruppe C2/m (C12/m1, Nr. 12). Dabei erfolgt ein translationsgleicher Übergang vom Index 2, bei dem eine Transformation der Zellachsen entsprechend $a, b, c \rightarrow b$, -a, c auftritt. Da demzufolge auch die Symmetrie abnimmt spaltet sowohl die durch Eisen besetzte 4a-Lage als auch die durch Schwefel besetzte 8f-Lage in jeweils zwei neue Lagen im FeSbS₂Br auf.

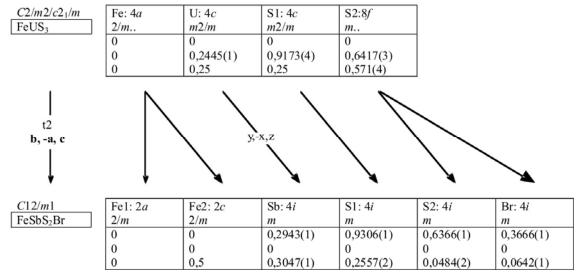


Abb. 4.2: Symmetrie-Stammbaum für die Gruppe-Untergruppe-Beziehung von FeUS₃ zu FeSbS₂Br nach *H. Bärnighausen* [27]. Die im FeSbS₂Br auftretenden Lagen wurden der Dissertation von *M. F. Bräu* [4] entnommen.

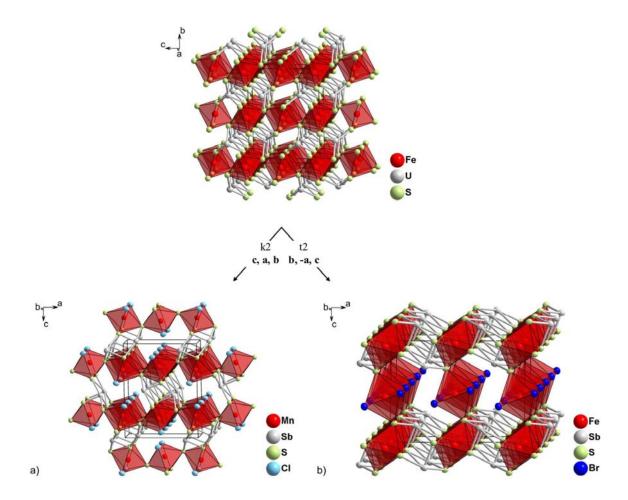


Abb. 4.3: Veranschaulichung der Gruppe-Untergruppe-Beziehung von FeUS₃ [45] zu a) MnSbS₂Cl [48] und b) FeSbS₂Br [4]. Die entsprechenden Übergänge sind zum einen klassengleich und zum anderen translationsgleich [28].

4.3 Synthese und Charakterisierung der Edukte FeS, SbSBr und BiSBr

Zur Synthese der FeSb_{1-x}Bi_xS₂Br Serie wurde das binäre Edukt FeS aus den Elementen sowie die ternären Edukte SbSBr und BiSBr aus den Verbindungen Sb₂S₃, SbBr₃, Bi₂S₃ und BiBr₃ durch die Reaktion eines stöchiometrischen Verhältnisses in evakuierten Quarzampullen erhalten. Dabei erfolgte das Aufschmelzen bei Temperaturen von 300 °C bis 400 °C und das anschließende Tempern bei Temperaturen zwischen 250 °C und 350 °C. Um die dabei erhaltenen Proben auf ihre Phasenreinheit hin zu überprüft und zu indizieren wurden die Pulverdiffraktogramme Nr. A.7.1 bis A.7.3 angefertigt.

Tab. 4.3: Vergleich der erhaltenen Zellkonstanten und Zellvolumina der synthetisierten Edukte mit den jeweiligen Literaturangaben.

Verbindung	Raumgruppe	a/ Å	b/ Å	c/ Å	V/ Å ³	Literatur
FeS	$P6_3/mmc$	3,43(1)		5,79(1)	58,99(1)	[55]
	$P6_3/mmc$	3,44(1)		5,88(1)	60,26(1)	[56]
	$P6_3/mmc$	3,445(3)		5,875(5)	60,4(1)	d. Arb.
SbSBr	Pnma	8,20(1)	3,95(1)	9,70(1)	314,18(1)	[57]
	Pnma	8,212(1)	3,963(1)	9,72(1)	316,33(1)	[58]
	Pnma	8,212(5)	3,963(2)	9,720(5)	316,32(5)	[59]
	Pnma	8,245(2)	3,9674(7)	9,746(2)	318,80(3)	d. Arb.
BiSBr	Pnma	8,02(1)	4,01(1)	9,70(1)	311,95(1)	[57]
	Pnma	8,1666(9)	4,0492(6)	9,8532(9)	325,83(5)	[60]
	Pnma	8,1512(8)	4,0615(3)	9,853(1)	326,194(2)	d. Arb.

4.4 Synthese und Charakterisierung der Mischkristallreihe FeSb_{1-x}Bi_xS₂Br

4.4.1 Synthese der Mischkristallreihe FeSb_{1-x}Bi_xS₂Br

Um den Einfluss der Substitution des Antimons durch Bismut auf die Struktur des FeSbS₂Br zu untersuchen, synthetisierte *A. Pointner* die Verbindungen FeSbS₂Br, FeSb_{0,7}Bi_{0,3}S₂Br, FeSb_{0,7}Bi_{0,3}S₂Br, welche Teil der Mischkristallreihe FeSb_{1-x}Bi_xS₂Br sind und charakterisierte diese anhand von Pulverdiffraktogrammen [3]. Hierbei verwendete er als Edukte die binären Verbindungen FeS, Sb₂S₃, Bi₂S₃, SbBr₃ und BiCl₃, welche im stöchiometrischen Verhältnis in Quarzampullen eingewogen und zur Reaktion gebracht wurden. Nach dem Aufschmelzen erfolgte ein zweiwöchiges Tempern bei 500 °C. Von der Verbindung FeSbS₂Br bestimmte *M. F. Bräu* im Anschluss daran die Kristallstruktur [4]. Im Rahmen dieser Arbeit wurde noch die Verbindung FeSb_{0,51}Bi_{0,49}S₂Br hergestellt und durch Pulverdiffraktommetrie und Kristallstrukturanalyse charakterisiert, sowie die Kristallstruktur von FeBiS₂Br ermittelt. Die Synthese von FeSb_{0,51}Bi_{0,49}S₂Br erfolgte hierbei aus den Edukten FeS, SbSBr und BiSBr, die im stöchiometrischen Verhältnis in Quarzampullen eingewogen und bei 500 °C zwei Wochen getempert wurden.

4.4.2 Charakterisierung der Mischkristallreihe $FeSb_{1-x}Bi_xS_2Br$ mittels Pulverdiffraktometrie

Durch den Vergleich und die Indizierung der von den erhaltenen Proben gemessenen Pulverdiffraktogramme Nr. A.7.4 bis A.7.8 wurde überprüft, ob die Mischkristallreihe FeSb_{1x}Bi_xS₂Br eine lineare Zunahme der Zellvolumina nach *L. Vegard* [43] aufweist. Dabei konnten keine Nebenprodukte gefunden werden. Die Abbildung 4.4 gibt alle gemessenen Pulverdiffraktogramme entsprechend ihrer Probenzusammensetzung gestaffelt wieder.

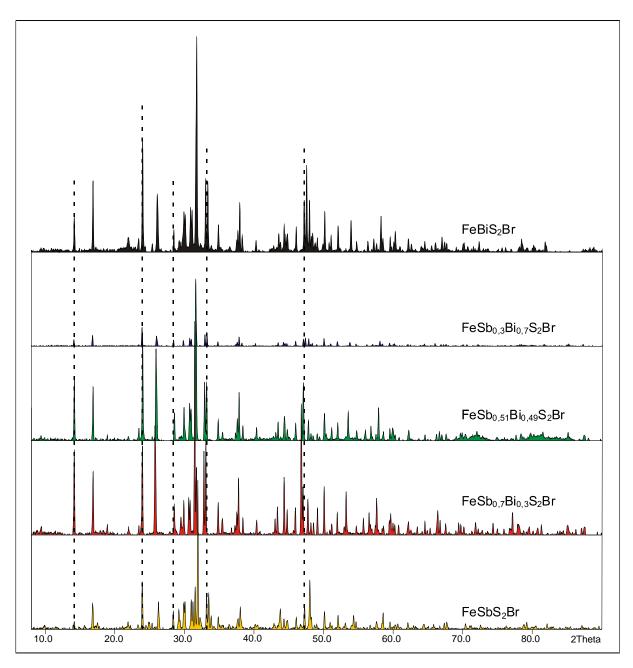


Abb. 4.4: Vergleich der gemessenen Pulverdiffraktogramme. Die gestrichelten Linien geben die Positionen der 200, 202, 003, 311 und 020 Reflexe von FeSbS₂Br an.

Tab. 4.4: Die Zellkonstanten und Zellvolumina der Mischkristallreihe FeSb_{1-x}Bi_xS₂Br

Verbindung	a/ Å	b/ Å	c/Å	β/°	$V/\text{Å}^3$
FeSbS ₂ Br	12,487(3)	3,7868(7)	9,425(2)	91,48(2)	445,5(2)
$FeSb_{0,7}Bi_{0,3}S_2Br$	12,498(2)	3,8246(5)	9,403(1)	91,381(6)	449,3(1)
$FeSb_{0,51}Bi_{0,49}S_2Br$	12,488(1)	3,8320(4)	9,3984(7)	91,371(5)	449,6(1)
$FeSb_{0,3}Bi_{0,7}S_2Br$	12,492(1)	3,8571(5)	9,3786(9)	91,27(1)	451,79(7)
FeBiS ₂ Br	12,497(1)	3,8807(3)	9,371(1)	91,253(8)	454,4(1)

Durch die Auftragung der in dieser Tabelle enthaltenen Zellkonstanten und Zellvolumina mit ihren Fehlern erhält man die in folgender Abbildungen 4.5 dargestellten Verläufe. Daran ist vor allem zu erkennen, dass die Zellkonstanten a und b mit steigendem Bismutgehalt zunehmen und die Zellkonstante c sowie der monokline Winkel β abnehmen. Außerdem nehmen die Zellvolumina ebenfalls leicht zu, wobei der nahezu lineare Verlauf darauf hinweist, dass die Regel von L. Vegard [43] erfüllt wird.

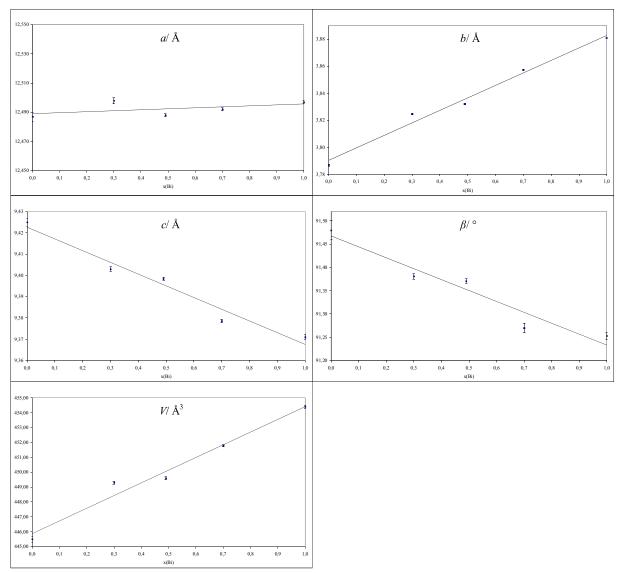


Abb. 4.5: Auftragung der verfeinerten Zellkonstanten a/ Å, b/ Å, c/ Å und $\beta/$ ° sowie der Zellvolumina V/ Å³ der Mischkristallreihe FeSb_{1-x}Bi_xS₂Br in Abhängigkeit vom Bismutgehalt (x). Die Ausgleichsgeraden wurden durch lineare Regression bestimmt.

Da diese Mischkristallreihe nur aus isotypen Verbindungen besteht erfolgt in ihrem Verlauf keine Entmischung, weshalb auch keine Mischungslücke auftritt.

Als Abschluss dieser Auswertungen erfolgt in der folgenden Abbildung 4.6 ein Vergleich der Pulverdiffraktogramme von FeSbS₂Br, FeSb_{0,51}Bi_{0,49}S₂Br und FeBiS₂Br mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

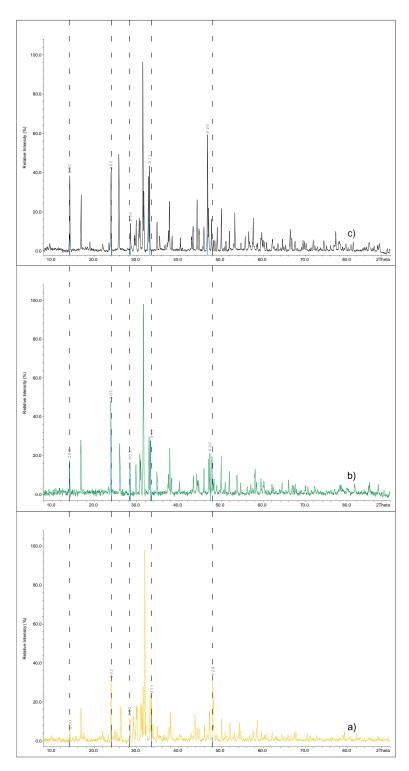


Abb. 4.6: Vergleichende Darstellung der Pulverdiffraktogramme von a) FeSbS₂Br, b) FeSb_{0,51}Bi_{0,49}S₂Br und c) FeBiS₂Br. Die gestrichelten Linien sollen die Verschiebungen der blau gefärbten Reflexe 200, 202, 003, 311 und 020 veranschaulichen.

Für die genauere Untersuchung der Strukturchemie der FeSb_{1-x}Bi_xS₂Br Mischkristallreihe dienten Einkristalle, welche aus den synthetisierten Proben präpariert und auf einem entsprechenden Diffraktometer vermessen wurden. Die Resultate der auf diesen Messungen beruhenden Strukturrechnungen werden in den folgenden Abschnitten dargestellt und zusammengefasst.

4.4.3.1 Die Verbindung FeSbS₂Br

In dem von A. Pointner [3] und M. F. Bräu [4] synthetisierten und charakterisierten FeSbS₂Br besetzten Eisen und Schwefel zwei unabhängige Lagen und Antimon genau wie Brom eine unabhängige Lage. Hierbei sitzt das Eisen im Zentrum zweier verschiedener Oktaeder. Die FeS_6 -Oktaeder mit Fe1 im Zentrum weisen Fe-S-Bindungen mit einer Länge von d(Fe-S) =2,500(2) Å und 2,596(6) Å auf, wodurch sich ein mit IVTON [18] berechnetes Volumen von 22,24(2) Å³ ergibt. Diese Oktaeder sind über gemeinsame Schwefelkanten zu Strängen entlang b miteinander verknüpft, welche ihrerseits durch SbS₅-Pyramiden in a-Richtung verbunden sind, sodass sich Schichten parallel zur ab-Ebene ergeben. Fe2 befindet sich im Zentrum der FeS₂Br₄-Oktaeder, welche ein mit IVTON [18] berechnetes Volumen von 23,37(1) $Å^3$ aufweisen. Diese Oktaeder bilden ebenfalls Stränge entlang b, welche durch gemeinsame Bromkanten zustande kommen. Hierin ist Brom mit d(Fe-Br) = 2,620(8) Å und Schwefel mit d(Fe-S) = 2.558(2) Å vom Eisen entfernt. Beide Oktaedertypen sind über gemeinsame Schwefelecken miteinander verknüpft, wodurch sich eine ABAB Stapelung entlang c ergibt. Die SbS₅-Pyramiden, in denen Antimon eine 1+2+2 Koordination durch Schwefel erfährt, weisen Bindungslängen von d(Sb-S) = 2,494(2) Å bis 3,058(2) Å auf, wobei die Pyramidenspitzen mit nur 2,494(2) Å den kürzesten Abstand zum Antimon aufweisen.

Die beiden im Rahmen dieser Arbeit hergestellten Verbindungen FeSb_{0,51}Bi_{0,49}S₂Br und FeBiS₂Br weisen entsprechend ihrer kristallographischen Daten A.4.1 und A.4.2 äquivalente Strukturen auf, welche aufgrund ihrer Isotypie zu FeSbS₂Br aber nicht explizit erläutert werden. Diese Strukturen dienen aber als Grundlage des strukturchemischen Vergleichs im folgenden Kapitel 4.4.4.

4.4.4 Ein strukturchemischer Vergleich der untersuchten Verbindungen

4.4.4.1 Die strukturchemische Verwandtschaft zwischen FeSbS₂Br, FeSb_{0.51}Bi_{0.49}S₂Br und FeBiS₂Br

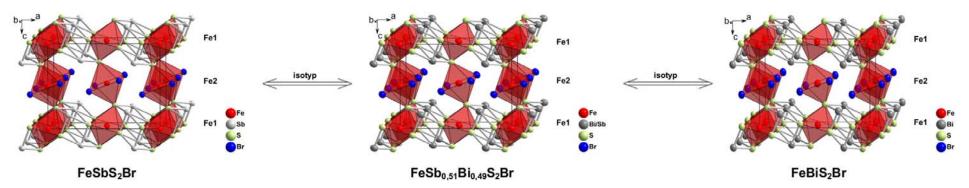


Abb.4.7: Die Kristallstrukturen von FeSbS₂Br, FeSb_{0,51}Bi_{0,49}S₂Br und FeBiS₂Br im Vergleich. Deutlich erkennbar ist hierbei die Isotypie dieser drei Verbindungen. Die dargestellten Ellipsoide repräsentieren eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von 90 %.

4.4.4.2 Die Bindungsverhältnisse und Volumina in den FeS₂- und FeS₂Br₄-Oktaedern

Die Volumina der in diesen Verbindungen enthaltenen FeS₆- und FeS₂Br₄-Oktaeder sind verschieden groß, da das Bromidion, mit einem Radius von 1,96 Å [44], etwas größer ist als das Sulfidion, mit einem Radius von 1,84 Å [44]. Insgesamt bleibt ihr Volumen über die drei Verbindungen FeSbS₂Br, FeSb_{0,51}Bi_{0,49}S₂Br und FeBiS₂Br betrachtet aber nahezu konstant. Das Volumen der FeS₆-Oktaeder variiert von $V(\text{Fe1S}_6) = 22,24(2)$ ų im FeSbS₂Br über $V(\text{Fe1S}_6) = 21,955(9)$ ų im FeSb_{0,51}Bi_{0,49}S₂Br bis zu $V(\text{Fe1S}_6) = 22,26(1)$ ų im FeBiS₂Br leicht, genau so wie das Volumen der FeS₂Br₄-Oktaeder, welches ausgehend von $V(\text{Fe2S}_2\text{Br}_4) = 23,37(1)$ ų im FeSbS₂Br über $V(\text{Fe2S}_2\text{Br}_4) = 23,020(8)$ ų im FeSb_{0,51}Bi_{0,49}S₂Br bis auf $V(\text{Fe2S}_2\text{Br}_4) = 23,18(1)$ ų im FeBiS₂Br etwas schwankt.

Table 4.5: Die Bindungslängen, Volumina und Volumendifferenzen der in den Verbindungen FeSbS₂Br, FeSb_{0.51}Bi_{0.49}S₂Br und FeBiS₂Br enthaltenen FeS₆- und FeS₂Br₄-Oktaeder.

	FeSbS ₂ Br	•	FeSb _{0,51} Bi ₀	$_{,49}$ S ₂ Br	FeBiS ₂ Br		
	Fe1S ₆	Fe2S ₂ Br ₄	Fe1S ₆	Fe2S ₂ Br ₄	Fe1S ₆	Fe2S ₂ Br ₄	
d(Fe-S/Br)/Å äquatorial	2,596(6)	2,620(8)	2,591(2)	2,620(2)	2,605(2)	2,642(3)	
d(Fe-S)/Å axial	2,500(2)	2,558(2)	2,479(5)	2,522(5)	2,478(6)	2,502(6)	
$V/\text{\AA}^3$	22,24(2)	23,37(1)	22,26(1)	23,020(8)	22,26(1)	23,18(1)	
$\Delta V / \text{Å}^3$		1,13	C	,76	0	,92	

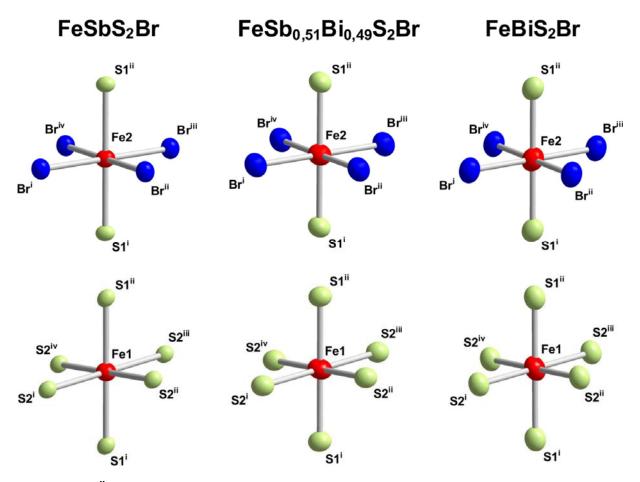


Abb. 4.8: Überblick über die in den Verbindungen FeSbS₂Br, FeSb_{0,51}Bi_{0,49}S₂Br und FeBiS₂Br enthaltenen FeS₆- und FeS₂Br₄-Oktaeder. Die dargestellten Ellipsoide repräsentieren eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von 90 %.

4.4.4.3 Die Bindungsverhältnisse in den Bi/SbS₅-Pyramiden

Da in der FeSb_{1-x}Bi_xS₂Br Mischkristallreihe eine Substitution der Antimonlage durch Bismut erfolgt vergrößern sich die Bindungslängen in den enthaltenen Bi/SbS₅-Pyramiden. Dies sieht man an den Bindungen zwischen den Schweratomen und den Pyramidenspitzen besonders deutlich. Hier sind die entsprechenden Abstände im FeSbS₂Br mit d(Sb-S) = 2,494(2) Å noch recht kurz und nehmen über d(Bi/Sb-S) = 2,537(5) Å im FeSb_{0,51}Bi_{0,49}S₂Br bis auf d(Bi-S) = 2,582(7) Å im FeBiS₂Br linear zu. Somit kommt es bei diesen Bindungen zu einer Verlängerung von 0,088 Å.

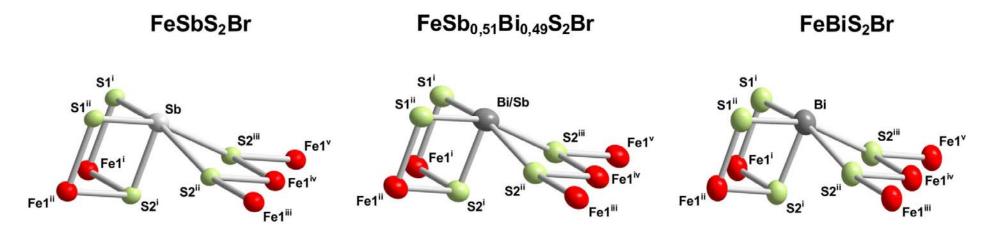


Abb. 4.9: Die Bindungsverhältnisse in den Bi/SbS₅-Pyramiden der Verbindungen FeSbS₂Br, FeSb_{0,51}Bi_{0,49}S₂Br und FeBiS₂Br. Die dargestellten Ellipsoide repräsentieren eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von 90%.

Die dargestellten Abstände des FeSbS₂Br betragen in Å: $d(Sb-S1^i) = 2,596(6)$, $d(Sb-S1^{ii}) = 2,596(6)$, $d(Sb-S2^{ii}) = 2,494(2)$, $d(Sb-S2^{ii}) = 3,058(2)$, $d(Sb-S2^{iii}) = 3,058(2)$.

Die dargestellten Abstände des FeSb_{0,51}Bi_{0,49}S₂Br betragen in Å: $d(Bi/Sb-S1^i) = 2,635(2)$, $d(Bi/Sb-S1^{ii}) = 2,635(2)$, $d(Bi/Sb-S2^{ii}) = 2,635(2)$, $d(Bi/Sb-S2^{ii}) = 3,042(5)$, $d(Bi/Sb-S2^{ii}) = 3,042(5)$, $d(Bi/Sb-S2^{ii}) = 3,042(5)$.

Die dargestellten Abstände des FeBiS₂Br betragen in Å: $d(Bi-S1^i) = 2,679(2)$, $d(Bi-S1^{ii}) = 2,679(2)$, $d(Bi-S2^{ii}) = 2,582(7)$, $d(Bi-S2^{ii}) = 3,050(7)$, $d(Bi-S2^{iii}) = 3,050(7)$.

4.5 Zusammenfassung

In der Mischkristallreihe FeSb_{1-x}Bi_xS₂Br findet ausgehend von FeSbS₂Br eine kontinuierliche Veränderung der Zellkonstanten statt, wobei a und b länger werden und β sowie c abnehmen. Daraus folgt eine nahezu lineare Zunahme der Zellvolumina gemäß der Regel von L. Vegard [43], ohne das eine Mischungslücke oder Zersetzung auftritt.

Ausgehend vom FeUS₃ [45] lässt sich für das FeSbS₂Br, genauso wie für die anderen Verbindungen mit der allgemeinen Zusammensetzung MPnQ₂X, eine Gruppe-Untergruppe Beziehung herleiten, die mit Hilfe eines Bärnighausen-Stammbaums [27] veranschaulicht werden kann. Hierin wird der Symmetrieabbau ausgehend von der orthorhombischen Aristotypverbindung bis zur monoklinen Zielverbindung aufgezeigt.

Die Volumina der in den kristallographisch untersuchten Verbindungen FeSbS₂Br, FeSb_{0,51}Bi_{0,49}S₂Br und FeBiS₂Br enthaltenen FeS₂Br₄-Oktaeder sind etwas größer als die der ebenfalls enthaltenen FeS₆-Oktaeder, wobei die Volumina beider Polyeder nur geringfügig variieren.

In den Bi/SbS₅-Pyramiden nehmen die enthaltenen Bindungslängen durch die Substitution von Antimon durch Bismut erkennbar zu, wobei vor allem die Abstände der Schweratome zu den Pyramidenspitzen von 2,494(2) Å im FeSbS₂Br über 2,537(5) Å im FeSb_{0,51}Bi_{0,49}S₂Br bis 2,582(7) Å im FeBiS₂Br wachsen.

V Quecksilber-Chalkogenometallate und Quecksilber-Chalkogenidhalogenide

5.1 Motivation

Metallisches Quecksilber ist eine bei Raumtemperatur silbrig glänzende Substanz mit einer für Flüssigkeiten außergewöhnlich hohen Dichte von 13,534 g/cm⁻³, die bei 357 °C siedet und bei -33,86 °C erstarrt. Im flüssigen Quecksilber weisen die Atome einen Abstand von d(Hg-Hg) = 3,10(1) Å zueinander auf. Flüssiges Quecksilber verfügt bei Raumtemperatur über einen Dampfdruck von 0,0013 bar, weshalb eine mit Quecksilberdampf gesättigte Luft 15 mg Quecksilber pro m³ beinhaltet [61, 62].

Bereits 1922 gelang *L. W. McKeehan* und *P. P. Cioffi* [63] die Strukturbestimmung des unterhalb von -33,86 °C auftretenden α -Hg, das in der rhomboedrischen Raumgruppe $R\overline{3}m$ (Nr. 166) mit den Zellkonstanten a=3,458(1) Å, b=6,684(1) Å und Z=3 in einem Volumen von V=69,22(1) ų kristallisiert [64]. Hierin ist jedes Quecksilber von sechs nahen Hg-Atomen im Abstand von d(Hg-Hg)=2,992(1) Å und von sechs fernen Hg-Atomen im Abstand von d(Hg-Hg)=3,458(1) Å umgeben, sodass sich zunächst ein trigonales Antiprisma ergibt, welches zu einem Kuboktaeder erweitert wird.

Unterhalb von -194 °C wandelt sich dieses α -Hg in β -Hg um, welches mit den Zellkonstanten a=3,995(4) Å, c=2,825(3) Å und Z=2 in der tetragonalen Raumgruppe I4/mmm (Nr. 139) kristallisiert und dabei ein Volumen von V=45,09(8) ų einnimmt [65]. In dieser innenzentrierten Modifikation liegen Quecksilberstränge vor, die sich in einem Abstand von 3,158(2) Å entlang c durch den Kristall ziehen. Dabei ist die Hg-Hg-Bindung in diesen Strängen d(Hg-Hg)=2,825(3) Å lang. Da jedes Hg-Atom acht weitere Hg-Atome im Abstand von d(Hg-Hg)=3,158(2) Å um sich hat ergibt sich eine Koordinationssphäre in Form eines zweifach überkappten Würfels.

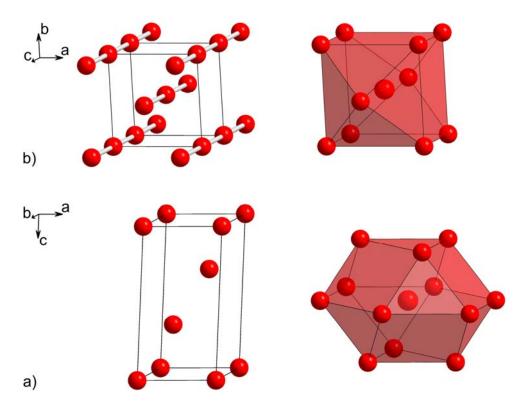


Abb. 5.1: Ausschnitte aus den Elementarzellen des a) α -Hg mit einem Kuboktaeder [63, 64] und des b) β -Hg mit einem zweifach überkappten Würfel als Umgebung eines zentralen Quecksilberatoms [65].

Da Quecksilber mit nahezu jedem anderen Element des Periodensystems reagieren kann und seine Tendenz zur Ausbildung von Hg-Hg-Bindungen stark ausgeprägt ist gehört die Strukturchemie des Quecksilbers zu den umfangreichsten überhaupt. Hierbei tritt es überwiegend in den Oxidationsstufen +1, mit Hg $_2^{2+}$ -Hanteln, und +2 sowohl ionischen wie auch kovalent gebunden in seinen Verbindungen auf.

Entsprechend den Betrachtungen von *D. Grdenic* [66] unterscheidet man bei den Quecksilberverbindungen zwischen einer charakteristischen und einer effektiven Koordinationssphäre, wobei erstere linear, trigonal oder tetraedrisch ist und durch die nächsten Nachbarn erzeugt wird und letztere meist tetraedrisch oder oktaedrisch ist und durch die Berücksichtigung zusätzlicher Liganden in größerem Abstand zustande kommt.

Alle Quecksilber(I)-Verbindungen haben eine L-Hg-Hg-L Struktur mit einer charakteristischen Koordinationszahl von zwei, die sowohl in organischen als auch anorganischen Verbindungen auftritt. So gibt es eine Vielzahl von Verbindungen in denen die Hg²⁺₂-Hantel mit dreibindigem oder vierbindigem Stickstoff, Phosphor, Chalkogenen oder Halogenen verknüpft sind [61, 62, 66]. Auch Bindungen des einwertigen Quecksilbers zu anderen Metallen wie z. B. Arsen, Antimon, Zinn und Cobalt sind bekannt [62, 67, 68].

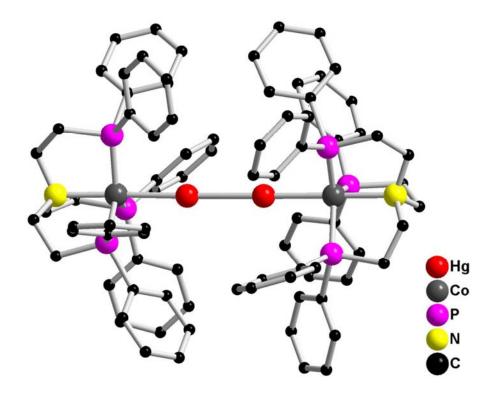


Abb. 5.2: In der Struktur des [N(CH₂CH₂PPh₂)₃]₂Co₂(μ-Hg₂) sind zwei metallorganische Liganden über Cobaltatome an eine zentrale Hg ²⁺₂-Hantel gebunden [68].

HgF₂, welches in der Calciumfluoridstruktur auskristallisiert, ist streng genommen das einzige Salz des Quecksilbers überhaupt, wohingegen in allen anderen Verbindungen das Quecksilber kovalente Bindungen ausbildet [61, 69]. In den bekanntesten Quecksilber(II)-Verbindungen tritt das Quecksilber mit Stickstoff, Chalkogenen oder Halogenen in Kontakt. Außerdem fällt die hohe Affinität des zweiwertigen Quecksilbers zu Schwefel auf, genauso wie seine Fähigkeit auch mit Kohlenstoff kovalente Bindungen auszubilden [61, 62].

Tritt elementares oder zweiwertiges Quecksilber in Kontakt mit anderen Metallen, so kommt es in den meisten Fällen zur Bildung von Amalgamen, welche flüssige oder feste und leicht verformbare Legierungen des Metalls mit Quecksilber darstellen [61]. Bei diesen meist exothermen Prozessen kommt es zu deutlichen Volumenreduktionen der verwendeten Edukte, wie man z. B. bei der Bildung des CsHg aus Cäsium und Quecksilber sieht, in dessen Verlauf beide Metalle eine Volumenkontraktion um 29 % erfahren [70]. Ein merklicher Unterschied der Quecksilberlegierungen zu vielen anderen intermetallischen Verbindungen besteht darin, dass hier oft keine großen Phasenbreiten wie z. B. bei Kupferlegierungen auftreten, sondern quasi diskrete Verbindungen mit einem genauen stöchiometrischen Verhältnis gebildet werden. So enthält das Na-Hg-Phasendiagramm die Verbindungen Na₃Hg, Na₈Hg₃, Na₃Hg₂,

NaHg, NaHg₂ und NaHg₄. Dieses Verhalten beruht natürlich auch auf der starken Tendenz des Quecksilbers zur Ausbildung von Hg-Hg-Bindungen welches dazu führt, dass in diesen Legierungen Hg₄- und Hg₈-Cluster enthalten sind [70, 71].

Weitere Quecksilbercluster finden sich in den Zintl-Phasen des Quecksilbers, in denen man z. B. auch Stränge von eckenverknüpften Hg₈-Würfeln wie im K₂Hg₇, Hg₁₂-Ikosaeder wie im NaK₂₉Hg₄₈ oder Hg₃₂-Käfige wie im Mg(NH₃)₆Hg₂₂ finden kann [61, 72-74].

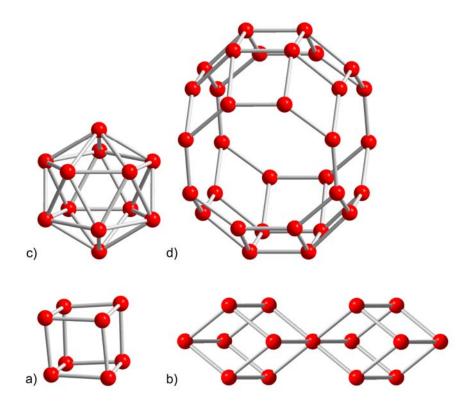


Abb. 5.3: Ausschnitte aus den Strukturen des a) Rb₁₆Hg₁₈ [71] mit Hg₈-Käfigen, des b) K₂Hg₇ [72] mit Strängen aus eckenverknüpften Hg₈-Würfeln, des c) NaK₂₉Hg₄₈ [73] mit Hg₁₂-Ikosaedern und des d) Mg(NH₃)₆Hg₂₂ [74] mit Hg₃₂-Käfigen.

Die Fähigkeit des Quecksilbers Hg-Hg-Bindungen zu knüpfen findet man nicht nur in diesen Quecksilberclustern und in den Quecksilber(I)-Verbindungen, sondern auch in einer Reihe anderer Substanzen in denen Quecksilberstränge ähnlich denen im β -Hg vorliegen. Diese sind entweder in Hg $_3^{2+}$ - bzw. Hg $_4^{2+}$ -Fragmente zerstückelt, oder verlaufen als Band aus fehlgeordneten und unterbesetzten Hg-Positionen durch den gesamten Kristall und bewirken so eine eindimensionale metallische Leitfähigkeit. Beispiele hierfür sind die Verbindungen Hg $_3$ [AlCl $_4$] $_2$ [75], Hg $_3$ [AsF $_6$] $_2$ [76], Hg $_3$ [TaF $_5$] $_2$ SO $_4$ [77] und Hg $_3$ [NdF $_5$] $_2$ SO $_4$ [77] mit Hg $_3^{2+}$ -Einheiten, Hg $_4$ [AsF $_6$] $_2$ [78] und Hg $_4$ [Ta $_2$ F $_{11}$] $_2$ [77] mit Hg $_4^{2+}$ -Strängen sowie das entsprechend

seiner Farbe, als "Alchemisten-Gold" bezeichnete $Hg_{2,86}[AsF_6]$ [79] welches $_{\infty}^{-1}Hg$ -Bänder aus fehlgeordneten und unterbesetzten Hg-Lagen beinhaltet.

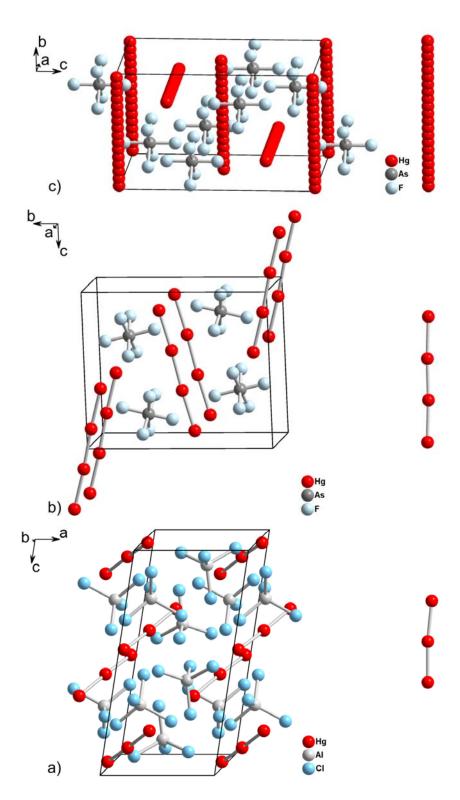


Abb. 5.4: Ausschnitte aus den Elementarzellen des a) $Hg_3[AlCl_4]_2$ mit Hg_3^{2+} -Einheiten [75], b) $Hg_4[AsF_6]_2$ mit Hg_4^{2+} -Strängen [78] und c) $Hg_{2,86}[AsF_6]$ mit $_{\infty}^{1}Hg$ -Bändern aus fehlgeordneten und unterbesetzten Hg-Lagen [79].

Die im Rahmen dieser Arbeit synthetisierten und untersuchten Verbindungen sollen dazu dienen die Strukturchemie des Quecksilbers mit den Chalkogenen Schwefel, Selen und Tellur zu erweitern. Dazu wurden die Verbindungen HgBi₂S₄, Hg_{0,5}Bi₂S₃Cl, Hg₄BiS₂Cl₅, Hg₄BiSe₂Cl₅ und Hg₃Bi₂Te₂Cl₈ hergestellt und durch Pulverdiffraktometrie, Einkristallstrukturananlyse und UV/VIS- sowie Raman-Spektroskopie untersucht. Die Verifizierung einiger dabei gewonnener Erkenntnisse erfolgte an Hand von Bandstruktur- und DOS-Rechnungen.

In den nun folgenden Abschnitten dieses Themenbereichs werden zunächst in Kapitel 5.2 die bei den Synthesen verwendeten binären Quecksilberverbindungen charakterisiert. Im Anschluss daran erfolgt in den Kapiteln 5.3 bis 5.7 die Diskussion der im Rahmen dieser Arbeit dargestellten und näher betrachteten Verbindungen, die im Kapitel 5.8 noch einmal zusammengefasst wird.

5.2 Charakterisierung der Edukte HgS, HgSe, HgTe, HgCl $_2$ und Hg $_2$ Cl $_2$

Die verwendeten binären Edukte HgS, HgSe, HgTe, HgCl₂ und Hg₂Cl₂ wurden käuflich erworben. Die Pulverdiffraktogramme Nr. A.8.1 bis A.8.5 dienten zur Überprüfung ihrer Phasenreinheit und Indizierung. Die Synthese und Charakterisierung der ebenfalls verwendeten Edukte Bi₂S₃ und Bi₂Se₃ wird in Kapitel 3.2 beschrieben.

Tab. 5.1: Vergleich der erhaltenen Zellkonstanten und Zellvolumina der synthetisierten Edukte mit den jeweiligen Literaturangaben.

Varhinduna	Daymamınıa	a/ Å	b/ Å	c/ Å	V/ Å ³	Litaratur
Verbindung	Raumgruppe		D/ A			Literatur
HgS	$P3_{1}2$	4,16(1)		9,54(1)	142,98(1)	[80]
	$P3_{1}2$	4,146(1)		9,497(1)	141,36(1)	[81]
	$P3_{1}2$	4,145(2)		9,496(2)	141,2(2)	[82]
	$P3_{1}2$	4,1489(2)		9,4947(5)	141,54(2)	[83]
	$P3_{1}2$	4,1463(4)		9,4902(8)	141,30(1)	d. Arb.
HgSe	$F\overline{4}3m$	6,05(1)			221,45(1)	[84]
	$F\overline{4}3m$	6,083(1)			225,09(1)	[85]
	$F\overline{4}3m$	6,0850(2)			225,311(8)	d. Arb.
НgТе	$F\overline{4}3m$	6,43(1)			265,85(1)	[84]
	$F\overline{4}3m$	6,463(1)			269,96(1)	[85]
	$F\overline{4}3m$	6,38(1)			259,69(1)	[86]
	$F\overline{4}3m$	6,4583(2)			269,372(2)	d. Arb.
HgCl ₂	Pnma	12,667(1)	5,936(1)	4,307(1)	322,85(1)	[87]
	Pnma	12,735(5)	5,963(5)	4,325(5)	328,44(1)	[88]
	Pnma	12,765(6)	5,972(3)	4,330(2)	330,09(4)	[89]
	Pnma	12,755(2)	5,9728(7)	4,3293(6)	329,82(8)	d. Arb.
Hg ₂ Cl ₂	I4/mmm	4,47(1)		10,89(1)	217,59(1)	[90]
-	I4/mmm	4,4795(5)		10,9054(9)	218,83(8)	[91]
	I4/mmm	4,4842(8)		10,912(2)	219,42(3)	d. Årb.

5.3 Synthese und Charakterisierung von HgBi₂S₄

5.3.1 Synthese von HgBi₂S₄

Die Synthese von HgBi₂S₄ erfolgte entsprechen der Anleitung von *W. S. Brower* et al. [5] aus HgS und Bi₂S₃. Ein stöchiometrisches Verhältnis dieser Edukte wurde dafür in einem Achatmörser verrieben und in Quarzampullen überführt, die nach ihrer Evakuierung abgeschmolzen wurden. Nach einer zweiwöchigen Reaktion bei 650 °C entstand ein graues feinkörniges Pulver mit einigen grauen Nadeln.

5.3.2 Charakterisierung mittels Pulverdiffraktometrie

Zur Analyse der erhaltenen Proben wurde ein Pulverdiffraktogramm angefertigt und mit einem aus Einkristalldaten [6] berechneten Pulverdiffraktogramm verglichen.

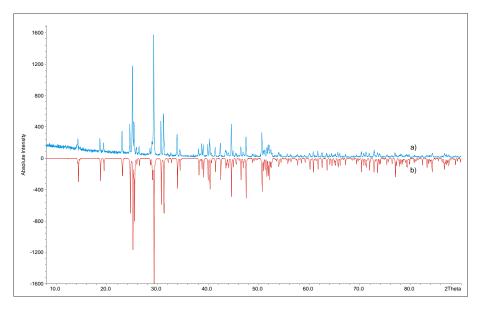


Abb. 5.5: Vergleich eines gemessenen Pulverdiffraktogramms von HgBi₂S₄ a) mit einem aus Einkristalldaten [6] berechneten b).

Die Indizierung des aufgenommenen Pulverdiffraktogramms ergibt eine monokline Elementarzelle mit den in der folgenden Tabelle aufgeführten Zellkonstanten. Diese stimmen sehr gut mit den Literaturangaben [6] überein.

Tab. 5.2: Vergleich der Zellkonstanten und Zellvolumina von HgBi₂S₄ aus [6] mit den in dieser Arbeit ermittelten.

a/ Å	b/ Å	c/ Å	β/ °	V / $Å^3$	Literatur
14,17(1)	4,06(1)	13,99(1)	118,27(1)	708,85(4)	[6]
14,168(3)	4,0530(7)	13,972(2)	118,26(1)	706,7(3)	d. Arb.

5.3.3 Die Kristallstruktur von HgBi₂S₄

Das von W. S. Brower et al. [5] erstmals synthetisierte und von W. G. Mumme und J. A. Watts [6] charakterisierte HgBi₂S₄ kristallisiert in der monoklinen Raumgruppe C2/m. Es verfügt über eine Struktur mit zwei unabhängigen Quecksilber- und Bismut- sowie vier unabhängigen Schwefel-Lagen, was auch aus den kristallographischen Daten A.5.1 hervorgeht. Die darin enthaltenen Schichten sind parallel zur ab-Ebene im Abstand von 1,93(1) Å angeordnet. Sie bestehen aus HgS₆-Oktaedern, die entlang b über gemeinsame Kanten zu Strängen verknüpft sind, die durch BiS₅-Pyramiden miteinander verbunden werden. Dabei betragen die Bindungslängen in den Hg1S₆-Oktaedern d(Hg-S) = 2,370(3) Å und 3,130(7) Å sowie d(Hg-S) = 2,370(3)S) = 2,36(2) Å und 3,159(6) Å in den Hg2S₆-Oktaedern. Demzufolge ergibt sich ein mit IVTON [18] berechnetes Volumen von 31,6(6) Å³ für die Hg1S₆-Oktaeder sowie ein Volumen von 33,0(7) Å³ für die Hg2S₆-Oktaeder. Die Bindungslängen in den BiS₅-Pyramiden liegen zwischen d(Bi-S) = 2,63(2) Å und 2,863(4) Å für die Bi1S₅-Pyramiden und zwischen d(Bi-S) = 2.586(6) Å und 2.862(8) Å in den $Bi2S_5$ -Pyramiden. Bei einer Vergrößerung der Koordinationssphäre des Bil gelangt man zu einer 3+2+1 Umgebung entsprechend eines verzerrten und gestreckten Bi1S₆-Oktaeders mit einem maximalen Abstand von d(Bi-S) =3,071(3) Å. Für Bi2 erhält man bei dieser Betrachtung eine 3+2+2 Umgebung in Gestallt eines BiS₇-Polyeders mit einem maximalen Abstand von d(Bi-S) = 3.376(3) Å. Die in diesen Polvedern enthaltenen weitesten Bi-S-Abstände bestehen zwischen den Schichten.

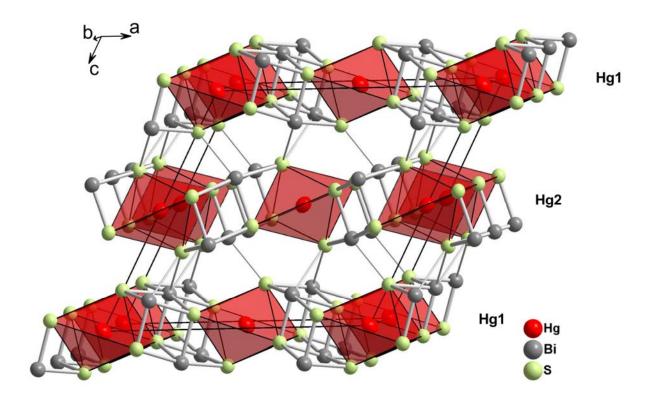


Abb. 5.6: Die Elementarzelle von HgBi₂S₄ entlang *b*. Charakteristisch ist der schichtartige Aufbau aus HgS₆-Oktaedern und BiS₅-Pyramiden. Die dargestellten Ellipsoide repräsentieren eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von 90%.

Table 5.3: Die Bindungslängen, Volumina und Volumendifferenzen der im HgBi₂S₄ enthaltenen HgS₆-Oktaeder.

	${ m HgBi_2S_4}$				
	Hg1	Hg2			
d(Hg-S)/Å äquatorial	3,130(7)	3,159(6)			
$d(Hg-S)/A$ axial V/A^3	2,370(3)	2,358(2)			
$V/\text{Å}^3$	31,6(6)	33,0(7)			
$\Delta V/\text{Å}^3$		1,4			

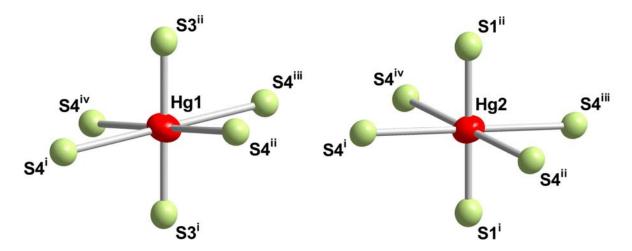


Abb. 5.7: Überblick über die im HgBi₂S₄ enthaltenen HgS₆-Oktaeder. Die dargestellten Ellipsoide repräsentieren eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von 90%.

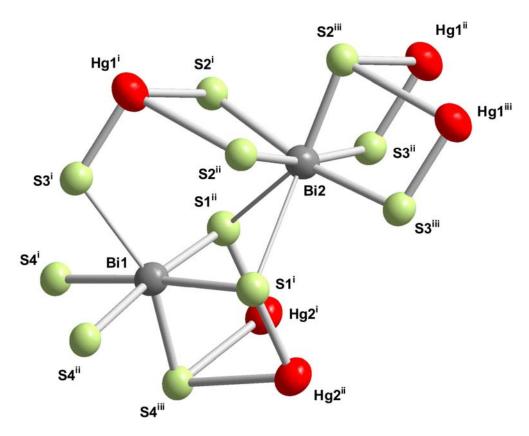


Abb. 5.8: Die Bindungsverhältnisse in den BiS₆-Oktaedern und BiS₇-Polyedern des HgBi₂S₄. Die Bi-S-Abstände zwischen den Schichten sind dünner gezeichnet. Die verwendeten Ellipsoide repräsentieren eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von 90%.

Die dargestellten Abstände des HgBi₂S₄ betragen in Å: $d(Bi1-S1^i) = 2,863(4)$, $d(Bi1-S1^{ii}) = 2,863(4)$, $d(Bi1-S3^i) = 3,071(3)$, $d(Bi1-S4^i) = 2,818(4)$, $d(Bi1-S4^{ii}) = 2,818(4)$, $d(Bi1-S4^{ii}) = 2,818(4)$, $d(Bi1-S4^{iii}) = 2,818(4)$, $d(Bi2-S1^{ii}) = 3,376(3)$, $d(Bi2-S1^{ii}) = 3,376(3)$, $d(Bi2-S2^{ii}) = 2,862(8)$, $d(Bi2-S2^{iii}) = 2,862(8)$, $d(Bi2-S2^{iii}) = 2,819(4)$.

5.3.4 Bestimmung der optischen Bandlücke durch UV/VIS-Spektroskopie

Die Bestimmung der optischen Bandlücke des pulverförmigen grauen HgBi₂S₄ wurde mit Hilfe eines Zweistrahlphotometers durchgeführt. Aus den erhaltenen Daten wurde entsprechend der Kubelka-Munk-Theorie [23] ein Absorptionsspektrum erstellt, woraus sich die optische Bandlücke durch eine lineare Interpolation auf die Basislinie entsprechend des Tauc-Plots [24] zu 882 nm oder 1,41 eV ermitteln lässt. Deshalb ist diese Substanz als Halbleiter einzustufen.

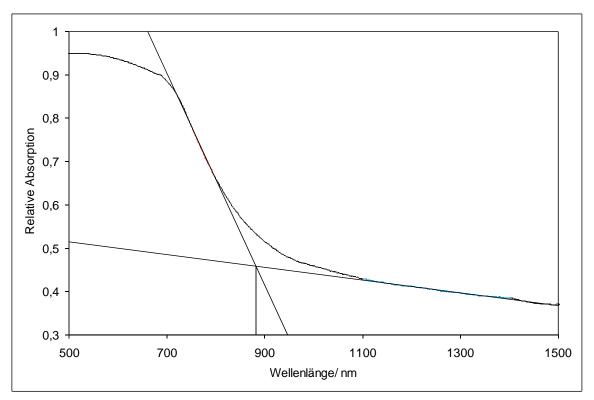


Abb. 5.9: Das UV/VIS-Spektrum von HgBi₂S₄. Eingezeichnet sind auch die Geraden, welche zur Bestimmung der optischen Bandlücke entsprechend des Tauc-Plots [24] benötigt werden.

5.3.5 Charakterisierung durch Raman-Spektroskopie

Für die weitere Analyse der Bindungsverhältnisse im HgBi₂S₄ wurde ein Raman-Spektrum verwendet, welches in Abbildung 5.10 dargestellt ist. Die darin auftretenden Intensitätsmaxima lassen sich den Schwingungen der enthaltenen Hg-S- und Bi-S-Bindungen zuordnen und liegen in Bereichen der für HgS [92-94] und Bi₂S₃ [95, 96] publizierten Werte. Dabei haben die Hg-S-Schwingungen Wellenzahlen von $\tilde{\nu}_1$ = 159 cm⁻¹ (HgS: 150 cm⁻¹), $\tilde{\nu}_2$ = 222 cm⁻¹ (HgS: 215 cm⁻¹), $\tilde{\nu}_3$ = 261 cm⁻¹ (HgS: 255 cm⁻¹) und $\tilde{\nu}_4$ = 310 cm⁻¹ (HgS: 310 cm⁻¹). Die Wellenzahlen der Bi-S-Schwingungen betragen ihrerseits $\tilde{\nu}_1$ = 170 cm⁻¹ (Bi₂S₃: 170 cm⁻¹), $\tilde{\nu}_2$

= 187 cm⁻¹ (Bi₂S₃: 185 cm⁻¹), \tilde{v}_3 = 234 cm⁻¹ (Bi₂S₃: 236 cm⁻¹) und \tilde{v}_4 = 276 cm⁻¹ (Bi₂S₃: 279 cm⁻¹). Die hier zu beobachtenden Übereinstimmungen treten auf, da in den HgS₆-Oktaedern des HgBi₂S₄ ähnliche Schwingungen wie in den Hg-S-Strängen des HgS möglich sind. Auch die strukturellen Verwandtschaften der BiS₅-Pyramiden bzw. BiS₆-Oktaeder und BiS₇-Polyeder zu den im Bi₂S₃ enthaltenen Baueinheiten ermöglichen äquivalente Schwingungen.

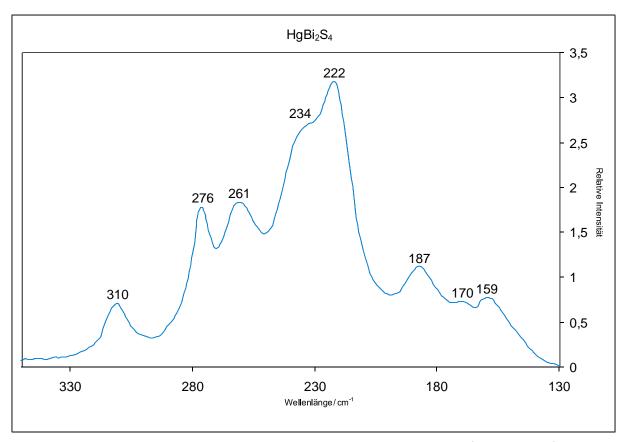


Abb. 5.10: Das Raman-Spektrum von HgBi₂S₄ im Bereich von 130 cm⁻¹ bis 350 cm⁻¹ mit den ermittelten Schwingungswellenzahlen.

5.4 Synthese und Charakterisierung von Hg_{0.5}Bi₂S₃Cl

5.4.1 Synthese von Hg_{0.5}Bi₂S₃Cl

Die Synthese von Hg_{0,5}Bi₂S₃Cl erfolgte aus den Edukten HgCl₂, Bismut und Schwefel in ausgeheizten und evakuierten Quarzampullen bei 370 °C über einen Zeitraum von zwei Wochen. Dabei entstand aber nicht nur das gewünschte Produkt in Form von dunkelroten Nadeln, sondern auch die beiden Nebenprodukte HgBi₂S₄ und BiSCl. Die Bildung des Hg_{0,5}Bi₂S₃Cl erfolgte entsprechen der Reaktionsgleichung:

$$0.5 \operatorname{HgCl}_2 + 2 \operatorname{Bi} + 3 \operatorname{S} \rightarrow \operatorname{Hg}_{0.5} \operatorname{Bi}_2 \operatorname{S}_3 \operatorname{Cl}$$

Syntheseversuche die unter anderen Reaktionsbedingungen durchgeführt wurden führten zu deutlich schlechteren Ausbeuten hinsichtlich des gewünschten Produkts und waren deshalb ungünstiger. Aufgrund des hohen Anteils an Nebenprodukten muss aber trotzdem davon ausgegangen werden, dass die gewählten Reaktionsbedingungen nicht optimal waren.

5.4.2 Charakterisierung mittels Pulverdiffraktometrie

An einem Pulverdiffraktogramm dieser Probe lassen sich alle entstehenden Produkte indizieren und man kann anhand der wichtigsten Reflexe abschätzen, dass etwa 40 % der eingesetzten Reaktionsmenge zu Nebenprodukten umgesetzt wird. Der Grund für diesen hohen Anteil an den Nebenprodukten HgBi₂S₄ [5, 6] und BiSCl [97] liegt wahrscheinlich an der enormen thermodynamischen Stabilität dieser schon länger bekannten Verbindungen.

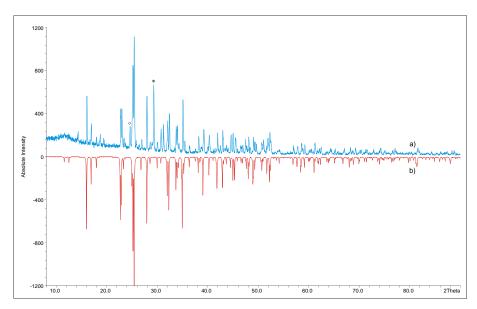


Abb. 5.11: Vergleich eines gemessenen Pulverdiffraktogramms von Hg_{0,5}Bi₂S₃Cl a) mit einem aus Einkristalldaten berechneten b). Die beiden wichtigsten Reflexe der Nebenprodukte HgBi₂S₄ (*) und BiSCl (•) dienten zur Abschätzung ihres Anteils am Reaktionsprodukt.

Die Indizierung und Verfeinerung des aufgenommenen Pulverdiffraktogramms ergab für $Hg_{0,5}Bi_2S_3Cl$ eine monoklinen Elementarzelle mit den in der folgenden Tabelle aufgeführten Zellkonstanten. Das erste Nebenprodukt $HgBi_2S_4$ kristallisiert entsprechend den Literaturangaben [6] ebenfalls in einer monoklinen Elementarzelle. BiSCl als zweites Nebenprodukt besitzt laut Literaturangaben [97] eine orthorhombische Elementarzelle.

Tab. 5.4: Vergleich der Zellkonstanten und Zellvolumina von Hg_{0,5}Bi₂S₃Cl, HgBi₂S₄ und BiSCl aus bisherigen Arbeiten [6, 99] zu den in dieser Arbeit ermittelten.

Verbindung	a/ Å	b/ Å	c/ Å	β/ °	V/ Å ³	Literatur
Hg _{0,5} Bi ₂ S ₃ Cl	7,843(5)	4,022(3)	10,804(6)	104,87(4)	329,4(5)	d. Arb.
$HgBi_2S_4$	14,17(1)	4,06(1)	13,99(1)	118,27(1)	708,85(4)	[6]
$HgBi_2S_4$	14,16(1)	4,047(3)	13,989(7)	118,19(8)	706,6(6)	d. Arb.
BiSCl	7,751(2)	3,9955(5)	9,9920(5)		309,44(8)	[97]
BiSCl	7,787(4)	3,998(3)	9,984(7)		310,8(2)	d. Arb.

5.4.3 Die Kristallstruktur von Hg_{0.5}Bi₂S₃Cl

5.4.3.1 Beschreibung der Kristallstruktur von Hg_{0.5}Bi₂S₃Cl

 $Hg_{0,5}Bi_2S_3Cl$ kristallisiert in der monoklinen Raumgruppe $P2_1/m$ (Nr.11). In seiner Struktur besetzt Quecksilber genau wie Chlor eine, Bismut zwei und Schwefel drei unabhängige

Lagen, wie den kristallographischen Daten A.5.2 entnommen werden kann. Die Gesamtstruktur besteht aus einem [Bi₂S₃Cl]-Netzwerk in dessen Hohlräumen Hg²⁺-Ionen eingebettet sind. In diesem [Bi₂S₃Cl]-Netzwerk hat Bi1 eine 3+1+2 Umgebung in Form eines verzerrten Oktaeders, der von drei nahen Schwefel im Abstand von d(Bi-S) = 2,681(2) Å bis 2,752(3) Å, einem fernen Schwefel im Abstand von d(Bi-S) = 2,971(4) Å, sowie zwei fernen Chlor im Abstand von d(Bi-S) = 2.971(4) Å aufgebaut wird. Bi2 besitzt im Gegensatz dazu eine 1+4+2 Umgebung in Form eines überkappten Oktaeders, der aus einem nahen Schwefel im Abstand von d(Bi-S) = 2,583(5) Å, vier fernen Schwefel im Abstand von d(Bi-S) = 2,768(2) Å und 2,939(5) Å, sowie zwei fernen Chlor im Abstand von d(Bi-S) = 3,279(3) Å besteht. Sowohl die BiS₄Cl₂-Oktaeder als auch die überkappten Bi₅Cl₂-Oktaeder sind mit Polyedern der gleichen Sorte entlang b verbunden. Dabei erfolgt diese Verknüpfung bei den BiS₄Cl₂-Oktaedern über gemeinsame SCl-Kanten und bei den Bi₅Cl₂-Polyedern über gemeinsame S₂Cl-Fächen. Die dreidimensionale Struktur kommt dadurch zustande, dass die BiS₄Cl₂-Oktaeder und die überkappten Bi₅Cl₂-Oktaeder entlang c gemeinsame S-Ecken aufweisen. In den hierin auftretenden Hohlräumen sitzen Hg²⁺-Ionen, welche einer nur zu 50 % besetzten Hg-Lage zuzuordnen sind, weshalb sich für diese Verbindung die Summenformel Hg_{0.5}Bi₂S₃Cl ergibt. Dieses Quecksilber besitzt Bindungen zu dem benachbarten Schwefel im Abstand von d(Hg-S) = 2,355(5) Å. Unterbesetzte Hg-Lagen wie im $Hg_{0.5}Bi_2S_3Cl$ treten zwar nicht häufig auf, konnten aber auch schon in den Verbindungen Hg_{2.8}[AsF₆]_{0.94}, Hg_{2.86}[AsF₆], Hg_{2.86}[SbF₆], Hg_{2.9}[SbF₆], Hg_{2.88}[NbF₆], Hg_{2.86}[TaF₆] und Hg_{2.88}[TaF₆] gefunden werden [79, 98-101]. Der Abstand zwischen den einzelnen Hg-Lagen beträgt hier zwischen d(Hg-Hg) =2,617(1) Å im $Hg_{2.86}[SbF_6]$ und d(Hg-Hg) = 2,674(4) Å im $Hg_{2.86}[TaF_6]$, welcher um etwa 0,6 Å länger ist als der Abstand zwischen den Hg-Lagen von $Hg_{0.5}Bi_2S_3Cl$, der mit d(Hg-Hg) =2,011(2) Å sehr kurz ausfällt. Auf die möglichen Ursachen für diesen sehr geringen Hg-Hg-Abstand wird im folgenden Abschnitt 5.4.3.2 näher eingegangen.

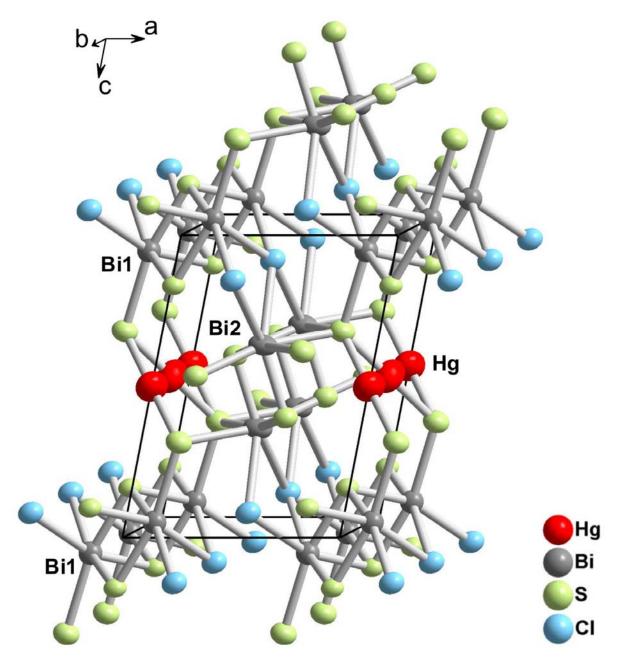


Abb. 5.12: Die Elementarzelle des Hg_{0,5}Bi₂S₃Cl entlang *b*. Charakteristisch ist das [Bi₂S₃Cl]⁻Netzwerk aus BiS₄Cl₂-Oktaedern und Bi₅Cl₂-Polyedern in das Hg²⁺-Ionen eingebettet sind. Die dargestellten Ellipsoide repräsentieren eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von 90 %.

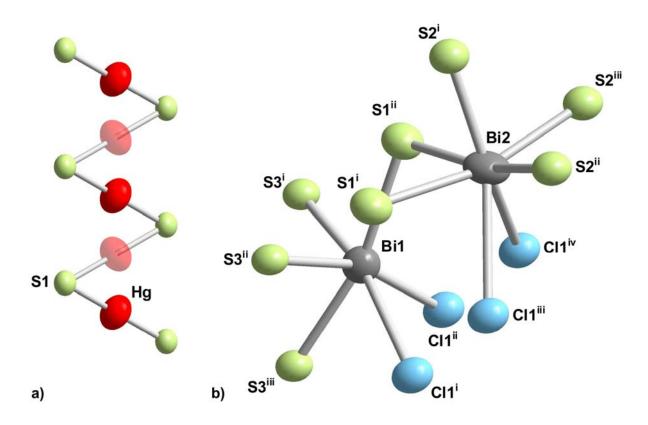


Abb. 5.13: Ausschnitte aus der Kristallstruktur des Hg_{0,5}Bi₂S₃Cl mit a) der unterbesetzten Hg-Lage und dem daran gebundenen Schwefel sowie b) den BiS₄Cl₂-Oktaedern und BiS₅Cl₂-Polyedern. Die verwendeten Ellipsoide repräsentieren eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von 90%.

Die dargestellten Abstände des $Hg_{0,5}Bi_2S_3Cl$ betragen in Å: d(Hg-Hg) = 2,011(2), d(Hg-S1) = 2,355(5), $d(Bi1-S1^{ii}) = 2,962(1)$, $d(Bi1-S3^{i}) = 2,681(2)$, $d(Bi1-S3^{ii}) = 2,681(2)$, $d(Bi1-S3^{ii}) = 2,681(2)$, $d(Bi1-S1^{ii}) = 2,971(4)$, $d(Bi1-C11^{i}) = 2,971(4)$, $d(Bi2-S1^{i}) = 2,939(5)$, $d(Bi2-S2^{ii}) = 2,583(5)$, $d(Bi2-S2^{ii}) = 2,768(2)$, $d(Bi2-S2^{iii}) = 2,768(2)$, $d(Bi2-C11^{iii}) = 3,279(3)$, $d(Bi2-C11^{iv}) = 3,279(3)$.

5.4.3.2 Ein Vergleich der Kristallstruktur von Hg_{0,5}Bi₂S₃Cl mit den Kristallstrukturen der beiden isotypen Verbindungen AgBi₂S₃Cl und AgBi₂Se₃Cl

Wenn man die [Bi₂S₃Cl] -Teilstruktur des Hg_{0,5}Bi₂S₃Cl als Ausgangspunkt wählt und nach strukturchemisch verwandten Verbindungen sucht gelangt man sofort zu den beiden von *M. Ruck* synthetisierten und charakterisierten Verbindungen AgBi₂S₃Cl und AgBi₂Se₃Cl [102]. Diese besitzen aber nicht nur eine quasi äquivalente [Bi₂Q₃Cl] -Teilstruktur (Q: S, Se), sondern kristallisieren auch in der gleichen monoklinen Raumgruppe *P*2₁/*m* (Nr. 11) mit nahezu gleichen Zellkonstanten und Zellvolumina.

Tab. 5.5: Vergleich der Zellkonstanten und Zellvolumina von Hg_{0,5}Bi₂S₃Cl aus dieser Arbeit mit denjenigen von AgBi₂S₃Cl und AgBi₂Se₃Cl [102].

Verbindung	a/ Å	b/ Å	c/ Å	β/ °	V / $Å^3$	Literatur
Hg _{0,5} Bi ₂ S ₃ Cl	7,843(5)	4,022(3)	10,804(6)	104,87(4)	329,4(5)	d. Arb.
AgBi ₂ S ₃ Cl	7,765(3)	3,999(1)	10,829(5)	103,18(4)	327,4(2)	[102]
AgBi ₂ Se ₃ Cl	7,9738(8)	4,1067(2)	11,135(1)	104,17(1)	353,53(5)	[102]

Wie auch aus der folgenden Tabelle 5.6 und der anschließenden Abbildung 5.14 hervorgeht, besteht der einzige gewichtige strukturelle Unterschied zwischen diesen Verbindungen und dem Hg_{0,5}Bi₂S₃Cl in der Position und Besetzung der Hg- bzw. Ag-Lagen.

Tab. 5.6: Vergleich der Atomkoordinaten, Wyckofflagen, Besetzungen und isotropen Auslenkungsparameter von Hg_{0.5}Bi₂S₃Cl, AgBi₂S₃Cl und AgBi₂Se₃Cl.

Varhindung	Atom	Wylzofflogon	Dogotzungen				II
Verbindung	Atom	Wykofflagen	Besetzungen	x	<u>y</u>	<u>Z</u>	$U_{\rm eq}$
$Hg_{0,5}Bi_2S_3Cl$	Hg(1)	2c	0,5	0	0,5	0,5	0,051(1)
	Bi(1)	2e	1,0	0,1751(1)	0,25	0,9321(1)	0,024(1)
	Bi(2)	2e	1,0	0,5166(1)	0,25	0,3451(1)	0,031(1)
	S(1)	2e	1,0	0,2152(6)	0,25	0,6668(5)	0,029(1)
	S(2)	2e	1,0	0,6839(6)	0,25	0,5854(4)	0,026(1)
	S(3)	2e	1,0	0,0522(6)	0,25	0,1488(4)	0,022(1)
	Cl(1)	2e	1,0	0,5973(6)	0,25	0,9012(4)	0,026(1)
AgBi ₂ S ₃ Cl	Ag(1)	2 <i>e</i>	1,0	0,0592(1)	0,25	0,4058(1)	0,038(1)
_	Bi(1)	2e	1,0	0,1854(1)	0,25	0,9271(1)	0,018(1)
	Bi(2)	2e	1,0	0,5380(1)	0,25	0,3455(1)	0,020(1)
	S(1)	2e	1,0	0,1993(2)	0,25	0,6608(1)	0,017(1)
	S(2)	2e	1,0	0,6827(2)	0,25	0,5852(1)	0,015(1)
	S(3)	2e	1,0	0,0425(2)	0,25	0,1465(1)	0,013(1)
	Cl(1)	2e	1,0	0,5958(2)	0,25	0,8966(1)	0,018(1)
AgBi ₂ Se ₃ Cl	Ag(1)	2e	1,0	0,0471(2)	0,25	0,4137(1)	0,051(1)
	Bi(1)	2e	1,0	0,1892(1)	0,25	0,9326(1)	0,020(1)
	Bi(2)	2e	1,0	0,5302(1)	0,25	0,3434(1)	0,025(2)
	Se(1)	2e	1,0	0,2015(2)	0,25	0,6638(1)	0,024(1)
	Se(2)	2e	1,0	0,6932(2)	0,25	0,5870(1)	0,016(1)
	Se(3)	2e	1,0	0,0473(2)	0,25	0,1522(1)	0,014(1)
	Cl(1)	2 <i>e</i>	1,0	0,5955(4)	0,25	0,8998(3)	0,022(1)

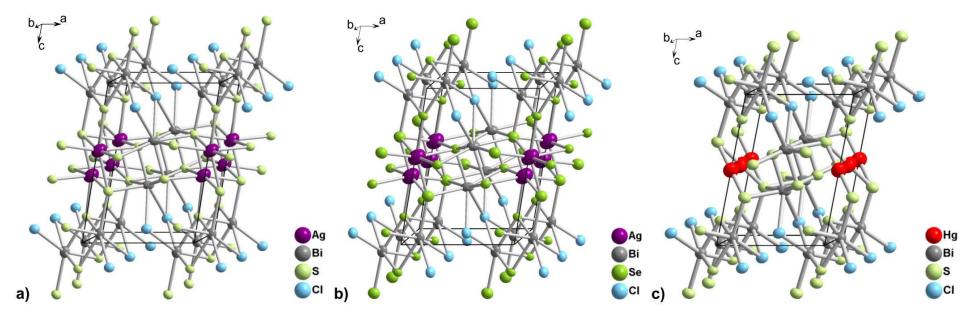


Abb.5.14: Die Elementarzellen von a) AgBi₂S₃Cl, b) AgBi₂Se₃Cl und c) Hg_{0,5}Bi₂S₃Cl im Vergleich. Die dargestellten Ellipsoide repräsentieren eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von 90%.

Dabei nimmt das Quecksilber im Hg_{0.5}Bi₂S₃Cl die Wyckoff-Position Hg1: 2c (0 ½ ½) ein, wohingegen das Silber im AgBi₂S₃Cl mit Ag1: 2e (0,0592(1) ¹/₄ 0,4058(1)) und im AgBi₂Se₃Cl mit Ag1: 2e (0,0471(2) ¼ 0,4137(1)) von dieser Position erheblich vor allem in c-Richtung nach unten bzw. oben abweicht. Somit liegt das Quecksilber des Hg_{0.5}Bi₂S₃Cl nicht im Zentrum von MeQ6-Oktaedern (Me: Hg, Ag; Q: S, Se), wie das beim Silber des AgBi₂S₃Cl und AgBi₂Se₃Cl der Fall ist, sondern auf den Kantenmitten der entsprechenden Q6-Oktaeder. Dies ist deshalb etwas erstaunlich, da diese MeQ6-Oktaeder im Hg0.5Bi2S3Cl mit einem anhand von IVTON [18] berechneten Volumen von 29,8(8) Å³ sogar größer wären als im AgBi₂S₃Cl, wo sie laut IVTON [18] ein Volumen von 28,5(5) Å³ einnehmen. Hierfür kann man sich verschiedene Ursachen überlegen. Ein Argument das für die aufzufindende Hg-Lage spricht ist die dadurch möglich werdende mit d(Hg-S) = 2,355(5) Å sehr kurze lineare Bindung des Quecksilbers zu Schwefel. Ein weiterer Grund der die eingenommene Hg-Lage begünstigt ist der dadurch auftretende mit d(Hg-Hg) = 2,011(2) Å sehr kurze Abstand zwischen den einzelnen halbbesetzten Hg-Positionen. Dieses letzte Argument ist vor allem deshalb sehr bedeutend, da bei den Hg-Atomen des Hg_{0.5}Bi₂S₃Cl wohl eine Lagefehlordnung dicht benachbarter Positionen auftritt, wie sie auch für die Ag-Atome in den beiden Verbindungen AgBi₂S₃Cl und AgBi₂Se₃Cl von M. Ruck angenommen wird. Dafür sprechen auch die mit $U_{eq}(Hg_{0.5}Bi_2S_3Cl) = 0.051(1)$, $U_{eq}(AgBi_2S_3Cl) = 0.038(1)$ und $U_{eq}(AgBi_2Se_3Cl)$ = 0,051(1) großen Temperaturfaktoren der Hg- und Ag-Lagen in den genannten Verbindungen.

Zur Veranschaulichung der hier diskutierten Argumente, welche für die aufgefundene Hg-Lage sprechen, dient die folgende Abbildung 5.15. Darin werden Ausschnitte aus der Hg_{0,5}Bi₂S₃Cl Struktur gezeigt, in welche die im AgBi₂S₃Cl enthaltene Ag-Lage eingefügt wurde.

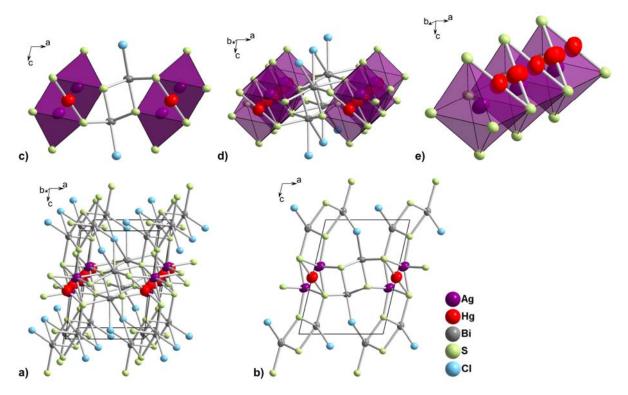


Abb.5.15: Die Elementarzelle des Hg_{0,5}Bi₂S₃Cl, worin die Ag-Lage von AgBi₂S₃Cl eingefügt wurde a) und b). Verschiedene Betrachtungsvarianten der sich dadurch ergebenden AgS₆-Oktaeder mit der Hg-Lage des Hg_{0,5}Bi₂S₃Cl auf den jeweiligen Kantenmitten dieser AgS₆-Oktaeder c, d und e). Die dargestellten Ellipsoide repräsentieren eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von 90%.

5.4.4 Charakterisierung durch Rasterelektronenmikroskopie

Zur Überprüfung der aus Einkristalldaten berechneten Summenformel wurde ein Kristall für die Elementaranalyse mittels EDX ausgewählt. Abbildung 5.16 zeigt eine REM-Aufnahme dieses Kristalls, sowie das Messprofil der durchgeführten Elementaranalyse. Aus dieser Messung ergibt sich eine Zusammensetzung von 7% Hg, 37% Bi, 41% S und 15% Cl, die zu einer rechnerischen Summenformel von Hg_{0,5}Bi_{2,61}S_{2,75}Cl führt. In Anbetracht der Messungenauigkeit dieses Verfahren liegt diese hypothetische Summenformel aber sehr nahe an der aus Einkristalldaten ermittelten Summenformel von Hg_{0,5}Bi₂S₃Cl, wodurch diese bestätigt wird.

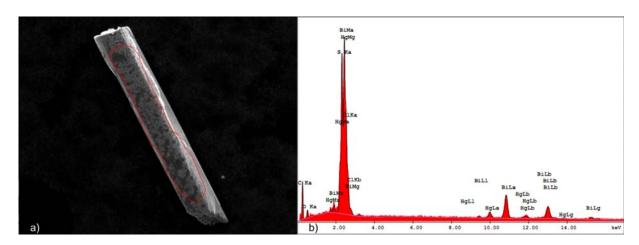


Abb. 5.16: REM-Aufnahme eines $Hg_{0,5}Bi_2S_3Cl$ Kristalls a) und das Messprofil der daran durchgeführten Elementaranalyse b).

5.5 Synthese und Charakterisierung von Hg₄BiS₂Cl₅

5.5.1 Synthese von Hg₄BiS₂Cl₅

Die Synthese von Hg₄BiS₂Cl₅ erfolgte aus den binären Edukten HgCl₂, Hg₂Cl₂, HgS und Bi₂S₃ entsprechen der Reaktionsgleichung:

$$3 \operatorname{HgCl}_2 + 2 \operatorname{Hg}_2 \operatorname{Cl}_2 + \operatorname{HgS} + \operatorname{Bi}_2 \operatorname{S}_3 \rightarrow 2 \operatorname{Hg}_4 \operatorname{BiS}_2 \operatorname{Cl}_5$$

Die Umsetzung erfolgte in evakuierten Quarzampullen bei 350 °C über einen Zeitraum von zwei Wochen. Das erhaltene Produkt liegt als gelbes Pulver oder in Form von transparenten gelben Kristallen vor, wobei kein Kristallhabitus bevorzugt auftritt.

5.5.2 Charakterisierung mittels Pulverdiffraktometrie

Zur Analyse und Charakterisierung der erhaltenen Proben wurde ein Pulverdiffraktogramm aufgenommen und mit einem aus Einkristalldaten berechneten verglichen.

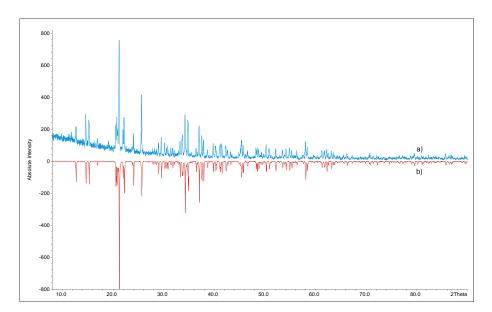


Abb. 5.17: Vergleich eines gemessenen Pulverdiffraktogramms von Hg₄BiS₂Cl₅ a) mit einem aus Einkristalldaten berechneten b).

Die Indizierung und Verfeinerung des aufgenommenen Pulverdiffraktogramms ergab eine monokline Elementarzelle mit den in der folgenden Tabelle aufgeführten Zellkonstanten.

Tab. 5.7: Zusammenstellung der Zellkonstanten und des Zellvolumens von Hg₄BiS₂Cl₅.

a/ Å	b/ Å	c/ Å	β/ °	$V/$ $Å^3$	Literatur
a = 8,015(2)	b = 10,457(3)	c = 8,753(2)	$\beta = 112,780(1)$	676,3(3)	d. Arb.

5.5.3 Die Kristallstruktur von Hg₄BiS₂Cl₅

Entsprechend den kristallographischen Daten A.5.3 kristallisiert Hg₄BiS₂Cl₅ in der monoklinen Raumgruppe *P*2₁ (Nr. 4). Es lässt sich wegen der räumlichen Anordnung der enthaltenen Strukturelemente gut als Interkalationsverbindung beschreiben.

5.5.3.1 Die $_{\infty}^{2}$ [Hg₄S₂]²⁺-Teilstruktur

Die $_{_{\infty}}^{^{2}}\left[Hg_{4}S_{2}\right]^{2+}$ -Teilstruktur mit vier unabhängigen Quecksilber- und zwei unabhängigen Schwefel-Lagen besteht aus gefalteten Schichten, die parallel zur [111]-Ebene im Abstand von 2,76(1) Å verlaufen. Jede Schicht besteht aus Hg₈S₆-Ringen, die von sich abwechselnden Hg₃S-Pyramiden und Hg₂-Hanteln gebildet werden. Hierbei haben die Hg-S-Bindungen eine Länge von d(Hg-S) = 2,398(1) Å bis 2,469(1) Å, welche etwas länger sind als im Zinnober mit d(Hg-S) = 2,377(2) Å [80-83] und im Bereich der vergleichbaren Verbindungen $\delta-Hg_3S_2Cl_2$ [4], β-Hg₃S₂Br₂ [103], β-Hg₃S₂[SiF₆] [104], Hg₃S₂[ZrCl₆] [105] und Hg₃S₂CII [106] liegen. Auch die Hg-Hg-Bindungen mit einer Länge von d(Hg-Hg) = 2,549(1) Å stimmen gut mit den Hg-Hg-Abständen der Quecksilber(I)-halogenide Hg₂F₂ [107, 108], Hg₂Cl₂ [90, 91], Hg₂Br₂ [90, 108, 109] und Hg_2I_2 [90, 110, 111] überein. Die Faltung der $_\infty^2$ [Hg_4S_2] $^{2+}$ -Schichten ist eine Folge der Hg-S-Hg-Winkel von 96,51(1)° und 98,72(1)°. Diese $_{_{\infty}}^{^{2}}$ [Hg₄S₂]²⁺-Teilstruktur unterscheidet sich von allen bisher untersuchten Quecksilbersulfiden hauptsächlich dadurch, dass sie die erste Verbindung ist in der die beiden für das Quecksilber häufigsten Oxidationszahlen +1 und +2 gleichermaßen auftreten und den enthaltenen Quecksilberlagen eindeutig zugeordnet werden können. Diese gemischte Valenz tritt auch bei Hg₄BiSe₂Cl₅ auf, welches im folgenden Kapitel 5.6 charakterisiert wird.

5.5.3.2 Die $_{\infty}^{-1}$ [BiCl₅]²⁻-Teilstruktur

Die $_{\infty}^{1}$ [BiCl₅]²⁻-Teilstruktur aus einer Bismut- und fünf Chlor-Lagen besteht aus BiCl₆-Oktaedern, die über gemeinsame Ecken zu Ketten entlang *b* verknüpft sind. Diese Ketten sind zwischen den $_{\infty}^{2}$ [Hg₄S₂]²⁺-Schichten eingebettet, wobei hier ein Hg-Cl-Abstand von *d*(Hg-Cl)

= 2,897(5) Å und 2,970(3) Å auftritt. Die Bi-Cl-Abstände sind mit d(Bi-Cl) = 2,613(2) Å bis 2,767(8) Å deutlich länger als im BiCl₃ [112-114] mit d(Bi-Cl) = 2,464(4) Å bis 2,528(3) Å, aber vergleichbar mit denen von Cs₃[BiCl₆] [115], CsK₂[BiCl₆] [116], Cs₂Na[BiCl₆] [116, 117] und Hg₆As₄[BiCl₆]Cl [118]. Da die Cl-Bi-Cl-Winkel entlang der Verlaufsrichtung nur 153,32(1) ° betragen weisen die Ketten der ${}^{1}_{\infty}$ [BiCl₅]²⁻-Teilstruktur eine zickzackförmige Gestallt auf. Im Gegensatz zu allen bisher synthetisierten Verbindungen mit einer anionischen Teilstruktur aus BiCl₆-Oktaedern liegen im Hg₄BiS₂Cl₅, sowie auch in dem in Kapitel 5.6 näher beschriebenen Hg₄BiSe₂Cl₅, ausschließlich ${}^{1}_{\infty}$ [BiCl₅]²⁻-Stränge aus eckenverknüpften BiCl₆-Oktaedern vor. Im Gegensatz dazu wurden bisher nur isolierte BiCl₆-Oktaeder [115-124], [Bi₂Cl₁₁]⁵-Einheiten aus zwei eckenverknüpften BiCl₆-Oktaedern [125], [Bi₂Cl₁₀]⁴-Einheiten aus zwei kantenverknüpften BiCl₆-Oktaedern [126], [Bi₂Cl₉]³⁻-Einheiten aus zwei flächenverknüpften BiCl₆-Oktaedern [127], ${}^{1}_{\infty}$ [Bi₂Cl₈]²⁻-Stränge aus kantenverknüpften BiCl₆Oktaedern [127], ${}^{1}_{\infty}$ [Bi₂Cl₈]²⁻-Stränge aus kantenverknüpften BiCl₆Oktaedern [127], ${}^{1}_{\infty}$ [Bi₂Cl₈]³⁻-Schichten aus eckenverknüpften BiCl₆-Oktaedern synthetisiert [127, 129-132].

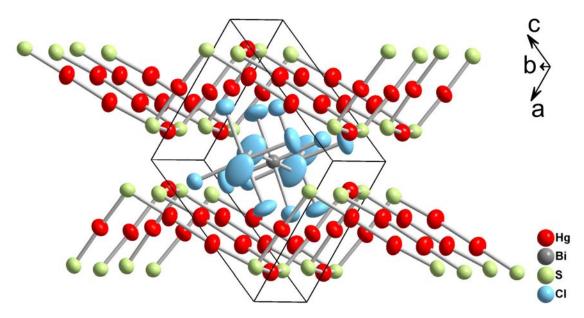


Abb. 5.18: Die Elementarzelle des Hg₄BiS₂Cl₅ entlang b aus $_{\infty}^{2}$ [Hg₄S₂]²⁺-Schichten und darin eingebetteten $_{\infty}^{1}$ [BiCl₅]²⁻-Strängen. Die dargestellten Ellipsoide repräsentieren eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von 90%.

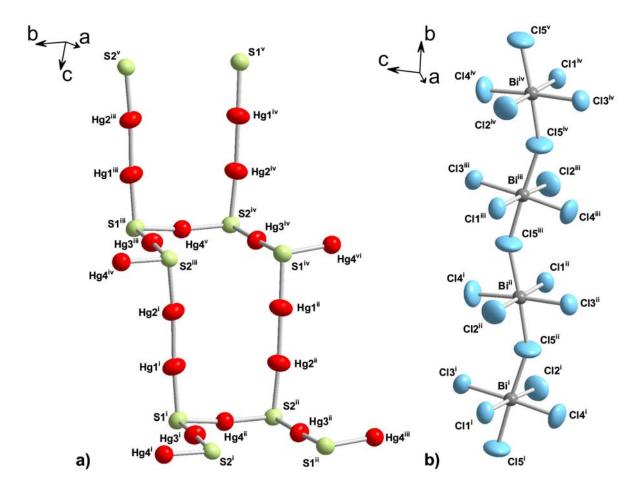


Abb. 5.19: Ausschnitte aus a) der schichtartigen $_{\infty}^{2}$ [Hg₄S₂]²⁺-Teilstruktur aus gewinkelten Hg₈S₆-Ringen und b) der kettenförmigen $_{\infty}^{1}$ [BiCl₅]²⁻-Teilstruktur aus eckenverknüpften BiCl₆-Oktaedern. Die verwendeten Ellipsoide repräsentieren eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von 90%.

Die dargestellten Abstände des Hg₄BiS₂Cl₅ betragen in Å: $d(\text{Hg4}^{ii}\text{-S1}^{i}) = 2,398(1), d(\text{Hg4}^{ii}\text{-S2}^{ii}) = 2,393(1), d(\text{Hg1}^{i}\text{-S1}^{i}) = 2,456(1), d(\text{Hg2}^{ii}\text{-S2}^{ii}) = 2,469(1), d(\text{Hg1}^{i}\text{-Hg2}^{i}) = 2,549(1), d(\text{Hg1}^{ii}\text{-Hg2}^{i}) = 2,549(1), d(\text{Hg3}^{iii}\text{-S2}^{iii}) = 2,469(1), d(\text{Hg1}^{ii}\text{-S1}^{iv}) = 2,456(1), d(\text{Hg3}^{iii}\text{-S2}^{iii}) = 2,357(4), d(\text{Hg3}^{iv}\text{-S2}^{iv}) = 2,354(3), d(\text{Hg3}^{ii}\text{-S1}^{iii}) = 2,354(3), d(\text{Hg3}^{iv}\text{-S2}^{iv}) = 2,357(4), d(\text{Hg4}^{v}\text{-S2}^{iv}) = 2,398(1), d(\text{Hg4}^{v}\text{-S2}^{iv}) = 2,393(1), d(\text{Bi}^{i}\text{-C11}^{i}) = 2,759(2), d(\text{Bi}^{i}\text{-C12}^{i}) = 2,613(2), d(\text{Bi}^{i}\text{-C13}^{i}) = 2,767(8), d(\text{Bi}^{i}\text{-C14}^{i}) = 2,613(7), d(\text{Bi}^{i}\text{-C15}^{i}) = 2,638(1), d(\text{Bi}^{i}\text{-C15}^{ii}) = 2,737(1).$

5.5.4 Bestimmung der optischen Bandlücke durch UV/VIS-Spektroskopie

Die optische Bandlücke des gelben Hg₄BiS₂Cl₅ wurde mit einem Zweistrahlphotometer bestimmt. Nach der Umwandlung der erhaltenen Daten entsprechend der Kubelka-Munk-

Theorie [23] in ein Absorptionsspektrum konnte daraus die optische Bandlücke mit Hilfe einer linearen Interpolation auf die Basislinie ähnlich dem Tauc-Plot [24] berechnet werden. Sie ergibt sich für Hg₄BiS₂Cl₅ zu 492 nm oder 2,52 eV, was der Komplementärfarbe Blau entspricht und eine Einordnung als Halbleiter nahelegt.

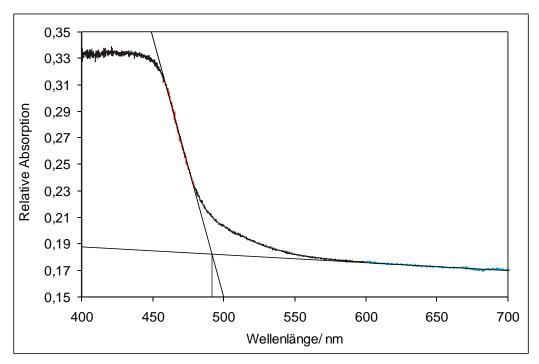


Abb. 5.20: Das UV/VIS-Spektrum von Hg₄BiS₂Cl₅ mit den zur Bestimmung der optischen Bandlücke entsprechend des Tauc-Plots [24] benötigten Geraden.

5.5.5 Charakterisierung durch Raman-Spektroskopie

enthalten sind und äquivalente Schwingungen zeigen. Auch die $_{\infty}^{-1}[BiCl_5]^{2-}$ -Teilstruktur dieser Verbindung weist zum Teil ähnliche Bindungsverhältnisse wie im BiCl₃ auf.

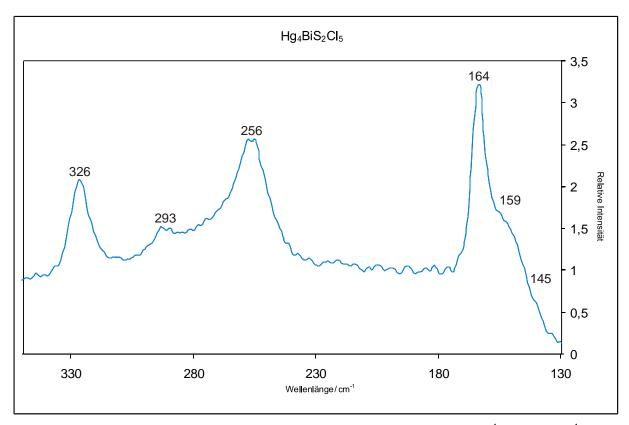


Abb. 5.21: Das Raman-Spektrum von Hg₄BiS₂Cl₅ im Bereich von 130 cm⁻¹ bis 350 cm⁻¹ mit den ermittelten Schwingungswellenzahlen.

5.5.6 Bandstruktur- und DOS- Rechnungen zu Hg₄BiS₂Cl₅

5.5.6.1 Die Bandstruktur von Hg₄BiS₂Cl₅

Die Bandstruktur von Hg₄BiS₂Cl₅ wurde mit CRYSTAL06 [26] berechnet und ergibt entsprechend der Abbildung 5.22 eine direkter Bandlücke von 2,46 eV, welche gut mit dem experimentellen Ergebnis von 2,52 eV aus der UV/VIS-Spektroskopie übereinstimmt.

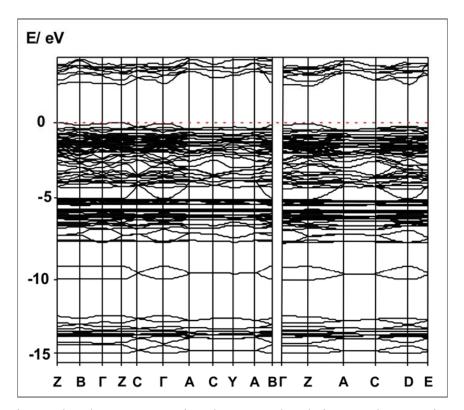


Abb. 5.22: Die Bandstruktur von Hg₄BiS₂Cl₅ entsprechend einer Rechnung mit CRYSTAL06 [26]. Die Fermie-Energie ist durch eine gestrichelte rote Linie gekennzeichnet. Hieraus ergibt sich eine direkte Bandlücke von 2,46 eV.

5.5.6.2 Die verschiedenen DOS und die TDOS von Hg₄BiS₂Cl₅

Die verschiedenen DOS und die TDOS von Hg₄BiS₂Cl₅, welche in Abbildung 5.23 zu sehen sind, wurden aus den Valenzorbitalen der beteiligten Atome berechnet (für S: 3sp, für Cl: 3sp, für Hg: 5d6sp und für Bi: 6sp, um die Bandstruktur und Bindungsverhältnisse näher zu analysieren. Diese Berechnungen führen ebenfalls zu einer Bandlücke von etwa 2,5 eV. Das Leitungsband wird dabei von antibindenden Bi-S-Zuständen gebildet, wohingegen das stark lokalisierte Valenzband aus S- und Cl-Orbitalen besteht, welches aber auch geringe Anteilen von Hg und Bi beinhaltet. Eine Ursache hierfür sind die schwachen kovalenten Bindungen zwischen Hg und S sowie Bi und Cl. Zwischen -1 eV und -4 eV finden sich die p-Orbitale der freien Elektronenpaare von S und Cl. Die darunter liegenden Maxima der DOS des S im Bereich von -4 eV bis -7,5 eV weisen auf dessen Bindungen zu Hg hin. In diesem Bereich, vor allem zwischen -6 eV und -7,5 eV zeigen nämlich auch die Hg-Atome erhöhte Zustandsdichten. Dabei unterscheiden sich Hg1 und Hg2 deutlich von Hg3 und Hg4 in den Maxima bei -5 eV, da bei Hg1 und Hg2 dieses Maximum aufgrund der Hg-Hg-Bindungen stark

angehoben wird. Die niedrigsten Energien von -12 eV bis -15 eV werden von den 3s- und 3p-Orbitalen des S und Cl eingenommen.

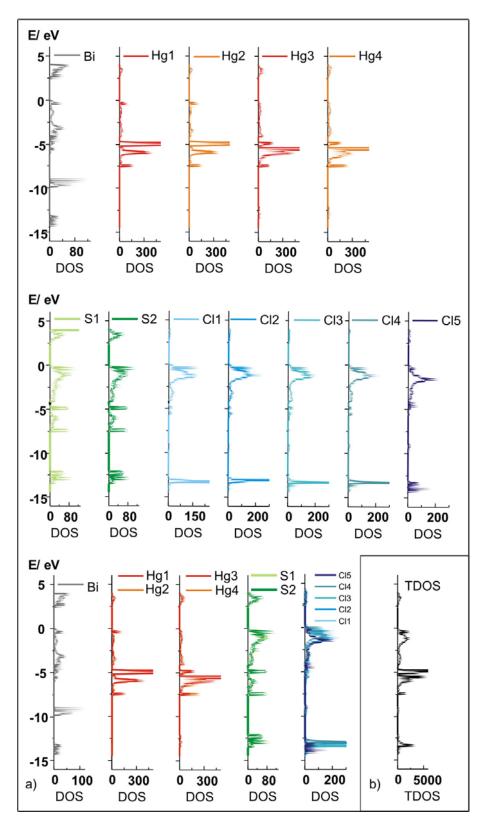


Abb. 5.23: Die verschiedenen DOS a) und die TDOS b) von Hg₄BiS₂Cl₅ entsprechend einer Rechnung mit CRYSTAL06 [26]. Hieraus ergibt sich unter anderem auch eine direkte Bandlücke von etwa 2,5 eV.

5.6 Synthese und Charakterisierung von Hg₄BiSe₂Cl₅

5.6.1 Synthese von Hg₄BiSe₂Cl₅

Die Synthese von Hg₄BiSe₂Cl₅ erfolgte analog zu der des Hg₄BiS₂Cl₅ aus den binären Edukten HgCl₂, Hg₂Cl₂, HgSe und Bi₂Se₃ entsprechen der Reaktionsgleichung:

$$3 \text{HgCl}_2 + 2 \text{Hg}_2 \text{Cl}_2 + \text{HgSe} + \text{Bi}_2 \text{Se}_3 \rightarrow 2 \text{Hg}_4 \text{BiSe}_2 \text{Cl}_5$$

Die Umsetzung erfolgte in evakuierten Quarzampullen bei 360 °C über einen Zeitraum von zwei Wochen. Das erhaltene Produkt ist ein gelbes Pulver in dem transparente gelbe Kristalle zu finden sind, wobei auch hier kein Kristallhabitus bevorzugt wird.

5.6.2 Charakterisierung mittels Pulverdiffraktometrie

Die Charakterisierung und Analyse der erhaltenen Proben erfolgte mit Hilfe eines aufgenommenen Pulverdiffraktogramms, das mit einem aus Einkristalldaten berechneten Pulverdiffraktogramm verglichen wurde.

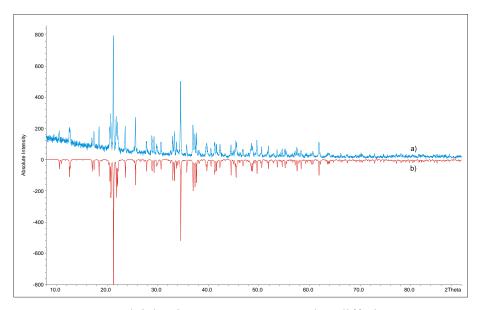


Abb. 5.24: Vergleich eines gemessenen Pulverdiffraktogramms von Hg₄BiSe₂Cl₅ a) mit einem aus Einkristalldaten berechneten b).

Indiziert und verfeinert wurde dieses Pulverdiffraktogramm mit einer monoklinen Elementarzelle. Dabei ergaben sich die in der folgenden Tabelle aufgeführten Zellkonstanten.

Tab. 5.8: Zusammenstellung der Zellkonstanten und des Zellvolumens von Hg₄BiSe₂Cl₅.

a/ Å	b/ Å	c/ Å	β/ °	V/ Å ³	Literatur
a=9,371(3)	b=10,374(3)	c = 14,082(5)	$\beta = 94,24(2)$	1365,2(1)	d. Arb.

5.6.3 Die Kristallstruktur von Hg₄BiSe₂Cl₅

Hg₄BiSe₂Cl₅ kristallisiert in der monoklinen Raumgruppe *P*2₁/*n* (Nr. 14), was auch aus den kristallographischen Daten A.5.4 hervorgeht. Diese Verbindung lässt sich genau wie das Hg₄BiS₂Cl₅ als Interkalationsverbindung beschreiben.

5.6.3.1 Die $_{\infty}^{-1}$ [Hg₄Se₂]²⁺-Teilstruktur

Vier unabhängige Quecksilber- und zwei unabhängigen Selen-Lagen bilden die gefalteten Doppelstränge der ${}^{1}_{\infty}[Hg_4Se_2]^{2+}$ -Teilstruktur. Diese Doppelstränge verlaufen parallel zu a in einem Abstand von 5,10(1) Å in b-Richtung und einem Abstand von 3,08(1) Å in c-Richtung, was einer Verschiebung um die halbe Flächendiagonalen der bc-Ebene entspricht. Ihre Struktur wird durch sich abwechselnde Hg₆Se₄- und Hg₄Se₄-Ringe aufgebaut. Die Hg₆Se₄-Ringe unterscheiden sich von den Hg₄Se₄-Ringen dadurch, dass hier entlang a Hg₂-Hanteln anstelle von einzelnen Quecksilberatomen enthalten sind. Die Hg-Se-Bindungen sind mit einer Länge von d(Hg-Se) = 2,426(2) Å bis 2,525(2) Å etwas kürzer als im HgSe mit d(Hg-Se)= 2,634(1) Å [84, 85] aber im Bereich der Hg-Se-Bindungslängen in der vergleichbaren Verbindung α-Hg₃Se₂I₂ [137, 138]. Auch die Hg-Hg-Bindungen mit einer Länge von d(Hg-Hg) = 2,550(2) Å stimmen gut mit den Hg-Hg-Abständen der Quecksilber(I)-halogenide Hg₂F₂ [109, 110], Hg₂Cl₂ [90, 91], Hg₂Br₂ [90, 108, 109] und Hg₂I₂ [90, 110, 111] überein. Die Faltung der [Hg₄Se₂]²⁺-Doppelstränge resultiert aus den Hg-Se-Hg-Winkeln von 94,7(1)° und 96,73(1)°. Ähnlich den [Hg₄S₂]²⁺-Schichten im Hg₄BiS₂Cl₅ treten auch in den $_{\scriptscriptstyle \infty}^{\scriptscriptstyle 1}[Hg_4Se_2]^{2+}\text{-}Doppelsträngen die beiden für das Quecksilber geläufigsten Oxidationszahlen }$ +1 und +2 gleichermaßen auf und lassen sich den enthaltenen Quecksilberlagen eindeutig zuordnen, weshalb das Hg₄BiSe₂Cl₅ die erste gemischtvalente Quecksilber-Selenid-Verbindung ist.

$$5.6.3.2$$
 Die $_{\infty}^{-1}$ [BiCl₅]²⁻-Teilstruktur

Genauso wie im $Hg_4BiS_2Cl_5$ besteht die $_{\infty}^{-1}[BiCl_5]^{2-}$ -Teilstruktur im $Hg_4BiSe_2Cl_5$ aus einer Bismut- und fünf Chlor-Lagen. Diese bilden $BiCl_6$ -Oktaeder aus, die über gemeinsame Cl-

Ecken zu Ketten entlang b miteinander verknüpft sind. Bei der Einbettung dieser ${}^1_{\infty}[BiCl_5]^{2^-}$ -Ketten zwischen den ${}^1_{\infty}[Hg_4Se_2]^{2^+}$ -Doppelsträngen tritt ein Hg-Cl-Abstand von d(Hg-Cl) = 2,947(2) Å auf. Die Bi-Cl-Bindungen unterscheiden sind mit einer Länge von d(Bi-Cl) = 2,567(6) Å bis 2,832(7) Å kaum von denen im $Hg_4BiS_2Cl_5$. Sie sind deutlich länger als die Bi-Cl-Bindungen im $BiCl_3$ [112-114] mit d(Bi-Cl) = 2,464(4) Å bis 2,528(3) Å aber vergleichbar mit denen von $Cs_3[BiCl_6]$ [115], $CsK_2[BiCl_6]$ [115], $Cs_2Na[BiCl_6]$ [116, 117] und $Hg_6As_4[BiCl_6]Cl$ [118]. Der Bindungswinkel in diesen ${}^1_{\infty}[BiCl_5]^{2^-}$ -Ketten beträgt entlang der Verlaufsrichtung nur 149,3(3)°, weshalb sie zickzackförmige sind. Im Gegensatz zu allen bisher synthetisierten Verbindungen, die eine anionische Teilstruktur aus $BiCl_6$ -Oktaedern enthalten [115-132], liegen im $Hg_4BiSe_2Cl_5$ sowie auch im $Hg_4BiS_2Cl_5$ ausschließlich $[BiCl_5]^{2^-}$ -Ketten aus eckenverknüpften $BiCl_6$ -Oktaedern vor.

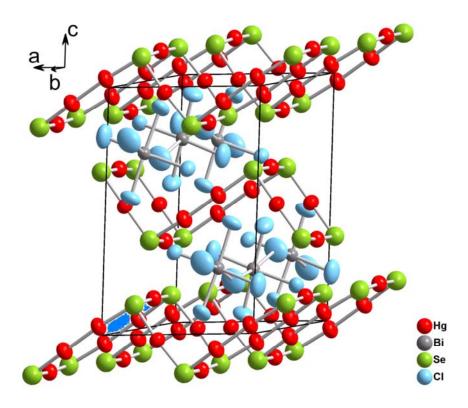


Abb. 5.25: Die Elementarzelle des Hg₄BiSe₂Cl₅ entlang b aus $_{\infty}^{1}$ [Hg₄Se₂]²⁺-Doppelsträngen und darin eingebetteten $_{\infty}^{1}$ [BiCl₅]²⁻-Ketten. Die dargestellten Ellipsoide repräsentieren eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von 90%.

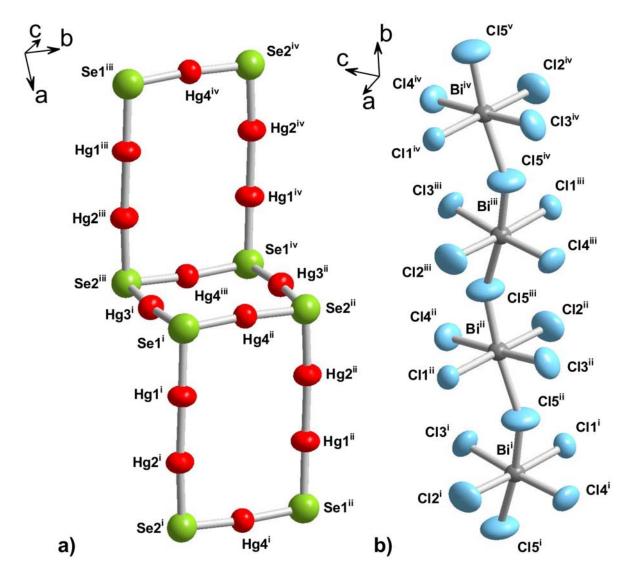


Abb. 5.26: Ausschnitte aus a) der doppelsträngigen ${}^1_{\infty}[Hg_4Se_2]^{2^+}$ -Teilstruktur aus Hg_6Se_4 - und Hg_4Se_4 -Ringen und b) der kettenförmigen ${}^1_{\infty}[BiCl_5]^{2^-}$ -Teilstruktur aus eckenverknüpften $BiCl_6$ -Oktaedern. Die verwendeten Ellipsoide repräsentieren eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von 90%.

Die dargestellten Abstände des Hg₄BiSe₂Cl₅ betragen in Å: $d(\text{Hg4}^{i}\text{-Se2}^{i}) = 2,472(3), d(\text{Hg4}^{i}\text{-Se1}^{ii}) = 2,470(3), d(\text{Hg2}^{i}\text{-Se2}^{i}) = 2,525(2), d(\text{Hg1}^{ii}\text{-Se1}^{ii}) = 2,523(2), d(\text{Hg1}^{i}\text{-Hg2}^{i}) = 2,550(2), d(\text{Hg1}^{i}\text{-Hg2}^{i}) = 2,550(2), d(\text{Hg1}^{i}\text{-Se1}^{i}) = 2,523(2), d(\text{Hg2}^{ii}\text{-Se2}^{ii}) = 2,525(2), d(\text{Hg4}^{ii}\text{-Se1}^{i}) = 2,470(3), d(\text{Hg4}^{ii}\text{-Se2}^{ii}) = 2,472(3), d(\text{Hg3}^{i}\text{-Se1}^{i}) = 2,431(2), d(\text{Hg3}^{ii}\text{-Se2}^{ii}) = 2,426(2), d(\text{Hg3}^{i}\text{-Se2}^{ii}) = 2,426(2), d(\text{Hg3}^{i}\text{-Se1}^{i}) = 2,431(2), d(\text{Bi}^{i}\text{-Cl1}^{i}) = 2,779(2), d(\text{Bi}^{i}\text{-Cl2}^{i}) = 2,635(2), d(\text{Bi}^{i}\text{-Cl3}^{i}) = 2,711(1), d(\text{Bi}^{i}\text{-Cl4}^{i}) = 2,681(1), d(\text{Bi}^{i}\text{-Cl5}^{i}) = 2,832(7), d(\text{Bi}^{i}\text{-Cl5}^{ii}) = 2,567(6).$

5.6.4 Bestimmung der optischen Bandlücke durch UV/VIS-Spektroskopie

Die Bestimmung der optischen Bandlücke wurde mit einem Zweistrahlphotometer durchgeführt. Nach der Transformation der erhaltenen Daten entsprechend der Kubelka-Munk-Theorie [23] in ein Absorptionsspektrum konnte daraus die optische Bandlücke durch eine lineare Interpolation auf die Basislinie ähnlich dem Tauc-Plot [24] zu 491 nm oder 2,53 eV berechnet werden, was der Komplementärfarbe Blau entspricht. Somit besitzt Hg₄BiSe₂Cl₅ eine optische Bandlücke die derjenigen von Hg₄BiS₂Cl₅ mit 2,52 eV entspricht. Deshalb kann auch diese Verbindung als Halbleiter betrachtet werden.

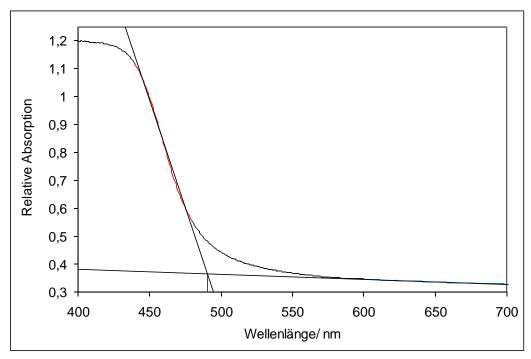


Abb. 5.27: Das UV/VIS-Spektrum von Hg₄BiSe₂Cl₅. Eingezeichnet sind auch die zur Berechnung der optischen Bandlücke entsprechend des Tauc-Plots [24] benötigten Geraden.

5.6.5 Charakterisierung durch Raman-Spektroskopie

Von Hg₄BiSe₂Cl₅ wurde das Raman-Spektrum in Abbildung 5.28 zur Ananlyse der Bindungsverhältnisse aufgenommen. Die darin auftretenden Intensitätsmaxima lassen sich den Schwingungen der enthaltenen Hg-Hg-, Hg-Se- und Bi-Cl-Bindungen zuordnen und liegen im Bereich der für Hg₂Br₂ [134], HgSe [139] und BiCl₃ [136] publizierten Werte. Für die Hg-Hg-Schwingung findet sich dabei eine Wellenzahl von $\widetilde{\nu}_1 = 139 \, \text{cm}^{-1}$ (Hg₂Br₂: 136 cm⁻¹), für die Hg-Se-Schwingungen liegen die Wellenzahlen bei $\widetilde{\nu}_1 = 197 \, \text{cm}^{-1}$ (HgSe: 210 cm⁻¹) sowie

 $\widetilde{v}_2=252~{\rm cm}^{-1}~({\rm HgSe}:~260~{\rm cm}^{-1})$ und für die Bi-Cl-Schwingungen findet man Wellenzahlen von $\widetilde{v}_1=188~{\rm cm}^{-1}~({\rm BiCl}_3:~180~{\rm cm}^{-1})$ sowie $\widetilde{v}_2=220~{\rm cm}^{-1}~({\rm BiCl}_3:~225~{\rm cm}^{-1})$. Die hier zu beobachtenden Übereinstimmungen liegen daran, dass in der $_{\infty}^{-1}[{\rm Hg}_4{\rm Se}_2]^{2+}$ -Teilstruktur des ${\rm Hg}_4{\rm BiSe}_2{\rm Cl}_5$ sowohl Hg-Hg-Bindungen wie im ${\rm Hg}_2{\rm Br}_2$ als auch Hg-Se-Bindungen wie im HgSe enthalten sind und äquivalente Schwingungen zeigen. Auch die $_{\infty}^{-1}[{\rm BiCl}_5]^{2-}$ -Teilstruktur dieser Verbindung weist zum Teil ähnliche Bindungsverhältnisse wie im BiCl $_3$ auf. Die im Vergleich zum Spektrum des ${\rm Hg}_4{\rm BiS}_2{\rm Cl}_5$ auffallende Wellenzahlenverschiebung der ${\rm Hg}_2{\rm Hg}_3{\rm Schwingung}~({\rm Hg}_4{\rm BiS}_2{\rm Cl}_5:~164~{\rm cm}^{-1})$ resultiert vermutlich aus der hier enthaltenen Bindung dieser Quecksilberatome zum schwereren Selen, die zu einer Verringerung der Wellenzahl führt. Den gleichen Effekt findet man auch bei den ${\rm Hg}_3{\rm Hg}_3{\rm Schwingung}$ der ${\rm Hg}_3{\rm Hg}_3{\rm Schwingung}$ von $\widetilde{v}_1=186~{\rm cm}^{-1}~({\rm Hg}_2{\rm F}_2)$ über $\widetilde{v}_2=167~{\rm cm}^{-1}~({\rm Hg}_2{\rm Cl}_2)$ und $\widetilde{v}_3=136~{\rm cm}^{-1}~({\rm Hg}_2{\rm Br}_2)$ bis auf $\widetilde{v}_4=113~{\rm cm}^{-1}~({\rm Hg}_2{\rm I}_2)$ schrittweise abnehmen [133-135].

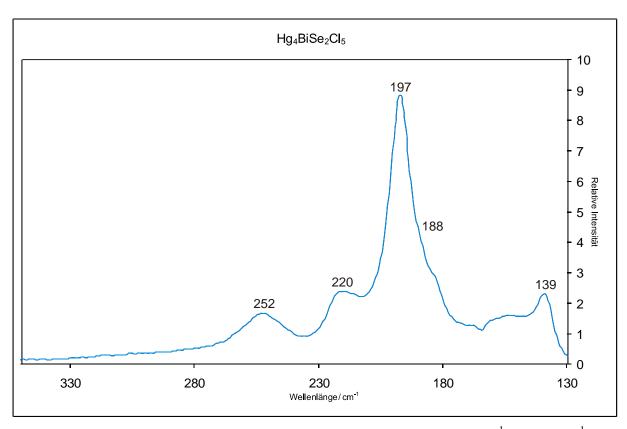


Abb. 5.28: Das Raman-Spektrum von Hg₄BiSe₂Cl₅ im Bereich von 130 cm⁻¹ bis 350 cm⁻¹ mit den ermittelten Schwingungswellenzahlen.

5.7 Synthese und Charakterisierung von Hg₃Bi₂Te₂Cl₈

5.7.1 Synthese von Hg₃Bi₂Te₂Cl₈

Die Synthese von Hg₃Bi₂Te₂Cl₈ erfolgte aus den binären Edukten HgCl₂, HgTe und BiCl₃ entsprechend der Reaktionsgleichung:

$$HgCl_2 + 2HgTe + 2BiCl_3 \rightarrow Hg_3Bi_2Te_2Cl_8$$

Dabei wurden die Ansätze in evakuierten Quarzampullen über einen Zeitraum von zwei Wochen bei 300 °C getempert. Das Abwiegen der Edukte erfolgte dabei in einer Handschuhbox, die mit Argon als Schutzgas gefüllt war, da das eingesetzte BiCl₃ sehr hygroskopisch ist. Nach erfolgter Reaktion erhält man ein gelbes Pulver und transparente gelbe Kristalle, die keinen speziellen Kristallhabitus bevorzugen.

5.7.2 Charakterisierung mittels Pulverdiffraktometrie

Die Analyse und Charakterisierung der erhaltenen Proben erfolgte mit einem aufgenommen Pulverdiffraktogramm, dass mit einem aus Einkristalldaten berechneten Pulverdiffraktogramm verglichen wurde.

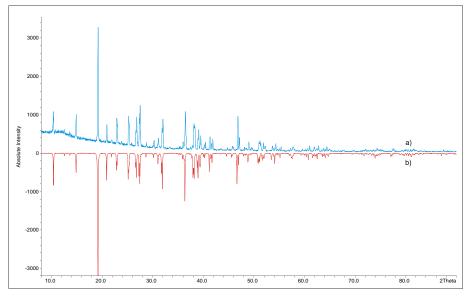


Abb. 5.29: Vergleich eines gemessenen Pulverdiffraktogramms von Hg₃Bi₂Te₂Cl₈ a) mit einem aus Einkristalldaten berechneten b).

Die Indizierung und Verfeinerung des aufgenommenen Pulverdiffraktogramms erfolgte mit einer monoklinen Elementarzelle. Dabei wurden die in der folgenden Tabelle aufgeführten Zellkonstanten erhalten.

Tab. 5.9: Zusammenstellung der Zellkonstanten und des Zellvolumens von Hg₃Bi₂Te₂Cl₈.

a/ Å	b/ Å	c/ Å	β/ °	$V/$ $Å^3$	Literatur
a = 17,494(1)	b = 7,7339(4)	c = 13,5410(9)	β = 104,129(5)	1776,7(1)	d. Arb.

5.7.3 Die Kristallstruktur von Hg₃Bi₂Te₂Cl₈

Entsprechend den kristallographischen Daten A.5.5 besteht die Struktur des in der monoklinen Raumgruppe C2/c (Nr. 15) auskristallisierenden $Hg_3Bi_2Te_2Cl_8$ aus zickzackförmigen $_{\infty}^2[Hg_3Te_2]^{2+}$ - und gefalteten $_{\infty}^2[Bi_2Cl_8]^{2-}$ -Schichten, die parallel zur bc-Ebene in einem Abstand von 1,04(1) Å angeordnet sind.

5.7.3.1 Die $_{\infty}^{2}$ [Hg₃Te₂]²⁺-Schichten

Zwei unabhängige Quecksilberlagen und eine unabhängigen Tellurlage bilden die zickzackförmigen $_{\infty}^{2}$ [Hg₃Te₂]²⁺-Schichten aus. Diese Schichten bestehen aus Hg₆Te₆-Ringen, welche von sechs miteinander verknüpften Hg₃Te-Pyramiden gebildet werden. Hierbei sind die enthaltenen Hg-Te-Bindungen zwischen d(Hg-Te) = 2,654(1) Å und 2,658(4) Å lang und somit etwas kürzer als im HgTe mit d(Hg-Te) = 2,799(1) Å [84-86], aber im Bereich anderer Qecksilbertelluride wie Hg₃Te₂BrI [140] und Rb₂Hg₃Te₄ [141]. Die Faltung der $_{\infty}^{2}$ [Hg₃Te₂]²⁺-Schichten ist eine Folge der Hg-Te-Hg-Winkel von 93,08(1) $^{\circ}$ und 95,44(1) $^{\circ}$. Die nahezu lineare Koordination des Quecksilbers mit Tellur ist eine Besonderheit des Hg₃Bi₂Te₂Cl₈ und lässt sich, außer in der von 1,6 GPa bis 8 GPa stabilen zinnoberartigen Hochdruckmodifikation des HgTe [142, 143], in keiner weiteren bisher untersuchten Quecksilber-Tellur-Verbindung finden. Zickzackförmige $_{\infty}^{2}$ [Hg₃Q₂]²⁺-Schichten aus Hg₆Q₆-Ringen finden sich auch in den vergleichbaren Verbindungen β-Hg₃S₂SiF₆, Hg₃S₂[ZrCl₆], Hg₃Se₂[HfCl₆], Hg₃Se₂[ZrCl₆] und Hg₃Se₂[ZrBr₆] [104, 105].

5.7.3.2 Die $_{\infty}^{2}$ [Bi₂Cl₈]²⁻-Schichten

Die ${}^2_{\infty}[Bi_2Cl_8]^{2^2}$ -Schichten werden von einer Bismutlage und vier Chlorlagen erzeugt. Dabei ordnen sich um das enthaltene Bismut fünf nahe Chlor in Abständen von d(Bi-Cl) = 2,534(3) Å bis 2,810(2) Å an, sodass eine leicht verzerrte BiCl₅-Pyramide entsteht. Die zweite Koordinationssphäre um das Bismut wird von zwei weiteren Chlor gebildet, die vom Schweratom d(Bi-Cl) = 3,255(8) Å und 3,329(6) Å entfernt sind, woraus sich eine 5+2 Umgebung für das Bismut in Form eines BiCl₇-Polyeders ergibt. Jedes dieser BiCl₇-Polyeder ist über gemeinsame Kanten mit drei weiteren BiCl₇-Polyedern verbunden, wodurch sich die ${}^2_{\infty}[Bi_2Cl_8]^{2^2}$ -Schichten ergeben. Ähnliche BiCl₅-Pyramiden und BiCl₇-Polyeder wie in dieser Struktur finden sich auch in den Verbindungen AuBiCl₆, Mo₆BiCl₁₅, Bi₄Se₈Cl₁₄, Bi₄Se₄Cl₁₄, Bi₅Se₁₀Cl₁₇, Bi₄Te₁₄Cl₁₆, PdBi₁₆Cl₂₂, Bi₇Cl₁₀ und Bi₁₂Cl₁₄ [144-151].

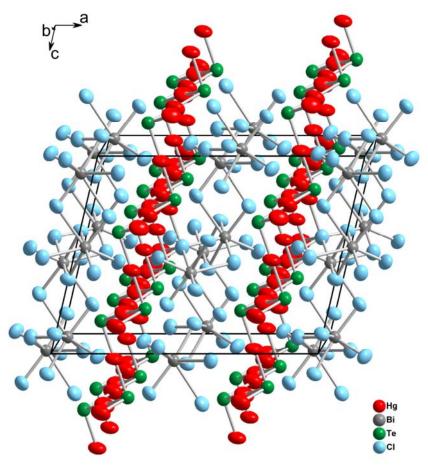


Abb. 5.30: Die Elementarzelle des Hg₃Bi₂Te₂Cl₈ entlang b aus parallelen ${}^2_{\infty}$ [Hg₃Te₂]²⁺- und ${}^2_{\infty}$ [Bi₂Cl₈]²⁻-Schichten. Die dargestellten Ellipsoide repräsentieren eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von 90%.

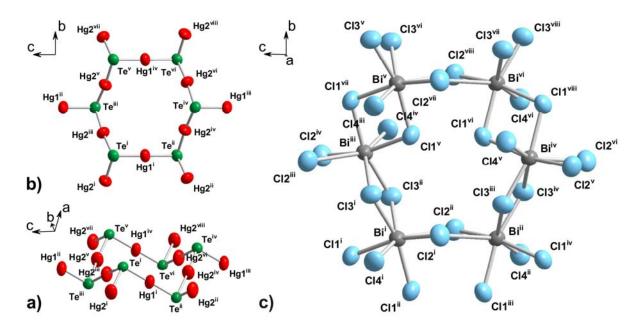


Abb. 5.31: Ausschnitte aus der $_{\infty}^{2}$ [Hg₃Te₂]²⁺-Schicht mit Hg₆Te₆-Ringen in Sessel-konformation a) und b) sowie der $_{\infty}^{2}$ [Bi₂Cl₈]²⁻-Schicht aus kantenverknüpften BiCl₇-Polyedern c). Die verwendeten Ellipsoide repräsentieren eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von 90 %. Die dargestellten Abstände von Hg₃Bi₂Te₂Cl₈ betragen in Å: $d(\text{Hg1}^{i}\text{-Te}^{i}) = 2,658(4)$, $d(\text{Hg2}^{ii}\text{-Te}^{i}) = 2,658(4)$, $d(\text{Hg2}^{ii}\text{-Te}^{i}) = 2,654(1)$, $d(\text{Hg2}^{iv}\text{-Te}^{ii}) = 2,655(1)$, $d(\text{Hg2}^{ii}\text{-Te}^{ii}) = 2,655(1)$, $d(\text{Hg2}^{iv}\text{-Te}^{iv}) = 2,654(1)$, $d(\text{Hg2}^{v}\text{-Te}^{iv}) = 2,655(1)$, $d(\text{Hg1}^{iv}\text{-Te}^{v}) = 2,658(4)$, $d(\text{Hg1}^{iv}\text{-C12}^{i}) = 2,778(5)$, $d(\text{Bi}^{i}\text{-C12}^{i}) = 3,329(6)$, $d(\text{Bi}^{i}\text{-C13}^{i}) = 2,710(2)$, $d(\text{Bi}^{i}\text{-C13}^{ii}) = 3,255(8)$, $d(\text{Bi}^{i}\text{-C14}^{i}) = 2,534(3)$.

5.7.4 Bestimmung der Optischen Bandlücke durch UV/VIS-Spektroskopie

Die optische Bandlücke des gelben Hg₃Bi₂Te₂Cl₈ wurde mit einem Zweistrahlphotometer bestimmt. Nach der Umwandlung der erhaltenen Daten entsprechend der Kubelka-Munk-Theorie [23] konnte aus dem erhaltenen Absorptionsspektrum die optische Bandlücke mit Hilfe einer linearen Interpolation auf die Basislinie gemäß dem Tauc-Plot [24] berechnet werden. Hieraus ergibt sich eine optische Bandlücke von 461 nm oder 2,69 eV, was der Komplementärfarbe Blau entspricht und eine Zuordnung zu den Halbleitern erlaubt.

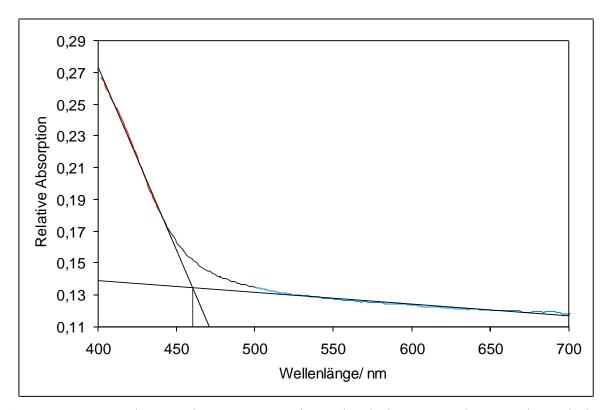


Abb. 5.32: Das UV/VIS-Spektrum von Hg₃Bi₂Te₂Cl₈ mit den zur Bestimmung der optischen Bandlücke entsprechend des Tauc-Plots [24] benötigten Geraden.

5.7.5 Charakterisierung durch Raman-Spektroskopie

Auch von $Hg_3Bi_2Te_2Cl_8$ wurde ein Raman-Spektrum zur Ananlyse der Bindungsverhältnisse aufgenommen, welches in Abbildung 5.33 dargestellt ist. Die in dieser Verbindung enthaltenen Hg-Te- und Bi-Cl-Bindungen erzeugen hierin verschiedene Schwingungsbanden, welche im Bereich der für HgTe [152, 153] und BiCl_3 [136] publizierten Werte liegen. Für die Hg-Te-Schwingungen finden sich dabei Wellenzahlen von \tilde{v}_1 = 156 cm⁻¹ (HgTe: 156 cm⁻¹) sowie \tilde{v}_2 = 274 cm⁻¹ (HgTe: 277 cm⁻¹) und für die Bi-Cl-Schwingungen findet man Wellenzahlen von \tilde{v}_1 = 143 cm⁻¹ (BiCl_3: 141 cm⁻¹), \tilde{v}_2 = 199 cm⁻¹ (BiCl_3: 180 cm⁻¹) sowie \tilde{v}_3 = 230 cm⁻¹ (BiCl_3: 225 cm⁻¹). Die hierbei auftretenden Übereinstimmungen mit den Literaturwerten liegen daran, dass in der $\frac{2}{\pi}$ [Hg_3Te_2]²⁺-Schicht auch Hg-Te-Bindungen wie im HgTe enthalten sind und äquivalente Schwingungen zeigen. Auch die $\frac{1}{\pi}$ [BiCl_3]²⁻-Teilstruktur dieser Verbindung weist zum Teil ähnliche Bindungsverhältnisse wie im BiCl_3 auf. Die im Vergleich zum Spektrum von Hg_4BiSe_2Cl_5 erkennbaren Wellenzahlenverschiebungen einer Bi-Cl-Schwingung (Hg_4BiSe_2Cl_5: 188 cm⁻¹, Hg_3Bi_2Te_2Cl_8: 199 cm⁻¹) lässt sich vermutlich auf die unterschiedlichen Bindungswinkeln an den verbrückenden Cl-Atomen zurückführen. So

beträgt dieser Bindungswinkel in der $_{\infty}^{-1}[BiCl_5]^{2-}$ -Teilstruktur des $Hg_4BiSe_2Cl_5$ 149,28(3) °, wohingegen die entsprechenden Bindungswinkel in der $_{\infty}^{-2}[Bi_2Cl_8]^{2-}$ -Schicht des $Hg_3Bi_2Te_2Cl_8$ nur 102,57(6) °, 107,74(5) ° und 108,79(7) ° betragen.

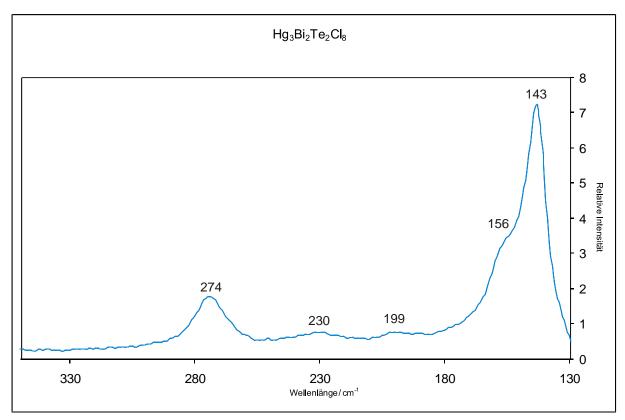


Abb. 5.33: Das Raman-Spektrum von Hg₃Bi₂Te₂Cl₈ im Bereich von 130 cm⁻¹ bis 350 cm⁻¹ mit den ermittelten Schwingungswellenzahlen.

5.8 Zusammenfassung

Das HgBi₂S₄ aus Kapitel 5.3 wurde von *W. S. Brower* et al. [5] erstmals synthetisiert und von *W. G. Mumme* und *J. A. Watts* [6] röntgenographisch charakterisiert. In seiner Struktur befindet sich das Quecksilber im Zentrum von HgS₆-Oktaedern, die über gemeinsame Kanten Stränge entlang *b* ausbilden, welche durch BiS₅-Pyramiden zu Schichten in der *ab*-Ebene miteinander verknüpft sind. Diese Schichten sind durch schwache Van-der-Waals-Wechselwirkungen miteinander verbunden. Die optische Bandlücke dieser grauen Verbindung konnte an Hand eines UV/VIS-Spektrums zu 882 nm oder 1,41 eV bestimmt werden.

Die Struktur des Hg_{0,5}Bi₂S₃Cl aus Kapitel 5.4 besteht aus einem [Bi₂S₃Cl] -Netzwerk in dessen Hohlräumen Hg²⁺-Ionen eingebettet sind. Diese Hg²⁺-Ionen besitzen kovalente Bindungen zum benachbarten Schwefel und lassen sich einer nur zu 50 % besetzten Hg-Lage zuordnen. Zwar gibt es neben Hg_{0,5}Bi₂S₃Cl noch einige Verbindungen die unterbesetzte Hg-Lagen enthalten [79, 98-101], aber ungewöhnlich an dieser Substanz ist der mit *d*(Hg-Hg) = 2,011(2) Å sehr geringe Abstand dieser Quecksilberpositionen. Dieser Befund lässt sich hauptsächlich durch eine Lagefehlordnung erklären, wie sie auch schon für die Ag-Lagen der beiden strukturchemisch sehr ähnlichen Verbindungen AgBi₂S₃Cl und AgBi₂Se₃Cl von *M. Ruck* [102] angenommen wurde.

Das in Kapitel 5.5 behandelte Hg4BiS2Cl₅ lässt sich gut als Interkalationsverbindung beschreiben. Die enthaltene $_{\infty}^{2}$ [Hg4S2]²⁺-Teilstruktur besteht aus gefalteten Schichten, die parallel zur [111]-Ebene angeordnet sind. Diese Schichten bestehen aus Hg8S6-Ringen, die von sich abwechselnden Hg3S-Pyramiden und Hg2-Hanteln gebildet werden. Somit ist das Hg4BiS2Cl₅ die erste Verbindung in dessen Quecksilber-Sulfid-Teilstruktur beide für das Quecksilber häufigsten Oxidationsstufen +1 und +2 gleichermaßen enthalten sind und den jeweiligen Hg-Lagen eindeutig zugeordnet werden können. Die $_{\infty}^{1}$ [BiCl₅]²⁻-Teilstruktur wird durch BiCl₆-Oktaeder aufgebaut, die über gemeinsame Ecken zu Ketten entlang *b* verknüpft sind. BiCl₆-Oktaeder finden sich zwar auch in einigen anderen Verbindungen [115-132], aber nur im Hg4BiS2Cl₅ und Hg4BiSe2Cl₅ bilden diese Ketten aus, die durch eine Eckenverknüpfung dieser Oktaeder entstehen. Von dieser gelben Verbindung wurde ebenfalls mittels einer UV/VIS-Messung die optische Bandlücke bestimmt und durch Bandstrukturund DOS-Rechnungen betätigt. Sie beträgt 492 nm oder 2,52 eV, wonach auch das Hg4BiS2Cl₅ ein Halbleiter ist.

Genauso wie das $Hg_4BiS_2Cl_5$ kann auch das in Kapitel 5.6 charakterisierte $Hg_4BiSe_2Cl_5$ als Interkalationsverbindung betrachtet werden. Seine $\frac{1}{\infty}[Hg_4Se_2]^{2+}$ -Teilstruktur besteht aus parallel zueinander entlang a verlaufen Doppelsträngen, die durch sich abwechselnde Hg_6Se_4 -und Hg_4Se_4 -Ringe aufgebaut werden. In den Hg_6Se_4 -Ringen sind im Gegensatz zu den Hg_4Se_4 -Ringen Hg_2 -Hanteln enthalten. Wie in den $\frac{2}{\infty}[Hg_4S_2]^{2+}$ -Schichten des $Hg_4BiS_2Cl_5$ treten auch in diesen $\frac{1}{\infty}[Hg_4Se_2]^{2+}$ -Doppelsträngen des $Hg_4BiSe_2Cl_5$ die beiden für das Quecksilber geläufigsten Oxidationszahlen +1 und +2 gleichermaßen auf und lassen sich den enthaltenen Hg-Lagen eindeutig zuordnen, was außer in dieser Verbindung bisher noch in keiner Quecksilber-Selen-Verbindung gefunden wurde. Die $\frac{1}{\infty}[BiCl_5]^{2-}$ -Teilstruktur des $Hg_4BiSe_2Cl_5$ wird genauso wie im $Hg_4BiS_2Cl_5$ durch $BiCl_6$ -Oktaeder gebildet, die über gemeinsame Ecken zu Ketten entlang b miteinander verknüpft sind, was auch ein charakteristisches Strukturmerkmal beider Verbindungen darstellt. Die optische Bandlücke dieser Verbindung wurde an Hand eines UV/VIS-Spektrum zu 491 nm oder 2,53 eV bestimmt. Demzufolge ist auch das ebenfalls gelbe $Hg_4BiSe_2Cl_5$ zu den Halbleitern zu rechnen.

Der Hauptunterschied in diesen $[Hg_4Q_2]^{2^+}$ -Teilstrukturen besteht darin, dass im $Hg_4BiS_2Cl_5$ die Hg4-Lage eine Vernetzung der Hg_8S_6 -Ringe entlang b bewirkt, wodurch die vorliegende schichtartige Struktur resultiert. Im Gegensatz dazu führt die Hg4-Lage im $Hg_4BiSe_2Cl_5$ keine Vernetzung entlang b durch, weshalb hier Hg_6Se_4 - und Hg_4Se_4 -Ringe enthalten sind, die zu Doppelsträngen verbunden sind.

Die Struktur des $Hg_3Bi_2Te_2Cl_8$, das in Kapitel 5.7 vorgestellt wird, besteht aus zickzackförmigen $_{\infty}^{2}[Hg_3Te_2]^{2+}$ - und gefalteten $_{\infty}^{2}[Bi_2Cl_8]^{2-}$ -Schichten, die parallel zur bc-Ebene angeordnet sind. Die $_{\infty}^{2}[Hg_3Te_2]^{2+}$ -Schichten bestehen aus Hg_6Te_6 -Ringen, die eine dem Cyclohexan äquivalente Sesselkonformation aufweisen und von sechs miteinander verknüpften Hg_3Te -Pyramiden gebildet werden. Die darin auftretende nahezu lineare Koordination des Quecksilbers mit Tellur ist eine Besonderheit des $Hg_3Bi_2Te_2Cl_8$ und findet sich, außer in einer zinnoberartigen Hochdruckmodifikation des HgTe [142, 143], in keiner weiteren bisher untersuchten Quecksilber-Tellur-Verbindung. Die $_{\infty}^{2}[Bi_2Cl_8]^{2-}$ -Schichten werden durch kantenverknüpfte $BiCl_7$ -Polyeder aufgebaut. Mit Hilfe eins UV/VIS-Spektrums wurde auch die optische Bandlücke des $Hg_3Bi_2Te_2Cl_8$ zu 461 nm oder 2,69 eV ermittelt, weshalb auch diese gelbe Verbindung ein Halbleiter ist.

VI Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit hat drei Themenbereiche der anorganischen Chemie als wesentlichen Inhalt, nämlich die in Kapitel 3 beschriebenen Mischkristallreihen MnSb_{2-x}Bi_xS₄ und MnSb_{2-x}Bi_xSe₄, die in Kapitel 4 betrachtete FeSb_{1-x}Bi_xS₂Br Mischkristallreihe und die in Kapitel 5 behandelten Quecksilber-Chalkogenometallate und Quecksilber-Chalkogenidhalogenide. Dabei liegt der Schwerpunkt der Arbeit eindeutig auf der Synthese und röntgenographischen Charakterisierung der hergestellten Substanzen. Die ebenfalls durchgeführten Untersuchungen der physikalischen Eigenschaften mancher Verbindungen dienen hierbei lediglich der etwas genaueren Betrachtungen und können als Ausgangspunkt tiefergehender Studien aufgefasst werden.

Der erste Themenbereich ergab sich dabei als logische Konsequenz aus der von D. Kurowski durchgeführten Synthese und röntgenographischen Charakterisierung der ternären Verbindungen MnSb₂S₄, MnBi₂S₄, MnSb₂Se₄ und MnBi₂Se₄ [1, 2], welche am selben Lehrstuhl erfolgte. In dieser Arbeit wird unter anderem die strukturchemische Verwandtschaft zwischen MnSb₂S₄ und den anderen drei genannten Verbindungen untersucht. So findet sich in der $MnSb_{2-x}Bi_xS_4$ Serie im Bereich von x = 0.4 bis x = 1.0 eine Mischungslücke, was durch die Bestimmung der Zellkonstanten und Zellvolumina aufgezeigt wurde, wohingegen in der MnSb_{2-x}Bi_xSe₄ Serie ein durchweg linearer Verlauf der Zellkonstanten und Zellvolumina entsprechen der Regel von L. Vegard [43] auftritt. Diese strukturchemisch sehr verschiedenen Verläufe ergeben sich hauptsächlich aus der unterschiedlichen Position der Manganlagen. Denn im MnSb₂S₄, welches isotyp zu HgBi₂S₄ [6] ist, besetzt das Mangan die Wyckoff-Positionen Mn1: 2a (0 0 0) und Mn2: 2c (0 0 $\frac{1}{2}$), wohingegen in den Verbindungen MnBi₂S₄, MnSb₂Se₄ und MnBi₂Se₄, welche isotyp zu FeSb₂Se₄ [3, 30] kristallisieren, das Mangan die Wyckoff-Positionen Mn1: 2a (0 0 0) und Mn2: 2d (0 ½ ½) einnimmt. Dadurch kommt es zu einer Strukturvariation, die im MnBi₂S₄, MnSb₂Se₄ und MnBi₂Se₄ eine Verschiebung der Mn2-enthaltenden Schichten um a/2 gegenüber den entsprechenden Schichten im MnSb₂S₄ zur Folge hat, wie in den Abbildungen 3.1, 3.8 und 3.9 gezeigt wird. Ermöglicht wird diese abweichende Schichtstapelung auch dadurch, dass diese Schichten nur durch schwache Vander-Waals-Wechselwirkungen zusammengehalten werden.

Die Ursache für diesen strukturellen Übergang ist darin zu sehen, dass sich die c-Achse im Verlauf der MnSb_{2-x}Bi_xS₄ Mischkristallreihe deutlich verkürzt, weshalb es zu einer Annäherung der enthaltenen Schichten kommt. Dies führt in den zum HgBi₂S₄ isotypen Verbindungen zu einer direkten Übereinanderlagerung der enthaltenen MeS₆-Oktaeder (Me: Hg, Mn, Bi), wie aus den Abbildungen 3.1, 3.8 und 3.9 ebenfalls hervorgeht. In einem Bereich von x = 0 bis x = 0.4 ist dies noch möglich da hier die Schichten mit etwa 2,35(1) Å (Schichtabstand im MnSb₂S₄) noch recht weit voneinander entfernt sind, wohingegen sich die Schichten im Bereich von x = 1.0 bis x = 2.0 mit einem Abstand von etwa 1,97(1) Å (Schichtabstand im Mn_{0.94}Bi_{2.04}S₄) dafür bereits zu nahe kommen, weshalb hier eine zu MnSb₂Se₄ isotype Struktur angenommen wird, in der die MeS₆-Oktaeder quasi auf Lücke sitzen.

Außerdem enthalten diese Verbindungen, abgesehen vom MnSb₂S₄, auch noch eine statistische Mn/Sb- bzw. Mn/Bi-Mischbesetzungen, welche schon durch *D. Kurowski* [1] und *S. Lee* et al. [29] aufgefunden wurde und die anhand der Verbindungen Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S₄, Mn_{0,94}Bi_{2,04}S₄, Mn_{0,88}Sb_{2,08}Se₄, Mn_{0,94}Sb_{1,64}Bi_{0,4}Se₄ und Mn_{0,73}Bi_{2,18}Se₄ mittels Einkristall-strukturanalyse bestätigt werden konnte. Dabei ist diese Mischbesetzung in der MnSb_{2-x}Bi_xSe₄ Serie deutlich stärker ausgeprägt als in der MnSb_{2-x}Bi_xS₄ Serie, was mit Hilfe der Abbildungen A.3.11 und A.3.22 veranschaulicht wird, weshalb die in der MnSb_{2-x}Bi_xSe₄ Mischkristallreihe vorgefundenen MeQ₆-Oktaeder (Me: Mn, Sb und Bi; Q: S, Se) stärkere Volumendifferenzen zwischen mischbesetzten und unterbesetzten MeQ₆-Oktaedern aufweisen als das in der MnSb_{2-x}Bi_xS₄ Mischkristallreihe der Fall ist.

Im zweiten Themenbereich ist die FeSb_{1-x}Bi_xS₂Br Serie Gegenstand der Untersuchungen, die in Zusammenarbeit mit *A. Pointner* [3] und *M. F. Bräu* [4] entstand. Hier findet im Verlauf der Mischkristallreihe eine kontinuierliche Veränderung der Zellkonstanten und Zellvolumina gemäß der Regel von *L. Vegard* [43] statt, ohne dass eine Mischungslücke oder Zersetzung auftritt. Dieser Befund lässt sich auch anhand der dargestellten und mittels Einkristallstrukturanalyse untersuchten Verbindungen FeSbS₂Br, FeSb_{0,51}Bi_{0,49}S₂Br und FeBiS₂Br bekräftigen. Ausgehend vom FeUS₃ [45] werden hier auch zwei Gruppe-Untergruppe-Beziehung anhand der jeweiligen Bärnighausen-Stammbäume [27] aufgestellt, welche den strukturchemischen Übergang von FeUS₃ zu zwei Verbindungen der allgemeinen Summenformel MPnQ₂X (M: Mn, Fe, Cd; Pn: Sb, Bi; Q: S, Se; X: Cl, Br, I) erläutern, die eine verzerrte und substituierte Variante des FeUS₃ darstellen. Dabei ergibt sich für das in der orthorhombischen Raumgruppe *Cmcm* (Nr. 63) auftretende MnSbS₂Cl [48, 49] ein klassengleicher Übergang 2.

Ordnung, bei dem eine Transformation der Zellachsen entsprechend $a, b, c \rightarrow c, a, b$ auftritt. Beim FeSbS₂Br [3, 4] hingegen, das in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12) kristallisiert, liegt ein translationsgleicher Übergang 2. Ordnung vor, der eine Transformation der Zellachsen entsprechend $a, b, c \rightarrow b, -a, c$ beinhaltet. Zusammenfassend werden diese Übergänge in Abbildung 4.3 veranschaulicht.

Die Erweiterung der Strukturchemie des Quecksilbers stand im Zentrum des dritten Themenbereichs.

Dafür wurde zunächst die von W. S. Brower et al. [5] erstmals synthetisierte und von W. G. Mumme und J. A. Watts [6] röntgenographisch charakterisierte Verbindung HgBi₂S₄ synthetisiert und ebenfalls röntgenographisch aber auch spektrometrisch untersucht.

Das im Anschluss daran beschriebene $Hg_{0,5}Bi_2S_3Cl$ wird durch ein $[Bi_2S_3Cl]^-$ -Netzwerk aufgebaut in dessen Hohlräumen Hg^{2+} -Ionen über kovalente Hg-S-Bindungen eingebettet sind. Diese Hg^{2+} -Ionen werden von einer nur zu 50 % besetzten Hg-Lage erzeugt. Dabei ist der Abstand dieser Hg^{2+} -Ionen zueinander mit d(Hg-Hg) = 2,011(2) Å sehr gering, was eine Lagefehlordnung dieser dicht benachbarter Hg-Positionen nahelegt, wie sie auch schon für die Ag-Lagen der beiden strukturchemisch sehr ähnlichen Verbindungen $AgBi_2S_3Cl$ und $AgBi_2Se_3Cl$ von M. Ruck [102] angenommen wurde.

Die beiden Substanzen $Hg_4BiS_2Cl_5$ und $Hg_4BiSe_2Cl_5$ lassen sich gut als Interkalationsverbindungen beschreiben, in denen $_{\infty}^{-1}[BiCl_5]^{2^-}$ -Ketten aus eckenverknüpften $BiCl_6$ -Oktaedern in eine $[Hg_4Q_2]^{2^+}$ -Teilstruktur (Q: S, Se) eingebettet sind. Im $Hg_4BiS_2Cl_5$ besteht diese $_{\infty}^{-2}[Hg_4S_2]^{2^+}$ -Teilstruktur aus gefalteten Schichten, welche aus Hg_8S_6 -Ringen bestehen die ihrerseits von sich abwechselnden Hg_3S -Pyramiden und Hg_2 -Hanteln gebildet werden. Im Gegensatz dazu besteht die $_{\infty}^{-1}[Hg_4Se_2]^{2^+}$ -Teilstruktur des $Hg_4BiSe_2Cl_5$ aus Doppelsträngen, die von sich abwechselnden Hg_6Se_4 - und Hg_4Se_4 -Ringen aufgebaut werden, wobei in den Hg_6Se_4 -Ringen Hg_2 -Hanteln enthalten sind.

Diese $[Hg_4Q_2]^{2^+}$ -Teilstrukturen von $Hg_4BiS_2Cl_5$ und $Hg_4BiSe_2Cl_5$ unterscheiden sich in erster Linie durch die unterschiedliche Vernetzung der enthaltenen Hg_8S_6 - Hg_6Se_4 - und Hg_4Se_4 -Ringe, welche durch die Hg4-Lage bewirkt wird. So erzeugt diese Hg4-Lage im $Hg_4BiS_2Cl_5$ aus den Hg_8S_6 -Ringen eine schichtartige $^2_\infty$ $[Hg_4S_2]^{2^+}$ -Teilstruktur, wohingegen im $Hg_4BiSe_2Cl_5$ durch eine fehlende Verknüpfung entlang b eine $^1_\infty$ $[Hg_4Se_2]^{2^+}$ -Teilstruktur in Form von Doppelsträngen resultiert.

Diese beiden Substanzen stellen außerdem die ersten Vertreter von gemischtvalenten Quecksilber-Sulfid- bzw. Quecksilber-Selenid-Verbindungen dar, in denen die beiden für das Quecksilber häufigsten Oxidationszahlen +1 und +2 gleichermaßen auftreten und sich den enthaltenen Hg-Lagen eindeutig zuordnen lassen.

Die Struktur des zuletzt beschriebenen $Hg_3Bi_2Te_2Cl_8$ besteht aus zickzackförmigen $_{\infty}^2$ $[Hg_3Te_2]^{2+}$ - und gefalteten $_{\infty}^2$ $[Bi_2Cl_8]^{2-}$ -Schichten, die parallel zur bc-Ebene angeordnet sind. Dabei werden die $_{\infty}^2$ $[Hg_3Te_2]^{2+}$ -Schichten von Hg_6Te_6 -Ringen aufgebaut, die eine dem Cyclohexan äquivalente Sesselkonformation aufweisen und aus miteinander verknüpften Hg_3Te -Pyramiden bestehen. Die $_{\infty}^2$ $[Bi_2Cl_8]^{2-}$ -Schichten werden ihrerseits durch kantenverknüpfte BiCl₇-Polyeder aufgebaut. In den $_{\infty}^2$ $[Hg_3Te_2]^{2+}$ -Schichten wird das Quecksilber nahezu linear durch Tellur koordiniert, was vorher nur in einer Hochdruckmodifikation des HgTe [142, 143] gefunden werden konnte.

Somit konnte durch diese Arbeit auch das Strukturchemische Spektrum des Quecksilbers durch eine Reihe neu gefundener sowie der Verifizierung bereits bekannter Strukturelemente bestätigt und zum Teil deutlich erweitert werden, was dem Verständnis der Quecksilberchemie zu gute kommt.

VII Literaturverzeichnis

[1] D. Kurowski:

Mangan-Chalkogenmetallate der 15. Gruppe und binäre Kupfertelluride Dissertation, Universität Regensburg, **2003**.

[2] A. Pfitzner und D. Kurowski:

A new Modification of MnSb₂S₄ crystallizing in the HgBi₂S₄ Structure Type. Z. Kristallogr. **2000**, *215*, 373-376.

[3] A. Pointner:

Die quaternären partiell halogenierten Mangan- und Eisensulfosalze: Synthese und Charakterisierung
Zulessungserbeit Universität Regensburg 2006

Zulassungsarbeit, Universität Regensburg, 2006.

[4] *M. F. Bräu*:

Gruppe 11 und 12 Halogenide als Präparatives Hilfsmittel Dissertation, Universität Regensburg, **2007**.

[5] W. S. Brower; H. S. Parker und R. S. Roth:

Synthesis of mercury bismuth sulfide (HgBi₂S₄).

Mater. Res. Bull. 1973, 8, 859-862.

[6] *W. G. Mumme* und *J. A. Watts*:

Mercury bismuth sulfide (HgBi₂S₄): crystal structure and relationship with the pavonite homologous series.

Acta Crystallogr., Sect. B: Struct. Sci. 1980, B36, 1300-1304.

[7] *G. Brauer*:

Handbuch der Präparativen Anorganischen Chemie in drei Bänden Erster Band, 3. Auflage, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart **1975**.

- [8] STOE WinXPOW, Version 1.08, STOE & Cie GmbH, Darmstadt, 2000.
- [9] X-Area Softwarepaket, Version 1.35, STOE & Cie GmbH, Darmstadt, 2006.
- [10] XPREP DATA PREPARATION & SPACE EXPLORATION Ver. 5.1/NT Bruker Analytical X-ray Systems, **1997**.
- [11] X-RED32, Version 1.31, STOE & Cie GmbH, Darmstadt, 2005.
- [12] X-SHAPE, Version 2.07, STOE & Cie GmbH, Darmstadt, 2005.

[13] G. Sheldrick:

SHELX97 Programs for the solution and refinement of crystal structures, University of Göttingen, **1997**.

[14] *L. J. Farrugia*:

WINGX, Version 1.70.01.

J. Appl. Cryst. 1999, 32, 837-838.

[15] A. L. Spek:

PLATON, A Multipurpose Crystallographic Tool, University of Utrecht, 2005. J. Appl. Cryst. **2003**, *36*, 7-13.

[16] S. C. Abrahams und E. T. Keve:

Normal probability plot analysis of error in measured and derived quantities and standard deviations.

Acta Crystallogr., Sect. A: Found. Crystallogr. 1971, A27, 157-165.

[17] E. Parthé und L. M. Gelato:

The standardization of inorganic crystal-structure data. Acta Crystallogr., Sect. A: Found. Crystallogr. **1984**, *A40*, 169-183.

[18] T. Balic Zunic und I. Vickovic:

IVTON - program for the calculation of geometrical aspects of crystal structures and some crystal chemical applications.

J. Appl. Crystallogr. 1996, 29, 305-306.

[19] K. Brandenburg und H. Putz:

Endeavour, Version 1.2c, Crystal Impact GbR, 2000-2008.

- [20] EDAX, Genesis, Version 4.52, **2005**.
- [21] Setsoft, Version 1.5, SETARAM Engineering, 2000.
- [22] Bruins Instruments, Omega software, Version 3.3 2006.

[23] *P. Kubelka* und *F. Munk*:

Ein Beitrag zur Optik der Farbanstriche.

Z. tech. Phys. **1931**, *1*, 593-601.

[24] J. Tauc; R. Grigorovici und A. Vancu:

Optical properties and electronic structure of amorphous germanium.

Phys. Status Solidi 1966, 15, 627-637.

- [25] Resolution Pro software, Version 4.1.0.101, Varian Inc., 2006.
- [26] R. Dovesi; V. R. Saunders; C. Roetti; R. Orlando; C. M. Zicovich-Wilson; F. Pascale; B. Civalleri; K. Doll; N. M. Harrison; I. J. Bush; Ph. D' Arco und M. Llunell: CRYSTAL06, user's guide Turin 2006.

[27] H. Bärnighausen:

Group-subgroup relations between space groups: a useful tool in crystal chemistry. Commun. Math. Chem. **1980**, *9*, 139-175.

[28] T. Hahn:

International Tables for Crystallography, Volume A: Space-Group Symmetry; Fifth Edition.

Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2002.

[29] S. Lee; E. Fischer; J. Czerniak und N. Nagasundaram:

Synthesis and structure of two phases with both extended and point defects:

 $Mn_{1-x}Bi_{2+y}S_4$ and $Mn_{1-x}Bi_{2+y}Se_4$.

J. Alloys Compd. 1993, 197, 1-5.

[30] H. Djieutedjeu; P. F. P. Poudeu; N. J. Takas; J. P. A. Makongo; A. Rotaru; K. G. S. Ranmohotti; C. J. Anglin; L. Spinu und J. B. Wiley:

Structural-Distortion-Driven Cooperative Magnetic and Semiconductor-to-Insulator Transitions in Ferromagnetic FeSb₂Se₄.

Angew. Chem. Inter. Ed. 2010, 49, 10173-10177.

[31] *H. Ott*:

Die Strukturen von MnO, MnS, AgF, NiS, SnI₄, SrCl₂, BaF₂, Präzisionsmessungen einiger Alkalihalogenide. Z. Kristallogr. **1926**, *63*, 222-230.

[32] H. Franzen und C. Sterner:

The X-ray photoelectron spectra of MnS, MnSe, and MnTe J. Solid State Chem. **1978**, *25*, 227-230.

[33] V. M. Goldschmidt:

Geochemical distribution laws of the elements. VIII. Researches on the structure and properties of crystals.

Matemal.-Naturv. Klasse 1927, 8, 7-156.

[34] W. Hofmann:

Die Struktur der Minerale der Antimonitgruppe.

Z. Kristallogr. 1933, 86, 225-245.

[35] D. O. McKee und J. T. McMullan:

Comment on the structure of antimony trisulfide.

Z. Kristallogr. 1975, 142, 447-449.

[36] *E. Dönges*:

Über Chalkogenohalogenide des dreiwertigen Antimons und Wismuts. II. Über Selenohalogenide des dreiwertigen Antimons und Wismuts und über Antimon(III)-selenide. Mit 2 Abbildungen.

Z. Anorg. Allg. Chem. 1950, 263, 280-291.

[37] G. P. Voutsas; A. G. Papazoglou und P. J. Rentzeperis:

The crystal structure of antimony selenide, Sb₂Se₃.

Z. Kristallogr. 1985, 171, 261-268.

[38] *R.*. *Caracas* und *X*. *Gonze*:

First-principles study of the electronic properties of A_2B_3 minerals, with A=Bi, Sb and B=S, Se.

Phys. Chem. Min. 2005, 32, 295-300.

[39] K.. Lukaszewicz; J. Stepien-Damm; A. Pietraszko; A. Kajokas und J. Grigas: Crystal structure, thermal expansion, dielectric permittivity and phase transitions of

Crystal structure, thermal expansion, dielectric permittivity and phase transitions of Bi_2S_3 .

Pol. J. Chem. **1999**, 73, 541-546.

[40] K.. Schubert; K. Anderko; M. Kluge; H. Beeskow; M. Ilschner; E. Dorre und P. Esslinger:

Strukturuntersuchungen der Legierungsphasen Cu₂Te, CuTe, Cu₃Sb, InTe, Bi₂Se₃, Pb₅Sb₃ und Pb₅Bi₃.

Naturwiss. 1953, 40, 269.

[41] E. Ya. Atabaeva; S. A. Mashkov und S. V. Popova: Crystal structure of a new modification of bismuth selenide II. Kristallografiya **1973**, *18*, 173-174.

[42] S. Nakajima:

The crystal structure of $Bi_2Te_{3-x}Se_x$. Phys. Chem. Solid **1963**, *24*, 479-485.

[43] *L. Vegard*:

Die Konstruktion der Mischkristalle und die Raumfüllung der Atome. Z. Phys. **1921**, *5*, 17-26.

[44] R. D. Shannon:

Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic distances in halides and chalcogenides.

Acta Crystallogr., Sect. A: Found. Crystallogr. 1976, A32, 751-767.

[45] H. Noël und J. Padiou:

Crystal structure of iron uranium sulfide (FeUS₃). Acta Crystallogr., Sect. B: Struct. Sci. **1976**, *B32*, 1593-1595.

[46] *L. Wang*; *Yi-C. Hung*; *S.-J. Hwu*; *H.-J. Koo* und *M.-H. Whangbo*: Synthesis, Structure, and Properties of a New Family of Mixed-Framework Chalcohalide Semiconductors: CdSbS₂X (X = Cl, Br), CdBiS₂X (X = Cl, Br), and CdBiSe₂X (X = Br, I).

Chem. Mater. 2006, 18, 1219-1225.

[47] M. F. Bräu; F. Rau und A. Pfitzner:

Die inkommensurabel modulierten Strukturen FeSbS₂Cl und FeSbSe₂Br.

Z. Anorg. Allg. Chem. 2006, 632, 2119.

[48] C. Doussier; P. Léone und Y. Moëlo:

Single crystal structure and magnetic properties of MnSbS₂Cl. Solid State Sci. **2004**, *6*, 1387-1391.

[49] C. Doussier; G. André; P. Léone; E. Janod und Y. Moëlo:

Magnetic study of two isotypic manganese chloro-sulfides: MnSbS₂Cl and the new compound MnBiS₂Cl.

J. Solid State Chem. **2006**, *179*, 486-491.

[50] C. Doussier; Y. Moëlo und P. Léone:

Synthesis and crystal structures of four new bromo-chalcogenides: $MnSbS_2Br$, $MnBiSe_2Br$ and two allotropic forms of $MnSbSe_2Br$. Crystal chemistry of the $MnPnQ_2X$ family (Pn = Sb, Bi; Q = S, Se; X = Cl, Br, I). Solid State Sci. **2006**, *8*, 652-659.

[51] A. Yamamoto:

Crystallography of quasiperiodic crystals.

Acta Crystallogr., Sect. A: Found. Crystallogr. 1996, A52, 509-560.

[52] A. Pfitzner; M. Zabel und F. Rau:

Preparation and Crystal Structure of MnBiS₂Br.

Monatsh. Chem. 2005, 136, 1977-1983.

[53] O. Tougait; J. A. Ibers und A. Mar:

Manganese antimony diselenide iodide, MnSbSe₂I.

Acta Crystallogr., Sect. C: Cryst. Struct. Commun. 2003, C59, i77-i78.

[54] A. Pfitzner; M. Zabel und F. Rau:

Preparation and crystal structure of MnBiSe₂I.

Z. Anorg. Allg. Chem. 2005, 631, 1439-1441.

[55] N. Alsen:

Röntgenographische Untersuchungen der Kristallstrukturen von Magnetkies, Breithauptit,

Pentlandit, Millerit und verwandten Verbindungen.

Geolog. Foerening. Stockholm 1925, 47, 19-73.

[56] *F. Xu* und *A. Navrotsky*:

Enthalpies of formation of pyrrhotite $Fe_{1-0.125x}S$ (0<=x<=1) solid solutions

Am. Mineral. 2010, 95, 717-723.

[57] E. Dönges:

Über Chalkogenohalogenide des dreiwertigen Antimons und Wismuts. I. Über Thiohalogenide des dreiwertigen Antimons und Wismuts.

Z. Anorg. Chem. 1950, 263, 112-132.

[58] D. Siapkas; A. Bartzokas; G. P. Voutsas und P.J. Rentzeperis:

Crystal structure and optical lattice vibrations of SbSBr crystals.

Z. Kristallogr. **1986**, 175, 305-315.

[59] *T. Inushima*:

X-ray study of crystal structure and diffuse scattering spectra of ferroelectric SbSBr having pseudo-Jahn-Teller phase transition.

J. Phys. Chem. Solids 1999, 60, 587-598.

[60] G. P. Voutsas und P. J. Rentzeperis:

The crystal structure of bismuth sulfide bromide, BiSBr.

Z. Kristallogr. **1984**, *166*, 153-158.

[61] A. F. Holleman; E. Wieberg und N. Wieberg:

Lehrbuch der Anorganischen Chemie, 102. Auflage

Walter de Gryer Verlag Berlin und New York 2007

[62] K. Brodersen:

Quecksilber – ein giftiges, nützliches und ungewöhnliches Edelmetall.

Chem. uns. Zeit 1982, 16, 23-31.

[63] L. W. McKeehan und P. P. Cioffi:

The crystal structure of mercury.

Phys. Rev. 1922, 19, 444-446.

[64] R. St. Amand und B. C. Giessen:

On the metastable system mercury-thallium.

J. Less-Common Metals 1978, 58, 161-172.

[65] *J. E. Schirber*:

Some properties of β-Hg

Dissertation, Universität Iowa, 1961.

[66] D. Grdenic:

The structural chemistry of mercury.

Quart. Rev. 1965, 19, 303-328.

[67] K. Brodersen:

Dimercury(I)-Nitrogen Compounds and Other Addition Complexes of the 'Hg-Hg⁺ ion.

Comments Inorg. Chem. **1981**, *1*, 207-225.

[68] C. A. Ghilardi; S. Midollini und S. Moneti:

X-ray crystal structure of $[N(CH_2CH_2PPh_2)_3]_2Co_2(\mu-Hg_2)$: the dimeric Hg $_2^{2+}$ ion forms a linear bridge between the two cobalt atoms.

Chem. Commun. 1981, 16, 865-866.

[69] F. Ebert und H. Woitinek:

Kristallstrukturen von Fluoriden. II. HgF, HgF₂, CuF and CuF₂.

Z. Anorg. Allg. Chem. 1933, 210, 269-272.

[70] H. J. Deiseroth:

Alkalimetall-Amalgame.

Chem. uns. Zeit 1991, 25, 83-86.

[71] H. J. Deiseroth und A. Strunck:

Hg₈-Cluster ("Mercuban") in Rb₁₆Hg₁₈.

Angew. Chem. 1989, 101, 1286-1287.

[72] *E. Biehl* und *H.-J.Deiseroth*:

K₂Hg₇ und Rb₂Hg₇, zwei Vertreter eines neuen Strukturtyps binärer intermetallischer Verbindungen.

Z. Anorg. Allg. Chem. 1999, 625, 1337-1342.

[73] *H.-J. Deiseroth* und *E. Biehl*:

NaK₂₉Hg₄₈: A Contradiction to or an Extension of Theoretical Concepts to Rationalize the Structures of Complex Intermetallics?

J. Solid State Chem. **1999**, 147, 177-184.

[74] I.-C. Hwang; T. Drews und K. Seppelt:

Mg(NH₃)₆Hg₂₂, a Mercury Intercalation Compound.

J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 8486-8489.

[75] R. D. Ellison; H. A. Levy und K. W. Fung:

Crystal and molecular structure of trimercury chloroaluminate, Hg₃(AlCl₄)₂. Inorg. Chem. **1972**, *11*, 833-836.

morg. Chem. **1772**, 11, 655-656.

[76] B. D. Cutforth; C. G. Davies; P. A. W. Dean; R. J. Gillespie; P. R. Ireland und P. K. Ummat:

Preparation and Raman spectra of compounds of the trimercury($^{2+}$) cation. Crystal structure of trimercury bis(hexafluoroarsenate(V) Hg₃(AsF₆)₂. Inorg. Chem. **1973**, *12*, 1343-1347.

[77] I. D. Brown; R. J. Gillespie; K. R. Morgan; J. F. Sawyer; K. J. Schmidt; Z. Tun; P. K. Ummat und J. E. Vekris:

Preparation and crystal structure of $Hg_3(NbF_5)_2SO_4$, $Hg_3(TaF_5)_2SO_4$, and $Hg_4(Ta_2F_{11})_2$. Inorg. Chem. **1987**, *26*, 689-693.

- [78] B. D. Cutforth; R. J. Gillespie; P. Ireland; J. F. Sawyer und P. K. Ummat: Preparation and crystal structure of tetramercury bis(hexafluoroarsenate) Hg₄(AsF₆)₂. Inorg. Chem. **1983**, 22, 1344-1347.
- [79] I. D. Brown; B. D. Cutforth; C. G. Davies; R. J. Gillespie; P. R. Ireland und J. E. Vekris: Alchemists' gold, mercury gold fluoride (Hg_{2,86}AsF₆). X-ray crystallographic study of a novel disordered mercury compound containing metallically bonded infinite cations. Can. J. Chem. **1974**, *52*, 791-793.
- [80] H. E. Buckley und W. S. Vernon: The crystal structures of the sulfides of mercury. Min. Mag. **1925**, 20, 382-392.
- [81] *K. L. Aurivillius*:
 Crystal structure of cinnabar.
 Acta Chem. Scand. **1950**, *4*, 1413-1436.
- [82] *P. Auvray* und *F. Genet*: Refining the crystal structure of cinnabar, α-mercury(II) sulfide. Bull. Soc. fr. de Minéral. Cristallogr. **1973**, *96*, 218-219.
- [83] T. Schleid; P. Lauxmann und C. Schneck: Röntgenographische Einkristalluntersuchungen an alpha-(HgS) (Zinnober). Z. Kristallogr., Supp. Issue. 1999, 16, 95.
- [84] *W. F. de Jong*: Die Struktur des Tiemannit und Koloradoit. Z. Kristallogr. **1926**, *63*, 466-472.
- [85] S. Yu. Paranchich; L. D. Paranchich; V. N. Makogonenko und V. B. Lototskii: Structural, electric, and thermal properties of Fe_xHg_{1-x}Se. Inorg. Mater. **1989**, *25*, 198-201.
- [86] W. Palosz und H. Wiedemeier: Mass flux, Crystal composition and Solid solubility studies of the Hg_{1-x}Mn_xTe – HgI₂ vapor transport system. J. Less-Common Metals 1989, 156, 299-324.
- [87] I. H. Brækken und L. Harang: Die Kristallstruktur einiger orthorhombischer Verbindungen des Typs MX₂. Z. Kristallogr. 1928, 68, 123-138.
- [88] H. Brækken und W. Scholten: Die Kristallstruktur des Quecksilberchlorids HgCl₂. Z. Kristallogr. 1934, 89, 448-455.
- [89] *V. Subramanian* und *K. Seff*: Mercuric chloride, a redetermination. Acta Crystallogr., Sect. B: Struct. Sci. **1980**, *B36*, 2132-2135.
- [90] *R. J. Havighurst*: Crystal structure of the mercurous halides. Am. J. Sci. **1925**, *10*, 15-28.

[91] N. J. Calos; C. H. L. Kennard und R. L. Davis: The structure of calomel, Hg₂Cl₂, derived from neutron powder data. Z. Kristallogr. **1989**, 187, 305-307.

[92] *M. A. Nusimovici* und *A. Meskaoui*: Raman Scattering by α-HgS (Cinnabar).

Phys. Stat. Sol. B: 1973, 58, 121-125.

[93] W. Imaino; C. T. Simpson; W. M. Becker und A. K. Ramdas: Resonant Raman effect in cinnabar.

Phys. Rev. B: **1980**, *21*, 634-642.

[94] S. V. Gotoshia und L. V. Gotoshia:

Laser Raman and resonance Raman spectroscopies of natural semiconductor mineral cinnabar, α-HgS, from various mines.

J. Phys. D: Appl. Phys. 2008, 41, 115406/1-115406/6.

[95] *K. Trentelman*:

A note on the characterization of bismuth black by Raman microscopy.

J. Raman Spectrosc. 2009, 40, 585-589.

[96] S. Kharbish; E. Libowitzky und A. Beran:

Raman spectra of isolated and interconnected pyramidal XS_3 groups ($X = Sb_3$) in stibnite, bismuthinite, kermesite, stephanite, and bournonite.

J. Miner. 2009, 21, 325-333.

[97] G. P. Voutsas und P. J. Rentzeperis:

The crystal structure of the paraelectric bismuth thiochloride, BiSCl.

Z. Kristallogr. 1980, 152, 109-118.

[98] A. J. Schultz; J. M. Williams; N. D. Miro; A. G. MacDiarmid und A. J. Heeger:

A neutron diffraction investigation of the crystal and molecular structure of the anisotropic superconductor Hg_3AsF_6 .

Inorg. Chem. 1978, 17, 646-649.

[99] Z. Tun und I. D. Brown:

The low-temperature structures of mercury hexafluoroantimonate $(Hg_{3-\delta}SbF_6)$ and mercury hexafluoroantalate $(Hg_{3-\delta}TaF_6)$.

Acta Crystallogr., Sect. B: Struct. Sci. 1986, B42, 209-213.

[100] Z. Tun und I. D. Brown:

The structure of mercury hexafluoroantimonate $Hg_{3-\delta}SbF_6$.

Acta Crystallogr., Sect. B: Struct. Sci. 1982, B38, 2321-2324.

[101] Z. Tun; I. D. Brown und P. K. Ummat:

The room-temperature structures of mercury niobium fluoride, $Hg_{3-\delta}NbF_6$, and mercury tantalum fluoride, $Hg_{3-\delta}TaF_6$.

Acta Crystallogr., Sect. C: Cryst. Struct. Commun. 1984, C40, 1301-1303.

[102] M. Ruck:

Synthese und Kristallstrukturen der quaternären Chalkogenidchloride $AgBi_2S_3Cl$ und $AgBi_2Se_3Cl$.

Z. Anorg. Allg. Chem. 2002, 628, 1537-1540.

[103] Yu. V. Voroshilov; V. A. Khudolii; V. V. Pan'ko und Yu. V. Minets:

Phase equilibria in the $HgS-HgTe-HgBr_2$ system and crystal structure of $Hg_3S_2Br_2$ and Hg_3TeBr_4 .

Inorg. Mater. 1996, 32, 1281-1286.

[104] H. Puff; G. Lorbacher und D. Heine:

Quecksilberchalkogen-Fluorosilicate.

Naturwiss. **1969**, *56*, 461.

[105] J. Beck und S. Hedderich:

Expanded polycationic mercury-chalcogen networks in the layered compounds $Hg_3E_2[MX_6]$ (E = S, Se; M = Zr, Hf; X = Cl, Br).

J. Solid State Chem. 2003, 172, 12-16.

[106] N. V. Pervukhina; S. V. Borisov; S. A. Magarill; D. Yu. Naumov und V. I. Vasiliev:

Crystal structure of the synthetic analog of radtkeite Hg₃S₂CII.

J. Struct. Chem. 2004, 45, 720-723.

[107] D. Grdenic und C. Djordjevic:

The mercury-mercury bond length in the mercurous ion. II. The crystal structure of mercurous fluoride.

J. Chem. Soc. 1956, 1956, 1316-1319.

[108] E. Dorm:

Crystal chemistry of the mercurous ion and of mercurous salts.

Chem. Commun., Univ. Stockholm 1970, 1970, 1-25.

[109] *E. Hylleraas*:

Die Anordnung der Atome in den tetragonalen Kristallen der einwertigen Quecksilberhalogenide Hg₂Cl₂, Hg₂Br₂, Hg₂J₂.

Berechnung der optischen Doppelbrechung von Hg₂Cl₂.

Z. Phys. **1926**, *36*, 859-896.

[110] R. J. Havighurst:

Parameters in crystal structure. The mercurous halides.

J. Am. Chem. Soc. 1926, 48, 2113-2125.

[111] *M. L. Huggins* und *P. L. Magill*:

The crystal structures of mercuric and mercurous iodides.

J. Am. Chem. Soc. 1927, 49, 2357-2367.

[112] S. C. Nyburg; G. A. Ozin und J. T. Szymanski:

Crystal and molecular structure of bismuth trichloride.

Acta Crystallogr., Sect. B: Struct. Sci. 1971, B27, 2298-2304.

[113] S. C. Nyburg; G. A. Ozin und J. T. Szymanski:

Crystal and molecular structure of bismuth trichloride. Erratum.

Acta Crystallogr., Sect. B: Struct. Sci. 1972, B28, 2885.

[114] *H. Bartl*:

Meßzeitersparnis durch Profilauswertung bei der Registrierung von

Neutroneneinkristallreflexen. Die Kristallstruktur von Wismuttrichlorid, BiCl₃.

Fresenius Z. Anal. Chem. **1982**, *312*, 17-18.

[115] F. Benachenhou; G. Mairesse; G. Nowogrocki und D. Thomas:

Structural studies cesium-potassium-bismuth mixed chlorides relation to the crystal structures of A_2BMX_6 , A_3MX_6 , and A_2MX_6 .

J. Solid State Chem. 1986, 65, 13-26.

[116] L. R. Morss und W. R. Robinson:

Crystal structure of cesium sodium bismuth hexachloride Cs₂NaBiCl₆.

Acta Crystallogr., Sect. B: Struct. Sci. 1972, B28, 653-654.

[117] G. Meyer; S. J. Hwu und J. D. Corbett:

Low-temperature crystal growth of Cs₂LiLuCl₈-II and Cs₂KScCl₈ under reducing conditions and their structural refinement.

Z. Anorg. Allg. Chem. 1986, 535, 208-212.

[118] J. Beck; S. Hedderich und U. Neisel:

Synthesis and Crystal Structures of Hg₆Sb₅Br₇, Hg₆As₄BiCl₇, and Hg₆Sb₄BiBr₇, Built of a Polycationic Mercury-Pnictide Framework with Trapped Anions.

J. Solid State Chem. 2000, 154, 350-355.

[119] A. A. Udovenko; R. L. Davidovich; M. A. Medkov; R. G. Gerr und Yu. T. Struchkov:

Crystal structure of the ternary salt tripotassium hexachlorobismuthate \cdot 2 potassium chloride \cdot potassium hydrogen fluoride (KH₃F₄).

Koordinats Khim 1987, 13, 274-278.

[120] A. A. Udovenko und R. L. Davidovich:

Crystal structure of ternary salt K₃BiCl_{6.2}KClKH₃F₄ at 103 K.

Koordinats Khim **1991**, 17, 1545-1546.

[121] M. Atoji und T. Watanabe:

X-ray investigation of Co(NH₃)₆PbCl₆ and Co(NH₃)₆BiCl₆.

J. Chem. Phys. **1952**, 20, 1045-1046.

[122] K. Prassides; P. Day und A. K. Cheetham:

Crystal structures of mixed-valency and mixed-metal salts $A_2MIII_{0,5}SbV_{0,5}X_6$ (A = Rb,

Cs; M = Sb, Bi, In, Tl, Fe, Rh; X = Cl, Br). A powder neutron diffraction study. Inorg. Chem. **1985**, *24*, 545-552.

morg. Chem. **1763**, 24, 545-552.

[123] I. Belkyal; R. Mokhlisse; B. Tanouti; K.-F. Hesse und W. Depmeier:

Crystal structure of (NH₄)₃BiCl₆.

Eur. J. Solid State Inorg. Chem. 1997, 34, 1085-1091.

[124] E. Herdtweck und U. Kreusel:

Structure of tetrakis(dimethylammonium) chloride hexachlorobismuthate(III), $\{[(C H_3)_2 NH_2]^+\}_4Cl^*[BiCl_6]^{3-}$.

Acta Crystallogr., Sect. C: Crtyst. Struct. Commun. 1993, C49, 318-320.

[125] J. Lefebvre; P. Carpenter und R. Jakubas:

Structures and phase transition in the ferroelectric crystal of pentakis (methylammonium) undecachlorodibis muthate (III): $[NH_3(CH_3)]_5Bi_2Cl_{11}$.

Acta Crystallogr., Sect. B: Struct. Sci. 1991, B47, 228-234.

[126] S. Jarraya; R. B. Hassen; A. Daoud und T. Jouini:

Dimethylammonium pentachlorobismuthate(III).

Acta Crystallogr., Sect. C: Cryst. Struct. Commun. 1995, C51, 2537-2578.

[127] H. Ishihara; K. Yamada; T. Okuda und A. Weiss:

The structures of $M_2X_9^{3-}$ (M = Bi; X = Cl, Br) ions determined by Rietveld analysis of x-ray powder diffraction data.

Bull. Chem. Soc. Jpn. 1993, 66, 380-383.

[128] B. Kruss und M. L. Ziegler:

Crystal and molecular structure of thiotrithiazyl tetrachlorobismuthate, (S₄N₃)BiCl₄. Z. Naturforsch., B: J. Chem. Sci. **1972**, *27b*, 1282-1283.

[129] K. Kihara und T. Sudo:

Crystal structures of β-Cs₃Sb₂Cl₉ and Cs₃Bi₂Cl₉.

Acta Crystallogr., Sect. B: Struct. Sci. 1974, B30, 1088-1093.

[130] G. Meyer und A. Schönemund:

Zur Kenntnis der Hochtemperatur-Phasenumwandlung bei Cs₃Bi₂Cl₉.

Z. Anorg. Allg. Chem. 1980, 468, 185-192.

[131] I. Belkyal; R. Mokhlisse; B. Tanouti; K. F. Hesse und W. Depmeier:

Crystal structure of tris(mono-methylammonium)nonachloro-dibismuthate(III), (CH₃NH₃)₃Bi₂Cl₉.

Z. Kristallogr. 1997, 212, 139-140.

[132] M. Wojtas; G. Bator; R. Jakubas; J. Zaleski; B. Kosturek und J. Baran:

Crystal structure, phase transitions and ferroelastic properties of [(CH₃)₂NH₂]₃[Bi₂Cl₉].

J. Solid State Chem. **2003**, *173*, 425-434.

[133] H. Stammreich und T. T. Sans:

Hg-Hg stretching frequencies and bond length in mercurous compounds.

J. Mol. Struct. 1967, 1, 55-60.

[134] J. R. Durig; K. K. Lau; G. Nagarajan; M. Walker und J. Bragin:

Vibrational Spektra and Molecular Potential Fields of Mercurous Chloride, Bromide, and Iodide.

J. Chem. Phys. **1969**, *50*, 2130-2139.

[135] *T. Osaka*:

Far-Infrared Absorption Spectra of Mercurous Halides.

J. Chem. Phys. 1970, 54, 863-867.

[136] E. Denchik; S. C. Nyburg; G. A. Ozin and J. T. Szymanski:

Raman Spektra of Gaseous and Solid Bismuth Trichloride. Resonance Fluorescence Spectra of gaseous BiCl and BiBr.

Inorg. Phys. Theor. 1971, 20, 3157-3159.

[137] H. Puff und R. Kohlschmidt:

Die Kristallstruktur von Hg₃S₂Cl₂.

Naturwiss. 1962, 49, 299-300.

[138] J. Beck und S. Hedderich:

Synthesis and Crystal Structure of Hg₃S₂I₂ and Hg₃Se₂I₂, New Members of the Hg₃E₂X₂ Family.

J. Solid State Chem. 2000, 151, 73-76.

[139] K. Kumazaki:

Dielectric Constant in Zn_xHg_{1-x}Se Determined by Raman Scattering.

Phys. Stat. Sol. B: **1990**, 160, K173-K176.

[140] Yu. V. Minets; Yu. V. Voroshilov und V. V. Pan'ko:

The structures of mercury chalcogenhalogenides Hg₃X₂Hal₂.

J. Alloys Compd. 2004, 367, 109-114.

[141] J. Li; Z. Chen; K.-C. Lam; S. Mulley und D. M. Proserpio:

Rb₂Hg₃Te₄: A New Layered Compound Synthesized from Solvothermal Reactions.

Inorg. Chem. 1997, 36, 684-687.

[142] N. G. Wright; M. I. McMahon; R. J. Nelmes und A. San-Miguel:

Crystal structure of the cinnabar phase of mercury telluride (HgTe).

Phys. Rev. B: Condens. Matter Mater. Phys. 1993, 48, 13111-13114.

[143] A. San-Miguel; N. G. Wright; M. I. McMahon und R. J. Nelmes:

Pressure evolution of the cinnabar phase of HgTe.

Phys. Rev. B: Condens. Matter Mater. Phys. 1995, 51, 8731-8736.

[144] J. Beck und St. Wagner:

Lewis-Säure-Base-Reaktionen von Goldtrihalogeniden mit Bismuttrihalogeniden - Synthese und Kristallstrukturen von AuBi X_6 (X = Cl, Br)

Z. Anorg. Allg. Chem. 1997, 623, 1810-1814.

[145] J. Beck und M. Hengstmann:

Das Addukt von BiCl₃ mit Mo₆Cl₁₂: [BiCl]-Hanteln in der Struktur von [BiCl][Mo₆Cl₁₄].

Z. Anorg. Allg. Chem. 1998, 624, 433-437.

[146] A. Baumann; J. Beck und T. Hilbert:

Octachalcogen cations Te_8^{2+} , Se_8^{2+} , and mixed $(Te_{8-x}Se_x)_8^{2+}$ stabilized by

chlorometallates of Bi, Zr, and Hf: synthesis and crystal structures of Se₈[Bi₄Cl₁₄] and

 $E_8[MCl_6]$ (E = Se, Te; M = Zr, Hf).

Z. Naturforsch., B: J. Chem. Sci. 1999, 54, 1253-1259.

[147] *J. Beck* und *T. Hilbert*:

Selen-Polykationen stabilisiert durch polymere Chlorobismutat-Anionen: Synthesen und Kristallstrukturen von Se₄[Bi₄Cl₁₄] und Se₁₀[Bi₅Cl₁₇].

Z. Anorg. Allg. Chem. 2000, 626, 837-844.

[148] J. Beck; A. Fischer und A. Stankowski:

Polymere, bandförmige Tellurkationen in den Strukturen des Chloroberyllats Te₇[Be₂Cl₆] und des Chlorobismutats (Te₄)(Te₁₀)[Bi₄Cl₁₆].

Z. Anorg. Allg. Chem. **2002**, *628*, 2542-2548.

[149] V. Dubenskyy und M. Ruck:

Das Subchlorid Bi₁₆PdCl₂₂: Pd@Bi₁₀⁴⁺-Polykationen in einem Raumnetzwerk aus

Chlorobismutat(III)-Anionen.

Z. Anorg. Allg. Chem. 2004, 630, 2458-2462.

[150] S. Hampel; P. Schmidt und M. Ruck:

Synthese, thermochemische Eigenschaften und Kristallstruktur von Bi₇Cl₁₀.

Z. Anorg. Allg. Chem. **2005**, *631*, 272-283.

[151] *R. M. Friedman* und *J. D. Corbett*:

Synthesis and crystal structure of dodecabismuth tetradecachloride, Bi₁₂Cl₁₄.

Inorg. Chim. Acta **1973**, 7, 525-527.

[152] K. K. Tiong; P. M. Amirtharaj; P. Parayanthal und F. H. Pollak:

Raman Scattering from (110) Hg_{0.8}Cd_{0.2}Te. Solid State Commun. **1984**, *50*, 891-894.

[153] Z. C. Feng und S. Perkowitz:

Raman and resonant Raman scattering from the HgTe/CdTe superlattice. Phys. Rev. B: **1990**, *41*, 6057.

A Anhang

A.1 Übersicht der Publikationen und Posterbeiträge

Zur Wahrung der Priorität wurden folgende Publikationen und Tagungsbeiträge vor Abschluss diese Dissertation veröffentlicht:

Veröffentlichungen

A. E. Voinescu; D. Touraud; A. Lecker; A. Pfitzner; W. Kunz und B. W. Ninham: Mineralization of CaCO₃ in the presence of egg white lysozyme. Langmuir **2007**, 23(24), 12269-12274.

A. E. Voinescu; D. Touraud; A. Lecker; A. Pfitzner; L. Kienle und W. Kunz: Initiation of Vaterite-Aragonite CaCO₃ Particles from Silicate-Casein Sols. J. Phys. Chem. C **2008**, 112(45), 17499-17506.

D. Weinzierl; *D. Touraud*; *A. Lecker*; *A. Pfitzner* und *W. Kunz*: Controlled preparation of hollow zinc oxide microspheres from aqueous solution using hexamethylenetetramine and cysteine.

Mater. Res. Bull. C **2008**, *43(1)*, 62-67.

Tagungsbeiträge

2023. September 2006	13. Vortragstagung der GDCh Fachgruppe Festkörperchemie und Materialforschung, Aachen A. Lecker, D. Kurowski, A. Pfitzner Synthese und Charakterisierung der Mischkristallreihe MnSb _{2-x} Bi _x Se ₄
2426. September 2008	14. Vortragstagung der GDCh Fachgruppe Festkörperchemie und Materialforschung, Bayreuth A. Lecker, A. Pfitzner Synthese und Charakterisierung der Verbindung Hg ₄ BiS ₂ Cl ₅
2023. September 2009	European Conference on Solid State Chemistry ECSSC XII, Münster A. Lecker, A. Pfitzner Synthesis and Crystal Structure of Hg ₃ Bi ₂ Te ₂ Cl ₈

A.2 Definitionen

A.2.1 Definitionen zur Einkristallstrukturanalyse

Maßzahl für die Übereinstimmung Symmetrieäquivalenter Reflexe R_{int}:

$$R_{\rm int} = \frac{\sum ||F_0|^2 - |\overline{F_0}|^2|}{\sum |F_0|^2}$$

Gütefaktoren der least-squares-Verfeinerung R_1 , wR_2 und GooF

$$R_{1} = \frac{\sum ||F_{0}| - |F_{c}||}{\sum |F_{0}|}; wR_{2} = \sqrt{\frac{\sum [w(F_{0}^{2} - F_{c}^{2})^{2}]}{\sum [w(F_{0}^{2})^{2}]}}; GooF = \sqrt{\frac{[w(F_{0}^{2} - F_{c}^{2})^{2}]}{n - p}}$$

n = Anzahl der Reflexe, p = Anzahl der Parameter

$$w = \frac{1}{\left(\sigma^{2}\left(F_{0}^{2}\right) + \left(0,01 \cdot u \cdot F_{0}^{2}\right)^{2}\right)}$$

 $U_{
m eq}$ ist definiert als ein drittel der Spur des orthogonalen $U_{
m ij}$ -Tensors.

Die Koeffizienten U_{ij} des Tensors des anisotropen Temperaturfaktors besitzt folgende Form:

$$-2\pi^{2} \cdot (h^{2} \cdot a^{*2} \cdot U_{11} + \dots + 2 \cdot h \cdot a^{*} \cdot b^{*} \cdot U_{12} + \dots)$$

A.2.2 Definitionen zur Pulverdiffraktometrie

$$R_{\rm p} = \frac{\sum |y_0 - y_c|}{\sum y_0}; wR_{\rm p} = \sqrt{\frac{\sum w(y_0 - y_c)^2}{\sum wy_0^2}}; R_{\rm Bragg} = \frac{\sum |I_0 - I_c|}{\sum |I_0|}$$

y₀, y_c: beobachtete und berechnete Einzelzählrate im Pulverdiffraktogramm

w: Gewichtung einer Zählrate w =
$$\frac{1}{v_0}$$

I₀, I_c: beobachtete und berechnete Intensität (Integrierte Fläche unter den Bragg-Peaks)

A.3 Die kristallographischen Daten von Kapitel 3

A.3.1 Die kristallographischen Daten von $Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S_4$

Table A.3.1: Die kristallographischen Daten und Messparameter von Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S₄

Verbindung	$Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S_4$
Molmasse / g/mol	523,29
Kristallfarbe	dunkelgrau
Kristallsystem	monoklin
Raumgruppe	C2/m (Nr. 12)
Zellkonstanten / Å; °	a = 12,7422(2)
	b = 3,8545(7)
	c = 14,9028(2)
•	$\beta = 114,564(1)$
Volumen / \mathring{A}^3 , Z	665,70(1), 4
Dichte / g/cm ³	5,232
Absorptionskoeffizient / mm ⁻¹	35,826
Diffraktometer	STOE IPDS I
Wellenlänge / Å	0,71073
Messtemperatur / K	293(2)
Θ-Bereich / °	3,01 - 25,33
hkl-Bereich	$-14 \le h \le 14, -4 \le k \le 4, -17 \le l \le 17$
gesammelte Reflexe	2506
unabhängige Reflexe	638
Absorptionskorrektur	numerisch
Vollständigkeit	90,1%
GooF	1,015
Parameter	49
$R_{ m int};R_{ m \sigma}$	0,0400; 0,0308
R_1 ; wR_2 [I>2 σ]	0,0420; 0,1084
R_1 ; wR_2 [alle Reflexe]	0,0465; 0,1105
Restelektronendichte / e·Å ⁻³	+1,303; -1,724

 $\label{eq:table A.3.2:} \mbox{ Die Atomkoordinaten, Wyckofflagen, Besetzungen und isotrope} \\ \mbox{ Auslenkungsparameter von } Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S_4$

Atom	Wykofflagen	Besetzung	х	У	Z	$U_{ m eq}$
Mn(1)	2 <i>a</i>	0,96(1)	0	0	0	0,044(2)
Bi(3)	2a	0,04(1)	0	0	0	0,044(2)
Mn(2)	2d	0,98(1)	0	0,5	0,5	0,043(2)
Bi(1)	4i	0,56(3)	0,3558(1)	0	0,1296(1)	0,043(1)
Sb(1)	4i	0,44(3)	0,3558(1)	0	0,1296(1)	0,043(1)
Bi(2)	4i	0,52(3)	0,2811(1)	0	0,6358(1)	0,039(1)
Sb(2)	4i	0,48(3)	0,2811(1)	0	0,6358(1)	0,039(1)
S(1)	4i	1,0	0,3363(5)	0	0,3275(3)	0,044(1)
S(2)	4i	1,0	0,6552(5)	0	0,0469(3)	0,041(1)
S(3)	4i	1,0	0,0121(4)	0	0,1782(3)	0,043(1)
S(4)	4i	1,0	0,1167(4)	0	0,4601(3)	0,038(1)

Table A.3.3: Die anisotropen Auslenkungsparameter U_{ij} von $Mn_{0,97}Sb_{0,92}Bi_{1,10}S_4$

Atom	U_{11}	U_{22}	U_{33}	U_{23}	U_{13}	U_{12}
Mn(1)/Bi(3)	0,041(3)	0,031(2)	0,062(2)	0	0,025(2)	0
Mn(2)	0,036(3)	0,036(2)	0,056(2)	0	0,020(2)	0
Bi(1)/Sb(1)	0,044(1)	0,033(1)	0,053(1)	0	0,022(1)	0
Bi(2)/Sb(2)	0,043(1)	0,035(1)	0,055(1)	0	0,022(1)	0
S(1)	0,041(3)	0,039(2)	0,053(2)	0	0,022(2)	0
S(2)	0,040(3)	0,033(2)	0,052(2)	0	0,021(2)	0
S(3)	0,041(3)	0,034(2)	0,053(2)	0	0,019(2)	0
S(4)	0,034(3)	0,032(2)	0,049(2)	0	0,018(2)	0

$\textbf{A.3.2} \ \text{Die kristallographischen Daten von } Mn_{0,94}Bi_{2,04}S_4$

Table A.3.4: Die kristallographischen Daten und Messparameter von $Mn_{0,94}Bi_{2,04}S_4$

Verbindung	$Mn_{0,94}Bi_{2,04}S_4$
Molmasse / g/mol	606,20
Kristallfarbe	dunkelgrau
Kristallsystem	monoklin
Raumgruppe	C2/m (Nr. 12)
Zellkonstanten / Å; °	a = 12,7681(2)
	b = 3.9179(1)
	c = 14,7544(3)
	$\beta = 115,295(2)$
Volumen / $Å^3$, Z	667,31(2), 4
Dichte / g/cm ³	6,034
Absorptionskoeffizient / mm ⁻¹	56,536
Diffraktometer	STOE IPDS I
Wellenlänge / Å	0,71073
Messtemperatur / K	293(2) K
Θ-Bereich / °	3,05 - 28,08
hkl-Bereich	$-16 \le h \le 16, -4 \le k \le 4, -19 \le l \le 19$
gesammelte Reflexe	2706
unabhängige Reflexe	877
Vollständigkeit	93,7%
Absorptionskorrektur	numerisch
GooF	1,074
Parameter	47
R_{int} ; R_{σ}	0,0717; 0,0522
R_1 ; wR_2 [I>2 σ]	0,0346; 0,0858
R_1 ; wR_2 [alle Reflexe]	0,0390; 0,0879
Restelektronendichte / e'Å ⁻³	+2,525; -1,830

 $\label{eq:Table A.3.5:} \mbox{ Die Atomkoordinaten, Wyckofflagen, Besetzungen und isotrope} \\ \mbox{ Auslenkungsparameter von } Mn_{0,94}Bi_{2,04}S_4$

Atom	Wykofflagen	Besetzungen	x	у	Z	$U_{ m eq}$
Mn(1)	2 <i>a</i>	0,92(1)	0	0	0	0,024(1)
Bi(3)	2a	0,08(1)	0	0	0	0,024(1)
Mn(2)	2d	0,96(1)	0	0,5	0,5	0,026(1)
Bi(1)	4i	1,0	0,3532(1)	0	0,1307(1)	0,024(1)
Bi(2)	4i	1,0	0,2844(1)	0	0,6381(1)	0,026(1)
S(1)	4i	1,0	0,3378(3)	0	0,3269(3)	0,022(1)
S(2)	4i	1,0	0,6555(3)	0	0,0509(3)	0,021(1)
S(3)	4i	1,0	0,0126(3)	0	0,1797(3)	0,023(1)
S(4)	4i	1,0	0,1164(3)	0	0,4595(3)	0,021(1)

Table A.3.6: Die anisotropen Auslenkungsparameter $U_{\rm ij}$ von ${\rm Mn_{0,94}Bi_{2,04}S_4}$

Atom	U_{11}	U_{22}	U_{33}	U_{23}	U_{13}	U_{12}
Mn(1)/Bi(3)	0,020(2)	0,022(2)	0,032(2)	0	0,012(1)	0
Mn(2)	0,018(1)	0,028(2)	0,029(2)	0	0,008(1)	0
Bi(1)	0,022(1)	0,023(1)	0,027(1)	0	0,010(1)	0
Bi(2)	0,022(1)	0,026(1)	0,030(1)	0	0,009(1)	0
S(1)	0,020(2)	0,024(2)	0,025(2)	0	0,012(1)	0
S(2)	0,018(2)	0,021(2)	0,025(2)	0	0,010(1)	0
S(3)	0,016(2)	0,021(2)	0,028(2)	0	0,005(1)	0
S(4)	0,017(2)	0,021(2)	0,025(2)	0	0,010(1)	0

$\textbf{A.3.3} \ \text{Die kristallographischen Daten von } Mn_{0,88}Sb_{2,08}Se_4$

Table A.3.7: Die kristallographischen Daten und Messparameter von Mn_{0,88}Sb_{2,08}Se₄

Verbindung	$Mn_{0.88}Sb_{2.08}Se_4$
Molmasse / g/mol	617,43
Kristallfarbe	dunkelgrau
Kristallsystem	monoklin
Raumgruppe	C2/m (Nr. 12)
Zellkonstanten / Å; °	a = 13,3388(3)
,	b = 3.9733(1)
	$c = 15{,}3136(3)$
	$\beta = 115,775(2)$
Volumen / $Å^3$, Z	730,87(2), 4
Dichte / g/cm ³	5,611
Absorptionskoeffizient / mm ⁻¹	28,934
Diffraktometer	STOE IPDS I
Wellenlänge / Å	0,71073
Messtemperatur / K	293(2) K
Θ-Bereich / °	2,95 - 25,68
hkl-Bereich	$-16 \le h \le 16, -4 \le k \le 4, -18 \le l \le 18$
gesammelte Reflexe	2952
unabhängige Reflexe	792
Vollständigkeit	98,4%
Absorptionskorrektur	numerisch
GooF	1,090
Parameter	47
$R_{\rm int}$; R_{σ}	0,0382; 0,0241
R_1 ; wR_2 [I>2 σ]	0,0318; 0,0804
R_1 ; wR_2 [alle Reflexe]	0,0346; 0,0816
Restelektronendichte / e'Å-3	+1,208; -1,430

 $\label{eq:continuous} \textbf{Table A.3.8:} \ \ \text{Die Atomkoordinaten, Wyckofflagen, Besetzungen und isotrope} \\ \ \ \text{Auslenkungsparameter von } Mn_{0,88}Sb_{2,08}Se_4$

Atom	Wykofflagen	Besetzungen	х	у	Z	U_{eq}
Mn(1)	2 <i>a</i>	0,84(1)	0	0	0	0,040(1)
Sb(3)	2d	0,16(1)	0	0	0	0,040(1)
Mn(2)	2d	0,92(1)	0	0,5	0,5	0,030(1)
Sb(1)	4i	1,0	0,3576(1)	0	0,1243(1)	0,035(1)
Sb(2)	4i	1,0	0,2739(1)	0	0,6336(1)	0,034(1)
Se(1)	4i	1,0	0,6589(1)	0	0,0535(1)	0,032(1)
Se(2)	4i	1,0	0,1161(1)	0	0,4569(1)	0,030(1)
Se(3)	4i	1,0	0,0114(1)	0	0,1815(1)	0,036(1)
Se(4)	4i	1,0	0,3363(1)	0	0,3227(1)	0,032(1)

Table A.3.9: Die anisotropen Auslenkungsparameter U_{ij} von $Mn_{0,88}Sb_{2,08}Se_4$

Atom	U_{11}	U_{22}	U_{33}	U_{23}	U_{13}	U_{12}
Mn(1)/Sb(3)	0,036(1)	0,031(1)	0,052(1)	0	0,019(1)	0
Mn(2)	0,024(1)	0,025(1)	0,039(1)	0	0,012(1)	0
Sb(1)	0,038(1)	0,030(1)	0,038(1)	0	0,017(1)	0
Sb(2)	0,031(1)	0,029(1)	0,040(1)	0	0,013(1)	0
Se(1)	0,032(1)	0,028(1)	0,037(1)	0	0,018(1)	0
Se(2)	0,027(1)	0,025(1)	0,037(1)	0	0,014(1)	0
Se(3)	0,034(1)	0,029(1)	0,039(1)	0	0,011(1)	0
Se(4)	0,033(1)	0,028(1)	0,038(1)	0	0,018(1)	0

A.3.4 Die kristallokraphischen Daten von Mn_{0,94}Sb_{1,64}Bi_{0,4}Se₄

 $\textbf{Table A.3.10:} \ \ Die \ kristallographischen \ Daten \ und \ Messparameter \ von \ Mn_{0,94}Sb_{1,64}Bi_{0,4}Se_4$

Verbindung	$Mn_{0.94}Sb_{1.64}Bi_{0.4}Se_4$
Molmasse / g/mol	650,75
Kristallfarbe	dunkelgrau
Kristallsystem	monoklin
Raumgruppe	C2/m (Nr. 12)
Zellkonstanten / Å; °	a = 13,3487(3)
,	b = 3.9942(1)
	c = 15,3012(3)
	$\beta = 115,810(1)$
Volumen / $Å^3$, Z	734,44(2), 4
Dichte / g/cm ³	5,885
Absorptionskoeffizient / mm ⁻¹	36,848
Diffraktometer	STOE IPDS I
Wellenlänge / Å	0,71073
Messtemperatur / K	293(2) K
Θ-Bereich / °	2,96 - 25,06
hkl-Bereich	$-15 \le h \le 15, -4 \le k \le 4, -18 \le l \le 18$
gesammelte Reflexe	2811
unabhängige Reflexe	721
Vollständigkeit	95,6%
Absorptionskorrektur	numerisch
GooF	1,148
Parameter	49
$R_{\mathrm{int}};R_{\mathrm{\sigma}}$	0,0493; 0,0373
R_1 ; wR_2 [I>2 σ]	0,0371; 0,0912
R_1 ; wR_2 [alle Reflexe]	0,0413; 0,0926
Restelektronendichte / e'Å ⁻³	+1,645; -1,141

 $\label{eq:continuous} \textbf{Table A.3.11:} \ Die \ Atomkoordinaten, \ Wyckofflagen, \ Besetzungen \ und \ isotrope$ $\ Auslenkungsparameter \ von \ Mn_{0,94}Sb_{1,64}Bi_{0,4}Se_4$

Atom	Wykofflagen	Besetzungen	х	У	Z	$U_{ m eq}$
Mn(1)	2 <i>a</i>	0,92(2)	0	0	0	0,036(1)
Sb(3)	2a	0,08(2)	0	0	0	0,036(1)
Mn(2)	2d	0,96(1)	0	0,5	0,5	0,036(1)
Sb(1)	4i	0,80(1)	0,2756(1)	0	0,6342(1)	0,039(1)
Bi(1)	4i	0,20(1)	0,2756(1)	0	0,6342(1)	0,039(1)
Sb(2)	4i	0,80(1)	0,3563(1)	0	0,1258(1)	0,036(1)
Bi(2)	4i	0,20(1)	0,3563(1)	0	0,1258(1)	0,036(1)
Se(1)	4i	1,0	0,3373(1)	0	0,3233(1)	0,036(1)
Se(2)	4i	1,0	0,6579(1)	0	0,0539(1)	0,034(1)
Se(3)	4i	1,0	0,0121(1)	0	0,1820(1)	0,037(1)
Se(4)	4i	1,0	0,1156(1)	0	0,4563(1)	0,033(1)

Table A.3.12: Die anisotropen Auslenkungsparameter U_{ij} von $Mn_{0,94}Sb_{1,64}Bi_{0,4}Se_4$

Atom	U_{11}	U_{22}	U_{33}	U_{23}	U_{13}	U_{12}
Mn(1)/Sb(3)	0,030(2)	0,035(2)	0,040(2)	0	0,013(1)	0
Mn(2)	0,029(1)	0,038(2)	0,038(2)	0	0,011(1)	0
Bi(1)/Sb(1)	0,034(1)	0,039(1)	0,037(1)	0	0,010(1)	0
Bi(2)/Sb(2)	0,034(1)	0,036(1)	0,034(1)	0	0,012(1)	0
Se(1)	0,035(1)	0,039(1)	0,034(1)	0	0,015(1)	0
Se(2)	0,029(1)	0,036(1)	0,034(1)	0	0,012(1)	0
Se(3)	0,031(1)	0,037(1)	0,035(1)	0	0,007(1)	0
Se(4)	0,028(1)	0,035(1)	0,034(1)	0	0,011(1)	0

A.3.5 Die kristallokraphischen Daten von $Mn_{0,73}Bi_{2,18}Se_4$

Table A.3.13: Die kristallographischen Daten und Messparameter von Mn_{0,73}Bi_{2,18}Se₄

Verbindung	$Mn_{0.73}Bi_{2.18}Se_4$
Molmasse / g/mol	811,52
Kristallfarbe	dunkelgrau
Kristallsystem	monoklin
Raumgruppe	C2/m (Nr. 12)
Zellkonstanten / Å; °	a = 13,3841(3)
,	b = 4.0712(1)
	c = 15,2517(3)
	$\beta = 115,926(2)$
Volumen / $Å^3$, Z	747,42(2), 4
Dichte / g/cm ³	7,212
Absorptionskoeffizient / mm ⁻¹	71,782
Diffraktometer	STOE IPDS I
Wellenlänge / Å	0,71073
Messtemperatur / K	293(2) K
Θ-Bereich / °	2,97 - 25,28
hkl-Bereich	$-16 \le h \le 16, -4 \le k \le 4, -18 \le l \le 18$
gesammelte Reflexe	3059
unabhängige Reflexe	772
Vollständigkeit	98,8%
Absorptionskorrektur	numerisch
GooF	1,142
Parameter	47
$R_{\mathrm{int}}; R_{\sigma}$	0,0467; 0,0308
R_1 ; wR_2 [I>2 σ]	0,0394; 0,0941
R_1 ; wR_2 [alle Reflexe]	0,0446; 0,0955
Restelektronendichte / e'Å-3	+3,930; -3,184

 $\label{eq:continuous} \textbf{Table A.3.14:} \ \ Die \ Atomkoordinaten, \ Wyckofflagen, \ Besetzungen \ und isotrope$ $\ Auslenkungsparameter \ von \ Mn_{0,73}Bi_{2,18}Se_4$

Atom	Wykofflagen	Besetzungen	х	у	Z	$U_{ m eq}$
Mn(1)	2 <i>a</i>	0,64(1)	0	0	0	0,032(1)
Bi(3)	2a	0,36(1)	0	0	0	0,032(1)
Mn(2)	2d	0,82(1)	0	0,5	0,5	0,025(1)
Bi(1)	4i	1,0	0,2816(1)	0	0,6381(1)	0,033(1)
Bi(2)	4i	1,0	0,3499(1)	0	0,1307(1)	0,035(1)
Se(1)	4i	1,0	0,3421(2)	0	0,3245(1)	0,029(1)
Se(2)	4i	1,0	0,6607(1)	0	0,0623(1)	0,029(1)
Se(3)	4i	1,0	0,0092(2)	0	0,1866(1)	0,033(1)
Se(4)	4i	1,0	0,1145(1)	0	0,4551(1)	0,025(1)

Table A.3.15: Die anisotropen Auslenkungsparameter U_{ij} von $Mn_{0,73}Bi_{2,18}Se_4$

Atom	U_{11}	U_{22}	U_{33}	U_{23}	U_{13}	U_{12}
Mn(1)/Bi(3)	0,025(1)	0,028(2)	0,044(1)	0	0,014(1)	0
Mn(2)	0,017(2)	0,025(3)	0,030(2)	0	0,007(2)	0
Bi(1)	0,026(1)	0,029(1)	0,037(1)	0	0,007(1)	0
Bi(2)	0,031(1)	0,031(1)	0,041(1)	0	0,012(1)	0
Se(1)	0,029(1)	0,026(1)	0,035(1)	0	0,017(1)	0
Se(2)	0,023(1)	0,029(1)	0,033(1)	0	0,012(1)	0
Se(3)	0,024(1)	0,026(1)	0,038(1)	0	0,004(1)	0
Se(4)	0,021(1)	0,024(1)	0,030(1)	0	0,012(1)	0

A.4 Die kristallographischen Daten von Kapitel 4

A.4.1 Die kristallokraphischen Daten von $FeSb_{0,51}Bi_{0,49}S_2Br$

Tab. A.4.1: Die kristallographischen Daten und Messparameter von FeSb_{0.51}Bi_{0.49}S₂Br

Verbindung	$FeSb_{0.51}Bi_{0.49}S_2Br$
Molmasse / g/mol	364,38
Kristallfarbe	dunkelrot
Kristallsystem	monoklin
Raumgruppe	C2/m (Nr. 12)
Zellkonstanten / Å; °	a = 12,488(1)
	b = 3,8320(4)
	c = 9,3984(7)
	$\beta = 91,371(5)$
Volumen / \mathring{A}^3 , Z	449,6(1), 4
Dichte / g/cm ³	5,389
Absorptionskoeffizient / mm ⁻¹	35,210
Diffraktometer	STOE IPDS I
Wellenlänge / Å	0,71073
Messtemperatur / K	293(2) K
Θ- Bereich / °	2,17 - 27,79
hkl-Bereich	$-16 \le h \le 16, -5 \le k \le 5, -12 \le l \le 12$
gesammelte Reflexe	3797
unabhängige Reflexe	605
Vollständigkeit	99,2%
Absorptionskorrektur	numerisch
GooF	1,116
Parameter	35
$R_{\rm int}; R_{\sigma}$	0,0611; 0,0249
R_1 ; wR_2 [I>2 σ]	0,0238; 0,0567
R_1 ; wR_2 [alle Reflexe]	0,0263; 0,0578
Restelektronendichte / e'Å ⁻³	+1,834; -0,870

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Tab. A.4.2:} & Die Atomkoordinaten, Wyckofflagen, Besetzungen und isotrope \\ Auslenkungsparameter von $FeSb_{0,51}Bi_{0,49}S_2Br$ \end{tabular}$

Atom	Wykofflagen	Besetzungen	x	у	Z	$U_{ m eq}$
Fe(1)	2 <i>a</i>	1,0	0	0	0	0,023(1)
Fe(2)	2c	1,0	0	0	0,5	0,023(1)
Sb(1)	4i	0,51(1)	0,2901(1)	0	0,1992(1)	0,025(1)
Bi(1)	4i	0,49(1)	0,2901(1)	0	0,1992(1)	0,025(1)
S(1)	4i	1,0	0,6354(1)	0	0,0496(2)	0,021(1)
S(2)	4i	1,0	0,0685(1)	0	0,7546(2)	0,021(1)
Br(1)	4i	1,0	0,3662(1)	0	0,5633(1)	0,024(1)

Tab. A.4.3: Die anisotropen Auslenkungsparameter U_{ij} von FeSb_{0,51}Bi_{0,49}S₂Br

Atom	U_{11}	U_{22}	U_{33}	U_{23}	U_{13}	U_{12}
Fe(1)	0,025(1)	0,021(1)	0,022(1)	0	0,005(1)	0
Fe(2)	0,027(1)	0,019(1)	0,022(1)	0	0,001(1)	0
Bi(1)/Sb(1)	0,032(1)	0,020(1)	0,024(1)	0	0,003(1)	0
S(1)	0,023(1)	0,018(1)	0,020(1)	0	0,002(1)	0
S(2)	0,025(1)	0,020(1)	0,019(1)	0	0,001(1)	0
Br(1)	0,026(1)	0,020(1)	0,025(1)	0	0,004(1)	0

${\bf A.4.2}$ Die kristallographischen Daten von FeBiS $_2$ Br

 $\textbf{Tab. A.4.4:} \ Die \ kristallographischen \ Daten \ und \ Messparameter \ von \ FeBiS_2Br$

Verbindung	FeBiS ₂ Br
Molmasse / g/mol	408,86
Kristallfarbe	dunkelrot
Kristallsystem	monoklin
Raumgruppe	C2/m (Nr. 12)
Zellkonstanten / Å; °	a = 12,497(1)
20111011544111011 / 11,	b = 3,8807(3)
	c = 9,371(1)
	$\beta = 91,253(8)$
Volumen / $Å^3$, Z	454,4(1), 4
Dichte / g/cm ³	5,977
Absorptionskoeffizient / mm ⁻¹	51,374
Diffraktometer	STOE IPDS I
Wellenlänge / Å	0,71073
Messtemperatur / K	293(2) K
Θ-Bereich / °	3,26-25,23
hkl-Bereich	$-14 \le h \le 14, -4 \le k \le 4, -11 \le l \le 11$
gesammelte Reflexe	3004
unabhängige Reflexe	469
Vollständigkeit	98,1%
Absorptionskorrektur	numerisch
GooF	1,300
Parameter	34
$R_{ m int}; R_{ m \sigma}$	0,0386; 0,0214
R_1 ; wR_2 [I>2 σ]	0,0307; 0,0720
R_1 ; wR_2 [alle Reflexe]	0,0328; 0,0726
Restelektronendichte / e'Å ⁻³	+2,435; -1,820

Tab. A.4.5: Die Atomkoordinaten, Wyckofflagen, Besetzungen und isotrope Auslenkungsparameter von FeBiS₂Br

Atom	Wykofflagen	Besetzungen	x	y	Z	U_{eq}
Fe(1)	2 <i>a</i>	1,0	0	0	0	0,018(1)
Fe(2)	2c	1,0	0	0	0,5	0,017(1)
Bi(1)	4i	1,0	0,2878(1)	0	0,2016(1)	0,018(1)
S(1)	4i	1,0	0,6347(2)	0	0,0522(4)	0,016(1)
S(2)	4i	1,0	0,0674(3)	0	0,7534(3)	0,016(1)
Br (1)	4i	1,0	0,3657(1)	0	0,5628(1)	0,018(1)

Tab. A.4.6: Die anisotropen Auslenkungsparameter U_{ij} von FeBiS $_2$ Br

Atom	U_{11}	U_{22}	U_{33}	U_{23}	U_{13}	U_{12}
Fe(1)	0,017(1)	0,019(2)	0,018(1)	0	0,001(1)	0
Fe(2)	0,019(1)	0,016(2)	0,016(1)	0	-0,002(1)	0
Bi(1)	0,020(1)	0,016(1)	0,017(1)	0	0,002(1)	0
S(1)	0,015(2)	0,017(2)	0,016(2)	0	0,000(1)	0
S(2)	0,017(2)	0,015(2)	0,015(2)	0	-0,001(1)	0
Br (1)	0,018(1)	0,018(1)	0,020(1)	0	0,002(1)	0

A.5 Die kristallographischen Daten von Kapitel 5

A.5.1 Die kristallographischen Daten von HgBi₂S₄

Tab. A.5.1: Die kristallographischen Daten und Messparameter von HgBi₂S₄

Verbindung	HgBi ₂ S ₄
Molmasse / g/mol	746,79
Kristallfarbe	mattgrau
Kristallsystem	monoklin
Raumgruppe	C2/m (Nr. 12)
Zellkonstanten / Å; °	a = 14,168(3)
	b = 4,0530(7)
	c = 13,972(2)
	$\beta = 118,26(1)$
Volumen / \mathring{A}^3 , Z	706,7(3), 4
Dichte / g/cm ³	7,019
Absorptionskoeffizient / mm ⁻¹	72,407
Diffraktometer	STOE IPDS I
Wellenlänge / Å	0,71073
Messtemperatur / K	293(2) K
Θ-Bereich / °	2,88 - 27,86
hkl-Bereich	$-18 \le h \le 18, -5 \le k \le 5, -18 \le l \le 18$
gesammelte Reflexe	6046
unabhängige Reflexe	953
Vollständigkeit	98,7%
Absorptionskorrektur	numerisch
GooF	1,237
Parameter	46
$R_{\rm int}$; R_{σ}	0,0806; 0,0332
R_1 ; wR_2 [I>2 σ]	0,0308; 0,0669
R_1 ; wR_2 [alle Reflexe]	0,0328; 0,0678
Restelektronendichte / e·Å ⁻³	+3,818; -2,4531

 $\label{thm:condinate} \textbf{Tab. A.5.2:} \ \ Die \ Atomkoordinaten, \ Wyckofflagen, \ Besetzungen \ und \ isotrope$ $\ Auslenkungsparameter \ von \ HgBi_2S_4$

Atom	Wykofflagen	Besetzungen	х	у	Z	$U_{ m eq}$
Hg(1)	2a	1,0	0	0	0	0,031(1)
Hg(2)	2c	1,0	0	0	0,5	0,030(1)
Bi(1)	4i	1,0	0,2256(1)	0	0,3680(1)	0,024(1)
Bi(2)	4i	1,0	0,3505(1)	0	0,1376(1)	0,025(1)
S(1)	4i	1,0	0,1543(2)	0	0,6715(2)	0,024(1)
S(2)	4i	1,0	0,6886(2)	0	0,0629(2)	0,022(1)
S(3)	4i	1,0	0,0011(2)	0	0,1702(2)	0,023(1)
S(4)	4i	1,0	0,3745(2)	0	0,5722(2)	0,022(1)

Tab. A.5.3: Die anisotropen Auslenkungsparameter $U_{\rm ij}$ von HgBi $_2$ S $_4$

Atom	U_{11}	U_{22}	U_{33}	U_{23}	U_{13}	U_{12}
Hg(1)	0,036(1)	0,032(1)	0,032(1)	0	0,021(1)	0
Hg(2)	0,024(1)	0,030(1)	0,031(1)	0	0,010(1)	0
Bi(1)	0,024(1)	0,021(1)	0,025(1)	0	0,011(1)	0
Bi(2)	0,026(1)	0,025(1)	0,026(1)	0	0,013(1)	0
S(1)	0,025(1)	0,023(1)	0,026(1)	0	0,013(1)	0
S(2)	0,022(1)	0,021(1)	0,023(1)	0	0,011(1)	0
S(3)	0,021(1)	0,023(1)	0,024(1)	0	0,010(1)	0
S(4)	0,021(1)	0,020(1)	0,025(1)	0	0,011(1)	0

$\textbf{A.5.2} \ \text{Die kristallographischen Daten von } Hg_{0,5}Bi_2S_3Cl$

Tab. A.5.4: Die kristallographischen Daten und Messparameter von $Hg_{0,5}Bi_2S_3Cl$

Verbindung	$Hg_{0,5}Bi_2S_3Cl$
Molmasse / g/mol	649,89
Kristallfarbe	dunkelrot
Kristallsystem	monoklin
Raumgruppe	$P2_{1}/m$ (Nr. 11)
Zellkonstanten / Å; °	a = 7,843(5)
	b = 4,022(3)
	c = 10,804(6)
	$\beta = 104,87(4)$
Volumen / $Å^3$, Z	329,4(4), 2
Dichte / g/cm ³	6,552
Absorptionskoeffizient / mm ⁻¹	66,166
Diffraktometer	STOE IPDS I
Wellenlänge / Å	0,71073
Messtemperatur / K	293(2) K
Θ-Bereich / °	2,69 - 25,09
hkl-Bereich	$-9 \le h \le 9, -4 \le k \le 4, -12 \le l \le 12$
gesammelte Reflexe	3737
unabhängige Reflexe	677
Vollständigkeit	99,9%
Absorptionskorrektur	numerisch
GooF	1,079
Parameter	44
$R_{ m int}$; $R_{ m \sigma}$	0,0442; 0,0265
R_1 ; wR_2 [I>2 σ]	0,0351; 0,0921
R_1 ; wR_2 [alle Reflexe]	0,0403; 0,0942
Restelektronendichte / e ⁻ Å ⁻³	+1,788; -3,036

 $\label{thm:condinate} \textbf{Tab. A.5.5:} \ \ Die \ Atomkoordinaten, \ Wyckofflagen, \ Besetzungen \ und \ isotrope$ $\ Auslenkungsparameter \ von \ Hg_{0,5}Bi_2S_3Cl$

Atom	Wykofflagen	Besetzungen	х	У	Z	$U_{ m eq}$
Hg(1)	2c	0,5	0	0,5	0,5	0,051(1)
Bi(1)	2e	1,0	0,1751(1)	0,25	0,9321(1)	0,024(1)
Bi(2)	2e	1,0	0,5166(1)	0,25	0,3451(1)	0,031(1)
S(1)	2e	1,0	0,2152(6)	0,25	0,6668(5)	0,029(1)
S(2)	2e	1,0	0,6839(6)	0,25	0,5854(4)	0,026(1)
S(3)	2e	1,0	0,0522(6)	0,25	0,1488(4)	0,022(1)
Cl(1)	2e	1,0	0,5973(6)	0,25	0,9012(4)	0,026(1)

Tab. A.5.6: Die anisotropen Auslenkungsparameter U_{ij} von $Hg_{0,5}Bi_2S_3Cl$

Atom	U_{11}	U_{22}	U_{33}	U_{23}	U_{13}	U_{12}
Hg(1)	0,043(1)	0,059(1)	0,048(1)	0,011(1)	0,005(1)	0,004(1)
Bi(1)	0,027(1)	0,020(1)	0,027(1)	0	0,006(1)	0
Bi(2)	0,042(1)	0,030(1)	0,021(1)	0	0,010(1)	0
S(1)	0,033(2)	0,031(3)	0,024(2)	0	0,009(2)	0
S(2)	0,028(2)	0,027(3)	0,021(2)	0	0,005(2)	0
S(3)	0,024(2)	0,023(2)	0,017(2)	0	0,004(2)	0
Cl(1)	0,029(2)	0,024(3)	0,023(2)	0	0,003(2)	0

A.5.3 Die kristallographischen Daten von Hg₄BiS₂Cl₅

Tab. A.5.7: Die kristallographischen Daten und Messparameter von Hg₄BiS₂Cl₅

X	II Did di
Verbindung	$Hg_4BiS_2Cl_5$
Molmasse / g/mol	1252,71
Kristallfarbe	gelb
Kristallsystem	monoklin
Raumgruppe	P2 ₁ (Nr. 4)
Zellkonstanten / Å; °	a = 8,015(2)
	b = 10,457(3)
	c = 8,753(2)
	$\beta = 112,780(1)$
Volumen / Å^3 , Z	675,3(3), 2
Dichte / g/cm ³	6,158
Absorptionskoeffizient / mm ⁻¹	59,519
Diffraktometer	STOE IPDS I
Wellenlänge / Å	0,71073
Messtemperatur / K	293(2) K
Θ-Bereich / °	2,52 - 27,77
hkl-Bereich	$-10 \le h \le 10, -13 \le k \le 13, -11 \le l \le 11$
gesammelte Reflexe	11570
unabhängige Reflexe	3172
Vollständigkeit	99,6%
Absorptionskorrektur	numerisch
GooF	1,043
Flack-x-Parameter	0,239(2)
Parameter	111
$R_{\mathrm{int}};R_{\mathrm{\sigma}}$	0,0535; 0,0414
R_1 ; wR_2 [I>2 σ]	0,0269; 0,0565
R_1 ; wR_2 [alle Reflexe]	0,0318; 0,0576
Restelektronendichte / e'Å ⁻³	+2,920; -2,387

Tab. A.5.8: Die Atomkoordinaten, Wyckofflagen, Besetzungen und isotrope Auslenkungsparameter von Hg₄BiS₂Cl₅

Atom	Wykofflagen	Besetzungen	х	у	Z	U_{eq}
Hg(1)	2 <i>a</i>	1,0	0,0742(1)	0,1790(1)	0,6707(1)	0,036(1)
Hg(2)	2a	1,0	0,0498(1)	0,6725(1)	0,6450(1)	0,038(1)
Hg(3)	2a	1,0	0,5031(1)	0,1804(1)	0,0189(1)	0,031(1)
Hg(4)	2a	1,0	0,1896(1)	0,4317(1)	0,9802(1)	0,029(1)
Bi(1)	2a	1,0	0,4967(1)	0,4322(1)	0,4906(1)	0,020(1)
S(1)	2a	1,0	0,1950(4)	0,2029(4)	0,9751(4)	0,024(1)
S(2)	2a	1,0	0,8075(3)	0,1593(5)	0,0514(4)	0,027(1)
Cl(1)	2a	1,0	0,1630(4)	0,9230(8)	0,3077(5)	0,052(1)
Cl(2)	2a	1,0	0,1335(3)	0,4358(7)	0,2878(3)	0,034(1)
Cl(3)	2a	1,0	0,6061(4)	0,4514(4)	0,2279(4)	0,036(1)
Cl(4)	2a	1,0	0,4049(5)	0,4000(5)	0,7438(5)	0,051(1)
Cl(5)	2a	1,0	0,5003(8)	0,1854(5)	0,4292(7)	0.073(1)

Tab. A.5.9: Die anisotropen Auslenkungsparameter U_{ij} von Hg₄BiS₂Cl₅

Atom	U_{11}	U_{22}	U_{33}	U_{23}	U_{13}	U_{12}
Hg(1)	0,035(1)	0,044(1)	0,026(1)	-0,006(1)	0,008(1)	-0,004(1)
Hg(2)	0,036(1)	0,047(1)	0,026(1)	0,007(1)	0,007(1)	0,003(1)
Hg(3)	0,023(1)	0,037(1)	0,032(1)	0,000(1)	0,009(1)	0,005(1)
Hg(4)	0,028(1)	0,028(1)	0,029(1)	0,001(1)	0,009(1)	0,000(1)
Bi(1)	0,021(1)	0,019(1)	0,020(1)	0,001(1)	0,007(1)	0,000(1)
S(1)	0,023(1)	0,028(1)	0,023(1)	0,002(1)	0,010(1)	0,000(1)
S(2)	0,023(1)	0,030(2)	0,027(1)	-0,002(1)	0,008(1)	-0,001(1)
Cl(1)	0,027(1)	0,046(2)	0,030(1)	0,002(2)	0,010(1)	0,005(2)
Cl(2)	0,030(1)	0,061(3)	0,049(2)	0,001(3)	-0,004(1)	-0,005(2)
Cl(3)	0,037(1)	0,042(3)	0,033(2)	0,003(2)	0,017(1)	-0,004(1)
Cl(4)	0,062(2)	0,066(4)	0,038(2)	0,007(2)	0,032(2)	-0,006(2)
Cl(5)	0,120(4)	0,020(2)	0,074(3)	-0,002(3)	0,032(3)	-0,003(2)

$\textbf{A.5.4} \ Die \ kristallographischen \ Daten \ von \ Hg_4BiSe_2Cl_5$

Tab. A.5.10: Die kristallographischen Daten und Messparameter von Hg₄BiSe₂Cl₅

Verbindung	$Hg_4BiSe_2Cl_5$
Molmasse / g/mol	1346,51
Kristallfarbe	gelb
Kristallsystem	monoklin
Raumgruppe	$P2_1/n$ (Nr.: 14)
Zellkonstanten / Å; °	a = 9,371(3)
	b = 10,374(3)
	c = 14,082(5)
	$\beta = 94,24(2)$
Volumen / $Å^3$, Z	1365,2(1), 2
Dichte / g/cm ³	6,551
Absorptionskoeffizient / mm ⁻¹	63,933
Diffraktometer	STOE IPDS I
Wellenlänge / Å	0,71073
Messtemperatur / K	293(2) K
Θ-Bereich / °	2,44 - 25,09
hkl-Bereich	$-11 \le h \le 11, -12 \le k \le 12, -16 \le l \le 16$
gesammelte Reflexe	15361
unabhängige Reflexe	2310
Vollständigkeit	95,0%
Absorptionskorrektur	numerisch
GooF	0,968
Parameter	110
$R_{ m int};R_{ m \sigma}$	0,0677; 0,0362
R_1 ; wR_2 [I>2 σ]	0,0427; 0,1130
R_1 ; wR_2 [alle Reflexe]	0,0622; 0,1211
Restelektronendichte / e'Å ⁻³	+2,190; -4,503

Tab. A.5.11: Die Atomkoordinaten, Wyckofflagen, Besetzung und isotrope Auslenkungsparameter von Hg₄BiSe₂Cl₅

Atom	Wykofflagen	Besetzungen	x	у	Z	$U_{ m eq}$
Hg(1)	4 <i>e</i>	1,0	0,4015(1)	0,2503(1)	0,5468(1)	0,040(1)
Hg(2)	4 <i>e</i>	1,0	0,6209(1)	0,2504(1)	0,4500(1)	0,039(1)
Hg(3)	4 <i>e</i>	1,0	0,0094(1)	0,2468(1)	0,4900(1)	0,035(1)
Hg(4)	4 <i>e</i>	1,0	0,6611(1)	0,0056(1)	0,1463(1)	0,033(1)
Bi(1)	4 <i>e</i>	1,0	0,2535(1)	0,4992(1)	0,2340(1)	0,023(1)
Se(1)	4 <i>e</i>	1,0	0,1737(3)	0,2575(3)	0,6316(2)	0,051(1)
Se(2)	4 <i>e</i>	1,0	0,3369(3)	0,2327(3)	0,8536(2)	0,050(1)
Cl(1)	4 <i>e</i>	1,0	0,5337(5)	0,0029(5)	0,3314(3)	0,034(1)
Cl(2)	4 <i>e</i>	1,0	0,9781(6)	0,0006(8)	0,1956(6)	0,058(2)
Cl(3)	4 <i>e</i>	1,0	0,3265(7)	0,0366(6)	0,0869(4)	0,045(1)
Cl(4)	4 <i>e</i>	1,0	0,3243(7)	0,4756(5)	0,0538(4)	0,043(1)
Cl(5)	4 <i>e</i>	1,0	0,2329(9)	0,2420(6)	0,2992(5)	0,064(3)

Tab. A.5.12: Die anisotropen Auslenkungsparameter U_{ij} von Hg₄BiSe₂Cl₅

Atom	U_{11}	U_{22}	U_{33}	U_{23}	U_{13}	U_{12}
Hg(1)	0,030(1)	0,047(1)	0,043(1)	-0,001(1)	0,010(1)	0,002(1)
Hg(2)	0,031(1)	0,046(1)	0,042(1)	-0,001(1)	0,010(1)	-0,002(1)
Hg(3)	0,031(1)	0,040(1)	0,032(1)	-0,001(1)	-0,001(1)	0,000(1)
Hg(4)	0,033(1)	0,030(1)	0,037(1)	0,000(1)	0,002(1)	0,000(1)
Bi(1)	0,023(1)	0,021(1)	0,026(1)	-0,001(1)	0,003(1)	0,000(1)
Se(1)	0,049(1)	0,050(1)	0,053(1)	0,004(1)	0,002(1)	0,002(1)
Se(2)	0,049(1)	0,051(1)	0,048(1)	0,001(1)	0,003(1)	0,003(1)
Cl(1)	0,030(3)	0,039(2)	0,033(2)	-0.004(2)	0,000(2)	0,001(2)
Cl(2)	0,028(3)	0,063(4)	0,080(4)	-0,001(3)	-0,003(3)	0,000(3)
Cl(3)	0,044(3)	0,054(3)	0,037(2)	0,018(2)	0,006(2)	-0,004(2)
Cl(4)	0,057(4)	0,043(3)	0,031(2)	-0,007(2)	0,015(2)	0,002(2)
Cl(5)	0,083(5)	0,027(3)	0,083(4)	-0,003(3)	0,018(4)	-0,001(3)

$\textbf{A.5.5} \ Die \ kristallographischen \ Daten \ von \ Hg_3Bi_2Te_2Cl_8$

Tab. A.5.13: Die kristallographischen Daten und Messparameter von Hg₃Bi₂Te₂Cl₈

Verbindung	Hg ₃ Bi ₂ Te ₂ Cl ₈
Molmasse / g/mol	1558,53
Kristallfarbe	gelb
Kristallsystem	monoklin
Raumgruppe	C 2/c (Nr. 15)
Zellkonstanten / Å; °	a = 17,494(1)
Zenkonstanten / 11,	b = 7,7339(4)
	c = 13,5410(9)
	$\beta = 104,129(5)$
Volumen / $Å^3$, Z	1776,7(1), 4
Dichte / g/cm ³	5,835
Absorptionskoeffizient / mm ⁻¹	50,037
Diffraktometer	STOE IPDS I
Wellenlänge / Å	0,71073
Messtemperatur / K	293(2) K
Θ-Bereich / °	2,40 - 24,99
hkl-Bereich	$-20 \le h \le 20, -8 \le k \le -16 \le l \le 16$
gesammelte Reflexe	9312
unabhängige Reflexe	1554
Vollständigkeit	99,0%
Absorptionskorrektur	numerisch
GooF	0,985
Parameter	71
R_{int} ; R_{σ}	0,0430; 0,0229
R_1 ; wR_2 [I>2 σ]	0,0203; 0,0458
R_1 ; wR_2 [alle Reflexe]	0,0230; 0,0466
Restelektronendichte / e'Å-3	+1,054; -0,911

Tab. A.5.14: Die Atomkoordinaten, Wyckofflagen, Besetzungen und isotrope Auslenkungsparameter von Hg₃Bi₂Te₂Cl₈

Atom	Wykofflagen	Besetzungen	х	у	Z	$U_{ m eq}$
Hg(1)	4 <i>c</i>	1,0	0,25	0,25	0	0,044(1)
Hg(2)	8 <i>f</i>	1,0	0,2466(1)	0,0144(1)	0,2568(1)	0,049(1)
Bi(1)	8 <i>f</i>	1,0	0,0408(1)	0,2322(1)	0,4374(1)	0,027(1)
Te(1)	8 <i>f</i>	1,0	0,3335(1)	0,2508(1)	0,1942(1)	0,034(1)
Cl(1)	8 <i>f</i>	1,0	0,0008(1)	0,1091(2)	0,6134(1)	0,037(1)
Cl(2)	8 <i>f</i>	1,0	0,1033(1)	0,2696(2)	0,2760(1)	0,041(1)
Cl(3)	8f	1,0	0,1038(1)	0,4761(2)	0,0364(1)	0,039(1)
Cl(4)	8 <i>f</i>	1,0	0,1744(1)	0,1068(3)	0,5242(1)	0,042(1)

Tab. A.5.15: Die anisotropen Auslenkungsparameter U_{ij} von Hg₃Bi₂Te₂Cl₈

Atom	U_{11}	U_{22}	U_{33}	U_{23}	U_{13}	U_{12}
Hg(1)	0,060(1)	0,046(1)	0,027(1)	-0,001(1)	0,011(1)	-0,008(1)
Hg(2)	0,072(1)	0,035(1)	0,043(1)	0,007(1)	0,019(1)	-0,006(1)
Bi(1)	0,026(1)	0,026(1)	0,028(1)	0,002(1)	0,008(1)	0,000(1)
Te(1)	0,032(1)	0,038(1)	0,032(1)	-0,003(1)	0,007(1)	-0,002(1)
Cl(1)	0,045(1)	0,038(1)	0,031(1)	-0,006(1)	0,014(1)	-0,005(1)
Cl(2)	0,039(1)	0,048(2)	0,039(1)	0,003(1)	0,016(1)	-0,006(1)
Cl(3)	0,035(1)	0,034(1)	0,046(1)	0,002(1)	0,009(1)	0,003(1)
Cl(4)	0,034(1)	0,045(1)	0,041(1)	0,000(1)	0,003(1)	0,013(1)

A.6 Auswertung der Pulverdiffraktogramme von Kapitel 3

In diesem Abschnitt werden nur diejenigen Pulverdiffraktogramme dargestellt, die in Kapitel 3 noch nicht einzeln abgebildet sind. Des weiteren finden sich hier Angaben zu den durchgeführten Auswertungen aller in Kapitel 3 behandelten Pulverdiffraktogramme.

A.6.1 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnS

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnS erfolgte anhand von 7 Reflexen, die alle einzeln indizierbar sind in der kubischen Raumgruppe $Fm\overline{3}m$ (Nr. 225). Ihre Zellkonstante wurde zu a = 5,226(2) Å mit einem Zellvolumen von V = 142,70(8) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 74,8.

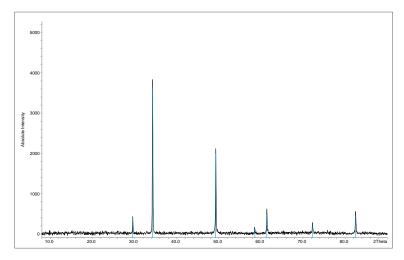


Abb. A.6.1: Pulverdiffraktogramm von MnS mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.6.2 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSe

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSe erfolgte anhand von 8 Reflexen, die alle einzeln indizierbar sind in der kubischen Raumgruppe $Fm\overline{3}m$ (Nr. 225). Ihre Zellkonstante wurde zu a = 5,4600(3) Å mit einem Zellvolumen von V = 162,77(2) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 250,0.

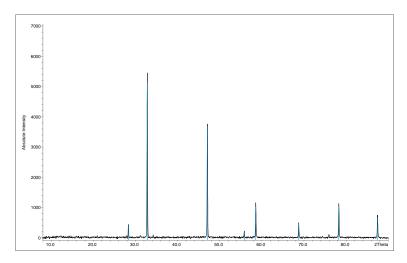


Abb. A.6.2: Pulverdiffraktogramm von MnSe mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.6.3 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von Sb₂S₃

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von Sb₂S₃ erfolgte anhand von 69 Reflexen, von denen 48 einzeln indizierbar sind in der orthorhombischen Raumgruppe *Pnma* (Nr. 62). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 11,313(1) Å, b = 3,8383(6) Å und c = 11,231(1) Å mit einem Zellvolumen von V = 487,66(8) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 73,6.

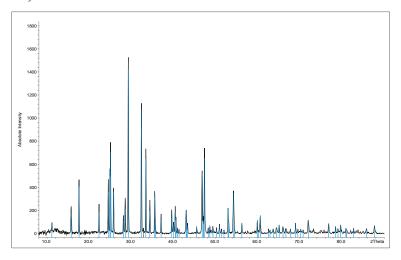


Abb. A.6.3: Pulverdiffraktogramm von Sb₂S₃ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.6.4 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von Sb₂Se₃

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von Sb₂Se₃ erfolgte anhand von 87 Reflexen, von denen 69 einzeln indizierbar sind in der orthorhombischen Raumgruppe *Pnma* (Nr. 62). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 11,782(2) Å, b = 3,9785(4) Å und c = 11,635(1) Å mit einem Zellvolumen von V = 545,4(1) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 112,0.

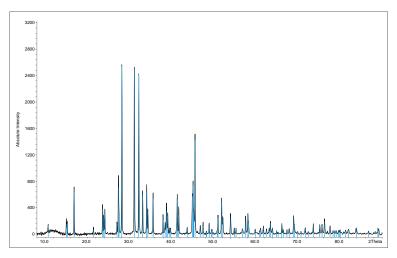


Abb. A.6.4: Pulverdiffraktogramm von Sb₂Se₃ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.6.5 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von Bi₂S₃

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von Bi₂S₃ erfolgte anhand von 86 Reflexen, von denen 57 einzeln indizierbar sind in der orthorhombischen Raumgruppe *Pnma* (Nr. 62). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 11,307(2) Å, b = 3,9831(5) Å und c = 11,156(1) Å mit einem Zellvolumen von V = 502,4(2) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 76,3.

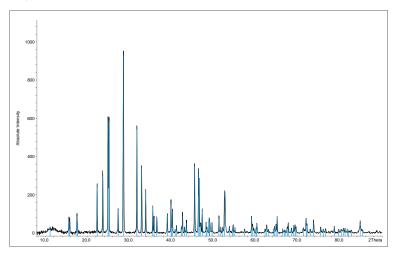


Abb. A.6.5: Pulverdiffraktogramm von Bi₂S₃ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.6.6 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von Bi₂Se₃

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von Bi₂Se₃ erfolgte anhand von 30 Reflexen, von denen 29 einzeln indizierbar sind in der trigonalen Raumgruppe $R \, \overline{3} \, m$ (Nr. 166). Ihre

Zellkonstanten wurden zu a = 4,1397(5) Å und c = 28,642(3) Å mit einem Zellvolumen von V = 425,07(1) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 78,5.

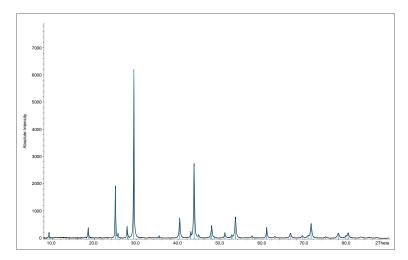


Abb. A.6.6: Pulverdiffraktogramm von Bi₂Se₃ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.6.7 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb₂S₄

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb₂S₄ erfolgte anhand von 103 Reflexen, von denen 97 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 12,7196(2) Å, b = 3,7942(1) Å, c = 15,0457(3) Å und $\beta = 113,858(2)$ ° mit einem Zellvolumen von V = 664,08(2) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 186,9. In diesem Pulverdiffraktogramm treten auch 6 Reflexe des Edukts Sb₂S₃ auf.

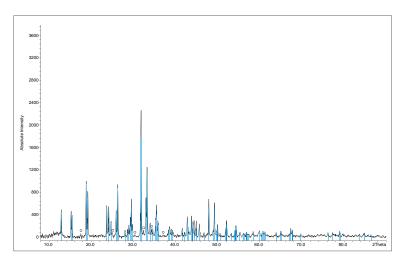


Abb. A.6.7: Pulverdiffraktogramm von MnSb₂S₄ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen (cyan) und nicht umgesetzten Sb₂S₃ (o).

A.6.8 Auswertung des Pulverdiffraktogramms der DTA Probe von MnSb₂S₄

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms der DTA Probe von MnSb₂S₄ erfolgte anhand von 34 Reflexen, von denen 24 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 12,72(2) Å, b = 3,790(4) Å, c = 14,99(2) Å und $\beta = 114,29(4)$ ° mit einem Zellvolumen von V = 658,4(2) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 4,3. In diesem Pulverdiffraktogramm treten auch Reflexe der enthaltenen Zersetzungsprodukte MnS und Sb₂S₃ auf.

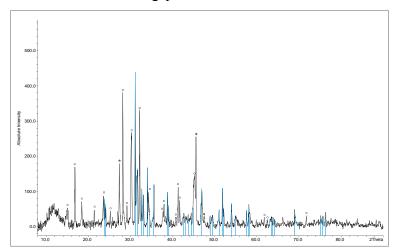


Abb. A.6.8: Pulverdiffraktogramm von MnSb₂S₄ nach der DTA mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen (cyan). Die darin enthaltenen Zersetzungsprodukte sind MnS (*) und Sb₂S₃ (o).

A.6.9 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnBi₂S₄

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnBi₂S₄ erfolgte anhand von 104 Reflexen, von denen 101 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 12,7681(2) Å, b = 3,9179(1) Å, c = 14,7544(3) Å und $\beta = 115,295(2)$ ° mit einem Zellvolumen von V = 667,31(2) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 222,2.

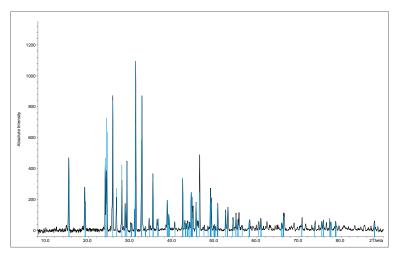


Abb. A.6.9: Pulverdiffraktogramm von MnBi₂S₄ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.6.10 Auswertung des Pulverdiffraktogramms der DTA Probe von MnBi₂S₄

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms der DTA Probe von MnBi₂S₄ erfolgte anhand von 50 Reflexen, von denen 18 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 13,02(1) Å, b = 3,956(5) Å, c = 15,39(2) Å und $\beta = 116,1(1)$ ° mit einem Zellvolumen von V = 712,1(1) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 5,8. In diesem Pulverdiffraktogramm treten auch Reflexe der enthaltenen Zersetzungsprodukte MnS und Bi₂S₃ auf.

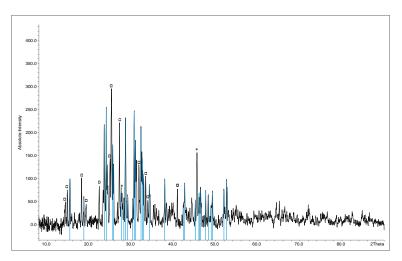


Abb. A.6.10: Pulverdiffraktogramm von $MnBi_2S_4$ nach der DTA mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen (cyan). Die darin enthaltenen Zersetzungsprodukte sind MnS (*) und Bi_2S_3 (\square).

A.6.11 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{1,8}Bi_{0,2}S₄

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{1,8}Bi_{0,2}S₄ erfolgte anhand von 68 Reflexen, von denen 67 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 12,7245(4) Å, b = 3,8066(1) Å, c = 15,0163(5) Å und $\beta = 114,007(2)$ ° mit einem Zellvolumen von V = 664,44(3) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 192,6. In diesem Pulverdiffraktogramm treten auch Reflexe von MnS und Sb₂S₃ auf.

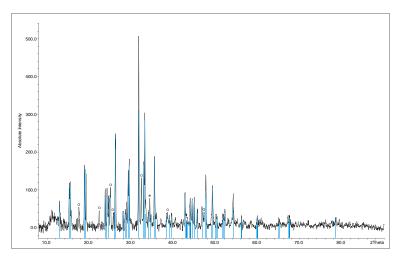


Abb. A.6.11: Pulverdiffraktogramm von MnSb_{1,8}Bi_{0,2}S₄ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen (cyan). Die darin enthaltene Zersetzungsprodukt sind MnS (*) und Sb₂S₃ (o).

A.6.12 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{1.6}Bi_{0.4}S₄

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{1,6}Bi_{0,4}S₄ erfolgte anhand von 76 Reflexen, von denen 72 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 12,7285(4) Å, b = 3,8185(1) Å, c = 14,9863(5) Å und $\beta = 114,136(3)$ ° mit einem Zellvolumen von V = 664,72(3) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 134,4. In diesem Pulverdiffraktogramm treten auch Reflexe von MnS und Sb₂S₃ auf.

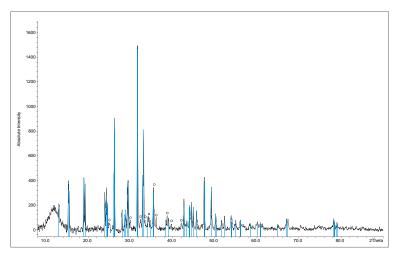


Abb. A.6.12: Pulverdiffraktogramm von MnSb_{1,6}Bi_{0,4}S₄ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen (cyan). Die darin enthaltenen Zersetzungsprodukte sind MnS (*) und Sb₂S₃ (o).

A.6.13 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{1,4}Bi_{0,6}S₄

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{1,4}Bi_{0,6}S₄ zeigte, dass in dieser Probe die beiden Verbindungen MnSb_{1,6}Bi_{0,4}S₄ und MnSbBiS₄ enthalten sind. Die Verfeinerung von MnSb_{1,6}Bi_{0,4}S₄ erfolgte anhand von 57 Reflexen, von denen 54 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a=12,7296(4) Å, b=3,8187(2) Å, c=14,9865(5) Å und $\beta=114,136(4)$ ° mit einem Zellvolumen von V=664,82(3) ų bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 113,1. Die Verfeinerung von MnSbBiS₄ erfolgte anhand von 70 Reflexen, von denen alle einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a=12,7440(4) Å, b=3,8541(1) Å, c=14,9017(5) Å und $\beta=114,574(3)$ ° mit einem Zellvolumen von V=665,64(3) ų bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 161,0. In diesem Pulverdiffraktogramm treten auch Reflexe von Sb₂S₃ auf.

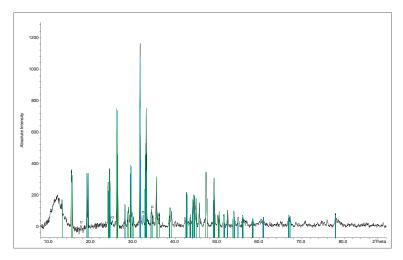


Abb. A.6.13: Pulverdiffraktogramm von $MnSb_{1,4}Bi_{0,6}S_4$ mit den zur Indizierung von $MnSb_{1,6}Bi_{0,4}S_4$ (grün) und $MnSbBiS_4$ (cyan) verwendeten Reflexen. Das darin enthaltenen Zersetzungsprodukte ist Sb_2S_3 (o).

A.6.14 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{1,2}Bi_{0,8}S₄

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{1,2}Bi_{0,6}S₄ zeigte, dass in dieser Probe die beiden Verbindungen MnSb_{1,6}Bi_{0,4}S₄ und MnSbBiS₄ enthalten sind. Die Verfeinerung von MnSb_{1,6}Bi_{0,4}S₄ erfolgte anhand von 56 Reflexen, von denen 53 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a=12,7296(4) Å, b=3,8182(2) Å, c=14,9870(5) Å und $\beta=114,148(3)$ ° mit einem Zellvolumen von V=664,82(3) ų bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 126,1. Die Verfeinerung von MnSbBiS₄ erfolgte anhand von 77 Reflexen, von denen alle einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a=12,7430(3) Å, b=3,8544(1) Å, c=14,9012(4) Å und $\beta=114,561(2)$ ° mit einem Zellvolumen von V=665,67(2) ų bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 178,3. In diesem Pulverdiffraktogramm treten auch Reflexe von Sb₂S₃ auf.

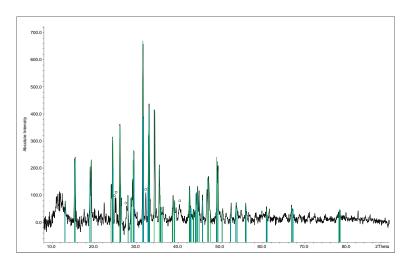


Abb. A.6.14: Pulverdiffraktogramm von $MnSb_{1,2}Bi_{0,8}S_4$ mit den zur Indizierung von $MnSb_{1,6}Bi_{0,4}S_4$ (grün) und $MnSbBiS_4$ (cyan) verwendeten Reflexen. Das darin enthaltenen Zersetzungsprodukt ist Sb_2S_3 (o).

A.6.15 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSbBiS₄

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSbBiS₄ erfolgte anhand von 125 Reflexen, von denen 122 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten entsprechen denen von MnSb_{1,6}Bi_{0,4}S₄ und wurden zu a = 12,7422(2) Å, b = 3,8545(7) Å, c = 14,9028(2) Å und $\beta = 114,564(1)$ ° mit einem Zellvolumen von V = 665,70(1) ų bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 210,6. In diesem Pulverdiffraktogramm treten auch Reflexe von MnS und Sb₂S₃ auf.

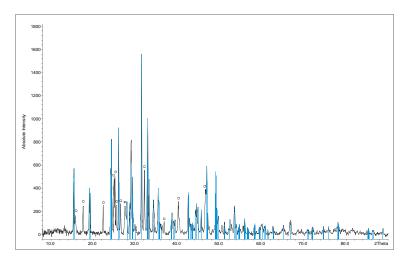


Abb. A.6.15: Pulverdiffraktogramm von MnSbBiS₄ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen (cyan). Die darin enthaltenen Zersetzungsprodukte sind MnS (*) und Sb₂S₃ (o).

A.6.16 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{0.8}Bi_{1,2}S₄

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{0,8}Bi_{1,2}S₄ erfolgte anhand von 59 Reflexen, von denen 58 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 12,7473(4) Å, b = 3,8670(1) Å, c = 14,8706(7) Å und $\beta = 114,698(3)$ ° mit einem Zellvolumen von V = 665,97(3) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 140,2. In diesem Pulverdiffraktogramm treten auch Reflexe von Sb₂S₃ auf.

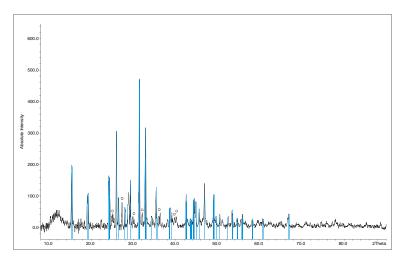


Abb. A.6.16: Pulverdiffraktogramm von MnSb_{0,8}Bi_{1,2}S₄ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen (cyan). Das darin enthaltene Zersetzungsprodukt ist Sb₂S₃ (o).

A.6.17 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{0.6}Bi_{1.4}S₄

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{0,6}Bi_{1,4}S₄ erfolgte anhand von 49 Reflexen, von denen 48 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 12,7538(6) Å, b = 3,8796(1) Å, c = 14,8405(7) Å und $\beta = 114,856(4)$ ° mit einem Volumen von V = 666,28(4) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 139,1. In diesem Pulverdiffraktogramm treten auch Reflexe von MnS und Sb₂S₃ auf.

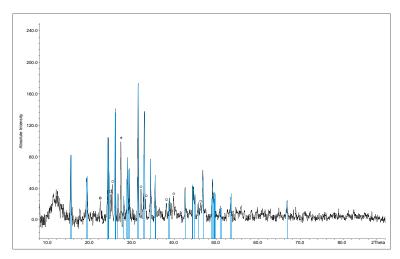


Abb. A.6.17: Pulverdiffraktogramm von MnSb_{0,6}Bi_{1,2}S₄ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen (cyan). Die darin enthaltene Zersetzungsprodukt sind MnS (*) und Sb₂S₃ (o).

A.6.18 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{0,4}Bi_{1,6}S₄

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{0,4}Bi_{1,6}S₄ erfolgte anhand von 55 Reflexen, von denen 54 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 12,7588(4) Å, b = 3,8925(1) Å, c = 14,8138(6) Å und $\beta = 115,005(3)$ ° mit einem Volumen von V = 666,75(3) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 139,7. In diesem Pulverdiffraktogramm treten auch Reflexe von MnS und Sb₂S₃ auf.

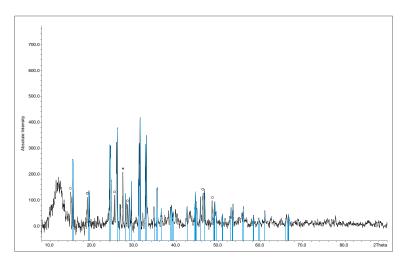


Abb. A.6.18: Pulverdiffraktogramm von MnSb_{0,4}Bi_{1,6}S₄ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen (cyan). Die darin enthaltenen Zersetzungsprodukte sind MnS (*) und Sb₂S₃ (o).

A.6.19 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{0,2}Bi_{1,8}S₄

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{0,2}Bi_{1,8}S₄ erfolgte anhand von 52 Reflexen, von denen 50 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 12,7612(4) Å, b = 3,9050(1) Å, c = 14,7854(7) Å und $\beta = 115,137(3)$ ° mit einem Volumen von V = 667,01(3) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 197,8. In diesem Pulverdiffraktogramm treten auch Reflexe von Sb₂S₃ auf.

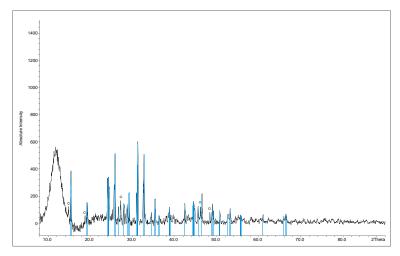


Abb. A.6.19: Pulverdiffraktogramm von MnSb_{0,2}Bi_{1,8}S₄ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen (cyan). Das darin enthaltenen Zersetzungsprodukt ist Sb₂S₃ (o).

A.6.20 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb₂Se₄

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb₂Se₄ erfolgte anhand von 70 Reflexen, von denen 54 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a=13,3388(3) Å, b=3,9733(1) Å, c=15,3136(3) Å und $\beta=115,775(2)$ ° mit einem Volumen von V=730,87(2) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 90,2.

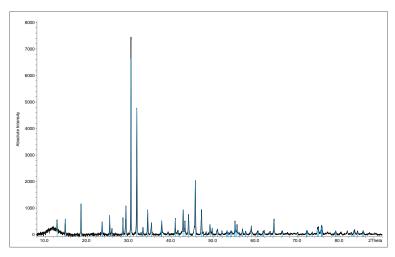


Abb. A.6.20: Pulverdiffraktogramm von MnSb₂Se₄ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.6.21 Auswertung des Pulverdiffraktogramms der DTA Probe von MnSb₂Se₄

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms der DTA Probe von MnSb₂Se₄ erfolgte anhand von 30 Reflexen, von denen 14 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 13,32(2) Å, b = 3,983(7) Å, c = 15,38(2) Å und $\beta = 116,21(8)$ ° mit einem Volumen von V = 731,9(1) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 2,6. In diesem Pulverdiffraktogramm treten auch Reflexe der enthaltenen Zersetzungsprodukte MnSe und Sb₂Se₃ auf.

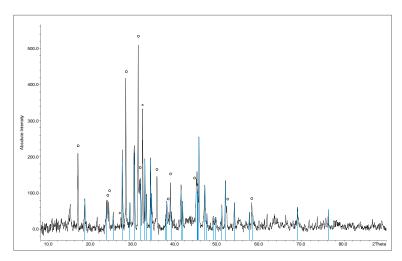


Abb. A.6.21: Pulverdiffraktogramm von MnSb₂Se₄ nach der DTA mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen (cyan). Die darin enthaltenen Zersetzungsprodukte sind MnSe (*) und Sb₂Se₃ (o).

A.6.22 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnBi₂Se₄

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnBi₂Se₄ erfolgte anhand von 92 Reflexen, von denen 83 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a=13,3841(3) Å, b=4,0712(1) Å, c=15,2517(3) Å und $\beta=115,926(2)$ ° mit einem Volumen von V=747,42(2) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 95,2.

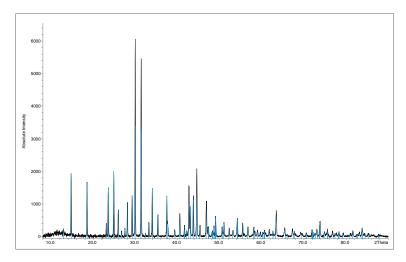


Abb. A.6.22: Pulverdiffraktogramm von MnBi₂Se₄ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.6.23 Auswertung des Pulverdiffraktogramms der DTA Probe von MnBi₂Se₄

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms der DTA Probe von MnBi₂Se₄ erfolgte anhand von 44 Reflexen, von denen 20 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 13,46(2) Å, b = 4,077(4) Å, c = 15,34(2) Å und $\beta = 116,62(7)$ ° mit einem Volumen von V = 752,3(2) ų bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 10,3. In diesem Pulverdiffraktogramm treten auch Reflexe der enthaltenen Zersetzungsprodukte MnSe und Bi₂Se₃ auf.

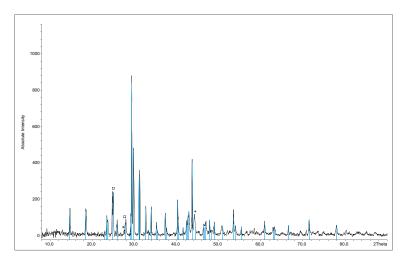


Abb. A.6.23: Pulverdiffraktogramm von MnBi₂Se₄ nach der DTA mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen (cyan). Die darin enthaltenen Zersetzungsprodukte sind MnSe (*) und Bi₂Se₃ (□).

A.6.24 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{1,8}Bi_{0,2}Se₄

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{1,8}Bi_{0,2}Se₄ erfolgte anhand von 69 Reflexen, von denen 55 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 13,3423(4) Å, b = 3,9823(2) Å, c = 15,3078(3) Å und $\beta = 115,796(2)$ ° mit einem Volumen von V = 732,29(3) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 89,7.

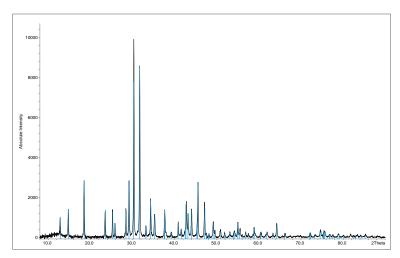


Abb. A.6.24: Pulverdiffraktogramm von MnSb_{1,8}Bi_{0,2}Se₄ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.6.25 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{1,6}Bi_{0,4}Se₄

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{1,6}Bi_{0,4}Se₄ erfolgte anhand von 89 Reflexen, von denen 74 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 13,3487(3) Å, b = 3,9942(1) Å, c = 15,3012(3) Å und $\beta = 115,810(1)$ ° mit einem Volumen von V = 734,44(2) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 107,8.

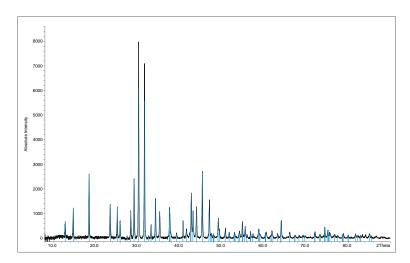


Abb. A.6.25: Pulverdiffraktogramm von MnSb_{1,6}Bi_{0,4}Se₄ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.6.26 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{1.4}Bi_{0.6}Se₄

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{1,4}Bi_{0,6}Se₄ erfolgte anhand von 99 Reflexen, von denen 85 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 13,3521(3)) Å, b = 4,0034(1) Å, c = 15,2944(3) Å und $\beta = 115,824(2)$ ° mit einem Volumen von V = 735,89(2) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 90,2.

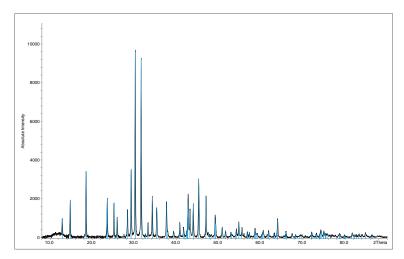


Abb. A.6.26: Pulverdiffraktogramm von MnSb_{1,4}Bi_{0,6}Se₄ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.6.27 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{1.2}Bi_{0.8}Se₄

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{1,2}Bi_{0,8}Se₄ erfolgte anhand von 100 Reflexen, von denen 82 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 13,3564(4) Å, b = 4,0130(1) Å, c = 15,2871(3) Å und $\beta = 115,836(2)$ ° mit einem Volumen von V = 737,48(2) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 96,1.

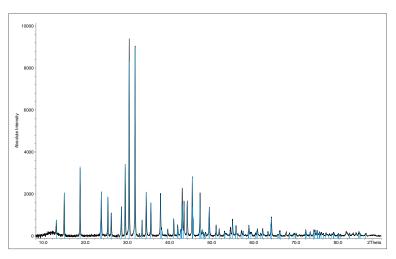


Abb. A.6.27: Pulverdiffraktogramm von MnSb_{1,2}Bi_{0,8}Se₄ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.6.28 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSbBiSe₄

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSbBiSe₄ erfolgte anhand von 106 Reflexen, von denen 83 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe *C2/m* (Nr.

12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 13,3627(3) Å, b = 4,0221(1) Å, c = 15,2830(3) Å und $\beta = 115,857(1)$ ° mit einem Volumen von V = 739,17(2) ų bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 119,2.

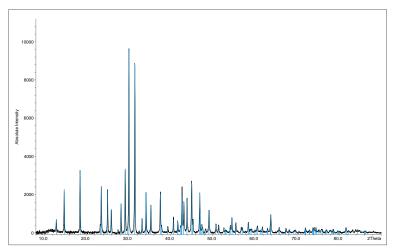


Abb. A.6.28: Pulverdiffraktogramm von MnSbBiSe₄ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.6.29 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von $MnSb_{0,8}Bi_{1,2}Se_4$

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{0,8}Bi_{1,2}Se₄ erfolgte anhand von 99 Reflexen, von denen 88 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 13,3655(3) Å, b = 4,0325(1) Å, c = 15,2768(3) Å und $\beta = 115,870(2)$ ° mit einem Volumen von V = 740,85(2) ų bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 114,0.

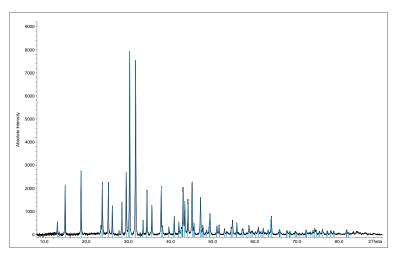


Abb. A.6.29: Pulverdiffraktogramm von MnSb_{0,8}Bi_{1,2}Se₄ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.6.30 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{0.6}Bi_{1.4}Se₄

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{0,6}Bi_{1,4}Se₄ erfolgte anhand von 91 Reflexen, von denen 79 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 13,3701(3) Å, b = 4,0414(1) Å, c = 15,2718(3) Å und $\beta = 115,888(2)$ ° mit einem Volumen von V = 742,38(2) ų bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 99,5.

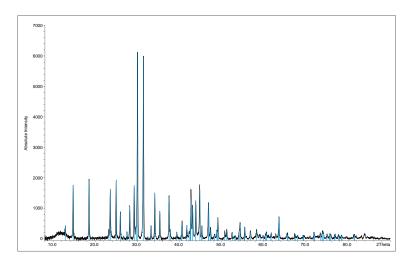


Abb. A.6.30: Pulverdiffraktogramm von MnSb_{0,6}Bi_{1,4}Se₄ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.6.31 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{0.4}Bi_{1.6}Se₄

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{0,4}Bi_{1,6}Se₄ erfolgte anhand von 109 Reflexen, von denen 98 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 13,3746(3) Å, b = 4,0519(1) Å, c = 15,2635(3) Å und $\beta = 115,900(1)$ ° mit einem Volumen von V = 744,09(2) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 117,1.

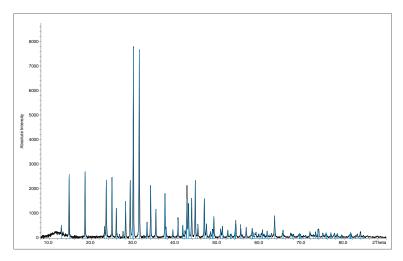


Abb. A.6.31: Pulverdiffraktogramm von MnSb_{0,4}Bi_{1,6}Se₄ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.6.32 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{0,2}Bi_{1,8}Se₄

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von MnSb_{0,2}Bi_{1,8}Se₄ erfolgte anhand von 102 Reflexen, von denen 88 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 13,3797(3) Å, b = 4,0617(1) Å, c = 15,2583(3) Å und $\beta = 115,915(2)$ ° mit einem Volumen von V = 745,82(2) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 121,7.

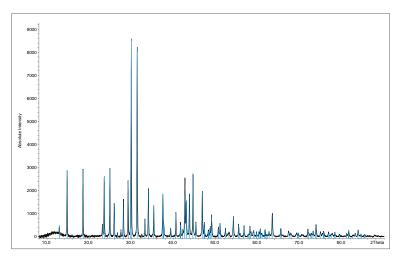


Abb. A.6.32: Pulverdiffraktogramm von $MnSb_{0,2}Bi_{1,8}Se_4$ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.7 Auswertung der Pulverdiffraktogramme von Kapitel 4

In diesem Abschnitt werden nur diejenigen Pulverdiffraktogramme dargestellt, die in Kapitel 4 behandelt werden. Des weiteren finden sich hier Angaben zu den durchgeführten Auswertungen aller in Kapitel 4 verwendeten Pulverdiffraktogramme. Diese Auswertungen wurden vorwiegend von *A. Pointner* durchgeführt und sind seiner Zulassungsarbeit [3] entnommen.

A.7.1 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von FeS

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von FeS erfolgte anhand von 5 Reflexen, von denen alle einzeln indizierbar sind in der hexagonalen Raumgruppe $P6_3/mmc$ (Nr. 194). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 3,445(3) Å und c = 5,875(5) Å mit einem Volumen von V = 60,4(1) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 189,1.

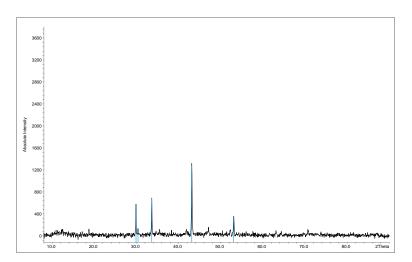


Abb. A.7.1: Pulverdiffraktogramm von FeS mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.7.2 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von SbSBr

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von SbSBr erfolgte anhand von 43 Reflexen, von denen 33 einzeln indizierbar sind in der orthorhombischen Raumgruppe Pnma (Nr. 62). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 8,245(2) Å, b = 3,9674(7) Å und c = 9,746(2) Å mit einem Volumen von V = 318,8(1) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 47,8.

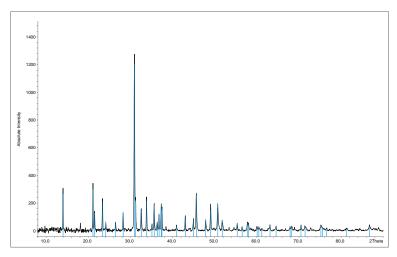


Abb. A.7.2: Pulverdiffraktogramm von SbSBr mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.7.3 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von BiSBr

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von BiSBr erfolgte anhand von 61 Reflexen, von denen 46 einzeln indizierbar sind in der orthorhombischen Raumgruppe Pnma (Nr. 62). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 8,1512(8) Å, b = 4,0615(3) Å und c = 9,853(1) Å mit einem Volumen von V = 326,21(7) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 138,0.

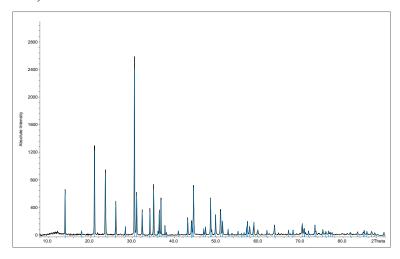


Abb. A.7.3: Pulverdiffraktogramm von BiSBr mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.7.4 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von FeSbS₂Br

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von FeSbS₂Br erfolgte anhand von 27 Reflexen, von denen 25 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 12,487(3) Å, b = 3,7868(7) Å, c = 9,425(2) Å und $\beta = 91,48(2)$ °

mit einem Volumen von $V = 445,5(2) \text{ Å}^3$ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 38,3.

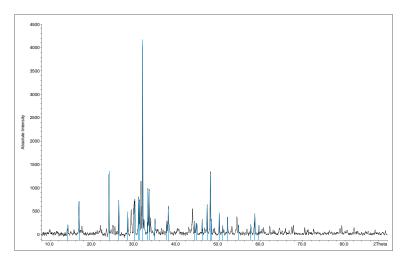


Abb. A.7.4: Pulverdiffraktogramm von FeSbS₂Br mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen [3].

A.7.5 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von FeSb_{0.7}Bi_{0.3}S₂Br

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von FeSb_{0,7}Bi_{0,3}S₂Br erfolgte anhand von 34 Reflexen, von denen 33 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 12,498(2) Å, b = 3,8246(5) Å, c = 9,403(1) Å und $\beta = 91,381(6)$ ° mit einem Volumen von V = 449,3(1) ų bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 76,1.

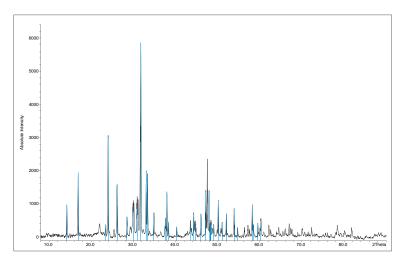


Abb. A.7.5: Pulverdiffraktogramm von FeSb_{0,7}Bi_{0,3}S₂Br mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen [3].

A.7.6 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von FeSb_{0.51}Bi_{0.49}S₂Br

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von FeSb_{0,51}Bi_{0,49}S₂Br erfolgte anhand von 56 Reflexen, von denen 52 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 12,488(1) Å, b = 3,8320(4) Å, c = 9,3984(7) Å und $\beta = 91,371(5)$ ° mit einem Volumen von V = 449,6(1) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 72,2.

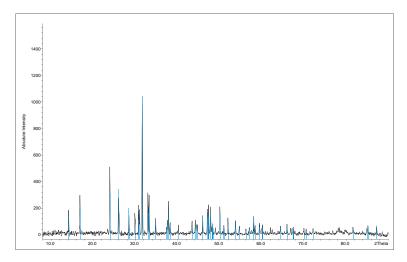


Abb. A.7.6: Pulverdiffraktogramm von FeSb_{0,51}Bi_{0,49}S₂Br mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.7.7 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von FeSb_{0.3}Bi_{0.7}S₂Br

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von FeSb_{0,3}Bi_{0,7}S₂Br erfolgte anhand von 38 Reflexen, von denen 33 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 12,492(1) Å, b = 3,8571(5) Å, c = 9,3786(9) Å und $\beta = 91,27(1)$ ° mit einem Volumen von V = 451,79(7) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 56,6.

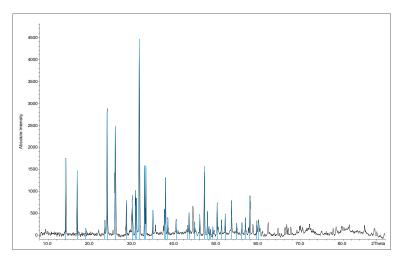


Abb. A.7.7: Pulverdiffraktogramm von FeSb_{0,3}Bi_{0,7}S₂Br mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen [3].

A.7.8 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von FeBiS₂Br

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von FeBiS₂Br erfolgte anhand von 61 Reflexen, von denen 51 einzeln und 3 nicht indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 12,497(1) Å, b = 3,8807(3) Å, c = 9,371(1) Å und $\beta = 91,253(8)$ ° mit einem Volumen von V = 454,4(1) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 54,7.

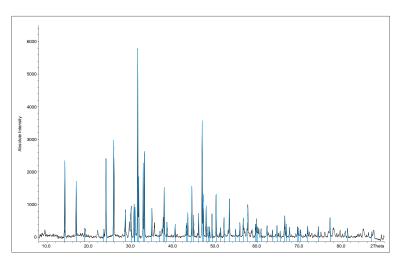


Abb. A.7.8: Pulverdiffraktogramm von FeBiS₂Br mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen [3].

A.8 Auswertung der Pulverdiffraktogramme von Kapitel 5

In diesem Abschnitt werden nur die Pulverdiffraktogramme dargestellt, die in Kapitel 5 behandelt werden. Des weiteren finden sich hier Angaben zu den durchgeführten Auswertungen aller in Kapitel 5 verwendeten Pulverdiffraktogramme.

A.8.1 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von HgS

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von HgS erfolgte anhand von 29 Reflexen, von denen 28 einzeln indizierbar sind in der trigonalen Raumgruppe $P3_121$ (Nr. 152). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 4,1463(4) Å und c = 9,4902(8) Å mit einem Volumen von V = 141,30(3) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 131,7.

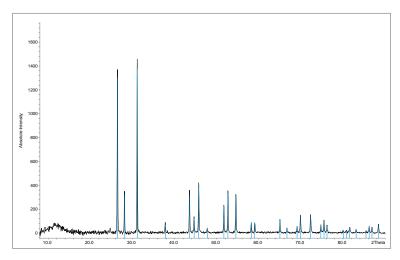


Abb. A.8.1: Pulverdiffraktogramm von HgS mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.8.2 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von HgSe

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von HgSe erfolgte anhand von 10 Reflexen, von denen alle einzeln indizierbar sind in der kubischen Raumgruppe $F\overline{4}3m$ (Nr. 216). Ihre Zellkonstante wurde zu a=6,0850(2) Å mit einem Volumen von V=225,31(1) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 644,7.

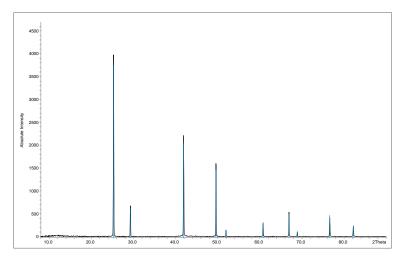


Abb. A.8.2: Pulverdiffraktogramm von HgSe mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.8.3 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von HgTe

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von HgTe erfolgte anhand von 12 Reflexen, von denen alle einzeln indizierbar sind in der kubischen Raumgruppe $F\overline{4}$ 3m (Nr. 216). Ihre Zellkonstante wurde zu a = 6,4583(2) Å mit einem Volumen von V = 269,37(1) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 479,3.

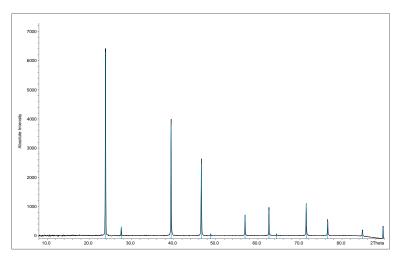


Abb. A.8.3: Pulverdiffraktogramm von HgTe mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.8.4 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von HgCl₂

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von $HgCl_2$ erfolgte anhand von 41 Reflexen, von denen 36 einzeln indizierbar sind in der orthorhombischen Raumgruppe *Pnma* (Nr. 62). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 12,755(2) Å, b = 5,9728(7) Å und c = 4,3293(6) Å mit einem Volumen von V = 329,8(1) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 104,2.

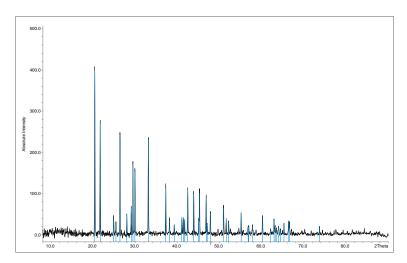


Abb. A.8.4: Pulverdiffraktogramm von HgCl₂ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.8.5 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von Hg₂Cl₂

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von Hg₂Cl₂ erfolgte anhand von 21 Reflexen, von denen alle einzeln indizierbar sind in der tetragonalen Raumgruppe I4/mmm (Nr. 139). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 4,4842(8) Å c = 10,912(2) Å mit einem Volumen von V = 219,42(8) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 70,8.

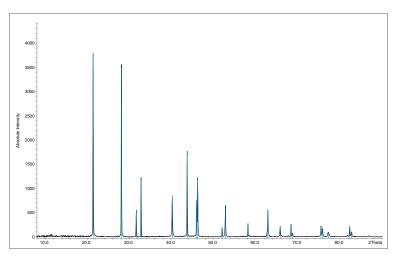


Abb. A.8.5: Pulverdiffraktogramm von Hg₂Cl₂ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.8.6 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von HgBi₂S₄

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von HgBi₂S₄ erfolgte anhand von 86 Reflexen, von denen 46 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 14,168(3) Å, b = 4,0530(7) Å, c = 13,972(2) Å und $\beta = 118,26(1)$ ° mit einem Volumen von V = 706,7(3) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 29,7.

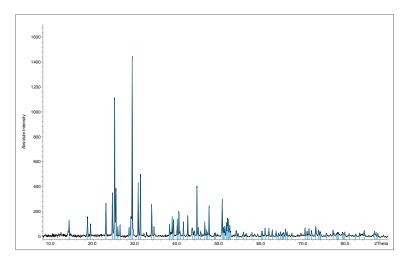


Abb. A.8.6: Pulverdiffraktogramm von HgBi₂S₄ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.8.7 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von Hg_{0.5}Bi₂S₃Cl

Das Hauptprodukt $Hg_{0.5}Bi_2S_3Cl$ konnte anhand von 78 Reflexen, von denen 37 einzeln indizierbar sind, in der monoklinen Raumgruppe $P2_1/m$ (Nr. 11) verfeinert werden. Ihre Zellkonstanten wurden zu a=7,843(5) Å, b=4,022(3) Å, c=10,804(6) Å und $\beta=104,87(4)$ ° mit einem Volumen von V=329,4(5) ų bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 40,0. Das erste Nebenprodukt dieser Probe $HgBi_2S_4$ konnte anhand von 62 Reflexen, von denen 25 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/m (Nr. 12) verfeinert werden. Ihre Zellkonstanten wurden zu a=14,16(1) Å, b=4,047(3) Å, c=13,989(7) Å und $\beta=118,19(8)$ ° mit einem Volumen von V=706,6(6) ų bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 12,6. Das zweite Nebenprodukt dieser Probe BiSCl konnte anhand von 39 Reflexen, von denen 30 einzeln indizierbar waren in der orthorombischen Raumgruppe Pnma (Nr. 62) verfeinert werden. Ihre Zellkonstanten wurden zu a=7,787(4) Å, b=3,998(3) Å und c=9,984(7) Å mit einem Volumen von V=310,8(2) ų bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 7,4.

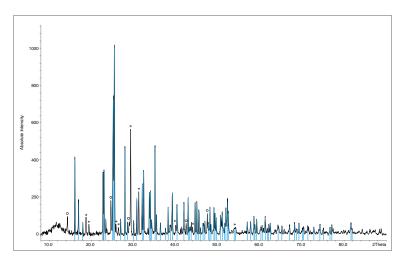


Abb. A.8.7: Pulverdiffraktogramm von Hg_{0,5}Bi₂S₃Cl mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen (cyan). Die darin enthaltenen Nebenprodukte sind HgBi₂S₄ (*) und BiSCl (o).

A.8.8 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von Hg₄BiS₂Cl₅

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von Hg₄BiS₂Cl₅ erfolgte anhand von 76 Reflexen, von denen 41 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe $P2_1$ (Nr. 4). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 8,015(2) Å, b = 10,457(3) Å, c = 8,753(2) Å und $\beta = 112,780(1)$ ° mit einem Volumen von V = 676,3(3) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 41,5.

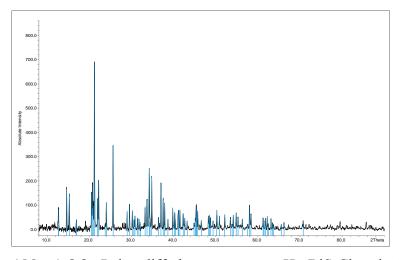


Abb. A.8.8: Pulverdiffraktogramm von Hg₄BiS₂Cl₅ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.8.9 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von Hg₄BiSe₂Cl₅

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von Hg₄BiSe₂Cl₅ erfolgte anhand von 59 Reflexen, von denen 27 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe $P2_1/n$ (Nr. 14). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 9,371(3) Å, b = 10,374(3) Å, c = 14,082(5) Å und $\beta = 94,24(2)$ ° mit einem Volumen von V = 1365,2(1) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 25,4.

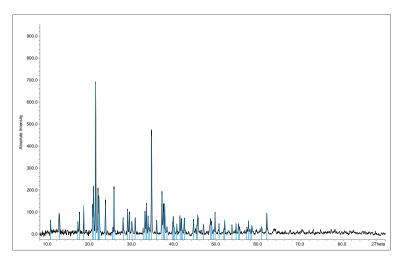


Abb. A.8.9: Pulverdiffraktogramm von Hg₄BiSe₂Cl₅ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.

A.8.10 Auswertung des Pulverdiffraktogramms von Hg₃Bi₂Te₂Cl₈

Die Auswertung des Pulverdiffraktogramms von Hg₃Bi₂Te₂Cl₈ erfolgte anhand von 87 Reflexen, von denen 79 einzeln indizierbar sind in der monoklinen Raumgruppe C2/c (Nr. 15). Ihre Zellkonstanten wurden zu a = 17,494(1) Å, b = 7,7339(4) Å, c = 13,5410(9) Å und $\beta = 104,129(5)$ ° mit einem Volumen von V = 1776,7(1) Å³ bestimmt. Der Figure of Merit dieser Indizierung beträgt 43,1.

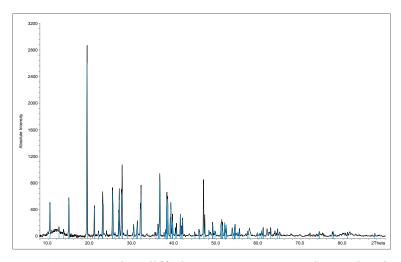


Abb. A.8.10: Pulverdiffraktogramm von Hg₃Bi₂Te₂Cl₈ mit den zur Indizierung verwendeten Reflexen.